NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60050-521

Deuxième édition
Second edition
2002-05

Vocabulaire Electrotechnique International

Partie 521 : Dispositifs à semiconducteurs et circuits intégrés

International Electrotechnical Vocabulary

Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60050-521:2002

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60050-521

Deuxième édition
Second edition
2002-05

Vocabulaire Electrotechnique International

Partie 521 : Dispositifs à semiconducteurs et circuits intégrés

International Electrotechnical Vocabulary

Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE XD

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Not for Resale

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS IV
INTRODUCTION – Principes d'établissement et règles suivies VIII

1 Domaine d'application 1
2 Références normatives 1
3 Termes et définitions 3

Section 521-01 – Notions de physique atomique 3
Section 521-02 – Propriétés des matériaux semiconducteurs 15
Section 521-03 – Traitement des matériaux semiconducteurs 44
Section 521-04 – Types de dispositifs à semiconducteurs 50
Section 521-05 – Termes généraux pour dispositifs à semiconducteurs 75
Section 521-06 – Termes particuliers aux diodes 89
Section 521-07 – Termes particuliers aux transistors 91
Section 521-08 – Termes particuliers aux thyristors 100
Section 521-09 – Termes particuliers aux dispositifs à effet hall et aux magnétoresistances 106
Section 521-10 – Termes particuliers aux circuits intégrés 113
Section 521-11 – Termes particuliers aux circuits intégrés numériques 117

INDEX en français, anglais, chinois, allemand, espagnol, japonais, polonais, portugais et suédois 126

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

CONTENTS

FOREWORD V
INTRODUCTION – Principles and rules followed IX

1 Scope 2
2 Normative references 2
3 Terms and definitions 3

Section 521-01 – Introduction to atomic physics 3
Section 521-02 – Properties of semiconductor materials 15
Section 521-03 – Processing semiconductor materials 44
Section 521-04 – Types of semiconductor devices 50
Section 521-05 – General terms for semiconductor devices 75
Section 521-06 – Specific terms for diodes 89
Section 521-07 – Specific terms for transistors 91
Section 521-08 – Specific terms for thyristors 100
Section 521-09 – Specific terms for hall-effect devices and magnetoresistors 106
Section 521-10 – Specific terms for integrated circuits 113
Section 521-11 – Specific terms for digital integrated circuits 117

INDEX in French, English, Chinese, German, Spanish, Japanese, Polish, Portuguese and Swedish 126

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 521 : DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTÉGRÉS

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60050-521 a été établie par le Groupe de Travail 1 du Comité d'études 47 : Dispositifs à semiconducteurs, sous la responsabilité du comité d'études 1 de la CEI : Terminologie.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

FDIS	Rapport de vote
1/1830/FDIS	1/1835/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette deuxième édition de la CEI 60050-521 est issue de l'édition originale de 1984 et des termes nouveaux ou modifiés approuvés dans le FDIS en référence.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Dans la présente partie du VEI les termes et définitions sont donnés en français et en anglais : de plus, les termes sont indiqués en chinois (cn), allemand (de), espagnol (es), japonais (ja), polonais (pl), portugais (pt) et suédois (sv).

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-521 has been prepared by Working Group 1 of IEC technical committee 47: Semiconductor devices, under the responsibility of IEC technical committee 1: Terminology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
1/1830/FDIS	1/1835/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This second edition of IEC 60050-521 is based on 1984 edition and new or modified approved terms in FDIS in reference.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

In this part of IEV, the terms and definitions are written in French and English; in addition the terms are given in Chinese (cn), German (de), Spanish (es), Japanese (ja), Polish (pl), Portuguese (pt) and Swedish (sv).

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2013. A cette date, la publication sera

- reconduite ;
- supprimée ;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2013. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INTRODUCTION
Principes d'établissement et règles suivies

Généralités

Le VEI (série CEI 60050) est un vocabulaire multilingue à usage général couvrant le champ de l'électrotechnique, de l'électronique et des télécommunications. Il comprend environ 18 500 *articles terminologiques* correspondant chacun à une *notion*. Ces articles sont répartis dans environ 80 *parties*, chacune correspondant à un domaine donné.

Exemples :

Partie 161 (CEI 60050-161) : Compatibilité électromagnétique

Partie 411 (CEI 60050-411) : Machines tournantes

Les articles suivent un schéma de classification hiérarchique Partie/Section/Notion, les notions étant, au sein des sections, classées par ordre systématique.

Les termes, définitions et notes des articles sont donnés dans les trois langues officielles de la CEI, c'est-à-dire français, anglais et russe (*langues principales du VEI*).

Dans chaque article, les termes seuls sont également donnés dans les *langues additionnelles du VEI* (arabe, chinois, allemand, grec, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et suédois).

De plus, chaque partie comprend un *index alphabétique* des termes inclus dans cette partie, et ce pour chacune des langues du VEI.

NOTE – Certaines langues peuvent manquer.

Constitution d'un article terminologique

Chacun des articles correspond à une notion, et comprend :

– un *numéro d'article,*

– éventuellement un *symbole littéral de grandeur ou d'unité*,

puis, pour chaque langue principale du VEI :

– le terme désignant la notion, appelé « *terme privilégié* », éventuellement accompagné de *synonymes* et d'*abréviations*,

– la *définition* de la notion,

– éventuellement la *source*,

– éventuellement des *notes*,

et enfin, pour les langues additionnelles du VEI, les termes seuls.

Numéro d'article

Le numéro d'article comprend trois éléments, séparés par des traits d'union :

– Numéro de partie : 3 chiffres,

– Numéro de section : 2 chiffres,

– Numéro de la notion : 2 chiffres (01 à 99).

Exemple : **151-13-82**

--`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050 series) is a general-purpose multilingual vocabulary covering the field of electrotechnology, electronics and telecommunication. It comprises about 18 500 *terminological entries*, each corresponding to a *concept*. These entries are distributed among about 80 *parts*, each part corresponding to a given field.

Examples:

Part 161 (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility

Part 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

The entries follow a hierarchical classification scheme Part/Section/Concept, the concepts being, within the sections, organized in a systematic order.

The terms, definitions and notes in the entries are given in the three IEC official languages, that is French, English and Russian (*principal IEV languages*).

In each entry the terms alone are also given in the *additional IEV languages* (Arabic, Chinese, German, Greek, Spanish, Italian, Japanese, Polish, Portuguese and Swedish).

In addition, each part comprises an *alphabetical index* of the terms included in that part, for each of the IEV languages.

NOTE – Some languages may be missing.

Organization of a terminological entry

Each of the entries corresponds to a concept, and comprises:

– an *entry number*,

– possibly a *letter symbol for quantity or unit*,

then, for each of the principal IEV languages:

– the term designating the concept, called "*preferred term*", possibly accompanied by *synonyms* and *abbreviations*,

– the *definition* of the concept,

– possibly the *source*,

– possibly *notes*,

and finally, for the additional IEV languages, the terms alone.

Entry number

The entry number is comprised of three elements, separated by hyphens:

– Part number: 3 digits,

– Section number: 2 digits,

– Concept number: 2 digits (01 to 99).

Example: **151-13-82**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Symboles littéraux de grandeurs et unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le numéro d'article.

Exemple :

131-11-22

symb. : R

résistance, f

Terme privilégié et synonymes

Le terme privilégié est le terme qui figure en tête d'un article ; il peut être suivi de synonymes. Il est imprimé en gras.

Synonymes :

Les synonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le terme privilégié : ils sont également imprimés en gras, sauf les synonymes déconseillés, qui sont imprimés en maigre, et suivis par l'attribut « (déconseillé) ».

Parties pouvant être omises :

Certaines parties d'un terme peuvent être omises, soit dans le domaine considéré, soit dans un contexte approprié. Ces parties sont alors imprimées en gras, entre parenthèses :

Exemple: **émission (électromagnétique)**

Absence de terme approprié :

Lorsqu'il n'existe pas de terme approprié dans une langue, le terme privilégié est remplacé par cinq points, comme ceci :

« ····· » (et il n'y a alors bien entendu pas de synonymes).

Attributs

Chaque terme (ou synonyme) peut être suivi d'attributs donnant des informations supplémentaires ; ces attributs sont imprimés en maigre, à la suite de ce terme, et sur la même ligne.

Exemples d'attributs :

– *spécificité d'utilisation du terme :*

  rang (d'un harmonique)

– *variante nationale :*

  unité de traitement CA

– *catégorie grammaticale :*

  électronique, adj

  électronique, f

– *abréviation :* **CEM** (abréviation)

– *déconseillé :* déplacement (terme déconseillé)

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Letter symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the entry number.

Example:

131-11-22

symb. : R

resistance

Preferred term and synonyms

The preferred term is the term that heads a terminological entry; it may be followed by synonyms. It is printed in boldface.

Synonyms:

The synonyms are printed on separate lines under the preferred term: they are also printed in boldface, excepted for deprecated synonyms, which are printed in lightface, and followed by the attribute "(deprecated)".

Parts that may be omitted:

Some parts of a term may be omitted, either in the field under consideration or in an appropriate context. Such parts are printed in boldface type, and placed in parentheses:

Example: **(electromagnetic) emission**

Absence of an appropriate term:

When no adequate term exists in a given language, the preferred term is replaced by five dots, like this:

" ····· " (and there are of course no synonyms).

Attributes

Each term (or synonym) may be followed by attributes giving additional information, and printed on the same line as the corresponding term, following this term.

Examples of attributes:

– *specific use of the term:*

  transmission line (in electric power systems)

– *national variant:* **lift** GB

– *grammatical information:*

  thermoplastic, noun

  AC, qualifier

– *abbreviation:* **EMC** (abbreviation)

– *deprecated:* choke (deprecated)

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Source

Dans certains cas il a été nécessaire d'inclure dans une partie du VEI une notion prise dans une autre partie du VEI, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité (VIM, ISO/CEI 2382, etc.), dans les deux cas avec ou sans modification de la définition (ou éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre, et placée entre crochets à la fin de la définition :

Exemple : [131-03-13 MOD]

(MOD indique que la définition a été modifiée)

Termes dans les langues additionnelles du VEI

Ces termes sont placés à la fin de l'article, sur des lignes séparées (une ligne par langue), précédés par le code alpha-2 de la langue, défini dans l'ISO 639, et dans l'ordre alphabétique de ce code. Les synonymes sont séparés par des points-virgules.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Source

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another IEV part, or from another authoritative terminology document (VIM, ISO/IEC 2382, etc.), in both cases with or without modification to the definition (and possibly to the term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed between square brackets at the end of the definition.

Example: [131-03-13 MOD]

(MOD indicates that the definition has been modified)

Terms in additional IEV languages

These terms are placed at the end of the entry, on separate lines (one single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the language defined in ISO 639, and in the alphabetic order of this code. Synonyms are separated by semicolons.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 521 : DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTÉGRÉS

1 Domaine d'application

Cette partie de la norme CEI 60050 donne la terminologie générale utilisée dans les domaines de la technologie des semiconducteurs, du développement des semiconducteurs et pour les types de semiconducteurs.

Cette terminologie est naturellement en accord avec la terminologie figurant dans les autres parties spécialisée du VEI.

2 Références normatives

Les références normatives se limitent essentiellement à la CEI 60050 Partie 151 : Dispositifs électriques et magnétiques, en cours de révision.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the general terminology used in the fields of semiconductor technology and semiconductor design and for types of semiconductors.

This terminology is of course consistent with the terminology developed in the other specialized parts of the IEV.

2 Normative references

Normative references are limited to IEC 60050 Part 151: Electric and magnetic devices, under revision.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

3 Termes et définitions

3 Terms and definitions

PARTIE 521 : DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTÉGRÉS

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS

Section 521-01 – Notions de physique atomique

Section 521-01 – Introduction to atomic physics

521-01-01

système non quantifié (de particules), m

système de particules dont on suppose que les énergies sont susceptibles de varier de manière continue. Le nombre des états microscopiques, défini par les positions et les vitesses des particules à un instant donné, est alors non limité

non-quantized system (of particles)

system of particles whose energies are assumed to be capable of varying in a continuous manner and in which the number of microscopic states defined by the positions and velocities of the particles at a given instant is therefore unlimited

cn **非量子化系统**(粒子的)
de **nichtquantisiertes System** (von Teilchen), n
es **sistema no cualificado** (de partículas)
ja **(粒子の) 非量子化系**
pl **układ niekwantowany** (cząstek)
pt **sistema não quantificado** (de partículas)
sv **okvantiserat system**

521-01-02

système quantifié (de particules), m

système de particules dont les énergies ne peuvent prendre que des valeurs discrètes

quantized system (of particles)

system of particles the energies of which can have discrete values only

cn **量子化系统**(粒子的)
de **quantisiertes System** (von Teilchen), n
es **sistema cuantificado** (de partículas)
ja **(粒子の) 量子化系**
pl **układ kwantowany** (cząstek)
pt **sistema quantificado** (de partículas)
sv **kvantiserat system**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-03

statistique de Maxwell-Boltzmann, f

ensemble de probabilités des états macroscopiques d'un système non quantifié de particules déterminé par les valeurs moyennes des coordonnées de positions, des vitesses ou de l'énergie, dans un volume très petit, mais non nul du système

Maxwell-Boltzmann statistics

probability distribution of the macroscopic states of a non-quantized system of particles, defined by the average values of the position, velocity or energy co-ordinates, in a very small, but finite, volume of the system

cn **麦克斯韦–玻尔兹曼统计**
de **Maxwell-Boltzmann-Statistik**, f
es **estadística de Maxwell-Boltzmann**
ja **マックスウェル - ボルツマン統計**
pl **rozkład Maxwella-Boltzmanna**
pt **estatística de Maxwell-Boltzmann**
sv **Maxwell-Boltzmann-fördelning**

521-01-04

relation de Boltzmann, f

relation exprimant que, à une constante additive près, l'entropie d'un système de particules est égale au produit du logarithme népérien de la probabilité de son état macroscopique par la constante de Boltzmann

Boltzmann relation

equation stating that, apart from an additive constant, the entropy of a system of particles is equal to the product of the Napierian (natural) logarithm of the probability of its macroscopic state and the Boltzmann constant

cn **玻尔兹曼关系**
de **Boltzmann-Beziehung**, f
es **relación de Boltzmann**
ja **ボルツマン関係**
pl **zależność Boltzmanna**
pt **relação de Boltzmann**
sv **Boltzmanns ekvation**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-05

loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f

relation algébrique donnant le nombre $\mathrm{d}N$ de particules d'un système non quantifié dont les composantes de vitesse sont comprises respectivement dans les intervalles $(u, u + \mathrm{d}u)$, $(v, v + \mathrm{d}v)$, $(w, w + \mathrm{d}w)$:

$$\mathrm{d}N = A \cdot \exp\left[\frac{-m(u^2 + v^2 + w^2)}{2kT}\right] \mathrm{d}u \cdot \mathrm{d}v \cdot \mathrm{d}w$$

où

$$A = N\left[\frac{m}{(2\pi \cdot kT)}\right]^{3/2}$$

N désigne le nombre total de particules

m la masse d'une particule

T la température thermodynamique

k la constante de Boltzmann

NOTE – $\mathrm{d}N/N$ représente la probabilité pour qu'une particule ait ses composantes de vitesse comprises dans les intervalles considérés.

Maxwell-Boltzmann velocity-distribution law

algebraic equation giving the number $\mathrm{d}N$ of particles of a non-quantized system, the components of velocity of which are comprised in the intervals $(u, u + \mathrm{d}u)$, $(v, v + \mathrm{d}v)$, $(w, w + \mathrm{d}w)$ respectively:

$$\mathrm{d}N = A \cdot \exp\left[\frac{-m(u^2 + v^2 + w^2)}{2kT}\right] \mathrm{d}u \cdot \mathrm{d}v \cdot \mathrm{d}w$$

where

$$A = N\left[\frac{m}{(2\pi \cdot kT)}\right]^{3/2}$$

N is the total number of particles

m is the mass of a particle

T is the thermodynamic temperature

k is the Boltzmann constant

NOTE – $\mathrm{d}N/N$ represents the probability that a particle has its components of velocity within the intervals considered.

cn **麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布律**
de **Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung**, f
es **ley de distribución de las velocidades de Maxwell-Boltzmann**
ja **マックスウェル - ボルツマン速度分布則**
pl **prawo rozkładu prędkości Maxwella-Boltzmanna**
pt **lei de distribuição das velocidades de Maxwell-Boltzmann**
sv **Maxwell-Boltzmanns hastighetsfördelning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-06

atome de Bohr, m

modèle de l'atome fondé sur les conceptions de Bohr et de Sommerfeld, d'après lesquelles les électrons d'un atome décriraient autour du noyau des orbites circulaires ou elliptiques discrètes

NOTE – A chacun des degrés de liberté de l'atome correspond une série d'états énergétiques qui déterminent les séries spectrales susceptibles d'être émises par l'atome.

Bohr atom

model of the atom based on the conception of Bohr and Sommerfeld, according to which the electrons of an atom move around the nucleus in discrete circular or elliptical orbits

NOTE – To each of the degrees of freedom of the atom there corresponds a series of energy states which determine the spectral series that may be emitted by the atom.

cn **玻尔原子**
de **Bohr-Atommodell**, n
es **átomo de Bohr**
ja **ボーア原子**
pl **atom Bohra**
pt **átomo de Bohr**
sv **Bohrs atommodell**

521-01-07

nombre quantique (d'un électron dans un atome donné), m

chacun des nombres caractérisant les degrés de liberté d'un électron dans un atome donné :

– le nombre quantique principal n
– le nombre quantique secondaire l
– le nombre quantique de spin s
– le nombre quantique interne j

quantum number (of an electron in a given atom)

each of the numbers characterizing the degree of freedom of an electron in a given atom:

– the principal quantum number n
– the orbital quantum number l
– the spin quantum number s
– the total angular momentum quantum number j

cn **量子数**（给定原子中电子的）
de **Quantenzahl** (eines Elektrons in einem gegebenen Atom), f
es **número cuántico** (de un electrón de un átomo dado)
ja **（与えられた原子内の電子の）量子数**
pl **liczba kwantowa** (elektronu w danym atomie)
pt **número quântico** (de um electrão num átomo dado)
sv **kvanttal**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-08

symb. : n
nombre quantique principal, m

nombre quantique entier positif qui caractérise les variations importantes du niveau d'énergie des électrons dans un atome

NOTE – Selon le modèle de l'atome de Bohr, le nombre quantique principal peut être considéré comme caractérisant le grandeur de l'orbite d'un électron.

principal quantum number
first quantum number

positive integer number characterizing the important changes of energy level of the electrons in an atom

NOTE – According to the Bohr atom model, the main quantum number may be considered as characterizing the size of an electron orbit.

cn **主量子数**
de **Hauptquantenzahl**, f
es **número cuántico principal**
ja **主量子数；第1量子数**
pl **liczba kwantowa główna; liczba kwantowa pierwsza**
pt **número quântico principal**
sv **huvudkvanttal**

521-01-09

symb. : l
nombre quantique secondaire, m
nombre quantique orbital, m

nombre quantique qui peut prendre toutes les valeurs entières de zéro à $n-1$, n désignant le nombre quantique principal

NOTE – Selon le modèle de l'atome de Bohr, le nombre quantique secondaire peut être considéré comme caractérisant le moment cinétique de l'électron dans son mouvement orbital.

orbital quantum number
second quantum number

quantum number which can have all whole values from zero to $n-1$, n designating the main quantum number

NOTE – According to the Bohr atom model, the orbital quantum number may be considered as characterizing the angular momentum of the electron in its orbital motion round the nucleus.

cn **轨道量子数**
de **Bahndrehimpulsquantenzahl**, f
es **número cuántico secundario**
ja **軌道量子数；第2量子数**
pl **liczba kwantowa orbitalna; liczba kwantowa druga**
pt **número quântico orbital; número quântico secundário**
sv **bikvanttal**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-10

symb. : s
(nombre quantique de) spin, m

nombre quantique qui caractérise le moment cinétique de l'électron considéré comme une petite sphère chargée en rotation autour de son axe

NOTE – Le spin peut prendre deux valeurs : +1/2 et –1/2.

spin (quantum number)

quantum number which gives the angular momentum of the electron considered as a small charged sphere revolving rotating around its axis

NOTE – The spin may have two values: +1/2 or –1/2.

cn **自旋(量子数)**
de **Spinquantenzahl**, f**; Spin**, m
es **espín**
ja **スピン（量子数）**
pl **liczba spinowa; spin**
pt **(número quântico de) spin**
sv **spinnkvanttal**

521-01-11

symb. : j
nombre quantique interne, m

nombre quantique qui caractérise la résultante des champs magnétiques engendrés par l'électron, d'une part dans son mouvement orbital et d'autre part dans son mouvement de rotation

NOTE – Les valeurs de ce nombre j forment une suite de nombres semi-entiers et entiers.

total angular momentum quantum number

quantum number which gives the resultant of the magnetic field engendered by the electron due to its orbital movement and due to its revolving on its own axis

NOTE – The values of this number j form a set of integral and semi-integral values.

cn **总角动量量子数**
de **Gesamtdrehimpulsquantenzahl**, f
es **número cuántico interno**
ja **総角運動量量子数**
pl **liczba kwantowa całkowitego momentu kątowego**
pt **(número quântico de) momento angular total**
sv **kvanttal för totalt rörelsemängdsmoment**

521-01-12

niveau d'énergie, m

énergie correspondant à un état quantifié d'un système physique

energy level (of a particle)

energy associated with a quantum state of a physical system

cn **能级**（粒子的）
de **Energieniveau** (eines Teilchens), n
es **nivel de energía** (de una partícula); **nivel energético** (de una partícula)
ja **（粒子の）エネルギー準位**
pl **poziom energetyczny** (cząstki)
pt **nível de energia**
sv **energinivå**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-13

diagramme énergétique, m

diagramme représentant les niveaux d'énergie des particules d'un système quantifié par des droites horizontales, ayant pour ordonnées l'énergie de ces particules

energy-level diagram

diagram representing the energy levels of the particles of a quantized system by horizontal lines, having for ordinates the energy of these particles

cn **能级图**
de **Energieniveau-Diagramm**, n
es **diagrama energético**
ja **エネルギー準位図**
pl **wykres poziomów energetycznych** (cząstek)
pt **diagrama de níveis de energia; diagrama energético**
sv **energinivådiagram**

521-01-14

principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m

principe suivant lequel chaque niveau d'énergie d'un système quantifié ne peut contenir que zéro, une ou deux particules

NOTE – Dans le cas de deux électrons, les spins sont de signes contraires.

Pauli-Fermi exclusion principle
Pauli principle

principle stating that each energy level of a quantized system can include only none, one or two particles

NOTE – In the case of two electrons, the spins are of opposite sign.

cn **泡利-费米不相容原理；泡利原理**
de **Pauli-Prinzip**, n
es **principio de exclusión de Pauli-Fermi**
ja **パウリ - フェルミの排他律；パウリの原理**
pl **zasada Pauliego-Fermiego; zakaz Pauliego**
pt **princípio de exclusão de Pauli-Fermi**
sv **Pauli-Fermis princip**

521-01-15

statistique de Fermi-Dirac, f
statistique de Fermi, f

ensemble de probabilités des états macroscopiques d'un système quantifié de particules, satisfaisant au principe d'exclusion de Pauli-Fermi

Fermi-Dirac statistics
Fermi statistics

set of probabilities of the macroscopic states of a quantized system of particles, with only discrete energy levels, obeying the Pauli-Fermi exclusion principle

cn **费米-狄拉克统计；费米统计**
de **Fermi-Dirac-Statistik**, f; **Fermi-Statistik**, f
es **estadística de Fermi-Dirac; estadística de Fermi**
ja **フェルミ - ディラック統計；フェルミ統計**
pl **rozkład Fermiego-Diraca**
pt **estatística de Fermi-Dirac; estatística de Fermi**
sv **fermistatistik**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-16

fonction de Fermi-Dirac, f

fonction qui exprime la probabilité $P(E)$ pour qu'une particule satisfaisant à la statistique de Fermi occupe un niveau d'énergie autorisé E

$$P(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_{\mathrm{F}}}{kT}\right)}$$

où

k est la constante de Boltzmann

T est la température thermodynamique

E_{F} est le niveau de Fermi

et où ce niveau est quantifié et peut contenir 0, 1 ou 2 électrons.

Fermi-Dirac function

function expressing the probability $P(E)$, for a particle obeying Fermi statistics, that it will occupy a permitted energy level (E)

$$P(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_{\mathrm{F}}}{kT}\right)}$$

where

k is the Boltzmann constant

T is the thermodynamic temperature

E_{F} is the Fermi-level

and where this level is quantized and may contain 0, 1 or 2 electrons.

cn **费米-狄拉克函数**
de **Fermi-Dirac-Funktion**, f
es **función de Fermi-Dirac**
ja **フェルミ - ディラック関数**
pl **funkcja Fermiego-Diraca**
pt **função de Fermi-Dirac**
sv **Fermi-Dirac-funktion**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-17

niveau de Fermi, m

dans un solide, niveau d'énergie qui sépare les états occupés des états inoccupés à la température de zéro kelvin

NOTE – Quand une bande interdite sépare les états occupés des états inoccupés, le niveau de Fermi est assigné au milieu de la bande interdite.

Fermi level

in a solid, energy level separating the occupied states from the unoccupied states at a temperature of zero kelvin

NOTE – When a forbidden band separates the occupied and unoccupied states, the Fermi-level is assigned to the centre of the forbidden band.

cn **费米能级**
de **Fermi-Niveau**, n
es **nivel de Fermi**
ja **フェルミ準位**
pl **poziom Fermiego**
pt **nível de Fermi**
sv **ferminivå**

521-01-18

électron célibataire, m

électron qui se trouve seul sur un niveau d'énergie

lone electron

electron which is alone on an energy level

cn **孤电子**
de **Einzelelektron**, n
es **electrón suelto**
ja **孤立電子**
pl **elektron samotny**
pt **electrão solitário**
sv **ensam elektron**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-19

loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f

relation algébrique donnant le nombre de particules $\mathrm{d}N$ d'un système quantifié en équilibre, dont les composantes de vitesse sont comprises dans des intervalles $(u,\ u + \mathrm{d}u)$, $(v,\ v + \mathrm{d}v)$, $(w,\ w + \mathrm{d}w)$:

$$\mathrm{d}N = 2N \cdot \frac{m^3}{h^3} \cdot \frac{\mathrm{d}u \cdot \mathrm{d}v \cdot \mathrm{d}w}{1 + \exp\left(\dfrac{E - E_\mathrm{M}}{kT}\right)}$$

où

N désigne le nombre total de particules

m la masse d'une particule

T la température thermodynamique

k la constante de Boltzmann

h la constante de Planck

E l'énergie cinétique d'une particule,

$$E = \frac{m}{2}\ (u^2 + v^2 + w^2)$$

E_M la fonction de travail interne

$\mathrm{d}N/N$ représente la probabilité pour qu'une particule ait ses composantes de vitesse comprises dans les intervalles considérés.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-19

Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law

algebraic equation giving the number $\mathrm{d}N$ of particles of a quantized system in equilibrium, the velocity components of which are included in the intervals $(u, u + \mathrm{d}u)$, $(v, v + \mathrm{d}v)$, $(w, w + \mathrm{d}w)$: respectively:

$$\mathrm{d}N = 2N \cdot \frac{m^3}{h^3} \cdot \frac{\mathrm{d}u \cdot \mathrm{d}v \cdot \mathrm{d}w}{1 + \exp\left(\frac{E - E_\mathrm{M}}{kT}\right)}$$

where

N is the total number of particles

m is the mass of the particle

T is the thermodynamic temperature

k is the Boltzmann constant

h is the Planck constant

E is the kinetic energy of a particle,

$$E = \frac{m}{2}\,(u^2 + v^2 + w^2)$$

E_M is the inner work function

$\mathrm{d}N/N$ represents the probability that a particle has its components within the intervals considered.

cn **费米–狄拉克–索末菲速度分布律**
de **Fermi-Dirac-Sommerfeld-Geschwindigkeitsverteilung**, f
es **ley de distribución de las velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld**
ja **フェルミ - ディラック - ゾンマーフェルト速度分布則**
pl **prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda**
pt **lei de distribuição das velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld**
sv **fermifördelning**

521-01-20

effet photoélectrique, m

phénomène électrique produit par l'absorption de photons

photoelectric effect

electrical phenomena produced by absorption of photons

cn **光电效应**
de **photoelektrischer Effekt**, m**; Photoeffekt**, m
es **efecto fotoeléctrico**
ja **光電効果**
pl **zjawisko fotoelektryczne**
pt **efeito fotoeléctrico**
sv **fotoelektrisk effekt**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-01-21

effet photovoltaïque, m

effet photoélectrique dans lequel l'absorption de photons produit une force électromotrice

photovoltaic effect

photoelectric effect in which an e.m.f. is produced by the absorption of photons

cn **光生伏打效应；光伏效应**
de **Sperrschicht-Photoeffekt**, m**; photovoltaischer Effekt**, m
es **efecto fotovoltaico**
ja **光起電力効果**
pl **zjawisko fotowoltaiczne**
pt **efeito fotovoltaico**
sv **fotoelektromotorisk effekt**

521-01-22

effet photoconductif, m

effet photoélectrique caractérisé par une variation de conductivité électrique

photoconductive effect

photoelectric effect characterized by the variation of electric conductivity

cn **光电导效应**
de **Photoleiteffekt**, m
es **efecto fotoconductivo**
ja **光導電効果**
pl **zjawisko fotokonduktywne**
pt **efeito fotocondutivo**
sv **fotokonduktiv effekt**

521-01-23

effet photoélectromagnétique, m

dans un semiconducteur soumis à un champ magnétique et à un rayonnement électromagnétique, apparition d'un champ électrique perpendiculaire au champ magnétique et au flux des porteurs de charge engendrés par effet photoélectrique et diffusant dans le semiconducteur

photoelectromagnetic effect

in a semiconductor subjected to a magnetic field and electromagnetic radiation, the development of an electric field perpendicular to the magnetic field and to the flow of charge carriers generated by the photoelectric effect and diffusing in the semiconductor

cn **光磁电效应**
de **photoelektromagnetischer Effekt**, m
es **efecto fotoelectromagnético**
ja **光電磁効果**
pl **zjawisko fotomagnetoelektryczne**
pt **efeito fotoelectromagnético**
sv **fotoelektromagnetisk effekt**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Section 521-02 – Propriétés des matériaux semiconducteurs

Section 521-02 – Properties of semiconductor materials

521-02-01

semiconducteur, m

substance dont la conductivité totale due aux porteurs de charge des deux signes est normalement comprise entre celle des conducteurs et celle des isolants, et dont la densité des porteurs de charge peut être modifiée par des excitations extérieures

semiconductor

substance whose total conductivity due to charge carriers of both signs is normally in the range between that of conductors and insulants, and in which the charge carrier density can be changed by external means

cn **半导体**
de **Halbleiter**, m
es **semiconductor**
ja **半導体**
pl **półprzewodnik**
pt **semicondutor**
sv **halvledare**

521-02-02

semiconducteur élémentaire, m

semiconducteur constitué à l'état pur d'un seul élément

single-element semiconductor

semiconductor which in the pure state consists of a single element

cn **单元素半导体**
de **Einzelelement-Halbleiter**, m
es **semiconductor elemental**
ja **単元素半導体**
pl **półprzewodnik pierwiastkowy**
pt **semicondutor elementar**
sv **ettelementshalvledare**

521-02-03

semiconducteur composé, m

semiconducteur constitué à l'état pur de plusieurs éléments dans des proportions proches de leur composition stoechiométrique

compound semiconductor

semiconductor which in the pure state consists of several elements in proportions close to the stochiometric composition

cn **化合物半导体**
de **Verbindungshalbleiter**, m
es **semiconductor compuesto**
ja **化合物半導体**
pl **półprzewodnik złożony**
pt **semicondutor composto**
sv **sammansatt halvledare**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

521-02-04

impureté, f

atomes étrangers dans un semiconducteur élémentaire
atomes étrangers ou atomes en excédent ou déficit par rapport à la composition stoechiométrique d'un semiconducteur composé

impurity

foreign atoms in a single-element semiconductor
foreign atoms or either an excess or a deficiency of atoms with respect to the stochiometric composition of a compound semiconductor

cn **杂质**
de **Störstelle**, f
es **impurezas**
ja **不純物**
pl **domieszka; zanieczyszczenie**
pt **impureza**
sv **störämne**

521-02-05

énergie d'activation des impuretés, f

écart entre un niveau d'énergie intermédiaire dû à une impureté et la bande énergétique voisine

impurity activation energy

gap between an intermediate energy level due to an impurity and the adjacent energy band

cn **杂质激活能**
de **Störstellen-Aktivierungsenergie**, f
es **energía de activación de impurezas**
ja **不純物活性化エネルギー**
pl **energia aktywacji domieszek**
pt **energia de activação das impurezas**
sv **aktiveringsenergi för störatom**

521-02-06

semiconducteur ionique, m

semiconducteur dans lequel la conductivité électrique due au mouvement des ions est prédominante par rapport à celle due au mouvement des électrons et des trous

ionic semiconductor

semiconductor in which the conductivity due to the flow of ions predominates over that due to the motion of electrons and holes

cn **离子半导体**
de **Ionenhalbleiter**, m
es **semiconductor iónico**
ja **イオン性半導体**
pl **półprzewodnik jonowy**
pt **semicondutor iónico**
sv **jonhalvledare**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-07

semiconducteur intrinsèque, m

semiconducteur presque pur et idéal dans lequel les concentrations d'électrons de conduction et de trous sont à peu près égales dans des conditions d'équilibre thermique

intrinsic semiconductor

nearly pure and ideal semiconductor in which the conduction electron and hole densities are nearly equal under conditions of thermal equilibrium

cn **本征半导体**
de **Eigenhalbleiter**, m
es **semiconductor intrínseco**
ja **真性半導体**
pl **półprzewodnik samoistny**
pt **semicondutor intrínseco**
sv **egen(halv)ledare; I-ledare**

521-02-08

semiconducteur extrinsèque, m

semiconducteur dans lequel la concentration de porteurs de charge dépend des impuretés ou des autres imperfections

extrinsic semiconductor

semiconductor in which charge carrier concentration depends upon impurities or other imperfections

cn **非本征半导体**
de **Störstellen-Halbleiter**, m
es **semiconductor extrínseco**
ja **外因性半導体**
pl **półprzewodnik niesamoistny**
pt **semicondutor extrínseco**
sv **stör(halv)ledare**

521-02-09

semiconducteur type N, m

semiconducteur extrinsèque dans lequel la concentration des électrons de conduction est supérieure à la concentration des trous

N-type semiconductor

extrinsic semiconductor in which the conduction electron density exceeds the hole density

cn **N型半导体**
de **N-Halbleiter**, m
es **semiconductor tipo N**
ja **N形半導体**
pl **półprzewodnik typu N**
pt **semicondutor de tipo N**
sv **N-ledare**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-10

semiconducteur type P, m

semiconducteur extrinsèque dans lequel la concentration des trous est supérieure à la concentration des électrons de conduction

P-type semiconductor

extrinsic semiconductor in which the hole density exceeds the conduction electron density

cn **P型半导体**
de **P-Halbleiter**, m
es **semiconductor tipo P**
ja **P形半導体**
pl **półprzewodnik typu P**
pt **semicondutor de tipo P**
sv **P-ledare**

521-02-11

semiconducteur compensé, m

semiconducteur dans lequel les effets des impuretés d'un type donné sur le nombre volumique des porteurs de charge sont partiellement ou totalement annulés par les effets des impuretés de type opposé

compensated semiconductor

semiconductor in which the effects of the impurities of a given type on the charge carrier density partially or completely cancel those of the other type

cn **补偿半导体**
de **Kompensations-Halbleiter**, m
es **semiconductor compensado**
ja **補償形半導体**
pl **półprzewodnik skompensowany**
pt **semicondutor compensado**
sv **kompenserad halvledare**

521-02-12

semiconducteur non dégénéré, m

semiconducteur dans lequel le niveau de Fermi est situé dans la bande interdite, loin de ses limites, à une distance au moins égale à deux fois le produit de la constante de Boltzmann par la température thermodynamique

NOTE – Les porteurs de charge d'un semiconducteur non dégénéré sont régis par la statistique de Maxwell-Boltzmann.

non-degenerate semiconductor

semiconductor in which the Fermi level is situated in the energy gap away from the boundaries at a distance at least twice as great as the product of Boltzmann's constant and the thermodynamic temperature

NOTE – The charge carriers in a non-degenerate semiconductor are governed by Maxwell-Boltzmann statistics.

cn **非简并半导体**
de **nichtentarteter Halbleiter**, m
es **semiconductor no degenerado**
ja **非縮退形半導体**
pl **półprzewodnik niezdegenerowany**
pt **semicondutor não degenerado**
sv **icke-degenererad halvledare**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-13

semiconducteur dégénéré, m

semiconducteur dans lequel le niveau de Fermi est situé dans la bande de conduction ou dans la bande de valence, ou à une distance de ces deux bandes inférieure à deux fois le produit de la constante de Boltzmann par la température absolue

NOTE – Les porteurs de charge d'un semiconducteur dégénéré sont régis par les lois statistiques de Fermi-Dirac.

degenerate semiconductor

semiconductor in which the Fermi level is situated in the conduction band, or in the valence band or is closer than twice the product of Boltzmann's constant and the thermodynamic temperature to either band

NOTE – The charge carriers of a degenerate semiconductor are governed by Fermi-Dirac statistics.

cn **简并半导体**
de **entarteter Halbleiter**, m
es **semiconductor degenerado**
ja **縮退形半導体**
pl **półprzewodnik zdegenerowany**
pt **semicondutor degenerado**
sv **degenererad halvledare**

521-02-14

électron de conduction, m

électron dans la bande de conduction d'un semiconducteur, qui peut se déplacer sous l'action d'un champ électrique

conduction electron

electron in the conduction band of a semiconductor, which is free to flow under the action of an electric field

cn **传导电子**
de **Leitungselektron**, n
es **electrones de conducción**
ja **伝導電子**
pl **elektron przewodzenia**
pt **electrões de condução**
sv **ledningselektron**

521-02-15

courant de conduction, m

transport de porteurs de charge libres dans un corps, provoqué par un champ électrique

conduction current

directed movement of free charge carriers in a medium under the influence of an electric field

cn **传导电流**
de **Leitungsstrom**, m
es **corriente de conduccíon**
ja **伝導電流**
pl **prąd przewodzenia**
pt **corrente de condução**
sv **ledningsström**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-16

conducteur, m

substance dans laquelle des porteurs de charge libres peuvent se déplacer sous l'action d'un champ électrique

conductor

substance having free charge carriers which can be moved by an electric field

cn **导体**
de **Leiter** (in der Halbleitertechnik), m
es **conductor**
ja **導体**
pl **przewodnik**
pt **condutor**
sv **ledare**

521-02-17

trou, m

lacune qui apparaît dans une bande d'énergie normalement pleine et qui peut être déplacée par un champ électrique en tant que charge électrique élémentaire

hole

vacancy appearing in a normally filled energy band, which can be moved by an electric field as an elementary positive charge

cn 空穴
de **Loch**, n**; Defektelektron**, n
es **hueco**
ja 正孔
pl **dziura**
pt **buraco**
sv **hål**

521-02-18

conduction par trous, f

conduction dans un semiconducteur due au déplacement de trous du réseau cristallin sous l'action d'un champ électrique

hole conduction

conduction in a semiconductor, in which holes in a crystal lattice are propagated through the lattice under the influence of an electric field

cn **空穴导电**
de **Löcherleitung**, f
es **conducción por huecos**
ja **ホール伝導**
pl **przewodzenie dziurowe**
pt **condução por buracos**
sv **hålledning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-19

conduction par électrons, f

conduction dans un semiconducteur due au déplacement d'électrons du réseau cristallin sous l'action d'un champ électrique

electron conduction

conduction in a semiconductor in which conduction electrons in a crystal lattice are propagated through the lattice under the influence of an electric field

cn **电子导电**
de **Elektronenleitung**, f
es **conducción por electrones**
ja **電子伝導**
pl **przewodzenie elektronowe**
pt **condução por electrões**
sv **elektronledning**

521-02-20

conduction intrinsèque, f

conduction dans un semiconducteur, due au déplacement de trous et d'électrons de conduction, ceux-ci provenant de la production de paires de porteurs de charge

intrinsic conduction

conduction in a semiconductor caused by the movement of holes and conduction electrons formed due to the thermal generation of pairs of charge carriers

cn **本征导电**
de **Eigenleitung**, f
es **conducción intrínseca**
ja **真性伝導**
pl **przewodzenie samoistne**
pt **condução intrínseca**
sv **egenledning; I-ledning**

521-02-21

conduction ionique, f

conduction dans un semiconducteur, due au déplacement continu d'ions provoqué par un apport permanent d'énergie extérieure

ionic conduction

conduction caused by the directed movement of charges due to the displacement of ions, the movement being maintained by a continuous contribution of external energy

cn **离子导电**
de **Ionenleitung**, f
es **conducción iónica**
ja **イオン伝導**
pl **przewodzenie jonowe**
pt **condução iónica**
sv **jonledning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-22

bande de conduction, f

bande permise partiellement occupée par des électrons libres de se mouvoir sous l'influence d'un champ électrique

conduction band

permitted energy band partially occupied by electrons that are free to move under the influence of an external electric field

cn **导带**
de **Leitungsband**, n
es **banda de conducción**
ja **伝導帯**
pl **pasmo przewodzenia**
pt **banda de condução**
sv **ledningsband**

521-02-23

bande de valence, f

bande permise occupée par les électrons de valence

NOTE 1 – Dans un cristal, la bande de valence est une bande pleine au zéro kelvin.

NOTE 2 – Un manque d'électrons dans la bande de valence donne naissance à des trous dans la bande de valence et à des électrons de conduction dans la bande de conduction.

valence band

permitted band occupied by the valence electrons

NOTE 1 – The valence band in an ideal crystal is completely occupied at the temperature of zero kelvin.

NOTE 2 – Electrons missing from the valence band give rise to conduction holes in the valence band and conduction electrons in the conduction band.

cn **价带**
de **Valenzband**, n
es **banda de valencia**
ja **価電子帯**
pl **pasmo walencyjne**
pt **banda de valência**
sv **valensband**

521-02-24

écart énergétique, m

écart entre le niveau d'énergie le plus bas de la bande de conduction et le niveau d'énergie le plus haut de la bande de valence

energy gap

gap between the lower energy boundary of the conduction band and the upper energy boundary of the valence band

cn **能隙**
de **Energielücke**, f
es **separación energética**
ja **エネルギーギャップ**
pl **odstęp energetyczny**
pt **separação energética**
sv **energigap**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-25

bande d'énergie (1), f
bande de Bloch, f

ensemble pratiquement continu de niveaux d'énergie dans une substance

energy band
Bloch band

virtually continuous set of energy levels in a substance

cn **能带；布洛赫带**
de **Bloch-Energieband**, n
es **banda de energía; banda de Bloch**
ja **エネルギー帯；ブロッホ帯**
pl **pasmo energetyczne; pasmo Blocha**
pt **banda de energia; banda de Bloch**
sv **energiband**

521-02-26

bande d'énergie (dans un semiconducteur) (2), f

ensemble des niveaux d'énergie des électrons dans un semiconducteur, limité par les valeurs minimale et maximale des énergies

energy band (in a semiconductor)

range of energy levels of electrons in a semiconductor, limited by the minimum and maximum values of the energies

cn **能带**（半导体中）
de **Energieband** (in einem Halbleiter), n
es **banda de energía** (en un semiconductor)
ja **（半導体中の）エネルギー帯**
pl **pasmo energetyczne** (w półprzewodniku)
pt **banda de energia** (num semicondutor)
sv **energiband** (i halvledare)

521-02-27

bande partiellement occupée, f

bande d'énergie dont tous les niveaux ne sont pas occupés par deux électrons de spins opposés

partially occupied band

energy band not all the levels of which correspond to the energy of each of two electrons with opposite spins

cn **部分占据带**
de **teilweise besetztes Band**, n
es **banda parcialmente ocupada**
ja **部分占有帯**
pl **pasmo zapełnione częściowo**
pt **banda parcialmente ocupada**
sv **delvis besatt band**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-28

bande d'excitation, f

bande d'énergie ayant un ensemble de niveaux d'énergie voisins qui correspondent à des états possibles d'excitation des électrons d'une substance

excitation band

energy band having a range of neighbouring energy levels which correspond to possible excited states of the electrons of a substance

cn **激发带**
de **Anregungsband**, n
es **banda de excitación**
ja **励起帯**
pl **pasmo pobudzenia**
pt **banda de excitação**
sv **excitationsband**

521-02-29

bande permise, f

bande d'énergie dont chaque niveau peut être occupé par des électrons

permitted band

energy band each level of which may be occupied by electrons

cn **允带**
de **erlaubtes Band**, n
es **banda permitida**
ja **許容帯**
pl **pasmo dozwolone**
pt **banda permitida**
sv **tillåtet band**

521-02-30

bande interdite, f

bande d'énergie qui ne peut être occupée par aucun électron

forbidden band

energy band that cannot be occupied by electrons

cn **禁带**
de **verbotenes Band**, n
es **banda reservada**
ja **禁制帯**
pl **pasmo zabronione**
pt **banda proibida**
sv **förbjudet band**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-31

isolant, m

substance dans lequelle la bande de valence est une bande pleine séparée de la première bande d'excitation par une bande interdite d'une largeur telle que, pour faire passer dans la bande de conduction des électrons de la bande de valence, il faut une énergie assez grande pour entraîner une décharge disruptive

insulant

substance in which the valence band is a filled band separated from the first excitation band by a forbidden band of such width that the energy needed to excite electrons from the valence band to the conduction band is so large as to disrupt the substance

cn **绝缘物**
de **isolierendes Medium** (in der Halbleitertechnik), n
es **aislante**
ja **絶縁体**
pl **izolator**
pt **isolante**
sv **isolator**

521-02-32

bande pleine, f

bande permise dans laquelle, à la température de zéro kelvin, tous les niveaux d'énergie sont occupés par des électrons

filled band

permitted band in which, at a temperature of zero kelvin, all the energy levels are occupied by electrons

cn **满带**
de **gefülltes Band**, n
es **banda llena**
ja **充満帯**
pl **pasmo zapełnione**
pt **banda cheia**
sv **fyllt band**

521-02-33

bande vide, f

bande permise dans laquelle, à la température de zéro kelvin, aucun niveau d'énergie n'est occupé par des électrons

empty band

permitted band in which, at a temperature of zero kelvin, no energy level is occupied by electrons

cn **空带**
de **leeres Band**, n
es **banda vacía**
ja **空帯**
pl **pasmo puste**
pt **banda vazia**
sv **tomt band**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-34

bande de surface, f

bande d'énergie permise constituée par les niveaux de surface d'un cristal

surface band

permitted band formed by the surface levels of a crystal

cn **表面带**
de **Oberflächenband**, n
es **banda de superficie**
ja **表面帯**
pl **pasmo powierzchniowe**
pt **banda de superfície**
sv **ytband**

521-02-35

niveau local, m

niveau situé dans une bande interdite et dû à une imperfection du réseau cristallin, dans le cas d'une faible concentration de défauts

local level

energy level in a forbidden band caused by a lattice imperfection in the case of a low concentration of defects

cn **局部能级**
de **örtliches Niveau**, n**; lokales Niveau**, n
es **nivel local**
ja **局在準位**
pl **poziom lokalny**
pt **nível local**
sv **lokal nivå**

521-02-36

niveau d'impureté, m

niveau local dû à une impureté

impurity level

local level due to the impurity

cn **杂质能级**
de **Störstellenniveau**, n
es **nivel de impurezas**
ja **不純物準位**
pl **poziom domieszkowy**
pt **nível de impureza**
sv **störämnesnivå**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-37

bande d'impureté, f

bande d'énergie constituée par l'ensemble des niveaux d'impureté d'un type donné et située en totalité, ou en partie, dans une bande interdite

impurity band

energy band formed by the combination of impurity levels of one type and entirely or partially located in the forbidden band

cn **杂质带**
de **Störstellenband**, n
es **banda de impurezas**
ja **不純物帯**
pl **pasmo domieszkowe**
pt **banda de impureza**
sv **störämnesband**

521-02-38

donneur, m

imperfection d'un réseau cristallin qui, lorsqu'elle est dominante, a pour conséquence la conduction par électrons, par suite de la libération d'électrons

donor

imperfection in a crystal lattice which, when it is predominant, permits electron conduction by the donation of electrons

cn **施主**
de **Donator**, m
es **donador**
ja **ドナー**
pl **donor**
pt **dador**
sv **donator**

521-02-39

accepteur, m

imperfection d'un réseau cristallin qui, lorsqu'elle est dominante, a pour conséquence la conduction par trous par suite de la capture d'électrons

acceptor

imperfection in a crystal lattice which, when it is predominant, permits hole conduction by the acceptance of electrons

cn **受主**
de **Akzeptor**, m
es **aceptador**
ja **アクセプター**
pl **akceptor**
pt **aceitador**
sv **acceptor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-40

niveau donneur, m

niveau d'impureté intermédiaire voisin de la bande de conduction dans un semiconducteur extrinsèque

NOTE – Le niveau donneur est plein à la température du zéro kelvin ; à toute autre température, il peut fournir des électrons à la bande de conduction. Les niveaux donneurs peuvent former des bandes d'impureté étroites.

donor level

intermediate impurity level close to the conduction band in an extrinsic semiconductor

NOTE – The donor level is filled at the temperature of zero kelvin; at any other temperature it can supply electrons to the conduction band. The donor levels can form narrow impurity bands.

cn **施主能级**
de **Donatorniveau**, n
es **nivel donador**
ja **ドナー準位**
pl **poziom donorowy**
pt **nível dador**
sv **donatornivå**

521-02-41

niveau accepteur, m

niveau d'impureté intermédiaire voisin de la bande de valence, dans un semiconducteur extrinsèque

NOTE – Le niveau accepteur est vide à la température de zéro kelvin ; à toute autre température, il peut recevoir des électrons provenant de la bande de valence. Les niveaux accepteurs peuvent former des bandes d'impureté étroites.

acceptor level

intermediate impurity level close to the valence band in extrinsic semiconductor

NOTE – The acceptor level is empty at the temperature of zero kelvin; at any other temperature it can receive electrons from the valence band. The acceptor levels can form narrow impurity bands.

cn **受主能级**
de **Akzeptorniveau**, n
es **nivel aceptador**
ja **アクセプター準位**
pl **poziom akceptorowy**
pt **nível aceitador**
sv **acceptornivå**

521-02-42

niveau de surface, m

niveau local dû à la présence d'une impureté ou d'une autre imperfection à la surface du cristal

surface level

local level caused by the presence of an impurity or other imperfection at the surface of the crystal

cn **表面能级**
de **Oberflächenniveau**, n
es **nivel de superficie**
ja **表面準位**
pl **poziom powierzchniowy**
pt **nível de superfície**
sv **ytnivå**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-43

énergie d'ionisation d'un donneur, f

énergie minimale à fournir à un électron situé au niveau donneur pour le transférer à la bande de conduction

ionizing energy of donor

minimum energy to be applied to an electron located at the donor level in order to transfer it to the conduction band

cn **施主电离能**
de **Donator-Ionisierungsenergie**, f
es **energía de ionización de un donador**
ja **ドナーのイオン化エネルギー**
pl **energia jonizacji donora**
pt **energia de ionização de um dador**
sv **joniseringsenergi för donator**

521-02-44

énergie d'ionisation d'un accepteur, f

énergie minimale à fournir à un électron de la bande de valence pour le transférer au niveau accepteur

ionizing energy of acceptor

minimum energy to be applied to a valence band electron in order to transfer it to the acceptor level

cn **受主电离能**
de **Akzeptor-Ionisierungsenergie**, f
es **energía de ionización de un aceptador**
ja **アクセプターのイオン化エネルギー**
pl **energia jonizacji akceptora**
pt **energia de ionização de um aceitador**
sv **joniseringsenergi för acceptor**

521-02-45

cristal idéal, m

cristal à structure parfaitement périodique, qui ne contient donc ni impuretés ni autres imperfections

ideal crystal

crystal which is perfectly periodic in structure, and accordingly contains no impurities or other imperfections

cn **理想晶体**
de **Idealkristall**, m
es **cristal ideal**
ja **完全結晶**
pl **kryształ idealny**
pt **cristal ideal**
sv **ideal kristall**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-46

composition stœchiométrique, f

composition chimique d'un corps dans lequel les éléments chimiques existent dans les proportions précises représentées par sa formule chimique

stochiometric composition

chemical composition of a compound in which the elements exist in the precise proportions represented by its chemical formula

cn **理想配比成份**
de **stöchiometrische Zusammensetzung**, f
es **composición estequiométrica**
ja **化学量論組成**
pl **skład stechiometryczny**
pt **composição estequiométrica**
sv **stökiometrisk sammansättning**

521-02-47

imperfection (d'un réseau cristallin), f

écart de structure par rapport à celle d'un cristal idéal

imperfection (of a crystal lattice)

deviation in structure from that of an ideal crystal

cn **缺陷**（晶格的）
de **Gitterstörstelle**, f
es **imperfección** (de un sólido cristalino)
ja **（結晶格子の）不完全性**
pl **defekt** (sieci krystalicznej)
pt **imperfeição** (de uma rede cristalina)
sv **störning** (i kristallgitter)

521-02-48

conductivité intrinsèque, f

conductivité d'un semiconducteur intrinsèque

intrinsic conductivity

conductivity of an intrinsic semicondutor

cn **本征电导率**
de **Eigenleitfähigkeit**, f
es **conductividad intrínseca**
ja **真性伝導度**
pl **przewodnictwo samoistne**
pt **condutividade intrínseca**
sv **egenkonduktivitet**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-49

conductivité de type N, f

conductivité dans un semiconducteur due au mouvement des électrons d'un donneur

N-type conductivity

conductivity caused by flow of electrons from a donor

cn **N型电导率**
de **N-Leitfähigkeit**, f
es **conductividad tipo N**
ja **N形伝導度**
pl **przewodnictwo typu N**
pt **condutividade de tipo N**
sv **elektronkonduktivitet**

521-02-50

conductivité de type P, f

conductivité dans un semiconducteur due au mouvement des trous d'un accepteur

P-type conductivity

conductivity caused by a flow of holes from an acceptor

cn **P型电导率**
de **P-Leitfähigkeit**, f
es **conductividad tipo P**
ja **P形伝導度**
pl **przewodnictwo typu P**
pt **condutividade de tipo P**
sv **hålkonduktivitet**

521-02-51

porteur (de charge) (dans un semiconducteur), m

dans un semiconducteur, électron de conduction, trou ou ion

(charge) carrier (in a semiconductor)

in a semiconductor, conduction electron or hole or ion

cn **载流子**（半导体中）
de **Ladungsträger** (in einem Halbleiter), m**; Träger** (in einem Halbleiter), m
es **portador (de carga)** (en un semiconductor); **portador**
ja **（半導体中の）電荷キャリア；キャリア**
pl **nośnik ładunku** (w półprzewodniku)
pt **portador de carga; portador**
sv **laddningsbärare**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-52

porteur majoritaire (dans une région semiconductrice), m

type de porteur de charge constituant plus de la moitié de la concentration totale des porteurs de charge

majority carrier (in a semiconductor region)

type of charge carrier constituting more than half of the total charge carrier density

cn **多（数载流）子**（半导体中）
de **Majoritätsträger** (in einer Halbleiterzone), m
es **portador mayoritario** (en una región semiconductora)
ja **（半導体領域中の）多数キャリア**
pl **nośnik większościowy** (w obszarze półprzewodnika)
pt **portador maioritário**
sv **majoritets(laddnings)bärare**

521-02-53

porteur minoritaire (dans une région semiconductrice), m

type de porteur de charge constituant moins de la moitié de la concentration totale des porteurs de charge

minority carrier (in a semiconductor region)

type of charge carrier constituting less than half of the total charge carrier density

cn **少（数载流）子**（半导体中）
de **Minoritätsträger** (in einer Halbleiterzone), m
es **portador minoritario** (en una región semiconductora)
ja **（半導体領域中の）少数キャリア**
pl **nośnik mniejszościowy** (w obszarze półprzewodnika)
pt **portador minoritário**
sv **minoritets(laddnings)bärare**

521-02-54

porteur en excès, m

électron de conduction ou trou en excédent sur le nombre déterminé par les conditions d'équilibre thermodynamique

excess carrier

conduction electron or hole in excess of the number determined by means of the thermodynamic equilibrium

cn **过剩载流子**
de **Überschussladungsträger**, m**; Überschussträger**, m
es **portador en exceso**
ja **過剰キャリア**
pl **nośnik nadmiarowy**
pt **portador em excesso**
sv **överskotts(laddnings)bärare**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-55

modulation de la conductivité (d'un semiconducteur), f

variation de la conductivité due à l'injection de porteurs en excès ou à l'extraction de porteurs de charge

conductivity modulation (of a semiconductor)

variation of the conductivity as a result of the injection of excess carriers or the removal of charge carriers

cn **电导率调制**（半导体的）
de **Leitfähigkeitsmodulation** (eines Halbleiters), f
es **modulación de la conductividad** (de un semiconductor)
ja **（半導体の）伝導度変調**
pl **modulacja przewodnictwa** (półprzewodnika)
pt **modulação da condutividade** (de um semicondutor)
sv **konduktivitetsmodulering**

521-02-56

vitesse de recombinaison en surface, f

vitesse à laquelle les électrons et les trous devraient diffuser vers la surface d'un semi-conducteur pour obtenir le taux de recombinaison conduisant à leur disparition en surface

NOTE – La vitesse de recombinaison en surface est égale au quotient :

a) du nombre de recombinaisons qui ont lieu à la surface par unités de temps et de surface ;

b) par la concentration en porteurs minoritaires en excès immédiatement sous la surface.

surface recombination velocity

velocity with which minority carriers would have to drift to the surface of the semiconductor in order to account for the rate at which they tend to combine there and are thus lost

NOTE – The surface recombination velocity is equal to the quotient of:

a) the number of recombinations taking place at the surface per unit time and area;

b) by the excess minority carrier concentration directly below the surface.

cn **表面复合速度**
de **Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit**, f
es **velocidad de recombinación en superficie**
ja **表面再結合速度**
pl **prędkość rekombinacji powierzchniowej**
pt **velocidade de recombinação em superfície**
sv **ytrekombineringshastighet**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-57

durée de vie dans le matériau (des porteurs minoritaires), f

intervalle de temps pendant lequel une densité donnée de porteurs minoritaires en excès dans la masse d'un semiconducteur homogène décroît par recombinaison jusqu'à atteindre 1/*e* de sa valeur d'origine

bulk lifetime (of minority carriers)

time interval in which a given density of excess minority carriers in the bulk of a homogeneous semiconductor decays by recombination to the fraction 1/*e* of its original value

cn **体寿命**（少数载流子的）
de **Volumenlebensdauer** (von Minoritätsträgern), f
es **vida media en el material** (de portadores minoritarios)
ja **（少数キャリアの）バルク寿命**
pl **czas życia objętościowy** (nośnika mniejszościowego)
pt **duração de vida no material** (de portadores minoritários)**;**
tempo de vida no material (de portadores minoritários)
sv **volymlivslängd**

521-02-58

mobilité (d'un porteur de charge), f

grandeur égale au quotient du module de la vitesse moyenne d'un porteur de charge dans la direction d'un champ électrique par le module de ce champ

(drift) mobility (of a charge carrier)

quantity equal to the quotient of the modulus of the mean velocity of a charge carrier in the direction of an electric field by the modulus of the field strength

cn **（漂移）迁移率**（载流子的）
de **Driftbeweglichkeit** (eines Ladungsträgers), f
es **movilidad** (de un portador de carga)
ja **（電荷の）（ドリフト）移動度**
pl **ruchliwość** (nośnika ładunku)
pt **mobilidade** (de um portador de carga)
sv **driftrörlighet**

521-02-59

diffusion (dans un semiconducteur), f

mouvement de particules dû seulement à un gradient de concentration

diffusion (in a semiconductor)

movement of particles caused only by a concentration gradient

cn **扩散**（半导体中）
de **Diffusion**, f
es **difusión** (en un semiconductor)
ja **（半導体中の）拡散**
pl **dyfuzja** (w półprzewodniku)
pt **difusão** (num semicondutor)
sv **diffusion**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-60

largeur de diffusion (des porteurs minoritaires), f

distance pour laquelle la densité des porteurs minoritaires décroît, pendant leur diffusion dans un semiconducteur homogène jusqu'à atteindre 1/*e* de la densité d'origine

diffusion length (of minority carriers)

distance in which the density of minority carriers decays to the fraction 1/*e* of the original density, during their diffusion in a homogeneous semiconductor

cn **扩散长度**（少数载流子的）
de **Diffusionslänge** (von Minoritätsträgern), f
es **longitud de difusión (**de portadores minoritarios)
ja **（少数キャリアの）拡散長**
pl **długość dyfuzji** (nośników mniejszościowych)
pt **comprimento de difusão** (dos portadores minoritários)
sv **diffusionsväglängd**

521-02-61

constante de diffusion (des porteurs de charge), f

quotient de la densité du courant de diffusion par le gradient de la concentration de porteurs de charge

diffusion constant (of charge carriers)

quotient of diffusion current density by the charge carrier concentration gradient

cn **扩散常数**（载流子的）
de **Diffusionskoeffizient** (von Ladungsträgern), m
es **constante de difusión** (de portadores de carga)
ja **（電荷の）拡散定数**
pl **stała dyfuzji** (nośników ładunku)
pt **constante de difusão** (dos portadores de carga)
sv **diffusionskonstant**

521-02-62

accumulation de porteurs de charge (dans un semiconducteur), f

augmentation locale de la concentration des porteurs de charge par rapport à celle qui existerait à l'état d'équilibre pour une polarisation nulle

charge carrier storage (in a semiconductor)

local increase in the concentration of charge carriers with respect to that which would exist under equilibrium in zero-bias state

cn **载流子贮存**（半导体中）
de **Ladungsträgerspeicherung** (in einem Halbleiter), f
es **acumulación de portadores de carga** (en un semiconductor)
ja **（半導体中の）電荷蓄積**
pl **akumulacja nośników ładunku** (w półprzewodniku)
pt **acumulação de portadores de carga** (num semicondutor)
sv **laddningsbärarlagring**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-63

piège, m

imperfection ou impureté dans un réseau cristallin dont le niveau d'énergie est situé dans la bande interdite du semiconducteur et qui agit comme centre pour la capture des électrons ou des trous

trap

crystal lattice imperfection or impurity whose energy level is situated in the forbidden band of the semiconductor and which acts as a centre for the capture of electrons or holes

cn **陷阱**
de **Störstellen-Haftstelle**, f**; Haftstelle**, f
es **trampa**
ja **トラップ**
pl **pułapka**
pt **armadilha**
sv **(störämnes)fälla**

521-02-64

centre de recombinaison, m

imperfection ou impureté dans un réseau cristallin dont le niveau d'énergie est situé dans la bande interdite du semiconducteur et qui permet la recombinaison des électrons de conduction et des trous

recombination centre

crystal lattice imperfection or impurity whose energy level is situated in the forbidden band of the semiconductor and which enables conduction electrons and holes to recombine

cn **复合中心**
de **Rekombinationszentrum**, n
es **centro de recombinación**
ja **再結合中心**
pl **centrum rekombinacji**
pt **centro de recombinação**
sv **rekombinationscenter**

521-02-65

limite PN, f

interface dans la région de transition entre les matériaux de type P et de type N, pour laquelle les concentrations en donneurs et en accepteurs sont égales

PN boundary

interface in the transition region between P-type and N-type material at which the donor and acceptor concentrations are equal

cn **PN界面**
de **PN-Grenzfläche**, f
es **límite PN**
ja **PN境界**
pl **granica PN**
pt **limite PN**
sv **PN-gräns**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-66

région de transition, f

région comprise entre deux régions semiconductrices homogènes dans laquelle les propriétés électriques changent

NOTE – Les deux régions homogènes n'appartiennent pas nécessairement au même matériau semiconducteur.

transition region

region between two homogeneous semiconducting regions, in which the electric properties change

NOTE – The two homogeneous regions are not necessarily of the same semiconductor material.

cn 过渡区
de **Übergangszone**, f
es **región de transición**
ja **遷移領域**
pl **obszar przejścia**
pt **região de transição**
sv **övergångsområde**

521-02-67

zone de transition de la concentration des impuretés, f

zone dans laquelle la concentration d'impuretés passe d'une valeur à une autre

impurity concentration transition zone

zone in which the impurity concentration changes from one value to another

cn 杂质浓度过渡区
de **Übergangszone der Störstellendichte**, f
es **zona de transición de la concentración de impurezas**
ja **不純物濃度遷移領域**
pl **obszar zmiany koncentracji domieszek**
pt **zona de transição da concentração das impurezas**
sv **övergångszon för störämneskoncentration**

521-02-68

région neutre, f

région dans laquelle il y a pratiquement neutralité électrique, les charges négatives des électrons et des atomes accepteurs ionisés équilibrant les charges positives des trous et des atomes donneurs ionisés

neutral region

region which is virtually electrically neutral, the negative charges of the electrons and of the ionized acceptor atoms balancing the positive charges of the holes and of the ionized donor atoms

cn 中性区
de **neutrale Zone**, f
es **región neutra**
ja **中性領域**
pl **obszar neutralny**
pt **região neutra**
sv **neutralt område**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-69

barrière de potentiel (1), f

différence de potentiel entre deux substances en contact ou entre deux régions homogènes de propriétés électriques différentes, due à la diffusion des porteurs de charge provenant de chacune des parties et à la création d'une charge d'espace

potential barrier

potential difference between two substances in contact or between two homogeneous regions having different electrical properties, due to the diffusion of charge carriers from each part and the creation of a space charge region

cn **势垒**
de **Potentialschwelle**, f
es **barrera de potencial**
ja **ポテンシャル障壁**
pl **bariera potencjału**
pt **barreira de potencial**
sv **potentialbarriär**

521-02-70

barrière de potentiel (d'une jonction PN) (2), f

barrière de potentiel existant entre deux points situés respectivement dans la région neutre du type P et dans la région neutre du type N

potential barrier (of a PN junction)

potential barrier between two points respectively located in the P-type neutral region and the N-type neutral region

cn **势垒**（PN结的）
de **Potentialschwelle eines PN-Übergangs**, f
es **barrera de potencial** (de una unión PN)
ja **（PN接合の）ポテンシャル障壁**
pl **bariera potencjału** (złącza PN)
pt **barreira de potencial** (de uma junção PN)
sv **potentialbarriär** (i PN-övergång)

521-02-71

barrière de Schottky, f

jonction entre un métal et un semiconducteur dans laquelle une région de transition, formée à la surface du semiconducteur, se comporte comme une barrière redresseuse

Schottky barrier

junction between a metal and a semiconductor in which a transition region, formed at the surface of the semiconductor, acts as a rectifying barrier

cn **肖特基势垒**
de **Schottky-Barriere**, f
es **barrera de Schottky**
ja **ショットキー障壁**
pl **bariera Schottky'ego**
pt **barreira de Schottky**
sv **Schottky-barriär**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-72

jonction, f

zone de transition entre des régions semiconductrices de propriétés électriques différentes ou entre un semiconducteur et une couche de type différent, caractérisée par l'existence d'une barrière de potentiel qui s'oppose au passage des porteurs de charge entre les deux régions

junction

transition layer between semiconductor regions of different electrical properties, or between a semiconductor and a layer of different type, being characterized by a potential barrier impeding the movement of charge carriers from one region to the other

cn **结**
de **Übergang**, m
es **unión**
ja **接合**
pl **złącze**
pt **junção**
sv **övergång**

521-02-73

jonction abrupte, f

jonction dont la largeur, dans la direction du gradient de concentration d'impuretés, est très petite par rapport à celle de la région de charge d'espace

abrupt junction

junction the width of which in the direction of the impurity-concentration gradient is much less than the width of the space charge region

cn **突变结**
de **abrupter Übergang**, m
es **unión abrupta**
ja **階段接合**
pl **złącze skokowe**
pt **junção abrupta**
sv **abrupt övergång**

521-02-74

jonction progressive, f

jonction dont la largeur, dans la direction du gradient de concentration d'impuretés, est comparable à celle de la région de charge d'espace

progressive junction

junction the width of which in the direction of the impurity-concentration gradient is comparable with the width of the space charge region

cn **缓变结**
de **allmählicher Übergang**, m
es **unión gradual**
ja **傾斜接合**
pl **złącze przejściowe stopniowane**
pt **junção progressiva**
sv **gradvis övergång**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-75

jonction par alliage, f

jonction formée en alliant un ou plusieurs matériaux à un cristal semiconducteur

alloyed junction

junction formed by alloying one or more materials to a semiconductor crystal

cn **合金结**
de **legierter Übergang**, m
es **unión por aleación**
ja **合金接合**
pl **złącze stopowe**
pt **junção por liga**
sv **legerad övergång**

521-02-76

jonction par diffusion, f

jonction formée par la diffusion d'une impureté à l'intérieur d'un cristal semiconducteur

diffused junction

junction formed by the diffusion of an impurity within a semiconductor crystal

cn **扩散结**
de **diffundierter Übergang**, m
es **unión por difusión**
ja **拡散接合**
pl **złącze dyfuzyjne**
pt **junção por difusão**
sv **diffunderad övergång**

521-02-77

jonction par tirage, f

jonction produite durant la croissance d'un cristal semiconducteur à partir d'un bain de fusion

grown junction

junction produced during the growth of a semiconductor crystal from a melt

cn **生长结**
de **gezogener Übergang**, m
es **unión por extracción**
ja **成長接合**
pl **złącze wyciągane**
pt **junção por estiramento**
sv **odlad övergång**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-78

jonction PN, f

jonction entre des matériaux semiconducteurs de type P et N

PN junction

junction between P and N type semiconductor materials

cn **PN结**
de **PN-Übergang**, m
es **unión PN**
ja **PN接合**
pl **złącze PN**
pt **junção PN**
sv **PN-övergång**

521-02-79

région de charge d'espace, f

région dans laquelle la charge électrique volumique résultante est différente de zéro

NOTE – La charge électrique résultante est due aux électrons, aux trous, aux accepteurs et aux donneurs.

space-charge region

region in which the net charge density is not zero

NOTE – The net charge is caused by electrons, holes, ionized acceptors and donors.

cn **空间电荷区**
de **Raumladungszone**, f
es **región de carga de espacio**
ja **空間電荷領域**
pl **obszar ładunku przestrzennego**
pt **região de carga espacial**
sv **rymdladdningsområde**

521-02-80

région de charge spatiale (d'une jonction PN), f

région de charge spatiale comprise entre les deux régions neutres respectivement de type P et de type N

space-charge region (of a PN junction)

space-charge region contained between two neutral regions of types P and N respectively

cn **空间电荷区**（PN结的）
de **Raumladungszone eines PN-Übergangs**, f
es **región de carga de espacio** (de una unión PN)
ja **（PN接合の）空間電荷領域**
pl **obszar ładunku przestrzennego** (złącza PN)
pt **região de carga espacial** (de uma junção PN)
sv **rymdladdningsområde** (i PN-övergång)

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-81

champ électrique interne, m

champ électrique dû à la présence de charges d'espace à l'intérieur d'un semiconducteur

internal electric field

electric field due to the presence of space charges inside a semiconductor

cn **内建电场**
de **inneres elektrisches Feld**, n
es **campo eléctrico interno**
ja **内部電界**
pl **pole elektryczne wewnętrzne**
pt **campo eléctrico interno**
sv **inre elektriskt fält**

521-02-82

couche d'appauvrissement (d'un semiconducteur), f
couche de déplétion, f

région dans laquelle la concentration des charges dues aux porteurs mobiles est insuffisante pour neutraliser la densité des charges fixes résultant des donneurs et des accepteurs

depletion layer (of a semiconductor)

region in which the mobile charge carrier concentration is insufficient to neutralize the net fixed charge density of ionized donors and acceptors

cn **耗尽层**（半导体的）
de **Verarmungsschicht** (eines Halbleiters), f
es **capa de agotamiento** (de un semiconductor)
ja **（半導体の）空乏層**
pl **warstwa zubożona** (w półprzewodniku)
pt **camada de depleção** (de um semicondutor)
sv **utarmningsområde**

521-02-83

effet tunnel (dans une jonction PN), m

processus par lequel une conduction s'établit à travers la barrière de potentiel d'une jonction PN et dans lequel les électrons circulent dans chaque direction entre la bande de conduction dans la région N et la bande de valence dans la région P

NOTE – L'effet tunnel, à la différence de la diffusion des porteurs de charge, entraîne seulement des électrons. Le temps de transit est pratiquement négligeable.

tunnel effect (in a PN junction)

process whereby conduction occurs through the potential barrier of a PN junction and in which electrons pass in either direction between the conduction band in the N-region and the valence band in the P-region

NOTE – Tunnel action, unlike the diffusion of charge carriers, involves electrons only. The transit time is practically negligible.

cn **隧道效应**（PN结中）
de **Tunneleffekt** (in einem PN-Übergang), m
es **efecto túnel** (en una unión PN)
ja **（PN接合中の）トンネル効果**
pl **zjawisko tunelowe** (w złączu PN)
pt **efeito túnel** (numa junção PN)
sv **tunneleffekt** (i PN-övergång)

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-02-84

effet magnétorésistant, m

variation de la résistance électrique d'un semiconducteur sous l'action d'un champ magnétique

magnetoresistive effect

change of the electrical resistance of a semiconductor or conductor due to a magnetic field

cn **磁(电)阻效应**
de **Magnetowiderstandseffekt**, m
es **efecto magnetorresistente**
ja **磁気抵抗効果**
pl **zjawisko magnetorezystywne**
pt **efeito magneto-resistivo**
sv **magnetoresistiv effekt**

521-02-85

effet piézorésistant, m
effet tensorésistant, m

variation de la résistance électrique d'un semiconducteur sous l'action d'une contrainte mécanique

piezoresistive effect
tensoresistive effect

change of the electrical resistance of a semiconductor or conductor due to mechanical stress

cn **压阻效应**
de **Piezowiderstandseffekt**, m; **Spannungswiderstandseffekt**, m
es **efecto piezorresistente; efecto tensorresistente**
ja **圧抵抗効果**
pl **zjawisko piezorezystywne; zjawisko tensorezystywne**
pt **efeito piezo-resistivo; efeito tenso-resistivo**
sv **piezoresistiv effekt**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Section 521-03 – Traitement des matériaux semiconducteurs

Section 521-03 – Processing semiconductor materials

521-03-01

croissance par tirage (d'un monocristal), f
croissance par la méthode de Czochralski, f

production d'un monocristal en tirant progressivement du bain de fusion le cristal en cours de formation

growing by pulling (of a single crystal)
growing by Czochralski's method

production of a single crystal by gradually withdrawing the developing crystal from the melt

cn **直拉生长**（单晶的）；**切克劳斯基法生长**
de **Einkristallziehen nach Czochralski**, n
es **crecimiento por extracción** (de un monocristal); **crecimiento por el método de Czochralski**
pl **metoda monokrystalizacji Czochralskiego**
pt **crescimento por extracção** (de um monocristal)**; crescimento pelo método de Czochralski**
sv **kristalldragning**

521-03-02

croissance d'un monocristal par fusion de zone, f

production d'un monocristal à l'aide d'un germe monocristallin, en faisant traverser une zone fondue d'abord par une partie du germe monocristallin, puis par le semiconducteur polycristallin accolé au germe

growing by zone melting (of a single crystal)

production of a single crystal with the aid of a monocrystalline seed by passing a molton zone first through a portion of the monocrystalline seed and then through the polycrystalline semiconductor material closely abutted to the seed

cn **区熔生长**（单晶的）
de **Einkristallziehen durch Zonenschmelzen**, n
es **crecimiento de un monocristal por fusión de zona**
ja **（単結晶の）帯域溶融成長**
pl **metoda monokrystalizacji strefowej**
pt **crescimento de um monocristal por fusão de zona**
sv **kristallodling med zonsmältning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-03-03

purification par zone, f

passage d'une ou de plusieurs zones fondues le long d'un cristal semiconducteur, afin de diminuer la concentration en impuretés dans le cristal

zone refining

passing of one or more molton zones along a semiconductor crystal for the purpose of reducing the impurity concentration in the crystal

cn **区熔提纯**
de **Zonenreinigen**, n
es **purificación por zona**
ja **帯域精製**
pl **oczyszczanie strefowe**
pt **purificação por zona**
sv **zonrening**

521-03-04

nivellement par zone, m

passage d'une ou de plusieurs zones fondues à travers un cristal semiconducteur, afin d'uniformiser la concentration en impuretés dans le cristal

zone levelling

passing of one or more molten zones through a semiconductor crystal for the purpose of uniformly distributing impurities in the crystal

cn **区熔夷平**
de **Zonennivellieren**, n
es **nivelación por zona**
ja **帯域均質化**
pl **wyrównywanie strefowe**
pt **nivelamento por zona**
sv **zonutjämning**

521-03-05

dopage (d'un semiconducteur), m

addition d'impuretés à un semiconducteur pour obtenir la conductivité désirée de type N ou de type P

doping (of a semiconductor)

addition of impurities to a semiconductor to achieve a desired N-type conductivity or P-type conductivity

cn **掺杂**
de **dotieren** (eines Halbleiters) (Verb)
es **dopado** (de un semiconductor)
ja **(半導体の) ドーピング**
pl **domieszkowanie** (półprzewodnika)
pt **dopagem** (de um semicondutor)
sv **dopning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-03-06

compensation au moyen d'impuretés, f

addition d'impuretés de type donneur à un semiconducteur de type P, ou d'impuretés de type accepteur à un semiconducteur de type N, conduisant à une compensation partielle équilibrée ou excédentaire

impurity compensation

addition of donor impurities to a P-type semiconductor or of acceptor impurities to an N-type semiconductor, leading to partial, balanced or over-compensation

cn **杂质补偿**
de **Störstellenkompensation**, f
es **compensación por impurezas**
ja **不純物補償**
pl **kompensacja domieszkowa**
pt **compensação por impurezas**
sv **störämneskompensering**

521-03-07

procédé par alliage, m

formation d'une jonction PN par fusion d'une substance donneuse ou accepteuse à la surface d'un cristal semiconducteur

NOTE 1 – La région recristallisée formée lors du refroidissement contient des atomes d'impuretés qui donnent naissance à une conductivité de type N (ou de type P) qui diffère de celle du cristal primitif.

NOTE 2 – On obtient généralement les jonctions PNP ou NPN par alliage sur les deux faces opposées du cristal primitif.

alloy technique

formation of a PN junction by fusing a donor or acceptor substance into the surface of a semiconductor crystal

NOTE 1 – The re-crystallized region formed on cooling contains impurity atoms which give rise to N-type, or P-type conductivity, which differs from that of the host crystal.

NOTE 2 – PNP or NPN junctions are usually formed by alloying from opposite sides of the host crystal.

cn **合金工艺**
de **Legierungstechnik**, f
es **técnica de aleación**
ja **合金技術**
pl **technika stopowa**
pt **técnica de liga**
sv **legeringsteknik**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-03-08

procédé par diffusion, m

formation d'une région à conductivité de type P ou de type N dans un cristal semiconducteur, obtenue par diffusion d'atomes d'impuretés dans le cristal

diffusion technique

formation of the region of P-type or N-type conductivity in a semiconductor crystal by diffusing impurity atoms into the crystal

cn **扩散工艺**
de **Diffusionstechnik**, f
es **técnica de difusión**
ja **拡散技術**
pl **technika dyfuzyjna**
pt **técnica de difusão**
sv **diffusionsteknik**

521-03-09

procédé planaire, m

formation de régions de type P ou de type N ou des deux types dans un cristal semiconducteur, par diffusion d'atomes d'impuretés dans le cristal à travers des ouvertures pratiquées dans une couche de protection du cristal

planar technique

formation of P-type or N-type regions or both in a semiconductor crystal by diffusion technique through apertures in a protective surface layer on the crystal

cn **平面工艺**
de **Planartechnik**, f
es **técnica planar**
ja **プレーナ技術**
pl **technika planarna**
pt **técnica planar**
sv **planarteknik**

521-03-10

procédé par microalliage, m

formation de petites jonctions PN par alliage, après dépôt électrolytique des donneurs ou des accepteurs dans de petites alvéoles

micro-alloy technique

formation of small PN junction by alloying after depositing the acceptor or donor materials in small pits by a process of electroplatting

cn **微合金工艺**
de **Mikrolegierungstechnik**, f
es **técnica de microaleación**
ja **微小合金技術**
pl **technika mikrostopu**
pt **técnica de microliga**
sv **mikrolegeringsteknik**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-03-11

procédé mesa, m

formation d'une jonction ayant la forme d'un plateau surélevé obtenu par attaque de la surface d'un semiconducteur dans les régions entourant le plateau qu'on désire former, réalisée par des diffusions ou des alliages successifs d'impuretés

mesa technique

formation of a junction in the shape of a raised plateau by successive impurity diffusions or alloying and then etching away material in the regions surrounding the plateau

cn **台面工艺**
de **Mesatechnik**, f
es **técnica mesa**
ja **メサ技術**
pl **technika "mesa"**
pt **técnica mesa**
sv **mesateknik**

521-03-12

épitaxie, f

dépôt d'une couche de matériau semiconducteur sur un substrat, cette couche ayant la même orientation cristalline que le substrat

epitaxy

disposition of a layer of semiconductor material onto a substrate, this layer having the same crystal orientation as the substrate

cn **外延**
de **Epitaxie**, f
es **epitaxis**
ja **エピタキシー**
pl **epitaksja**
pt **epitaxia**
sv **epitaxi**

521-03-13

passivation de surface, f

application ou croissance de couches protectrices à la surface d'un semiconducteur, après formation de régions de type P ou de type N, ou des deux types

surface passivation

application or growth of a protective layer on the surface of a semiconductor after the formation of regions of P-type, N-type or both

cn **表面钝化**
de **Oberflächenpassivierung**, f
es **pasivación de superficie**
ja **表面保護**
pl **pasywacja powierzchniowa**
pt **passivação de superfície**
sv **ytpassivering**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-03-14

implantation ionique, f

formation d'une région de conductivité de type N, de type P ou intrinsèque dans un cristal semiconducteur par implantation d'ions accélérés

ion implantation

formation of a region of P-type, N-type or intrinsic conductivity in semiconductor crystal by implanting accelerated ions

cn **离子注入**
de **Ionenimplantation**, f
es **implantación iónica**
ja **イオン注入**
pl **implantacja jonów**
pt **implantação iónica**
sv **jonimplantering**

521-03-15

dépôt en phase vapeur, m

dépôt de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides à partir d'une source de matériau en phase vapeur par dépôt physique ou par réaction chimique

vapour-phase deposition technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates from a source material in the vapour phase by physical deposition or chemical reaction

cn **汽相淀积工艺**
de **Abscheidung aus der Gasphase**, f
es **deposición en fase vapor**
ja **気相成長技術**
pl **osadzanie z fazy lotnej**
pt **depósito em fase vapor**
sv **ångfasdeponering**

521-03-16

sérigraphie, f

dépôt de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides par pression de pâtes à travers des écrans

screen-printing technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates by pressing pastes through screens

cn **丝网印刷工艺**
de **Siebdrucktechnik**, f
es **serigrafía**
ja **スクリーン印刷技術**
pl **technika sitodruku**
pt **serigrafia**
sv **screentryckning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-03-17

pulvérisation sous vide, f

procédé de formation de couches minces par lequel un bombardement d'ions ou une autre énergie est utilisé pour libérer des particules d'une source solide qui se déposent ensuite sur une surface proche

sputtering

process for forming films in which ion bombardment or other application of energy is used to free particles from a solid source that become deposited on a nearby surface

cn **溅射**
de **Zerstäubung**, f
es **pulverización en vacío**
ja **スパッタリング**
pl **napylanie**
pt **pulverização sob vácuo**
sv **partikeldeponering**

Section 521-04 – Types de dispositifs à semiconducteurs

Section 521-04 – Types of semiconductor devices

521-04-01

dispositif à semiconducteurs, m

dispositif dont les caractéristiques essentielles sont dues au flux de porteurs de charges à l'intérieur d'un semiconducteur

NOTE – Cette définition comprend les dispositifs dont les caractéristiques essentielles sont dues en partie seulement au flux de porteurs de charges dans un semiconducteur mais qui sont considérés comme des dispositifs à semiconducteurs pour la spécification.

semiconductor device

device whose essential characteristics are due to the flow of charge carriers within a semiconductor

NOTE – The definition includes devices whose essential characteristics are only in part due to the flow of charge carriers in a semiconductor but that are considered as semiconductor devices for the purpose of specification.

cn **半导体器件**
de **Halbleiterbauelement**, n
es **dispositivo semiconductor**
ja **半導体デバイス**
pl **przyrząd półprzewodnikowy**
pt **dispositivo semicondutor**
sv **halvledarkomponent**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-02

dispositif discret (à semiconducteurs), m

dispositif à semiconducteurs qui est spécifié pour accomplir une fonction élémentaire et qui n'est pas divisible en composants séparés fonctionnels par eux-mêmes

NOTE – Il n'existe pas de délimitation claire entre dispositifs discrets et circuits intégrés. En principe, un dispositif discret comporte un seul élément de circuit. Cependant, un dispositif vendu et spécifié en tant que dispositif discret peut comporter plusieurs éléments internes de circuit.

discrete (semiconductor) device

semiconductor device that is specified to perform an elementary function and that is not divisible into separate components functional in themselves

NOTE – There is no clear delimitation possible between discrete devices and integrated circuits. In principle, a discrete device consists of a single circuit element only. However, a device sold and specified as a discrete device may internally consist of more than one circuit element.

cn （半导体）分立器件
de **Einzelhalbleiterbauelement**, n**; Einzelbauelement**, n
es **dispositivo semiconductor discreto; dispositivo discreto**
ja **個別半導体デバイス；個別デバイス**
pl **przyrząd (półprzewodnikowy) dyskretny**
pt **dispositivo semicondutor discreto; dispositivo discreto**
sv **diskret halvledarkomponent**

521-04-03

diode (à semiconducteurs), f

dispositif à semiconducteurs à deux bornes possédant une caractéristique tension-courant asymétrique

NOTE – Sauf spécification contraire, ce terme s'applique normalement à un dispositif dont la caractéristique tension-courant est celle d'une seule jonction PN.

(semiconductor) diode

two-terminal semiconductor device having an asymmetrical voltage-current characteristic

NOTE – Unless otherwise qualified, this term usually means a device with the voltage-current characteristic typical of a single PN junction.

cn （半导体）二极管
de **Halbleiterdiode**, f**; Diode**, f
es **diodo (semiconductor); diodo**
ja **半導体ダイオード；ダイオード**
pl **dioda (półprzewodnikowa)**
pt **díodo semicondutor; díodo**
sv **halvledardiod**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-04

diode de signal, f

diode à semiconducteurs utilisée pour extraire ou acheminer des informations contenues dans un signal électrique qui varie avec le temps et peut être de nature numérique ou analogique

signal diode

semiconductor diode used for the purpose of extracting or processing information contained in an electronic signal which varies with time and may be either analogue or digital in nature

cn **信号二极管**
de **Signaldiode**, f
es **diodo de señal**
ja **シグナルダイオード**
pl **dioda sygnałowa**
pt **díodo de sinal**
sv **signaldiod**

521-04-05

diode tunnel, f

diode à semiconducteurs ayant une jonction PN dans laquelle une action tunnel se produit, créant une conductance différentielle négative dans une certaine partie de la caractéristique courant-tension dans le sens direct

tunnel diode

semiconductor diode having a PN junction in which tunnel action occurs giving rise to negative differential conductance in a certain range of the forward direction of the current-voltage characteristic

cn **隧道二极管**
de **Tunneldiode**, f
es **diodo túnel**
ja **トンネルダイオード**
pl **dioda tunelowa**
pt **díodo túnel**
sv **tunneldiod**

521-04-06

diode unitunnel, f

diode tunnel dont les courants de pic et de vallée sont approximativement égaux

unitunnel diode
backward diode

tunnel diode whose peak and valley point currents are approximately equal

cn **反向二极管**
de **Unitunneldiode**, f
es **diodo unitúnel**
ja **ユニトンネルダイオード ; バックワードダイオード**
pl **dioda wsteczna; dioda odwrotna**
pt **díodo unitúnel**
sv **backdiod**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-07

diode à capacité variable, f

diode à semiconducteurs dont la capacité aux bornes varie de manière définie en fonction de la tension appliquée, lorsque la diode est polarisée en inverse, et qui est destinée à des applications spécifiques de la variation de la capacité en fonction de la tension

variable-capacitance diode

semiconductor diode, the terminal capacitance of which varies in a defined manner as a function of applied voltage when biased in the reverse direction, and that is intended for specific applications of this capacitance-voltage relationship

cn **变容二极管**
de **Kapazitätsdiode**, f**; Kapazitätsvariationsdiode**, f
es **diodo de capacidad variable**
ja **可変容量ダイオード**
pl **dioda o zmiennej pojemności; dioda parametryczna; warikap**
pt **díodo de capacidade variável**
sv **kapacitansdiod**

521-04-08

diode mélangeuse, f

diode à semiconducteurs conçue pour la conversion en fréquence de signaux à l'aide d'une oscillation locale

mixer diode

semiconductor diode designed for frequency conversion of signals by means of a local oscillator

cn **混频二极管**
de **Mischerdiode**, f
es **diodo mezclador**
ja **ミクサーダイオード**
pl **dioda mieszająca**
pt **díodo misturador**
sv **blandardiod**

521-04-09

diode pour multiplication de fréquence, f

diode à semiconducteurs conçue pour la multiplication de la fréquence d'un signal

frequency-multiplication diode

semiconductor diode designed for multiplying the frequency of a signal

cn **倍频二极管**
de **Frequenzvervielfacherdiode**, f
es **diodo para multiplicación de frecuencia**
ja **周波数逓倍ダイオード**
pl **dioda mnożnika częstotliwości**
pt **díodo para multiplicação de frequência**
sv **frekvensmultipliceringsdiod**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-10

diode modulatrice, f

diode à semiconducteurs destinée à la modulation

modulator diode

semiconductor diode designed for modulation

cn **调制二极管**
de **Halbleiter-Modulationsdiode**, f**; Modulationsdiode**, f
es **diodo modulador**
ja **変調ダイオード**
pl **dioda modulacyjna**
pt **díodo modulador**
sv **moduleringsdiod**

521-04-11

diode détectrice, f

diode à semiconducteurs destinée à la démodulation

detector diode

semiconductor diode designed for demodulation

cn **检波二极管**
de **Halbleiter-Detektordiode**, f**; Detektordiode**, f
es **diodo detector**
ja **検波ダイオード**
pl **dioda detekcyjna**
pt **díodo detector**
sv **detektordiod**

521-04-12

diode à retour rapide, f

diode à semiconducteurs qui emmagasine une charge électrique lorsqu'elle est polarisée en direct et qui la restitue brusquement lors de la conduction qui suit l'établissement de la polarisation inverse, provoquant ainsi une variation brusque de l'impédance qu'elle présente

snap-off diode
step recovery diode

semiconductor diode that stores electric charge under forward bias and recovers from subsequent reverse-bias conduction in an abrupt fashion, thereby causing an abrupt transition of its terminal impedance

cn **阶跃恢复二极管**
de **Speicherschaltdiode**, f
es **diodo de retorno rápido**
ja **スナップオフダイオード；ステップリカバリダイオード**
pl **dioda ładunkowa**
pt **díodo de retorno rápido**
sv **diod med snabb återhämtning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-13

diode de commutation, f

diode à semiconducteurs conçue pour présenter une transition rapide d'un état à haute impédance à un état à basse impédance et réciproquement, suivant la polarité de la tension appliquée

switching diode

semiconductor diode designed for a fast transition from a high-impedance state to a low-impedance state and vice versa, depending on the polarity of the applied voltage

cn **开关二极管**
de **Schaltdiode**, f
es **diodo de conmutación**
ja **スイッチングダイオード**
pl **dioda przełączająca; dioda komutacyjna**
pt **díodo de comutação**
sv **switchdiod**

521-04-14

diode de commutation hyperfréquence, f

diode à semiconducteurs qui présente une transition brusque de l'état à haute impédance à celui à faible résistance et vice versa, selon la tension de polarisation continue ou le courant appliqué à la diode, et qui présente en hyperfréquence respectivement une forte ou une faible impédance, ce qui permet à la diode de laisser passer ou d'interrompre des signaux hyperfréquence

microwave switching diode

semiconductor diode that exhibits a fast transition from a high-impedance state to a low-resistance state and vice versa, depending on the d.c. bias voltage or current applied to the diode, thus representing at microwave frequencies a high or low impedance, respectively, which enables it to pass or interrupt microwave signals

cn **微波开关二极管**
de **Mikrowellen-Schaltdiode**, f
es **diodo de conmutación de microondas**
ja **マイクロ波スイッチングダイオード**
pl **dioda przełączająca mikrofalowa**
pt **díodo de comutação hiperfrequência**
sv **switchdiod för högfrekvens**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-15

diode de limitation hyperfréquence, f

diode à semiconducteurs qui présente une transition brusque de l'état à haute impédance à celui à faible résistance et vice versa, selon le niveau de puissance radiofréquence appliqué à la diode, et qui présente en hyperfréquence, respectivement une forte ou une faible impédance, ce qui permet à la diode de limiter ou de supprimer une énergie en hyperfréquence indésirable

microwave limiting diode

semiconductor diode that exhibits a fast transition from a high-impedance state to a low-resistance state and vice versa, depending on the r.f. power level delivered to the diode, thus representing at microwave frequencies a high or a low impedance, respectively, which enables it to limit or suppress unwanted microwave energy

cn **微波限幅二极管**
de **Mikrowellen-Begrenzerdiode**, f
es **diodo de limitación de microondas**
ja **マイクロ波制限ダイオード**
pl **dioda ograniczająca mikrofalowa**
pt **díodo de limitação hiperfrequência**
sv **begränsningsdiod för högfrekvens**

521-04-16

diode de tension de référence, f

diode à semiconducteurs qui développe entre ses bornes une tension de référence de précision spécifiée quand elle est polarisée pour fonctionner dans une gamme de courants spécifiée

voltage-reference diode

semiconductor diode which develops across its terminals a reference voltage of specified accuracy, when biased to operate within a specified current range

cn **电压基准二极管**
de **Spannungsreferenzdiode**, f**; Bezugsdiode**, f
es **diodo de tensión de referencia**
ja **基準電圧ダイオード**
pl **dioda odniesienia; dioda stabilizacyjna**
pt **díodo de tensão de referência**
sv **(spännings)referensdiod**

521-04-17

diode régulatrice de tension, f

diode à semiconducteurs qui développe entre ses bornes une tension essentiellement constante pour une gamme de courants spécifiée

voltage-regulator diode

semiconductor diode which develops across its terminals an essentially constant voltage throughout specified current range

cn **电压调整二极管**
de **Spannungsstabilisatordiode**, f
es **diodo regulador de tensión**
ja **定電圧ダイオード**
pl **dioda stabilizująca napięcie; dioda Zenera**
pt **díodo regulador de tensão**
sv **spänningsreglerdiod**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-18

diode régulatrice de courant, f

diode à semiconducteurs qui limite le courant à une valeur pratiquement constante dans une gamme spécifiée de tensions

current-regulator diode

semiconductor diode that limits current to an essentially constant value over a specified voltage range

cn **电流调整二极管**
de **Stromstabilisatordiode**, f
es **diodo regulador de corriente**
ja **定電流ダイオード**
pl **dioda stabilizująca prąd**
pt **díodo regulador de corrente**
sv **strömreglerdiod**

521-04-19

diode de redressement (à semiconducteurs), f

diode à semiconducteurs conçue pour le redressement et comprenant ses propres accessoires de refroidissement et de montage s'ils forment un tout avec elle

(semiconductor) rectifier diode

semiconductor diode designed for rectification and including its associated mounting and cooling attachments if integral with it

cn **（半导体）整流二极管**
de **Halbleiter-Gleichrichterdiode**, f
es **diodo semiconductor rectificador; diodo rectificador**
ja **半導体整流ダイオード；整流ダイオード**
pl **dioda prostownicza (półprzewodnikowa)**
pt **díodo rectificador (semicondutor)**
sv **likriktardiod**

521-04-20

diode de redressement à avalanche, f

diode de redressement à semiconducteurs qui a des caractéristiques données relatives à la tension de claquage minimale et qui est prévue pour dissiper de la puissance en surcharge accidentelle dans la région de claquage de sa caractéristique inverse

avalanche rectifier diode

semiconductor rectifier diode which has stated minimum breakdown voltage characteristics and is rated to dissipate power surges for a limited time in the breakdown region of its reverse characteristic

cn **雪崩整流二极管**
de **Lawinen-Gleichrichterdiode**, f
es **diodo rectificador de avalancha**
ja **アバランシェ形整流ダイオード**
pl **dioda prostownicza lawinowa**
pt **díodo rectificador de avalanche**
sv **lavindiod**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-21

bloc de redressement (à semiconducteurs), m

combinaison en un groupe unique d'une ou de plusieurs diodes de redressement à semiconducteurs avec éventuellement leurs accessoires de refroidissement et de montage et avec leurs connexions électriques ou mécaniques

(semiconductor) rectifier stack

single structure of several semiconductor rectifier diodes with their associated mountings, cooling attachments, if any, and connections whether electrical or mechanical

cn **半导体整流堆**
de **Halbleiter-Gleichrichterbaugruppe**, f
es **bloque semiconductor rectificador**
ja **半導体整流スタック**
pl **stos prostowniczy (półprzewodnikowy)**
pt **bloco rectificador semicondutor**
sv **likriktarstapel**

521-04-22

thermistance, f

résistance possédant un coefficient élevé et non linéaire et généralement négatif, de variation de la résistance avec la température

thermistor

resistor having a large non-linear (generally negative) temperature coefficient of resistance

cn **热敏电阻器**
de **Thermistor**, m
es **termistancia**
ja **サーミスタ**
pl **termistor**
pt **termistor**
sv **termistor**

521-04-23

thermoélément à semiconducteurs, m

dispositif à semiconducteurs basé sur l'effet Peltier ou Seebeck et conçu pour la conversion directe de la chaleur en énergie électrique ou réciproquement

semiconductor thermoelement

semiconductor device based on the Seebeck or Peltier effect and designed for direct conversion of heat into electric energy or vice versa

cn **半导体温差电器件**
de **Halbleiter-Thermoelement**, n
es **termoelemento semiconductor**
ja **半導体熱変換素子**
pl **termoelement półprzewodnikowy**
pt **termoelemento semicondutor**
sv **halvledartermoelement**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-24

dispositif à effet Hall, m

dispositif à semiconducteurs conçu pour utiliser l'effet Hall

Hall effect device

semiconductor device in which the Hall effect is utilized

cn **霍尔效应器件**
de **Halleffekt-Bauelement**, n
es **dispositivo de efecto Hall**
ja **ホール効果デバイス**
pl **hallotron**
pt **dispositivo de efeito Hall**
sv **hallkomponent**

521-04-25

modulateur à effet Hall, m

dispositif à effet Hall conçu spécialement pour la modulation

Hall modulator

Hall effect device which is specially designed for modulation purposes

cn **霍尔调制器**
de **Hallmodulator**, m
es **modulador Hall**
ja **ホール変調器**
pl **modulator hallotronowy**
pt **modulador de efeito Hall**
sv **hallmodulator**

521-04-26

générateur de Hall, m

plaque de Hall munie de connexions et, éventuellement, d'un boîtier et de plaques en matériaux ferreux ou non ferreux

Hall generator

Hall plate, together with leads and, where used, encapsulation and ferrous or non-ferrous plates

cn **霍尔发生器**
de **Hallgenerator**, m
es **generador Hall**
ja **ホール発電器**
pl **generator Halla**
pt **gerador de Hall**
sv **hallgenerator**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-27

multiplicateur de Hall, m

dispositif à effet Hall qui contient un générateur de Hall et une source d'induction magnétique et tel que la grandeur de sortie est proportionnelle au produit du courant de commande par le courant produisant l'induction magnétique

Hall multiplier

Hall effect device which contains a Hall generator and a coil as source of magnetic flux, such that the output quantity is proportional to the product of the control current and the current producing the magnetic flux

cn **霍尔乘法器**
de **Hallmultiplikator**, m
es **multiplicador Hall**
ja **ホール逓倍器**
pl **mnożnik hallotronowy**
pt **multiplicador de Hall**
sv **hallmultiplikator**

521-04-28

sonde de Hall, f
magnétomètre à effet Hall, m

dispositif à effet Hall spécifiquement conçu pour la mesure de l'induction magnétique

Hall probe
Hall effect magnetometer

Hall effect device specifically designed for the measurement of magnetic flux density

cn **霍尔探头；霍尔效应磁强计**
de **Hallsonde**, f**; Halleffekt-Magnetometer**, m
es **sonda de Hall; magnetómetro de efecto Hall**
ja **ホール探針；ホール効果磁力計**
pl **sonda Halla; magnetometr hallotronowy**
pt **sonda de Hall; magnetómetro de efeito Hall**
sv **hallsond**

521-04-29

magnétorésistance, f

dispositif à semiconducteurs dans lequel on utilise la variation de la résistance électrique en fonction de l'induction magnétique

magnetoresistor

semiconductor or conductor device in which the dependence of electric resistance on magnetic flux density is used

cn **磁（电）阻器**
de **Magnetowiderstand**, m
es **magnetorresistencia**
ja **磁気抵抗器**
pl **magnetorezystor**
pt **magnetorresistor**
sv **magnetoresistor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-30

disque de Corbino, m

magnétorésistance en forme de disque ; l'une des électrodes est une région conductrice au centre du disque, l'autre, une bande conductrice concentrique à la périphérie

Corbino disc

disc-shaped magnetoresistor whose two electrodes are a conductive region in the geometric centre of the disc and a conductive concentric strip around the outer perimeter of the disc

cn **科尔比诺圆盘**
de **Corbino-Scheibe**, f
es **disco de Corbino**
ja **コルビーノディスク**
pl **magnetorezystor tarczowy**
pt **disco de Corbino**
sv **corbinoskiva**

521-04-31

dispositif optoélectronique, m

dispositif à semiconducteurs qui émet un rayonnement optique, qui est sensible à un rayonnement optique ou l'utilise pour son fonctionnement interne, ou qui effectue une combinaison de ces fonctions

optoelectronic device

semiconductor device that emits or is responsive to optical radiation, or that utilises optical radiation for its internal purpose, or performs a combination of these functions

cn **光电子器件**
de **optoelektronisches Halbleiterbauelement**, n
es **dispositivo optoelectrónico**
ja **光電子デバイス**
pl **przyrząd optoelektroniczny**
pt **dispositivo optoelectrónico**
sv **optoelektronisk komponent**

521-04-32

photodiode, f

dispositif photoélectrique dans lequel l'absorption d'un rayonnement électromagnétique dans la jonction et à son voisinage, ou à la surface de contact d'un semiconducteur et d'un métal, produit une modification de résistance qui dépend de la direction du courant

photodiode

photoelectric device in which absorption of electomagnetic radiation in the junction and its neighbourhood or at a contact between a semiconductor and a metal, produces a change of resistance or a change of voltage

cn **光电二极管**
de **Photodiode**, f
es **fotodiodo**
ja **フォトダイオード**
pl **fotodioda**
pt **fotodíodo**
sv **fotodiod**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-33

cellule photoconductrice, f

dispositif dans lequel l'effet photoconductif est utilisé

photoconductive cell

device in which the photoconductive effect is utilized

cn **光电导电池**
de **photoelektrische Zelle**, f
es **célula fotoconductora**
ja **光導電セル**
pl **komórka fotoprzewodząca; fotokomórka**
pt **célula fotocondutiva**
sv **fotokonductiv cell**

521-04-34

cellule à effet photovoltaïque, f

dispositif dans lequel l'effet photovoltaïque est utilisé

photovoltaic cell

device in which the photovoltaic effect is utilized

cn **光生伏打电池；光伏电池**
de **Photoelement**, n**; photovoltaische Zelle**, f
es **célula fotovoltaica**
ja **光電池**
pl **komórka fotowoltaiczna; fotoogniwo**
pt **célula fotovoltaica**
sv **fotoelektromotorisk cell**

521-04-35

photoémetteur, m

dispositif optoélectronique qui convertit directement l'énergie électrique en énergie optique rayonnante

photoemitter

optoelectronic device that directly converts electric energy into optical radiant energy

cn **光发射器件**
de **strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement**, n
es **fotoemisor**
ja **フォトエミッタ**
pl **przyrząd elektroluminescencyjny**
pt **fotoemissor**
sv **fotoemitter**

--`,,```,,,,````-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-36

afficheur optoélectronique, m

photoémetteur à semiconducteurs conçu pour la présentation d'informations visuelles

optoelectronic display

semiconductor photoemitter designed for the presentation of visual information

cn **光电子显示器件**
de **optoelektronische Anzeige**, f
es **pantalla optoelectrónica**
ja **光電子ディスプレイ**
pl **wyświetlacz optoelektroniczny**
pt **visualizador optoelectrónico**
sv **optoelektronisk teckentablå**

521-04-37

diode laser, f

diode à semiconducteurs qui émet un rayonnement optique cohérent par une émission stimulée résultant de la recombinaison d'électrons de conduction et de trous lorsqu'elle est excitée par un courant électrique de valeur supérieure au courant de seuil de la diode

NOTE – La diode laser est montée sur une embase ou dans un boîtier avec ou sans moyen de couplage (par exemple, lentille, fibre amorce).

laser diode

semiconductor diode that emits coherent optical radiation through stimulated emission resulting from the recombination of conduction electrons and holes when excited by an electric current that exceeds the threshold current of the diode

NOTE – The laser diode is mounted on a submount or in a package with or without coupling means (e.g. lens, pigtail).

cn **激光二极管**
de **Laserdiode**, f
es **diodo láser**
ja **レーザダイオード**
pl **dioda laserowa**
pt **díodo laser**
sv **laserdiod**

521-04-38

module à diode laser, m

module qui comprend une diode laser et des moyens pour la stabilisation optique ou thermique automatique du flux énergétique

laser-diode module

module containing, together with the laser diode, means for an automatic optical and/or thermal stabilization of the radiant output power

cn **激光二极管模块**
de **Laserdiodenmodul**, n
es **módulo de diodo láser**
ja **レーザダイオードモジュール**
pl **moduł diody laserowej**
pt **módulo de díodo laser**
sv **laserdiodmodul**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-39

diode électroluminescente, f
DEL (abréviation)

diode à semiconducteurs qui émet un rayonnement optique non cohérent par une émission stimulée résultant de la recombinaison d'électrons de conduction et de trous lorsqu'elle est excitée par un courant électrique

light-emitting diode
LED (abbreviation)

semiconductor diode that emits non coherent optical radiation through stimulated emission resulting from the recombination of conduction electrons and photons, when excited by an electric current

cn **发光二极管；LED**（缩写词）
de **lichtemittierende Diode**, f**; LED** (Abkürzung)
es **diodo electroluminiscente**
ja **発光ダイオード；LED**
pl **dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED** (akronim)
pt **díodo emissor de luz; LED** (abreviatura)
sv **lysdiod**

521-04-40

diode infrarouge, f

diode électroluminescente qui émet un rayonnement infrarouge

infrared-emitting diode

light-emitting diode that emits infrared radiation

cn **红外发光二极管**
de **infrarotemittierende Diode**, f**; IRED** (Abkürzung)
es **diodo infrarrojo**
ja **赤外線発光ダイオード**
pl **dioda emitująca w (zakresie) podczerwieni; dioda na podczerwień**
pt **díodo emissor de infravermelho**
sv **infraröd strålande diod**

521-04-41

dispositif photosensible (à semiconducteurs), m

dispositif optoélectronique sensible à un rayonnement optique

(semiconductor) photosensitive device

optoelectronic device responsive to optical radiation

cn **(半导体)光敏器件**
de **lichtempfindliches Halbleiterbauelement**, n**; photoempfindliches Halbleiterbauelement**, n
es **dispositivo semiconductor fotosensible; dispositivo fotosensible**
ja **半導体感光性デバイス；感光性デバイス**
pl **przyrząd fotoelektryczny (półprzewodnikowy); fotoelement (półprzewodnikowy)**
pt **dispositivo semicondutor foto-sensível**
sv **ljuskänslig halvledarkomponent**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-42

récepteur photoélectrique (à semiconducteurs), m

dispositif photosensible à semiconducteurs qui utilise l'effet photoélectrique pour la réception d'un rayonnement optique

(semiconductor) photoelectric detector

semiconductor photosensitive device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical radiation

cn **(半导体)光电探测器**
de **photoelektrischer Halbleiterempfänger**, m
es **receptor semiconductor fotoeléctrico; receptor fotoeléctrico**
ja **半導体光電ディテクタ；光電ディテクタ**
pl **detektor fotoelektryczny (półprzewodnikowy)**
pt **receptor semicondutor fotoeléctrico**
sv **fotoelektrisk detektor**

521-04-43

photorésistance, f

dispositif photosensible à semiconducteurs qui utilise l'effet photoélectrique pour la réception d'un rayonnement optique

photoresistor

semiconductor photosensitive device that utilizes the change of electric conductivity produced by the absorption of optical radiation

cn **光敏电阻器**
de **Photowiderstand**, m**; photoleitfähige Halbleiterzelle**, f
es **fotorresistencia**
ja **フォトレジスタ**
pl **fotorezystor**
pt **fotorresistor**
sv **fotomotstånd**

521-04-44

photodiode à avalanche, f

photodiode fonctionnant avec une polarisation en inverse telle que le courant photoélectrique primaire subit une amplification dans la diode

avalanche photodiode

photodiode operating with a reverse bias such that the primary photocurrent undergoes amplification within the diode

cn **雪崩光电二极管**
de **Lawinen-Photodiode**, f
es **fotodiodo de avalancha**
ja **アバランシェフォトダイオード**
pl **fotodioda lawinowa**
pt **fotodíodo de avalanche**
sv **lavinfotodiod**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-45

photocoupleur, m
optocoupleur, m

dispositif optoélectronique conçu pour le transfert de signaux électriques par l'intermédiaire d'un rayonnement optique, afin d'assurer un couplage garantissant l'isolement de la sortie par rapport à l'entrée

photocoupler
optocoupler

optoelectronic device designed for the transfer of electrical signals by utilizing optical radiation to provide coupling while the output is isolated from the input

cn **光电耦合器**
de **Optokoppler**, m
es **fotoacoplador; optoacoplador**
ja フォトカプラ；オプトカプラ
pl **sprzęgacz fotonowy; transoptor**
pt **fotoacoplador; optoacoplador**
sv **optokopplare**

521-04-46

transistor, m

dispositif à semiconducteurs susceptible de fournir une amplification de puissance électrique et possédant trois électrodes ou plus

transistor

semiconductor device capable of providing amplification of electric power and having three or more electrodes

cn **晶体管**
de **Transistor**, m
es **transistor**
ja トランジスタ
pl **tranzystor**
pt **transistor**
sv **transistor**

521-04-47

transistor bipolaire à jonctions, m

transistor possédant au moins deux jonctions et dont le fonctionnement dépend à la fois des porteurs majoritaires et des porteurs minoritaires

bipolar junction transistor

transistor having at least two junctions and whose functioning depends on both majority carriers and minority carriers

cn **双极（结型）晶体管**
de **Bipolartransistor**, m; **Sperrschichttransistor**, m
es **transistor bipolar de unión**
ja バイポーラトランジスタ；接合形トランジスタ
pl **tranzystor bipolarny złączowy**
pt **transistor bipolar; transistor de junção**
sv **bipolär skikttransistor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-48

transistor unipolaire, m

transistor dont le fonctionnement dépend de manière prépondérante de porteurs de charge d'une seule polarité

unipolar transistor

transistor whose functionning depends predominantly on charge carriers of one polarity

cn **单极晶体管**
de **Unipolartransistor**, m
es **transistor unipolar**
ja **ユニポーラトランジスタ**
pl **tranzystor unipolarny**
pt **transistor unipolar**
sv **unipolärtransistor**

521-04-49

transistor bidirectionnel, m

transistor qui a sensiblement les mêmes caractéristiques électriques lorsque les bornes normalement désignées comme émetteur et collecteur sont interchangées

bidirectional transistor

transistor which has substantially the same electrical characteristics when the terminals normally designated as emitter and collector are interchanged

cn **双向晶体管**
de **Zweirichtungstransistor**, m**; bidirektionaler Transistor**, m
es **transistor bidireccional**
ja **双方向トランジスタ**
pl **tranzystor dwukierunkowy**
pt **transistor bidireccional**
sv **dubbelriktad transistor**

521-04-50

transistor tétrode, m

transistor à quatre électrodes, généralement transistor ordinaire à jonctions, ayant deux électrodes de base séparées et deux bornes de base

tetrode transistor

four-electrode transistor, usually a conventional junction transistor having two separate base electrodes and two base terminals

cn **四极晶体管**
de **Transistortetrode**, f
es **transistor tetrodo**
ja **4極管動作トランジスタ**
pl **tranzystor tetrodowy**
pt **transistor tétrodo**
sv **tetrodtransistor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-51

phototransistor, m

transistor dans lequel le courant produit par l'effet photoélectrique au voisinage de la jonction émetteur-base joue le rôle de courant de base qui est amplifié

phototransistor

transistor in which the current produced by the photoelectric effect in the neighbourhood of the emitter-base junction acts as base current which is amplified

cn **光电晶体管**
de **Phototransistor**, m
es **fototransistor**
ja **フォトトランジスタ**
pl **fototranzystor**
pt **fototransistor**
sv **fototransistor**

521-04-52

transistor à effet de champ, m

transistor dans lequel le courant circulant dans un canal conducteur est commandé par un champ électrique dû à une tension appliquée entre les bornes de grille et de source

field-effect transistor

transistor in which the current flowing through a conduction channel is controlled by an electric field arising from a voltage applied between the gate and source terminals

cn **场效应晶体管**
de **Feldeffekttransistor**, m
es **transistor de efecto de campo**
ja **電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy**
pt **transistor de efeito de campo**
sv **fälteffekttransistor**

521-04-53

transistor à effet de champ à jonction de grille, m

transistor à effet de champ ayant une ou plusieurs régions de grille qui forment une ou plusieurs jonctions PN avec le canal

junction-gate field-effect transistor

field-effect transistor having one or more gate regions which form PN junctions with the channel

cn **结栅场效应晶体管**
de **Sperrschicht-Feldeffekttransistor**, m
es **transistor de efecto de campo de unión de rejilla**
ja **接合ゲート電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy z bramką złączową**
pt **transistor de efeito de campo de junção de porta**
sv **fälteffekttransistor med PN-styre**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-54

transistor à effet de champ à grille isolé, m

transistor à effet de champ ayant une ou plusieurs électrodes de grille isolées électriquement du canal

insulated-gate field-effect transistor

field-effect transistor having one or more gate electrodes wich are electrically insulated from the channel

cn **绝缘栅场效应晶体管**
de **Isolierschicht-Feldeffekttransistor**, m**; IGFET** (Abkürzung)
es **transistor de efecto de campo de rejilla aislada**
ja **絶縁ゲート電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy z bramką izolowaną**
pt **transistor de efeito de campo de porta isolada**
sv **fälteffekttransistor med isolerat styre**

521-04-55

transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m

transistor à effet de champ à grille isolée dans lequel la couche isolante entre chaque électrode de grille et le canal est un oxyde

metal-oxide-semiconductor field-effect transistor
MOSFET (abbreviation)

insulated-gate field-effect transistor in which the insulating layer between each gate electrode and the channel is oxide material

cn **金属氧化物半导体场效应晶体管；MOSFET**(缩写词)
de **Feldeffekttransistor mit Metalloxid-Halbleiter**, m**; MOSFET** (Abkürzung)
es **transistor de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor**
ja **金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ；MOSFET**
pl **tranzystor polowy tlenkowy; tranzystor (polowy) MOS**
pt **transistor de efeito de campo (metal-óxido-semicondutor)**
sv **fälteffekttransistor med oxidisolerat styre; MOS-transistor**

521-04-56

transistor à effet de champ à canal N, m

transistor à effet de champ ayant un canal conducteur de type N

N-channel field-effect transistor

field-effect transistor which has an N-type conduction channel

cn **N沟道场效应晶体管**
de **N-Kanal-Feldeffekttransistor**, m
es **transistor de efecto de campo de canal N**
ja **Nチャネル電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy z kanałem N**
pt **transistor de efeito de campo de canal N**
sv **N-kanal (fälteffekt)transistor**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-57

transistor à effet de champ à canal P, m

transistor à effet de champ ayant un canal conducteur de type P

P-channel field-effect transistor

field-effect transistor which has a P-type conduction channel

cn **P沟道场效应晶体管**
de **P-Kanal-Feldeffekttransistor**, m
es **transistor de efecto de campo de canal P**
ja **Pチャネル電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy z kanałem P**
pt **transistor de efeito de campo de canal P**
sv **P-kanal (fälteffekt)transistor**

521-04-58

transistor à effet de champ à déplétion, m
transistor à effet de champ à appauvrissement, m

transistor à effet de champ ayant une conduction appréciable du canal pour une tension grille-source nulle, cette conduction du canal pouvant être augmentée ou diminuée suivant la polarité de la tension grille-source appliquée

depletion type field-effect transistor

field-effect transistor having appreciable channel conductivity for zero gate-source voltage where the channel conductivity may be increased or decreased according to the polarity of the applied gate-source voltage

cn **耗尽型场效应晶体管**
de **Feldeffekttransistor vom Verarmungstyp**, m
es **transistor de efecto de campo de agotamiento**
ja **デプレッション形電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy z kanałem zubożonym**
pt **transistor de efeito de campo de depleção;**
transistor de efeito de campo por empobrecimento
sv **fälteffekttransistor av utarmningstyp**

521-04-59

transistor à effet de champ à enrichissement, m

transistor à effet de champ qui a essentiellement une conduction nulle du canal pour une tension grille-source nulle, cette conduction du canal pouvant être augmentée par l'application d'une tension grille-source de polarité convenable

enhancement type field-effect transistor

field-effect transistor having substantially zero channel conductivity for zero gate-source voltage where the channel conductivity may be increased by the application of a gate-source voltage of appropriate polarity

cn **增强型场效应晶体管**
de **Feldeffekttransistor vom Anreicherungstyp**, m
es **transistor de efecto de campo de enriquecimiento**
ja **エンハンスメント形電界効果トランジスタ**
pl **tranzystor polowy z kanałem wzbogaconym**
pt **transistor de efeito de campo por enriquecimento**
sv **fälteffekttransistor av anrikningstyp**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-60

transistor à effet de champ métal-semiconducteur, m

transistor à effet de champ ayant une ou plusieurs électrodes de grille qui forment des barrières de Schottky avec le canal

metal-semiconductor-field-effect transistor
MESFET (abbreviation)

field-effect transistor having one or more gate electrodes that form Schottky barriers with the channel

cn **金属-半导体场效应晶体管；MESFET**(缩写词)
de **Feldeffekttransistor mit Metall-Halbleiter**, m**; MESFET** (Abkürzung)
es **transistor de efecto de campo de metal-semiconductor**
ja **金属半導体電界効果トランジスタ ; MESFET**
pl **tranzystor polowy złączowy z bramką metalową; MESFET** (akronim)
pt **transistor de efeito de campo metal-semicondutor**
sv **fälteffektransistor med metallstyre**

521-04-61

thyristor, m

dispositif à semiconducteurs bistable, comprenant trois jonctions ou plus, qui peut être commuté de l'état bloqué à l'état passant ou vice versa

NOTE – Les dispositifs ayant seulement trois couches mais possédant des caractéristiques de commutation similaires à celles des thyristors à quatre couches peuvent aussi être appelés thyristors.

thyristor

bi-stable semiconductor device comprising three or more junctions which can be switched from the off-state to the on-state or vice versa

NOTE – Devices having only three layers but having switching characteristics similar to those of four-layer thyristors may also be called thyristors.

cn **闸流晶体管；晶闸管**
de **Thyristor**, m
es **tiristor**
ja **サイリスタ**
pl **tyrystor**
pt **tiristor**
sv **tyristor**

521-04-62

thyristor diode bloqué en inverse, m

thyristor à deux bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas, mais présente un état bloqué en inverse

reverse blocking diode thyristor

two-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits reverse blocking state

cn **反向阻断二极闸流晶体管；反向阻断二极晶闸管**
de **rückwärts sperrende Thyristordiode**, f
es **tiristor diodo bloqueado en inversa**
ja **逆阻止2端子サイリスタ**
pl **tyrystor diodowy blokujący wstecznie**
pt **tiristor díodo bloqueado em sentido inverso**
sv **diodtyristor med spärrförmåga**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-63

thyristor triode bloqué en inverse, m

thyristor à trois bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas, mais présente un état bloqué en inverse

reverse blocking triode thyristor

three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits a reverse blocking state

cn **反向阻断三极闸流晶体管；反向阻断三极晶闸管**
de **rückwärts sperrende Thyristortriode**, f
es **tiristor triodo bloqueado en inversa**
ja **逆阻止3端子サイリスタ**
pl **tyrystor triodowy blokujący wstecznie**
pt **tiristor tríodo bloqueado em sentido inverso**
sv **triodtyristor med spärrförmåga**

521-04-64

thyristor diode passant en inverse, m

thyristor à deux bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas et conduit de forts courants à des tensions d'amplitude comparable à celle de la tension directe à l'état passant

reverse conducting diode thyristor

two-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts large currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage

cn **逆导二极闸流晶体管；逆导二极晶闸管**
de **rückwärts leitende Thyristordiode**, f
es **tiristor diodo conductor en inversa**
ja **逆導通2端子サイリスタ**
pl **tyrystor diodowy przewodzący wstecznie**
pt **tiristor díodo conduzindo em sentido inverso**
sv **diodtyristor utan spärrförmåga**

521-04-65

thyristor triode passant en inverse, m

thyristor à trois bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas et conduit de forts courants à des tensions d'amplitude comparable à celle de la tension directe à l'état passant

reverse conducting triode thyristor

three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts large currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage

cn **逆导三极闸流晶体管；逆导三极晶闸管**
de **rückwärts leitende Thyristortriode**, f
es **tiristor triodo conductor en inversa**
ja **逆導通3端子サイリスタ**
pl **tyrystor triodowy przewodzący wstecznie**
pt **tiristor tríodo conduzindo em sentido inverso**
sv **triodtyristor utan spärrförmåga**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-66

thyristor diode bidirectionnel, m
diac (abréviation)

thyristor à deux bornes présentant sensiblement le même comportement en commutation dans le premier et le troisième quadrants de la caractéristique principale

bidirectional diode thyristor
diac (abbreviation)

two-terminal thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and third quadrants of the current-voltage characteristic

cn **双向二极闸流晶体管；双向二极晶闸管；diac**(缩写词)
de **Zweirichtungs-Thyristordiode**, f**; doppeltgerichtete Thyristordiode**, f**; Diac** (Abkürzung)
es **tiristor diodo bidireccional; diac** (en abreviatura)
ja **双方向2端子サイリスタ；ダイアック**
pl **tyrystor diodowy dwukierunkowy; diak**
pt **tiristor díodo bidireccional; diac** (abreviatura)
sv **dubbelriktad diodtyristor; diac**

521-04-67

thyristor triode bidirectionnel, m
triac (abréviation)

thyristor à trois bornes présentant sensiblement le même comportement en commutation dans le premier et le troisième quadrants de la caractéristique principale

bidirectional triode thyristor
triac (abbreviation)

three-terminal thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and third quadrants of the current-voltage characteristic

cn **双向三极闸流晶体管；双向三极晶闸管；triac**(缩写词)
de **Zweirichtungs-Thyristortriode**, f**; doppeltgerichtete Thyristortriode**, f**; Triac** (Abkürzung)
es **tiristor triodo bidireccional; triac** (en abreviatura)
ja **双方向3端子サイリスタ；トライアック**
pl **tyrystor triodowy dwukierunkowy; triak**
pt **tiristor tríodo bidireccional; triac** (abreviatura)
sv **dubbelriktad triodtyristor; triac**

521-04-68

thyristor blocable, m

thyristor qui peut être commuté de l'état passant à l'état bloqué et vice versa en appliquant des signaux de commande, de polarité appropriée, à la borne de gâchette

turn-off thyristor

thyristor which can be switched from the on-state to the off-state and vice versa by applying control signals of appropriate polarity to the gate terminal

cn **可关断闸流晶体管；可关断晶闸管**
de **Ausschaltthyristor**, m**; GTO-Thyristor**, m
es **tiristor bloqueable**
ja **ターンオフサイリスタ**
pl **tyrystor wyłączający**
pt **tiristor bloqueável**
sv **släckbar tyristor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-69

thyristor P, m

thyristor dans lequel la borne de gâchette est connectée à la région P la plus proche de la cathode et qui est normalement commuté à l'état passant en appliquant un signal positif à la borne de gâchette par rapport à la borne de cathode

P-gate thyristor

thyristor in which the gate terminal is connected to the P-region nearest the cathode and which is normally switched to the on-state by applying a positive signal to the gate terminal with respect to the cathode terminal

cn **P栅闸流晶体管；P门极晶闸管**
de **kathodenseitig steuerbarer Thyristor**, m
es **tiristor P**
ja **Pゲートサイリスタ**
pl **tyrystor z bramką typu P**
pt **tiristor de porta P**
sv **tyristor med P-styre**

521-04-70

thyristor N, m

thyristor dans lequel la borne de gâchette est connectée à la région N la plus proche de l'anode et qui est normalement commuté à l'état passant en appliquant un signal négatif à la borne de gâchette par rapport à la borne d'anode

N-gate thyristor

thyristor in which the gate terminal is connected to the N-region nearest the anode and which is normally switched to the on-state by applying a negative signal to the gate terminal with respect to the anode terminal

cn **N栅闸流晶体管；N门极晶闸管**
de **anodenseitig steuerbarer Thyristor**, m
es **tiristor N**
ja **Nゲートサイリスタ**
pl **tyrystor z bramką typu N**
pt **tiristor de porta N**
sv **tyristor med N-styre**

521-04-71

thyristor asymétrique, m

thyristor triode bloqué en inverse dont la tension inverse a une valeur limite nettement inférieure à celle de la tension à l'état bloqué

asymmetrical thyristor

reverse blocking triode thyristor whose rated reverse voltage is significantly lower than its rated off-state voltage

cn **非对称闸流晶体管；非对称晶闸管**
de **asymmetrischer Thyristor**, m
es **tiristor asimétrico**
ja **非対称サイリスタ**
pl **tyrystor asymetryczny**
pt **tiristor assimétrico**
sv **asymmetrisk tyristor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-04-72

photothyristor, m

thyristor qui est conçu pour être déclenché par un rayonnement optique

photothyristor

thyristor that is designed to be triggered by optical radiation

cn **光敏闸流晶体管；光控晶闸管**
de **Photothyristor**, m
es **fototiristor**
ja **フォトサイリスタ**
pl **fototyrystor**
pt **fototiristor**
sv **fototyristor**

Section 521-05 – Termes généraux pour dispositifs à semiconducteurs

Section 521-05 – General terms for semiconductor devices

521-05-01

électrode (d'un dispositif à semiconducteurs), f

élément conducteur en contact avec un semiconducteur et destiné à remplir une ou plusieurs des fonctions suivantes : émettre ou collecter des électrons ou des trous, ou agir sur leur mouvement

electrode (of a semiconductor device)

conductive element in electric contact with a semiconductor that performs one or more of the functions of emitting or collecting electrons or holes, or of controlling their movements

cn **电极**（半导体器件的）
de **Elektrode** (eines Halbleiterbauelements), f
es **electrodo** (de un dispositivo semiconductor)
ja **（半導体デバイスの）電極**
pl **elektroda** (przyrządu półprzewodnikowego)
pt **eléctrodo** (de um dispositivo semicondutor)
sv **elektrod**

521-05-02

borne (d'un dispositif à semiconducteurs), f

élément conducteur destiné à assurer une connexion extérieure

terminal (of a semiconductor device)

conductive element provided for external connection

cn **引出端**（半导体器件的）
de **Anschluss**, m**; Anschlusspunkt**, m
es **borne** (de un dispositivo semiconductor)
ja **（半導体デバイスの）端子**
pl **końcówka** (przyrządu półprzewodnikowego)**; wyprowadzenie** (przyrządu półprzewodnikowego)
pt **terminal** (de um dispositivo semicondutor)
sv **pol**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-03

sens direct (d'une jonction PN), m

sens du courant qui circule lorsque la région de type P du semiconducteur est à une tension positive par rapport à la région de type N

forward direction (of a PN junction)

direction of current that results when the P-type semiconductor region is at a positive voltage relative to the N-type region

cn **正向**（PN结的）
de **Vorwärtsrichtung** (eines PN-Übergangs), f**; Durchlassrichtung** (eines PN-Übergangs), f
es **sentido directo** (de una unión PN)
ja **（PN接合の）順方向**
pl **kierunek przewodzenia** (złącza PN)
pt **sentido directo** (de uma junção PN)
sv **framriktning**

521-05-04

sens inverse (d'une jonction PN), m

sens du courant qui circule lorsque la région de type N du semiconducteur est à une tension positive par rapport à la région de type P

reverse direction (of a PN junction)

direction of current that results when the N-type semiconductor region is at a positive voltage relative to the P-type region

cn **反向**（PN结的）
de **Rückwärtsrichtung** (eines PN-Übergangs), f**; Sperrrichtung** (eines PN-Übergangs), f
es **sentido inverso** (de una unión PN)
ja **（PN接合の）逆方向**
pl **kierunek zaporowy** (złącza PN)
pt **sentido inverso** (de uma junção PN)
sv **backriktning**

521-05-05

région de résistance différentielle négative, f

toute partie de la caractéristique principale où la résistance différentielle est négative

negative differential resistance region

any portion of the voltage-current characteristic within which the differential resistance is negative

cn **负微分电阻区**
de **negativer differentieller Widerstandsbereich**, m
es **región de resistencia diferencial negativa**
ja **負性微分抵抗領域**
pl **obszar ujemnej rezystancji różniczkowej**
pt **região de resistência diferencial negativa**
sv **område med negativ differentiell resistans**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-06

claquage (d'une jonction PN polarisée en inverse), m

phénomène qui se manifeste par l'apparition d'une transition d'un état de haute résistance dynamique vers un état de résistance dynamique sensiblement plus faible, lorsque la grandeur du courant inverse augmente

breakdown (of a reverse-biased PN junction)

phenomenon, the initiation of which is observed as a transition from a state of high dynamic resistance to a state of substantially lower dynamic resistance for increasing magnitude of reverse current

cn **击穿**（反向偏置PN结的）
de **Durchbruch** (eines in Sperrrichtung vorgespannten PN-Übergangs), m
es **perforación** (de una unión PN polarizada en inversa)
ja **（逆バイアスされたPN接合の）降伏**
pl **przebicie** (złącza PN spolaryzowanego wstecznie)
pt **perfuração** (de uma junção PN polarizada inversamente)
sv **genombrott**

521-05-07

claquage par avalanche (d'une jonction PN), m

claquage provoqué par la multiplication cumulative des porteurs de charge dans un semiconducteur sous l'action d'un champ électrique intense et certains porteurs gagnant alors assez d'énergie pour libérer par ionisation de nouvelles paires électron-trou

avalanche breakdown (of a PN junction)

breakdown that is caused by the cumulative multiplication of charge carriers in a semiconductor under the action of a strong electric field which causes some carriers to gain enough energy to liberate new hole-electron pairs by ionization

cn **雪崩击穿**（半导体PN结的）
de **Lawinendurchbruch** (eines PN-Übergangs), m
es **perforación por avalancha** (de una unión PN)
ja **（半導体のPN接合の）アバランシェ降伏**
pl **przebicie lawinowe** (złącza półprzewodnikowego PN)
pt **perfuração por avalanche** (de uma junção PN semicondutora)
sv **lavingenombrott**

521-05-08

tension d'avalanche, f

tension appliquée à laquelle le claquage par avalanche se produit

avalanche voltage

applied voltage at which avalanche breakdown occurs

cn **雪崩电压**
de **Lawinendurchbruchspannung**, f
es **tensión de avalancha**
ja **アバランシェ電圧**
pl **napięcie przebicia lawinowego**
pt **tensão de avalanche**
sv **lavinspänning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-09

claquage par effet Zener (d'une jonction PN), m

claquage provoqué par la transition des électrons de la bande de valence à la bande de conduction ; cette transition est due à une action tunnel sous l'influence d'un champ électrique intense dans la jonction PN

Zener breakdown (of a PN junction)

breakdown caused by the transition of electrons from the valence band to the conduction band due to tunnel action under the influence of a strong electric field in a PN junction

cn **齐纳击穿**（ PN结的 ）
de **Zener-Durchbruch** (eines PN-Übergangs), m
es **perforación por efecto Zener** (de una unión PN)
ja **（PN接合の）ツェナー降伏**
pl **przebicie Zenera** (złącza PN)
pt **perfuração por efeito Zener** (de uma junção PN)**;**
perfuração por efeito túnel (de uma junção PN)
sv **zenergenombrott**

521-05-10

tension de Zener, f

tension minimale à travers une jonction PN à laquelle le claquage par effet Zener se produit

Zener voltage

minimum voltage across a PN junction at which Zener breakdown occurs

cn **齐纳电压**
de **Zener-Spannung**, f
es **tensión de Zener**
ja **ツェナー電圧**
pl **napięcie Zenera**
pt **tensão de Zener**
sv **zenerspänning**

521-05-11

claquage par effet thermique (d'une jonction PN), m

claquage provoqué par la génération de porteurs de charge libres, due aux effets cumulatifs de l'interaction de l'augmentation de la dissipation de puissance et de l'augmentation de la température de la jonction

thermal breakdown (of a PN junction)

breakdown caused by generation of free charge carriers owing to the cumulative interaction between increasing power dissipation and increasing junction temperature

NOTE – The English term "thermal runaway" is also used in some countries.

cn **热击穿**（ PN结的 ）
de **thermischer Durchbruch** (eines PN-Übergangs), m
es **perforación por efecto térmico** (de una unión PN)
ja **（PN接合の）熱破壊**
pl **przebicie cieplne** (złącza PN)
pt **perfuração por efeito térmico** (de uma junção PN)
sv **termiskt genombrott**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-12

pénétration (entre deux jonctions PN), f

contact entre les régions de charge d'espace de deux jonctions PN par suite de l'extension de l'une d'elles ou des deux

punch-through (between two PN junctions)

contact between the space charge regions of two PN junctions as a result of widening of one or both of them

cn **穿通**（两个PN结间的）
de **Durchgriff** (zwischen zwei PN-Übergängen), m
es **penetración** (entre dos uniones PN)
ja **（2つのPN接合間の）パンチスルー**
pl **zwarcie skrośne** (między dwoma złączami PN)
pt **penetração** (entre duas junções PN)
sv **penetration**

521-05-13

résistance thermique (d'un dispositif à semiconducteurs), f

quotient de la différence entre la température virtuelle du dispositif et la température d'un point de référence extérieur spécifié, par la puissance dissipée, en régime permanent, par le dispositif

thermal resistance

quotient of the difference between the virtual temperature of the device and the temperature of a stated external reference point, by the steady-state power dissipation in the device

cn **热阻**
de **Wärmewiderstand**, m**; thermischer Widerstand**, m
es **resistencia térmica** (de un dispositivo semiconductor)
ja **熱抵抗**
pl **rezystancja cieplna** (przyrządu półprzewodnikowego)
pt **resistência térmica** (de um dispositivo semicondutor)
sv **termisk resistans**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-14

température virtuelle (d'un dispositif à semiconducteurs), f
température équivalente interne (d'un dispositif à semiconducteurs), f

température théorique basée sur une représentation simplifiée du comportement thermique et électrique d'un dispositif à semiconducteurs

NOTE 1 – La température virtuelle n'est pas nécessairement la température la plus élevée du dispositif.

NOTE 2 – Basée sur la puissance dissipée et sur la résistance ou impédance thermique qui correspond à ce mode de fonctionnement, la température virtuelle peut être calculée à l'aide de la relation :

$$T_j = T_{boîtier} + \frac{P}{R_{th}} \qquad \textbf{ou} \qquad T_j = T_{amb} + \frac{P}{R_{th}}$$

virtual temperature
internal equivalent temperature (of a semiconductor device)

theoretical temperature which is based on a simplified representation of the thermal and electrical behaviour of the semiconductor device

NOTE 1 – The virtual temperature is not necessarily the highest temperature in the device.

NOTE 2 – Based on the power dissipation and the thermal resistance or impedance that corresponds to the mode of operation, the virtual junction temperature can be calculated from the formula:

$$T_j = T_{case} + \frac{P}{R_{th}} \qquad \textbf{or} \qquad T_j = T_{amb} + \frac{P}{R_{th}}$$

cn **有效温度；内部等效温度**（半导体器件的）
de **Ersatztemperatur** (eines Halbleiterbauelements), f
es **temperatura virtual** (de un dispositivo semiconductor);
temperatura equivalente interna (de un dispositivo semiconductor)
ja **仮想温度；（半導体デバイスの）内部等価温度**
pl **temperatura pozorna** (przyrządu półprzewodnikowego)
pt **temperatura virtual** (de um dispositivo semicondutor)**;**
temperatura equivalente interna (de um dispositivo semicondutor)
sv **virtuell temperatur**

521-05-15

température virtuelle (équivalente) de jonction, f

température virtuelle de la jonction d'un dispositif à semiconducteurs

virtual (equivalent) junction temperature

virtual temperature of the junction of a semiconductor device

cn **有效结温；等效结温**
de **Ersatz-Sperrschichttemperatur**, f
es **temperatura virtual (equivalente) de unión**
ja **仮想（等価）接合温度**
pl **temperatura pozorna złącza**
pt **temperatura virtual (equivalente) de junção**
sv **virtuell skikttemperatur**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-16

capacité thermique, f

quotient de l'énergie accumulée sous forme de chaleur dans le dispositif par la différence entre la température virtuelle du dispositif et la température d'un point de référence

thermal capacitance

quotient of the thermal energy stored in the device by the difference between the virtual temperature of the device and that of specified external reference point

cn **热容**
de **Wärmekapazität**, f
es **capacidad térmica**
ja **熱容量**
pl **pojemność cieplna**
pt **capacidade térmica**
sv **termisk kapacitans**

521-05-17

tension flottante, f

tension qui existe entre une borne en circuit ouvert et un point de référence lorsqu'on applique des tensions spécifiées à toutes les autres bornes

floating voltage

voltage between an open-circuited terminal and a reference point when specified voltages are applied to all other terminals

cn **浮置电压**
de **Schwebespannung**, f
es **tensión flotante**
ja **浮遊電圧**
pl **napięcie płynące**
pt **tensão flutuante**
sv **frispänning**

521-05-18

charge récupérée (d'une diode ou d'un thyristor), f

charge totale récupérée dans une diode ou dans un thyristor après commutation d'un état passant spécifié vers un état bloqué spécifié

NOTE – Cette charge est composée de celle des porteurs de charges stockés et de celle due à la capacité de la couche d'appauvrissement.

recovered charge (of a diode or thyristor)

total charge recovered from a diode or thyristor after switching from a specified forward (on-state) current condition to a specified reverse condition

NOTE – This charge includes components due to both charge carrier storage and depletion layer capacitance.

cn **恢复电荷**（二极管或闸流晶体管的）
de **Sperrverzögerungsladung** (einer Diode oder eines Thyristors), f
es **carga recuperada** (de un diodo o tiristor)
ja **（ダイオードやサイリスタの）回復電荷**
pl **ładunek odzyskiwany** (diody lub tyrystora)
pt **carga recuperada** (de um díodo ou de um tiristor)
sv **återhämtad laddning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-19

tension de seuil (d'une diode ou d'un thyristor), f

valeur de la tension à l'intersection de la droite représentant approximativement la caractéristique courant-tension dans le sens direct avec l'axe des tensions

threshold voltage (of a diode or thyristor)

value of the voltage at the intersection of the straight line approximation of the forward (on-state) current-voltage characteristic and the voltage axis

cn **阈值电压**（二极管或闸流晶体管的）
de **Schwellenspannung** (einer Diode oder eines Thyristors), f
es **tensión de umbral** (de un diodo o tiristor)
ja （ダイオードやサイリスタの）しきい値電圧
pl **napięcie progowe** (diody lub tyrystora)
pt **tensão de limiar** (de um díodo ou de um tiristor)
sv **tröskelspänning** (för diod eller transistor)

521-05-20

fréquence de coupure, f

fréquence pour laquelle le module d'une grandeur caractéristique mesurée a décru jusqu'à une fraction spécifiée de sa valeur aux basses fréquences

NOTE – Pour un transistor, la fréquence de coupure s'applique en général au rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit en base commune ou en émetteur commun.

cut-off frequency

frequency at which the magnitude of a measured characteristic quantity has decreased to a specified fraction of its low-frequency value

NOTE – For a transistor, the cut-off frequency usually applies to the small-signal short-circuit forward current transfer ratio for either the common-base or common-emitter configuration.

cn **截止频率**
de **Grenzfrequenz**, f
es **frecuencia de corte**
ja 遮断周波数
pl **częstotliwość odcięcia**
pt **frequência de corte**
sv **gränsfrekvens**

521-05-21

retard à la croissance, m
retard à la montée, m

temps écoulé entre l'application aux bornes d'entrée d'une impulsion qui commute un dispositif à semiconducteurs d'un état non conducteur vers un état conducteur et l'apparition, aux bornes de sortie, d'une impulsion de la valeur spécifiée

delay-time

time interval between a stepfunction change of the input signal level and the instant at which the magnitude of the output signal passes through a specified value which is close to its initial value

cn **延迟时间**
de **Verzögerungszeit**, f
es **retardo de subida**
ja 遅延時間
pl **czas opóźnienia**
pt **tempo de atraso**
sv **fördröjningstid**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-22

temps de croissance, m
temps de montée, m

temps écoulé enre les instants où la grandeur de l'impulsion aux bornes de sortie atteint des limites respectivement inférieure et supérieure spécifiées quand le dispositif à semi-conducteurs est commuté de son état non conducteur à son état conducteur

NOTE – Les limites inférieure et supérieure sont habituellement respectivement 10 % et 90 % de l'amplitude finale de l'impulsion de sortie.

rise time

time interval between the instants at which the magnitude of the pulse at the output terminals reaches specified lower and upper limits respectively when the semiconductor device is being switched from its non-conducting to its conducting state

NOTE – The lower and upper limits are usually 10 % and 90 % respectively of the final amplitude of the output pulse.

cn **上升时间**
de **Anstiegszeit**, f
es **tiempo de subida**
ja **立ち上がり時間**
pl **czas narastania**
pt **tempo de subida**
sv **stigtid**

521-05-23

retard à la décroissance, m
retard à la descente, m

temps écoulé entre le début de la décroissance de l'impulsion appliquée aux bornes d'entrée d'un dispositif à semiconducteurs et le début de la décroissance de l'impulsion engendrée par les porteurs de charge aux bornes de sortie

carrier storage time

time interval between the beginning of the fall of the pulse applied to the input terminals of a semiconductor device and the beginning of the fall of the pulse generated by charge carriers at the output terminals

cn **载流子贮存时间**
de **Speicherzeit**, f**; Entladeverzug**, m
es **retardo de caída**
ja **電荷蓄積時間**
pl **czas gromadzenia ładunku**
pt **tempo de armazenamento** (dos portadores)
sv **efterledningstid**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-24

temps de décroissance, m

temps écoulé entre les instants où la grandeur de l'impulsion aux bornes de sortie atteint des limites respectivement supérieure et inférieure spécifiées quand un dispositif à semi-conducteurs est commuté de son état conducteur à son état non conducteur

NOTE – Les limites supérieure et inférieure sont habituellement respectivement 90 % et 10 % de l'amplitude initiale de l'impulsion de sortie.

fall time

time interval between the instants at which the magnitude of the pulse at the output terminals reaches specified upper and lower limits respectively when a semiconductor device is being switched from its conducting to its non-conducting state

NOTE – The upper and lower limits are usually 90 % and 10 % respectively of the initial amplitude of the output pulse.

cn **下降时间**
de **Abfallzeit**, f
es **tiempo de caída**
ja **立ち下がり時間**
pl **czas opadania**
pt **tempo de descida**
sv **falltid**

521-05-25

temps de recouvrement direct, m

durée nécessaire au courant ou à la tension pour prendre une valeur spécifiée, après commutation instantanée à partir de zéro ou d'une tension inverse spécifiée jusqu'à une condition de polarisation directe spécifiée

forward recovery time

duration required for the current or voltage to recover to a specified value after instantaneous switching from zero or a specified reverse voltage to a specified forward bias condition

cn **正向恢复时间**
de **Durchlassverzögerungszeit**, f
es **tiempo de recuperación directa**
ja **順方向回復時間**
pl **czas ustalania się stanu przewodzenia**
pt **tempo de recuperação directo**
sv **återhämtningstid i framriktning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-26

temps de récupération inverse, m

temps nécessaire au courant ou à la tension pour reprendre une valeur spécifiée, après commutation instantanée à partir d'un courant direct spécifié jusqu'à un état de polarisation inverse spécifié

reverse recovery time

time required for the current or voltage to recover to a specified value after instantaneous switching from a specified forward (on-state) current condition to a specified reverse bias condition

cn **反向恢复时间**
de **Sperrverzögerungszeit**, f
es **tiempo de recuperación inversa**
ja **逆方向回復時間**
pl **czas odzyskania blokowania**
pt **tempo de recuperação inverso**
sv **återhämtningstid i backriktning**

521-05-27

dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m

dispositif discret ou circuit intégré qui peut être endommagé de façon irréversible par des potentiels électrostatiques qui apparaissent au cours d'opérations courantes de manipulation, d'essais et d'expédition

electrostatic-discharge-sensitive device

discrete device or integrated circuit that may be permanently damaged by electrostatic potentials encountered in routine handling, testing and shipping

cn **静电放电敏感器件**
de **elektrostatisch gefährdetes Bauelement**, n
es **dispositivo sensible a las descargas electrostáticas**
ja **静電気放電に敏感なデバイス**
pl **przyrząd wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne**
pt **dispositivo sensível às descargas electrostáticas**
sv **elektrostatiskt känslig komponent**

521-05-28

substrat, m

matériau sur lequel ou dans lequel sont fabriqués les éléments du dispositif ou du circuit à semiconducteurs

substrate

material upon or within which the semiconductor device or circuit elements are fabricated

cn **衬底；基片**
de **Substrat**, n
es **substrato**
ja **基板**
pl **podłoże**
pt **substrato**
sv **substrat**

--`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-29

tranche, f
plaquette, f

disque de faible épaisseur constitué d'un matériau semiconducteur ou d'un tel matériau déposé sur un substrat, dans lequel un ou plusieurs circuits ou dispositifs peuvent être réalisés

wafer

slice or a flat disc, either of semiconductor material or of such a material deposited on a substrate, in which one or more circuits or devices can be processed

cn **晶(圆)片**
de **Wafer**, m
es **oblea; plaqueta**
ja **ウェーハ**
pl **płytka**
pt **bolacha**
sv **skiva**

521-05-30

puce, f
pastille, f

composant découpé dans une tranche (ou tranche entière) et qui est destiné à accomplir une ou plusieurs fonctions dans un dispositif

chip
die

separated part (or whole) of a wafer intended to perform a function or functions in a device

cn **芯片；管芯**
de **Chip**, m
es **chip; pastilla**
ja **チップ；ダイ**
pl **struktura**
pt **chipe**
sv **chip**

521-05-31

boîtier, m

enveloppe pour une ou plusieurs puces, éléments à couches ou autres composants, qui permet la connexion électrique et fournit une protection mécanique et une protection contre l'environnement

package

enclosure for one or more chips, film elements or other components, that allows electrical connection and provides mechanical and environmental protection

cn **封装；外壳**
de **Gehäuse**, n
es **envase**
ja **パッケージ**
pl **obudowa**
pt **invólucro**
sv **kapsel**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-32

grille de connexion (d'un boîtier), f

grille métallique possédant des bornes et un support mécanique destiné à les aligner

lead frame (of a package)

metal frame providing terminals and mechanical support to align them

cn **引线框架**（封装的）
de **Gehäuserahmen**, m
es **rejilla de conexión** (de un envase)
ja （パッケージの）リードフレーム
pl **pasek montażowy; ażur**
pt **grelha de conexão** (de um invólucro)
sv **tilledarram**

521-05-33

radiateur, m

élément séparable du boîtier ou faisant corps avec lui, qui contribue à la dissipation de la chaleur produite à l'intérieur du boîtier

heat sink

separable element or integral part of the package that contributes to the dissipation of the heat produced within the package

cn **热沉**
de **Kühlkörper**, m
es **radiador**
ja ヒートシンク
pl **radiator**
pt **dissipador (de calor)**
sv **kylare**

521-05-34

paramètre de circuit, m

valeur d'une grandeur physique qui caractérise un élément de circuit ou un circuit

circuit parameter

value of a physical quantity that characterizes a circuit element or a circuit

cn **电路参数**
de **Schaltungsparameter**, m
es **parámetro de circuito**
ja **回路パラメータ**
pl **parametry układu**
pt **parâmetros de circuito**
sv **kretsparameter**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-05-35

circuit équivalent, m

arrangement d'éléments de circuit idéaux qui possède des paramètres de circuit, dans une gamme considérée, équivalents électriquement à ceux d'un circuit ou d'un dispositif particulier

NOTE – Pour les besoins de l'analyse le circuit équivalent remplace un circuit ou un dispositif plus compliqué.

equivalent circuit

arrangement of ideal circuit elements that has circuit parameters, over a range of interest, electrically equivalent to those of a particular circuit or device

NOTE – For analysis the equivalent circuit replaces a more complicated circuit or device.

cn **等效电路**
de **Ersatzschaltung**, f
es **circuito equivalente**
ja **等価回路**
pl **układ zastępczy**
pt **circuito equivalente**
sv **ekvivalent strömkrets**

521-05-36

élément de circuit parasite, m

élément de circuit non voulu qui vient inévitablement s'ajouter à un ou plusieurs éléments de circuit voulus

parasitic circuit element

unwanted circuit element that is an unavoidable adjunct of one or more wanted circuit elements

cn **寄生电路元件**
de **parasitäres Schaltungselement**, n
es **elemento de circuito parásito**
ja **寄生回路素子**
pl **element pasożytniczy układu**
pt **elemento de circuito parasita**
sv **parasitiskt kretselement**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Section 521-06 – Termes particuliers aux diodes

Section 521-06 – Specific terms for diodes

521-06-01

point de pic (d'une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d'une diode tunnel correspondant à la plus petite tension dans le sens direct pour laquelle la conductance différentielle est nulle

peak point (of a tunnel diode)

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode corresponding to the lowest voltage in the forward direction, for which the differential conductance is zero

cn **峰点**(隧道二极管的)
de **Gipfelpunkt** (einer Tunneldiode), m**; Höckerpunkt** (einer Tunneldiode), m
es **punta de pico** (de un diodo túnel)
ja **(トンネルダイオードの) ピーク点**
pl **punkt szczytowy** (diody tunelowej)**; szczyt** (diody tunelowej)
pt **ponto de pico** (de um díodo túnel)
sv **toppunkt**

521-06-02

point de vallée (d'une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d'une diode tunnel correspondant à la plus petite tension supérieure à la tension du point de pic, pour laquelle la conductance différentielle est nulle

valley point (of a tunnel diode)

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode corresponding to the lowest voltage greater than the peak point voltage, for which the differential conductance is zero

cn **谷点**(隧道二极管的)
de **Talpunkt** (einer Tunneldiode), m
es **punta de valle** (de un diodo túnel)
ja **(トンネルダイオードの) 谷点**
pl **punkt dolinowy** (diody tunelowej)**; dolina** (diody tunelowej)
pt **ponto de vale** (de um díodo túnel)
sv **dalpunkt**

521-06-03

point isohypse (d'une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d'une diode tunnel où le courant est égal au courant du point de pic, mais où la tension est supérieure à la tension du point de vallée

projected peak point (of a tunnel diode)

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode where the current is equal to the peak point current, but where the voltage is greater than the valley point voltage

cn **投影峰点**(隧道二极管的)
de **projizierter Gipfelpunkt** (einer Tunneldiode), m**;**
projizierter Höckerpunkt (einer Tunneldiode), m
es **punta de pico proyectada** (de un diodo túnel)
ja **(トンネルダイオードの) 投影ピーク点**
pl **punkt szczytowy przesunięty** (diody tunelowej)
pt **ponto de pico projectado** (de um díodo túnel)
sv **projicerad toppunkt**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-06-04

fréquence de coupure résistive, f

fréquence à laquelle la partie réelle de l'admittance de la diode est nulle, pour un point de polarisation spécifié

resistive cut-off frequency

freqeuncy at which the real part of the diode admittance at its terminals is zero, at a specified bias point

cn **电阻性截止频率**
de **Entdämpfungsfrequenz**, f
es **frecuencia de corte resistiva**
ja **抵抗遮断周波数**
pl **częstotliwość graniczna rezystywnościowa**
pt **frequência de corte resistiva**
sv **resistiv gränsfrekvens**

521-06-05

résistance apparente directe, f

valeur de la résistance définie par la pente de la droite représentant approximativement la caractéristique courant-tension dans le sens direct

forward slope resistance

value of the resistance calculated from the slope of the straight line approximation of the forward current-voltage characteristic

cn **正向斜率电阻**
de **Vorwärts-Ersatzwiderstand**, m
es **resistencia aparente directa**
ja **順方向勾配抵抗**
pl **rezystancja nachyleni(ow)a**
pt **resistência dinâmica directa; resistência aparente directa**
sv **differentiell framresistans**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Section 521-07 – Termes particuliers aux transistors

Section 521-07 – Specific terms for transistors

521-07-01

jonction émetteur, f

jonction entre les régions de base et d'émetteur normalement polarisée dans le sens direct, et que les porteurs de charge provenant d'une région où ils sont majoritaires traversent pour arriver dans une région où ils sont minoritaires

emitter junction

junction between the base and emitter regions, normally biased in the forward direction, and through which the charge carriers flow from a region in which they are majority carriers to one in which they are minority carriers

cn **发射结**
de **Emitterübergang**, m**; Emitter-Basis-Zonenübergang**, m
es **unión emisor**
ja **エミッタ接合**
pl **złącze emitera**
pt **junção emissora**
sv **emitterövergång**

521-07-02

jonction collecteur, f

jonction entre les régions de base et de collecteur normalement polarisée dans le sens inverse et que les porteurs de charge provenant d'une région où ils sont minoritaires traversent pour arriver dans une région où ils sont majoritaires

collector junction

junction between the base and collector regions, normally biased in the reverse direction, and through which the charge carriers flow from a region in which they are minority carriers to one in which they are majority carriers

cn **集电结**
de **Kollektorübergang**, m**; Kollektor-Basis-Zonenübergang**, m
es **unión colector**
ja **コレクタ接合**
pl **złącze kolektora**
pt **junção colectora**
sv **kollektorövergång**

521-07-03

base, f

région située entre les jonctions émetteur et collecteur d'un dispositif à semiconducteurs bipolaire

base

region between the emitter and collector junctions of a bipolar semiconductor device

cn **基区**
de **Basis**, f**; Basiszone**, f
es **base**
ja **ベース**
pl **baza**
pt **base**
sv **bas**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-04

émetteur, m

région située entre la jonction émetteur et l'électrode émetteur

emitter

region between the emitter junction and the emitter electrode

cn **发射区**
de **Emitter**, m**; Emitterzone**, f
es **emisor**
ja **エミッタ**
pl **emiter**
pt **emissor**
sv **emitter**

521-07-05

collecteur, m

région située entre la jonction collecteur et l'électrode collecteur

collector

region between the collector junction and the collector electrode

cn **集电区**
de **Kollektor**, m**; Kollektorzone**, f
es **colector**
ja **コレクタ**
pl **kolektor**
pt **colector**
sv **kollektor**

521-07-06

canal (d'un transistor à effet de champ), m

mince couche de semiconducteur entre la région de source et celle de drain, et dans laquelle circule un courant commandé par la différence de potentiel entre la grille et la source

channel (of a field-effect transistor)

thin semiconductor layer between the source region and the drain region, in which the current flow is controlled by the gate potential

cn **沟道**（场效应晶体管的）
de **Kanal** (eines Feldeffekttransistors), m
es **canal** (de un transistor de efecto de campo)
ja **（電界効果トランジスタの）チャネル**
pl **kanał** (tranzystora polowego)
pt **canal** (de um transistor de efeito de campo)
sv **kanal**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-07

source (d'un transistor à effet de champ), f

région à partir de laquelle les porteurs majoritaires circulent vers le canal

source (of a field-effect transistor)

region from which the majority carriers flow into the channel

cn **源区**（场效应晶体管的）
de **Source** (eines Feldeffekttransistors), f**; Sourcezone** (eines Feldeffekttransistors), m
es **fuente** (de un transistor de efecto de campo)
ja **（電界効果トランジスタの）ソース**
pl **źródło** (tranzystora polowego)
pt **fonte** (de um transistor de efeito de campo)
sv **emitter** (hos fälteffekttransistor)

521-07-08

drain (d'un transistor à effet de champ), m

région vers laquelle les porteurs majoritaires circulent en provenance du canal

drain (of a field-effect transistor)

region into which majority carriers flow from the channel

cn **漏区**（场效应晶体管的）
de **Drain** (eines Feldeffekttransistors), m**; Drainzone** (eines Feldeffekttransistors), m
es **sumidero** (de un transistor de efecto de campo)
ja **（電界効果トランジスタの）ドレイン**
pl **dren** (tranzystora polowego)**; ujście** (tranzystora polowego)
pt **dreno** (de um transistor de efeito de campo)
sv **kollektor** (hos fälteffekttransistor)

521-07-09

grille (d'un transistor à effet de champ), f

région dans laquelle s'exerce l'effet du champ électrique dû à la tension de grille de commande

gate (of a field-effect transistor)

region in which the electric field due to a control gate voltage is effective

cn **栅区**（场效应晶体管的）
de **Gate** (eines Feldeffekttransistors), n**; Gatezone** (eines Feldeffekttransistors), m
es **rejilla** (de un transistor de efecto de campo)
ja **（電界効果トランジスタの）ゲート**
pl **bramka** (tranzystora polowego)
pt **porta** (de um transistor de efeito de campo)**; grelha** (de um transistor de efeito de campo)
sv **styre** (hos fälteffekttransistor)

--`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-10

fonctionnement en mode de déplétion, m
fonctionnement en mode d'appauvrissement, m

fonctionnement d'un transistor à effet de champ, tel que la modification de la tension grille-source de zéro à une valeur finie diminue la valeur absolue du courant de drain

depletion mode operation

operation of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage from zero to a finite value decreases the magnitude of the drain current

cn **耗尽工作模式**
de **Verarmungsbetrieb**, m
es **funcionamiento en modo de agotamiento**
ja **デプレッションモード動作**
pl **tryb pracy ze zubożeniem**
pt **funcionamento em modo de depleção; funcionamento em modo de empobrecimento**
sv **utarmningsdrift**

521-07-11

fonctionnement en mode d'enrichissement, m

fonctionnement d'un transistor à effet de champ, tel que la modification de la tension grille-source de zéro à une valeur finie augmente la valeur absolue du courant de drain

enhancement mode operation

operation of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage from zero to a finite value increases the magnitude of the drain current

cn **增强工作模式**
de **Anreicherungsbetrieb**, m
es **funcionamiento en modo de enriquecimiento**
ja **エンハンスメントモード動作**
pl **tryb pracy ze wzbogaceniem**
pt **funcionamento em modo de enriquecimento**
sv **anrikningsdrift**

521-07-12

sens inverse de fonctionnement, m

mode de fonctionnement d'un transistor bipolaire à jonctions dans lequel le collecteur fonctionne comme émetteur et dans lequel le flux de porteurs minoritaires circule du collecteur vers la base

inverse direction of operation

mode of operating a bipolar junction transistor in which the collector acts as an emitter and in which the net flow of minority carriers is from the collector region to the base region

cn **反向工作**
de **inverser Betrieb**, m
es **sentido inverso de funcionamiento**
ja **逆方向動作**
pl **kierunek działania wsteczny**
pt **sentido inverso de funcionamento**
sv **inverterad arbetsriktning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-13

base commune, f

montage de circuit dans lequel la borne de base est commune au circuit d'entrée et au circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de l'émetteur et la borne de sortie, celle du collecteur

common base

circuit configuration in which the base terminal is common to the input circuit and to the output circuit and in which the input terminal is the emitter terminal and the output terminal is the collector terminal

cn **共基极**
de **Basisschaltung**, f
es **base común**
ja **ベース接地**
pl **baza wspólna**
pt **(montagem de) base comum**
sv **gemensam bas**

521-07-14

collecteur commun, m

montage de circuit dans lequel la borne du collecteur est commune au circuit d'entrée et au circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de la base et la borne de sortie, celle de l'émetteur

common collector

circuit configuration in which the collector terminal is common to the input circuit and to the output circuit and in which the input terminal is the base terminal and the output terminal is the emitter terminal

cn **共集电极**
de **Kollektorschaltung**, f
es **colector común**
ja **コレクタ接地**
pl **kolektor wspólny**
pt **(montagem de) colector comum**
sv **gemensam kollektor**

521-07-15

émetteur commun, m

montage de circuit dans lequel la borne de l'émetteur est commune au circuit d'entrée et au circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de la base et la borne de sortie, celle du collecteur

common emitter

circuit configuration in which the emitter terminal is common to the input circuit and to the output circuit and in which the input terminal is the base terminal and the output terminal is the collector terminal

cn **共发射极**
de **Emitterschaltung**, f
es **emisor común**
ja **エミッタ接地**
pl **emiter wspólny**
pt **(montagem de) emissor comum**
sv **gemensam emitter**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-16

base commune inverse, f

montage de circuit dans lequel la borne de base est commune au circuit d'entrée et au circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle du collecteur et la borne de sortie, celle de l'émetteur

inverse common base

circuit configuration in which the base terminal is common to the input circuit and to the output circuit and in which the input terminal is the collector terminal and the output terminal is the emitter terminal

cn **反向共基极**
de **inverse Basisschaltung**, f
es **base común inversa**
ja **逆方向ベース接地**
pl **baza wspólna odwrócona**
pt **(montagem de) base comum inversa**
sv **inverterad gemensam bas**

521-07-17

collecteur commun inverse, m

montage de circuit dans lequel la borne du collecteur est commune au circuit d'entrée et au circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de l'émetteur et la borne de sortie, celle de la base

inverse common collector

circuit configuration in which the collector terminal is common to the input circuit and to the output circuit and in which the input terminal is the emitter terminal and the output terminal is the base terminal

cn **反向共集电极**
de **inverse Kollektorschaltung**, f
es **colector común inverso**
ja **逆方向コレクタ接地**
pl **kolektor wspólny odwrócony**
pt **(montagem de) colector comum inverso**
sv **inverterad gemensam kollektor**

521-07-18

émetteur commun inverse, m

montage de circuit dans lequel la borne de l'émetteur est commune au circuit d'entrée et au circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle du collecteur et la borne de sortie, celle de la base

inverse common emitter

circuit configuration in which the emitter terminal is common to the input circuit and to the output circuit and in which the input terminal is the collector terminal and the output terminal is the base terminal

cn **反向共发射极**
de **inverse Emitterschaltung**, f
es **emisor común inverso**
ja **逆方向エミッタ接地**
pl **emiter wspólny odwrócony**
pt **(montagem de) emissor comum inverso**
sv **inverterad gemensam emitter**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-19

rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m

rapport du courant alternatif de sortie au courant sinusoïdal d'entrée qui le produit en régime de petits signaux, la sortie étant court-circuitée pour le courant alternatif

small-signal short-circuit forward current transfer ratio

ratio of the alternating output current to the sinusoidal input current producing it under small-signal conditions, the output being short-circuited to alternating current

cn **小信号短路正向电流传输比**
de **Kurzschluss-Stromübersetzung** (bei kleiner Ansteuerung), f**;**
Stromverstärkungsfaktor (bei kleiner Ansteuerung), m
es **relación de transferencia directa de corriente en pequeñas señales, con salida en cortocircuito**
ja **小信号短絡回路順方向電流伝達比**
pl **współczynnik zwarciowy małosygnałowy przenoszenia prądowego**
pt **relação de transferência directa da corrente para pequenos sinais, com saída em curtocircuito**
sv **(småsignal)strömförstärkningsfaktor**

521-07-20

valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f

rapport du courant continu de sortie au courant continu d'entrée, la tension de sortie étant maintenue constante

static forward current transfer ratio

ratio of the direct output current to the direct input current, the output voltage being held constant

cn **静态正向电流传输比**
de **Gleichstromverhältnis**, n
es **valor estático de la relación de transferencia directa de corriente**
ja **静的順方向電流伝達比**
pl **współczynnik statyczny przenoszenia prądowego**
pt **valor estático da relação de transferência directa da corrente**
sv **total strömförstärkningsfaktor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-21

symb. : f_T

fréquence de transition , f

produit du module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-circuit, pour de petits signaux, en montage émetteur commun $|h_{21e}|$ par la fréquence de mesure, cette fréquence étant choisie de telle façon que $|h_{21e}|$ décroisse sensiblement à raison de 6 dB par octave

transition frequency

product of the modulus of the common emitter small-signal short-circuit forward current transfer ratio $|h_{21e}|$ and the frequency of the measurement, this frequency being so chosen that $|h_{21e}|$ is decreasing at a slope of approximately 6 dB per octave

cn **特征频率**
de **Transitfrequenz**, f
es **frecuencia de transición**
ja **遷移周波数**
pl **częstotliwość przejścia**
pt **frequência de transição**
sv **extrapolerad enhetsgränsfrekvens**

521-07-22

symb. : f_1

fréquence du rapport de transfert unité de courant , f
fréquence unité, f

fréquence à laquelle le module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-circuit, pour de petits signaux, en montage émetteur commun $|h_{21e}|$ a été ramené à l'unité

frequency of unity current transfer ratio

frequency at which the modulus of the common-emitter small-signal short-circuit forward current transfer ratio $|h_{21e}|$ has decreased to unity

cn **单位电流传输比频率**
de **Einsfrequenz**, f
es **frecuencia de relación de transferencia unidad de corriente**
ja **単位電流伝達比周波数**
pl **częstotliwość graniczna** (jednostkowej wartości współczynnika przenoszenia prądowego)
pt **frequência da relação de transferência unitária de corrente**
sv **enhetsgränsfrekvens**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-07-23

tension de blocage (d'un transistor à effet de champ à déplétion), f

tension grille-source pour laquelle l'amplitude du courant de drain atteint une valeur spécifiée, faible

cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor)

gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low value

cn **截止电压**（耗尽型场效应晶体管的）
de **Abschnürspannung** (eines Feldeffekttransistors vom Verarmungstyp), f
es **tensión de bloqueo** (de un transistor de efecto de campo de agotamiento)
ja **（デプレッション形電界効果トランジスタの）遮断電圧**
pl **napięcie odcięcia** (tranzystora polowego z kanałem zubożonym)
pt **tensão de corte** (de um transistor de efeito de campo de depleção)
sv **strypspänning**

521-07-24

tension de seuil (d'un transistor à effet de champ à enrichissement), f

tension grille-source pour laquelle l'amplitude du courant de drain atteint une valeur spécifiée, faible

threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor)

gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low value

cn **阈值电压**（增强型场效应晶体管的）
de **Schwellenspannung** (eines Feldeffekttransistors vom Anreicherungstyp), f
es **tensión de umbral** (de un transistor de efecto de campo de enriquecimiento)
ja **（エンハンスメント形電界効果トランジスタの）しきい値電圧**
pl **napięcie progowe** (tranzystora polowego z kanałem wzbogaconym)
pt **tensão de limiar** (de um transistor de efeito de campo por enriquecimento)
sv **tröskelspänning** (för fälteffekttransistor av anrikningstyp)

521-07-25

transconductance (d'un transistor à effet de champ), f

rapport de l'accroissement du courant de drain à l'accroissement correspondant de la tension grille-source, la tension drain-source étant maintenue constante

transconductance (of a field-effect transistor)

ratio of the increment in the drain current to a corresponding incremental change of the gate-source voltage with the drain-source voltage held constant

cn **跨导**（场效应晶体管的）
de **Steilheit** (eines Feldeffekttransistors), f
es **transconductancia** (de un transistor de efecto de campo)
ja **（電界効果トランジスタの）相互コンダクタンス**
pl **transkonduktancja** (tranzystora polowego)
pt **transcondutância** (de um transistor de efeito de campo)
sv **branthet**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Section 521-08 – Termes particuliers aux thyristors

Section 521-08 – Specific terms for thyristors

521-08-01

gâchette, f

borne auxiliaire servant à commander la commutation d'un thyristor

gate

auxiliary terminal which controls the switching action of a thyristor

cn **栅极；门极**
de **Steueranschluss**, m
es **puerta**
ja **ゲート**
pl **bramka (tyrystora)**
pt **porta**
sv **styre**

521-08-02

courant principal, m

courant qui circule à travers le dispositif excepté le courant de gâchette

principal current

current which flows through the device excluding gate current

cn **主电流**
de **Hauptstrom**, m
es **corriente principal**
ja **主電流**
pl **prąd główny**
pt **corrente principal**
sv **huvudström**

521-08-03

borne maîtresse, f

borne à travers laquelle le courant principal circule

main terminal

terminal through which the main current flows

cn **主端子**
de **Hauptanschluss**, m
es **bornes principales**
ja **主端子**
pl **końcówka główna**
pt **terminais principais**
sv **huvud(ströms)uttag**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-08-04

tension principale, f

tension entre les bornes maîtresses

principal voltage

voltage between the main terminals

cn 主电压
de **Hauptspannung**, f
es **tensión principal**
ja 主電圧
pl **napięcie główne**
pt **tensão principal**
sv **huvudspänning**

521-08-05

caractéristique (courant-tension) principale, f

relation, généralement représentée graphiquement, entre la tension principale et le courant principal, avec s'il y a lieu, le courant de gâchette comme paramètre

principal (voltage-current) characteristic

function, usually represented graphically, relating the principal voltage to the principal current, with the gate current, where applicable, as a parameter

cn 主（电压-电流）特性
de **Hauptkennlinie**, f; **Haupt-Strom-Spannungs-Charakteristik**, f
es **característica (corriente-tensión) principal**
ja 主（電圧-電流）特性
pl **charakterystyka główna (napięciowo-prądowa)**
pt **característica (corrente-tensão) principal**
sv **huvudkarakteristik**

521-08-06

caractéristique (courant-tension) d'anode-cathode, f
caractéristique d'anode, f

relation, généralement représentée graphiquement, entre la tension d'anode et le courant principal, avec, s'il y a lieu, le courant de gâchette comme paramètre

anode-to-cathode (voltage-current) characteristic
anode characteristic

function, usually represented graphically, relating the anode voltage to the principal current, with the gate current, where applicable, as a parameter

cn 阳极-阴极（电压-电流）特性；阳极特性
de **Anoden-Kathoden-Kennlinie**, f; **Anoden-Kathoden-Spannungs-Strom-Charakteristik**, f
Anodenkennlinie, f
es **característica (corriente-tensión) de ánodo-cátodo; caractéristica de ánodo**
ja （電圧-電流）アノード-カソード特性；アノード特性
pl **charakterystyka anodowa**
pt **característica (corrente-tensão) de ânodo-cátodo**
sv **anodkarakteristik**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-08-07

état passant, m

état d'un thyristor correspondant à la partie faible résistance, faible tension de la caractéristique principale

NOTE – Pour les dispositifs passant en inverse, cette définition est applicable seulement pour les tensions d'anode positives.

on-state

condition of a thyristor corresponding to the low-resistance low-voltage portion of the principal characteristic

NOTE – In the case of reverse conducting devices, this definition is applicable only for positive anode voltages.

cn **通态**
de **Durchlasszustand**, m
es **estado conductor**
ja **オン状態**
pl **stan włączenia; stan przewodzenia**
pt **estado condutor**
sv **ledtillstånd**

521-08-08

état bloqué, m

état d'un thyristor correspondant à la partie de la caractéristique principale entre l'origine et le point ou les points de retournement

off-state

condition of a thyristor corresponding to the portion of the principal characteristic between the origin and the breakover point or points

cn **断态**
de **Vorwärts-Sperrzustand**, m
es **estado bloqueado**
ja **オフ状態**
pl **stan wyłączenia; stan blokowania**
pt **estado cortado**
sv **blocktillstånd**

521-08-09

état bloqué en inverse (d'un thyristor bloqué en inverse), m

état d'un thyristor bloqué en sens inverse et conduisant un courant inférieur à celui existant pour la tension de claquage inverse

reverse blocking state (of a reverse blocking thyristor)

condition of a reverse blocking thyristor corresponding to reverse currents of lower magnitude than the current at the reverse breakdown voltage

cn **反向阻断态**（反向阻断闸流晶体管的）
de **Rückwärts-Sperrzustand** (eines rückwärts sperrenden Thyristors), m
es **estado bloqueado en sentido inverso** (de un tiristor bloqueado en sentido inverso)
ja **（逆阻止サイリスタの）逆阻止状態**
pl **stan zaworowy** (tyrystora blokującego wstecznie)
pt **estado cortado em sentido inverso** (de um tiristor cortado em sentido inverso)
sv **spärrtillstånd**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-08-10

courant hypostatique, m
courant de maintien, m

courant principal minimal nécessaire pour maintenir un thyristor à l'état passant

holding current

minimum principal current required to maintain a thyristor in the on-state

cn **维持电流**
de **Haltestrom**, m**; Haltestromstärke**, f
es **corriente de mantenimiento**
ja **保持電流**
pl **prąd podtrzymywania**
pt **corrente de manutenção**
sv **hållström**

521-08-11

courant d'accrochage, m

courant principal minimal nécessaire pour maintenir un thyristor à l'état passant aussitôt après commutation de l'état bloqué vers l'état passant et après la fin du signal de déclenchement

latching current

minimum principal current required to maintain a thyristor in the on-state immediately after switching from the off-state to the on-state has occurred and the triggering signal has been removed

cn **擎住电流**
de **Einraststrom**, m**; Einraststromstärke**, f
es **corriente de retención**
ja **ラッチング電流**
pl **prąd zatrzaskiwania**
pt **corrente de retenção**
sv **låsström**

521-08-12

point de retournement, m

tout point de la caractéristique principale pour lequel la résistance différentielle est nulle, et où la tension principale atteint une valeur maximale

breakover point

any point on the principal characteristic for which the differential resistance is zero and where the principal voltage reaches a maximum value

cn **转折点**
de **Kipppunkt**, m
es **punto de retorno**
ja **ブレークオーバー点**
pl **punkt przełączania**
pt **ponto de retorno**
sv **vippunkt**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-08-13

résistance apparente à l'état passant, f

résistance égale à la pente de la droite utilisée pour la détermination de la tension de seuil, sur une caractéristique courant-tension

on-state slope resistance

resistance equal to the slope of the straight line used when determining the treshold voltage from the current-voltage characteristic

cn **通态斜率电阻**
de **Ersatzwiderstand**, m
es **resistencia aparente en estado conductor**
ja **オン状態勾配抵抗**
pl **rezystancja dynamiczna przewodzenia**
pt **resistência dinâmica no estado condutor; resistência aparente no estado condutor**
sv **differentiell ledresistans**

521-08-14

courant d'amorçage par la gâchette, m

le plus petit courant de gâchette nécessaire pour commuter un thyristor de l'état bloqué à l'état passant

gate trigger current

lowest gate current required to switch a thyristor from the off-state to the on-state

cn **栅极触发电流；门极触发电流**
de **Zündstrom**, m
es **corriente de disparo de puerta**
ja **ゲートトリガ電流**
pl **prąd przełączający bramki**
pt **corrente de disparo de porta**
sv **tänd(styr)ström**

521-08-15

tension d'amorçage par la gâchette, f

tension de gâchette nécessaire pour produire le courant d'amorçage par la gâchette

gate trigger voltage

gate voltage required to produce the gate trigger current

cn **栅极触发电压；门极触发电压**
de **Zündspannung**, f
es **tensión de disparo de puerta**
ja **ゲートトリガ電圧**
pl **napięcie przełączające bramki**
pt **tensão de disparo de porta**
sv **tänd(styr)spänning**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-08-16

tension de non-amorçage par la gâchette, f

tension de gâchette la plus élevée qui ne commute pas le thyristor de l'état bloqué à l'état passant

gate non-trigger voltage

highest gate voltage which will not cause the thyristor to switch from the off-state to the on-state

cn **栅极不触发电压；门极不触发电压**
de **höchste nichtzündende Steuerspannung**, f
es **tensión de no disparo de puerta**
ja **ゲート非トリガ電圧**
pl **napięcie nieprzełączające bramki**
pt **tensão de não-disparo de porta**
sv **icke-tändande styrspänning**

521-08-17

courant de non-amorçage par la gâchette, m

courant de gâchette correspondant à la tension de non-amorçage par la gâchette

gate non-trigger current

gate current corresponding to the gate non-trigger voltage

cn **栅极不触发电流；门极不触发电流**
de **höchster nichtzündender Steuerstrom**, m
es **corriente de no disparo de puerta**
ja **ゲート非トリガ電流**
pl **prąd nieprzełączający bramki**
pt **corrente de não-disparo de porta**
sv **icke-tändande styrström**

521-08-18

vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f

la plus petite valeur de la vitesse de croissance de la tension principale qui entraîne la commutation de l'état bloqué à l'état passant dans des conditions spécifiées

critical rate of rise of off-state voltage

lowest value of the rate of rise of principal voltage that will cause switching from the off-state to the on-state under specified conditions

cn **断态电压临界上升率**
de **kritische Spannungssteilheit**, f
es **velocidad crítica de crecimiento de la tensión de estado bloqueado**
ja **臨界オフ電圧上昇率**
pl **prędkość krytyczna wzrostu napięcia blokowania**
pt **velocidade crítica de crescimento da tensão no estado cortado**
sv **kritisk blockspänningsderivata**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-08-19

vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f

valeur la plus élevée de la vitesse de croissance du courant à l'état passant qu'un thyristor peut supporter sans détérioration

critical rate of rise of on-state current

highest value of the rate of rise of on-state current which a thyristor can withstand without deleterious effect

cn **通态电流临界上升率**
de **kritische Stromsteilheit**, f
es **velocidad crítica de crecimiento de la corriente de estado conductor**
ja **臨界オン電流上昇率**
pl **prędkość krytyczna wzrostu napięcia przewodzenia**
pt **velocidade crítica de crescimento da tensão no estado condutor**
sv **kritisk ledströmsderivata**

Section 521-09 – Termes particuliers aux dispositifs à effet hall et aux magnétoresistances

Section 521-09 – Specific terms for hall-effect devices and magnetoresistors

521-09-01

effet Hall, m

production dans un conducteur ou dans un semiconducteur d'un champ électrique proportionnel au produit vectoriel de la densité de courant par l'inductance magnétique

Hall effect

production in a conductor or in a semiconductor of an electric field strength proportional to the vector product of the current density and the magnetic flux density

cn **霍尔效应**
de **Halleffekt**, m
es **efecto Hall**
ja **ホール効果**
pl **zjawisko Halla**
pt **efeito Hall**
sv **halleffekt**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-02

symb. : R_{H}
coefficient de Hall, m

coefficient de proportionnalité R_{H} dans la relation quantitative de l'effet Hall :

$$\vec{E}_{\mathrm{H}} = R_{\mathrm{H}} (\vec{J} \times \vec{B})$$

où

$\vec{E}_{\mathrm{H}}$ est le champ électrique transversal résultant

$\vec{J}$ est la densité de courant

$\vec{B}$ est l'inductance magnétique

NOTE – Le type de porteurs majoritaires peut généralement être déduit du signe du coefficient de Hall.

Hall coefficient

coefficient of proportionality R_{H} in the Hall effect quantitative relation:

$$\vec{E}_{\mathrm{H}} = R_{\mathrm{H}} (\vec{J} \times \vec{B})$$

where

$\vec{E}_{\mathrm{H}}$ is the resulting transverse electric field strength

$\vec{J}$ is the current density

$\vec{B}$ is the magnetic flux density

NOTE – The sign of the majority carrier charge can usually be inferred from the sign of the Hall coefficient.

cn **霍尔系数**
de **Hallkoeffizient**, m
es **coeficiente de Hall**
ja **ホール係数**
pl **współczynnik Halla**
pt **coeficiente de Hall**
sv **hallkonstant**

521-09-03

angle de Hall, m

angle existant, en présence d'effet Hall, entre le champ électrique résultant et la densité de courant

Hall angle

angle which exists, in the presence of Hall effect, between the resulting electric field strength and the current density

cn **霍尔角**
de **Hallwinkel**, m
es **ángulo de Hall**
ja **ホール角**
pl **kąt Halla**
pt **ângulo de Hall**
sv **hallvinkel**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-04

symb. : μ_H
mobilité de Hall, f

produit du coefficient de Hall par la conductivité électrique

Hall mobility

product of the Hall coefficient and the electric conductivity

cn **霍尔迁移率**
de **Hallbeweglichkeit**, f
es **movilidad de Hall**
ja **ホール移動度**
pl **ruchliwość Halla**
pt **mobilidade de Hall**
sv **hallmobilitet**

521-09-05

tension de Hall, f

tension engendrée par effet Hall

Hall voltage

voltage generated by the Hall effect

cn **霍尔电压**
de **Hallspannung**, f
es **tensión de Hall**
ja **ホール電圧**
pl **napięcie Halla**
pt **tensão de Hall**
sv **hallspänning**

521-09-06

bornes Hall, f, pl

bornes d'un générateur de Hall entre lesquelles apparaît la tension de Hall

Hall terminals

terminals of a Hall generator between which the Hall voltage appears

cn **霍尔端**
de **Hallanschlüsse**, m, pl
es **bornes de Hall**
ja **ホール端子**
pl **końcówki hallotronu**
pt **terminais Hall**
sv **hall(spännings)uttag**

--`,,```,,,,````-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-07

borne de commande (d'un générateur de Hall), f

borne d'un générateur de Hall traversée par le courant de commande

control current terminal (of a Hall generator)

terminal of a Hall generator through which the control current flows

cn **控制电流端**（霍尔发生器的）
de **Steueranschluss** (eines Hallgenerators), m
es **bornes de control de corriente** (de un generator de Hall)
ja （ホール発電器の）制御電流端子
pl **końcówka prądu sterującego hallotronu**
pt **terminais de comando** (de um gerador de Hall)
sv **styr(ströms)uttag**

521-09-08

surface effective d'induction de la boucle de sortie, f

surface effective de la boucle délimitée par les conducteurs arrivant aux bornes de Hall et par le trajet conducteur approprié traversant le dispositif à effet Hall

effective induction area of the output loop

effective area of the loop enclosed by the leads to the Hall terminals and the relevant conductive path through the Hall effect device

cn **输出回路有效感应面积**
de **induktive Restfläche des Hallstromkreises**, f
es **superficie efectiva de inducción del bucle de salida**
ja 出力ループの実効誘導面積
pl **powierzchnia skuteczna pętli wyjściowej hallotronu**
pt **superfície efectiva de indução do anel de saída;**
superfície efectiva de indução da malha de saída
sv **effektiv area**

521-09-09

surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f

surface effective de la boucle délimitée par les conducteurs du courant de commande et par le trajet conducteur approprié traversant une plaque de Hall par effet Hall

effective induction area of the control current loop

effective area of the loop enclosed by the control current leads and the relevant conductive path through a Hall plate by the Hall effect

cn **控制电流回路有效感应面积**
de **induktive Restfläche des Steuerstromkreises**, f
es **superficie efectiva de inducción del bucle de la corriente de control**
ja 制御電流ループの実効誘導面積
pl **powierzchnia skuteczna pętli prądu sterującego**
pt **superfície efectiva de indução do anel da corrente de comando**
sv **styrströmsslingans effektiva area**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-10

champ induit (d'un générateur de Hall), m

champ magnétique produit par la circulation du courant de commande dans la boucle formée par les conducteurs du courant de commande et par le trajet conducteur approprié traversant un dispositif à effet Hall

self field (of a Hall generator)

magnetic field caused by the flow of control current through the loop formed by the control current leads and the relevant path through a Hall-effect device

cn **自建场**（霍尔发生器的）
de **Eigenfeld** (eines Hallgeräts), n
es **campo inducido** (de un generador de Hall)
ja **（ホール発電器の）自己磁界**
pl **pole indukowane** (generatora Halla)
pt **campo induzido** (de um gerador de Hall)
sv **egenfält**

521-09-11

courant de commande (d'un générateur de Hall), m

courant qui, en traversant une plaque Hall, donne naissance à la tension de Hall sous l'action d'un champ magnétique

control current (of a Hall generator)

current through a Hall plate which generates the Hall voltage by interaction with a magnetic field

cn **控制电流**（霍尔发生器的）
de **Steuerstrom** (eines Hallgenerators), m
es **corriente de control** (de un generator de Hall)
ja **（ホール発電器の）制御電流**
pl **prąd sterujący** (generatora Halla)
pt **corrente de comando** (de um gerador de Hall)
sv **styrström**

521-09-12

sensibilité magnétique (d'une sonde de Hall), f

quotient de la tension de Hall par l'inductance magnétique, dans la zone de fonctionnement linéaire d'une sonde de Hall

magnetic sensitivity (of a Hall probe)

quotient of the Hall voltage by the magnetic flux density in the linear operating range of a Hall probe

cn **磁灵敏度**（霍尔探头的）
de **magnetische Empfindlichkeit** (einer Hallsonde), f
es **sensibilidad magnética** (de una sonda de Hall)
ja **（ホール探針の）磁気感度**
pl **czułość magnetyczna** (sondy Halla)
pt **sensibilidade magnética** (de uma sonda de Hall)
sv **magnetisk känslighet**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-13

sensibilité au courant de commande (d'une sonde de Hall), f

quotient de la tension de Hall par le courant de commande, dans la zone de fonctionnement linéaire d'une sonde de Hall

control current sensitivity (of a Hall probe)

quotient of the Hall voltage by the control current in the linear operating range of a Hall probe

cn **控制电流灵敏度**（霍尔探头的）
de **Steuerstromempfindlichkeit** (einer Hallsonde), f
es **sensibilidad a la corriente de control** (de una sonda de Hall)
ja **（ホール発電器の）制御電流感度**
pl **czułość prądowa** (sondy Halla)
pt **sensibilidade à corrente de comando** (de uma sonda de Hall)
sv **styrströmskänslighet**

521-09-14

tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif à effet Hall), f

tension de Hall due à un champ magnétique variant avec le temps lorsque le courant de commande est nul

residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe)

voltage which exists at the Hall terminals when a time varying magnetic field is present and the control current zero

cn **零控制电流剩余电压**（霍尔探头的）
de **Restspannung bei Steuerstrom null** (einer Hallsonde), f
es **tensión residual para una corriente de control nula** (de un dispositivo de efecto Hall)
ja **（ホール効果探針の）ゼロ電流制御の残留電圧**
pl **napięcie szczątkowe przy prądzie sterującym zerowym** (sondy Halla)
pt **tensão residual para uma corrente de comando nula** (de um dispositivo de efeito Hall)
sv **restspänning för nollstyrström**

521-09-15

tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif à effet Hall), f

tension de Hall existant lorsqu'un courant de commande circule mais que le champ magnétique appliqué est nul

residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device)

voltage which exists at the Hall terminals when control current flows under the conditions of no applied magnetic field

cn **零磁场剩余电压**（霍尔探头的）
de **Restspannung bei Magnetfeld null** (eines Halleffekt-Bauelements), f
es **tensión residual para un campo magnético nulo** (de un dispositivo de efecto Hall)
ja **（ホール効果デバイスの）ゼロ磁場の残留電圧**
pl **napięcie szczątkowe przy polu magnetycznym zerowym** (hallotronu)
pt **tensão residual para um campo magnético nulo** (de um dispositivo de efeito Hall)
sv **restspänning för nollmagnetfält**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-16

tension de commande induite (d'un dispositif à effet Hall), f

force électromotrice induite dans la boucle formée par les conducteurs du courant de commande et par le trajet conducteur dans une plaque de Hall, due à une variation de l'induction magnétique

induced control voltage (of a Hall-effect device)

voltage induced in the loop formed by the control current leads and the current path through a Hall plate caused by a varying magnetic flux density

cn **感应控制电压**（霍尔效应器件的）
de **induzierte Steuerspannung** (eines Halleffekt-Bauelements), f
es **tensión de control inducida** (de un dispositivo de efecto Hall)
ja **（ホール効果デバイスの）誘導制御電圧**
pl **napięcie sterujące indukowane** (hallotronu)
pt **tensão de comando induzida** (de um dispositivo de efeito Hall)
sv **inducerad styrspänning**

521-09-17

courbe caractéristique d'une magnétorésistance, f

courbe représentant les variations de la résistance d'une magnétorésistance en fonction de l'induction magnétique

magnetoresistive characteristic curve

curve of resistance of a magnetoresistor versus magnetic flux density

cn **磁电阻特性曲线**
de **Kennlinie eines Magnetowiderstands**, f
es **curva característica de una magnetorresistencia**
ja **磁気抵抗特性曲線**
pl **charakterystyka magnetorezystora**
pt **curva característica magneto-resistiva**
sv **magnetoresistiv R/B-kurva**

521-09-18

coefficient de magnétorésistance, m

pour une induction magnétique spécifiée, quotient du taux de variation de la résistance d'une magnétorésistance avec l'induction magnétique par la résistance

magnetoresistive coefficient

at a specified magnetic flux density, quotient of the variation of the resistance with magnetic induction of a magnetoresistor by the resistance at that specified magnetic flux density

cn **磁电阻系数**
de **Widerstandskoeffizient eines Magnetowiderstands**, m
es **coeficiente de magnetorresistencia**
ja **磁気抵抗係数**
pl **współczynnik magnetorezystancji**
pt **coeficiente de magneto-resistência**
sv **magnetoresistiv koefficient**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-09-19

rapport de magnétorésistance, m

rapport de la résistance d'une magnétorésistance correspondant à une induction magnétique spécifiée, à la résistance correspondant à une induction magnétique nulle

magnetoresistive ratio

ratio of the resistance of a magnetoresistor at a specified magnetic flux density to the resistance at zero magnetic flux density

cn **磁电阻比**
de **Widerstandsverhältnis eines Magnetowiderstands**, n
es **relación de magnetorresistencia**
ja **磁気抵抗比**
pl **wskaźnik rezystancji magnetorezystora**
pt **relação de magneto-resistência**
sv **magnetoresistiv kvot**

521-09-20

sensibilité de magnétorésistance, f

taux de variation de la résistance d'une magnétorésistance avec l'induction magnétique pour une induction magnétique spécifiée

magnetoresistive sensitivity

rate of change of the resistance of a magnetoresistor with magnetic flux density at a specified magnetic flux density

cn **磁电阻灵敏度**
de **Empfindlichkeit eines Magnetowiderstands**, f
es **sensibilidad de magnetorresistencia**
ja **磁気抵抗感度**
pl **czułość rezystancyjna magnetorezystora**
pt **sensibilidade de magneto-resistência**
sv **magnetoresistiv känslighet**

Section 521-10 – Termes particuliers aux circuits intégrés

Section 521-10 – Specific terms for integrated circuits

521-10-01

microélectronique, f

domaine de la science et de l'ingénierie qui traite des circuits électroniques fortement miniaturisés et de leur utilisation

microelectronics

field of science and engineering that deals with highly miniaturized electronic circuits and their use

cn **微电子学**
de **Mikroelektronik**, f
es **microelectrónica**
ja **マイクロエレクトロニクス**
pl **mikroelektronika**
pt **microelectrónica**
sv **mikroelektronik**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-10-02

microstructure, f

dispositif électronique qui a une forte densité d'éléments de circuit et qui est considéré comme une seule unité

microcircuit

electronic device that has a high circuit-element density and that is considered to be a single unit

cn **微电路**
de **Mikroschaltung**, f
es **microcircuito**
ja **超小形回路**
pl **mikroukład**
pt **microcircuito**
sv **mikrokrets**

521-10-03

circuit intégré, m

microstructure dans laquelle tous les éléments de circuit ou certains d'entre eux sont associés de façon inséparable et interconnectés électriquement de façon qu'elle soit considérée comme indivisible pour la construction et le commerce

integrated circuit

microcircuit in which all or some of the circuit elements are inseparably associated and electrically interconnected so that it is considered to be indivisible for the purpose of construction and commerce

cn **集成电路**
de **integrierte Schaltung**, f
es **circuito integrado**
ja **集積回路 ; IC**
pl **układ scalony**
pt **circuito integrado**
sv **integrerad krets**

521-10-04

microassemblage, m

microstructure constituée de divers composants construits séparément et que l'on peut tester séparément avant de les rassembler et de les encapsuler

microassembly

microstructure consisting of various components which are constructed separately and can be tested separately before being assembled and sealed

cn **微组件**
de **zusammengesetzte Mikroschaltung**, f
es **microconjunto**
ja **マイクロアセンブリ**
pl **mikrozespół**
pt **micromontagem; microconjunto**
sv **komponentblock**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-10-05

circuit intégré à semiconducteurs, m

dispositif à semiconducteurs conçu comme un circuit intégré

semiconductor integrated circuit

semiconductor device designed as an integrated circuit

cn **半导体集成电路**
de **integrierte Halbleiterschaltung**, f
es **circuito integrado semiconductor**
ja **半導体集積回路；半導体IC**
pl **układ scalony półprzewodnikowy**
pt **circuito integrado semicondutor**
sv **integrerad halvledarkrets**

521-10-06

circuit intégré à couches, m

circuit intégré dont les éléments de circuit, y compris les interconnexions, sont des éléments à couches formés à la surface d'un substrat isolant

NOTE – Les éléments à couches peuvent être actifs ou passifs.

film integrated circuit

integrated circuit whose circuit elements, including the interconnections, are film elements formed on the surface of an insulating substrate

NOTE – The film elements may be active or passive.

cn **膜集成电路**
de **integrierte Schichtschaltung**, f
es **circuito integrado de película**
ja **膜集積回路**
pl **układ scalony warstwowy**
pt **circuito integrado em películas**
sv **integrerad filmkrets**

521-10-07

couche (d'un circuit intégré à couches), f

couche de matériau solide formée par tout procédé de dépôt sur un substrat ou sur d'autres couches déposées sur un substrat

film (of a film integrated circuit)

layer of solid material formed by any deposition process upon a substrate or upon other films deposited on a substrate

cn **膜**（膜集成电路的）
de **Schicht** (einer integrierten Schichtschaltung), f
es **película** (de un circuito integrado de película)
ja **（膜集積回路の）膜**
pl **warstwa** (układu scalonego warstwowego)
pt **película** (de um circuito integrado em películas)
sv **film**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-10-08

couche mince (d'un circuit intégré à couches), f

couche générée par un procédé d'accrétion tel que le dépôt en phase vapeur ou la pulvérisation sous vide

thin film (of a film integrated circuit)

film produced by an accretion process such as vapour phase deposition or vacuum sputtering

cn **薄膜**（膜集成电路的）
de **Dünnschicht** (einer integrierten Schichtschaltung), f
es **película delgada** (de un circuito integrado de película)
ja **（膜集積回路の）薄膜**
pl **warstwa cienka** (układu scalonego warstwowego)
pt **película fina** (de um circuito integrado em películas)
sv **tunnfilm**

521-10-09

couche épaisse (d'un circuit intégré à couches), f

couche générée par un procédé d'impression ou d'autres techniques similaires

thick film (of a film integrated circuit)

film produced by a printing process or other related techniques

cn **厚膜**（膜集成电路的）
de **Dickschicht** (einer integrierten Schichtschaltung), f
es **película gruesa** (de un circuito integrado de película)
ja **（膜集積回路の）厚膜**
pl **warstwa gruba** (układu scalonego warstwowego)
pt **película espessa** (de um circuito integrado em películas)
sv **tjockfilm**

521-10-10

circuit intégré multipuce, m

circuit intégré à semiconducteurs contenant au moins deux puces

multi-chip integrated circuit

semiconductor integrated circuit containing two or more chips

cn **多片集成电路**
de **integrierte Mehrchipschaltung**, f
es **circuito integrado multichip**
ja **マルチチップ集積回路**
pl **układ scalony wielostrukturowy**
pt **circuito integrado multichipe**
sv **multikrets**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-10-11

état de verrouillage, m

état réversible caractérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance, et résultant du déclenchement d'une structure bipolaire à quatre couches consécutif au courant résultant d'une surtension à l'entrée, à la sortie ou sur l'alimentation

latch-up state

reversible state in which a low-impedance path has resulted from and persists following the current resulting from an input, output or supply overvoltage that triggers a parasitic four-layer bipolar structure

cn **锁定态**
de **Einrastzustand**, m**; Latch-up-Zustand**, m
es **estado de bloqueo**
ja **ラッチアップ状態**
pl **stan zatrzaśnięcia**
pt **estado trancado**
sv **låsningsläge**

Section 521-11 – Termes particuliers aux circuits intégrés numériques

Section 521-11 – Specific terms for digital integrated circuits

521-11-01

réseau logique programmable, m

circuit intégré formé d'éléments fonctionnels logiques préfabriqués et d'éléments d'interconnexion programmables par l'utilisateur

programmable logic device
PLD (abbreviation)

integrated circuit that consists of logic elements with an interconnection pattern, parts of which are user programmable

cn **可编程逻辑器件；PLD**（缩写词）
de **programmierbare Logik-Schaltung**, f
es **red lógica programable**
ja **プログラマブルロジックデバイス**
pl **przyrząd logiczny programowalny; PLD** (akronim)
pt **dispositivo lógico programável**
sv **programmerbar logikkrets**

521-11-02

matrice logique programmable, f

réseau logique programmable dont les éléments fonctionnels sont principalement des réseaux de portes ET et des réseaux de portes OU

programmable logic array

programmable logic device in which the logic elements consist mainly of arrays of AND gates and arrays of OR gates

cn **可编程逻辑阵列**
de **programmierbare Logik-Anordnung**, f**; PLA** (Abkürzung)
es **matriz lógica programable**
ja **プログラマブルロジックアレイ；PLA**
pl **matryca logiczna programowalna**
pt **matriz lógica programável**
sv **programmerbar logikmatris**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-03

matrice prédiffusée programmable, f

réseau logique programmable dont les éléments fonctionnels comprennent des interrupteurs et des éléments de mémoire qui se comportent comme des groupes de portes

programmable gate array

programmable logic device in which the logic elements include switches and memory elements that behave as groups of gates

cn **可编程门阵列**
de **programmierbares Gatterfeld**, n
es **matriz de puerta programable**
ja **プログラマブルゲートアレイ**
pl **układ matrycowy programowalny; matryca bramek programowalna**
pt **matriz pré-difundida programável**
sv **programmerbar grindmatris**

521-11-04

cellule-mémoire, f

plus petite subdivision d'une mémoire dans laquelle un élément de données a été ou peut être introduit, dans laquelle il est ou peut être conservé, et de laquelle il peut être extrait

memory cell
memory element

smallest subdivision of a memory into which a unit of data has been or can be entered, in which it is or can be stored, and from which it can be retrieved

cn **存储单元**
de **Speicherelement**, n
es **célula de memoria**
ja **メモリセル；メモリ素子**
pl **komórka pamięci; element pamięci**
pt **célula de memória**
sv **minnescell**

521-11-05

mémoire à circuit intégré, f

circuit intégré constitué par un assemblage de cellules-mémoire et comprenant généralement des circuits associés : sélecteur d'adresse, amplificateurs, etc.

integrated circuit memory

integrated circuit consisting of memory cells and usually including associated circuits such as those for address selection, amplifiers, etc.

cn **集成电路存储器**
de **integrierte Speicherschaltung**, f
es **memoria de circuito integrado**
ja **集積回路メモリ；IC メモリ**
pl **pamięć półprzewodnikowa scalona; układ pamięci(owy) scalony**
pt **memória de circuito integrado**
sv **halvledarminne**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-06

mémoire morte, f

mémoire dont le contenu est destiné à être lu seulement et non à être modifié en fonctionnement normal

read-only memory
ROM (abbreviation)

memory in which the contents are intended to be read only and not to be altered during normal operation

cn **只读存储器；ROM**（缩写词）
de **Festwertspeicher**, m**; Festspeicher**, m**; ROM** (Abkürzung)
es **memoria de sólo lectura**
ja **読み出し専用メモリ；ROM**
pl **pamięć stała; ROM** (akronim)
pt **memória de leitura; ROM** (abreviatura)
sv **läsminne**

521-11-07

mémoire vive, f

mémoire dont le contenu est destiné à être lu et modifié en fonctionnement normal

read/write memory

memory in which the contents are intended to be both read and altered during normal operation

cn **读写存储器**
de **Schreib-Lese-Speicher**, m
es **memoria de lectura/escritura**
ja **リード／ライトメモリ**
pl **pamięć o zmiennej zawartości**
pt **memória de leitura e escrita**
sv **läs- och skrivminne**

521-11-08

mémoire à accès direct, f

mémoire qui permet d'accéder à n'importe quel emplacement adressable quel que soit l'ordre désiré

NOTE – Usuellement, ce terme est appliqué à une mémoire vive mais pourrait aussi s'appliquer à une mémoire morte.

random-access memory
RAM (abbreviation)

memory that permits access to any of its address locations in any desired sequence

NOTE – By common usage, this term usually denotes a "read/write" memory; but it could also apply to a "read-only" memory.

cn **随机存取存储器；RAM**（缩写词）
de **Speicher mit wahlfreiem Zugriff**, m**; RAM** (Abkürzung)
es **memoria de acceso directo**
ja **随時アクセス可能なメモリ；RAM**
pl **pamięć o dostępie swobodnym; pamięć o dostępie bezpośrednim; RAM** (akronim)
pt **memória de acesso directo; RAM** (abreviatura)
sv **RAM-minne; direktminne**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-09

mémoire vive statique, f

mémoire dans laquelle les données sont conservées en l'absence de signaux de commande

static (read/write) memory

memory in which the data content is retained in the absence of control signals

cn **静态(读写)存储器**
de **statischer Schreib-Lese-Speicher**, m**; statischer Speicher**, m
es **memoria de lectura/escritura estática**
ja スタティックリード／ライトメモリ；スタティックメモリ
pl **pamięć statyczna (o zmiennej zawartości)**
pt **memória estática de leitura e escrita**
sv **statiskt minne**

521-11-10

mémoire vive dynamique, f

mémoire vive dont les cellules exigent l'application répétitive de signaux de commande, afin de conserver les données

dynamic (read/write) memory

memory in which the cells require the repetitive application of control signals in order to retain the data stored

cn **动态(读写)存储器**
de **dynamischer Schreib-Lese-Speicher**, m**; dynamischer Speicher**, m
es **memoria de lectura/escritura dinámica**
ja ダイナミックリード／ライトメモリ；ダイナミックメモリ
pl **pamięć dynamiczna (o zmiennej zawartości)**
pt **memória dinâmica de leitura e escrita**
sv **dynamiskt minne**

521-11-11

mémoire volatile, f

mémoire dans laquelle les données stockées sont perdues lorsque les tensions d'alimentation ne lui sont plus appliquées

volatile memory

memory in which the data content is lost when power is no longer supplied to it

cn **易失性存储器**
de **flüchtiger Speicher**, m
es **memoria volátil**
ja 揮発性メモリ
pl **pamięć ulotna; pamięć nietrwała**
pt **memória volátil**
sv **flyktigt minne**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-12

mémoire à accès séquentiel, f

mémoire dans laquelle les zones de stockage ne peuvent être atteintes que dans un ordre prédéterminé

serial access memory

memory in which storage zones can only be accessed in a predetermined sequence

cn **串行存取存储器**
de **Speicher mit seriellem Zugriff**, m
es **memoria de acceso secuencial**
ja **シリアルアクセスメモリ**
pl **pamięć o dostępie szeregowym**
pt **memória de acesso sequencial**
sv **seriellt minne**

521-11-13

mémoire adressable par le contenu, f
mémoire associative, f

mémoire qui délivre l'ensemble des données d'une zone de stockage lorsqu'il y a correspondance entre une partie de ces données et les données présentées à l'entrée de la mémoire

content addressable memory
associative memory

memory that responds with all the data in a storage zone if a portion of that data matches the data input of the memory

cn **按内容访问存储器；关联存储器**
de **inhaltsadressierbarer Speicher**, m**; Assoziativspeicher**, m**; CAM** (Abkürzung)
es **memoria direccionable por el contenido; memoria asociativa**
ja **連想メモリ；アソシエイティブメモリ**
pl **pamięć skojarzeniowa**
pt **memória endereçável pelo conteúdo; memória associativa**
sv **associativt minne**

521-11-14

dispositif à transfert de charge, m

dispositif à semiconducteurs dont le fonctionnement dépend du déplacement effectif de paquets discrets de charges électriques à la surface ou dans le volume du semiconducteur, ou entre les interconnexions à la surface du semiconducteur

charge-transfer device

semiconductor device in which the operation depends on the effective movement of discrete packets of electric charge along or beneath the semiconductor surface, or through the interconnections on the semiconductor surface

cn **电荷转移器件**
de **Ladungsverschiebeschaltung**, f**; CTD** (Abkürzung)
es **dispositivo de transferencia de carga**
ja **電荷転送デバイス**
pl **przyrząd z przenoszeniem ładunku**
pt **dispositivo de transferência de carga**
sv **laddningsöverförande krets**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-15

dispositif en chapelet, m

dispositif à transfert de charge qui emmagasine des charges électriques dans des régions discrètes d'un semiconducteur et qui les transfère comme des paquets par l'intermédiaire d'une série de dispositifs de commutation qui interconnectent ces régions

bucket-brigade device

charge-transfer device that stores electric charge in discrete regions in a semiconductor and transfers this charge as a packet through a series of switching devices that interconnect these regions

cn **斗链器件**
de **Eimerkettenschaltung**, f**; BBD** (Abkürzung)
es **dispositivo en serie**
ja **バケットブリゲードデバイス**
pl **przyrząd łańcuchowy; BBD** (akronim)
pt **dispositivo em colar**
sv **paketöverförande krets**

521-11-16

dispositif à couplage de charge, m

dispositif à transfert de charge qui stocke des charges électriques dans des puits de potentiel et transfère la quasi-totalité de ces charges électriques comme des paquets par déplacement des puits de potentiel

charge-coupled device
CCD (abbreviation)

charge-transfer device that stores electric charge in potential wells and transfers this electric charge almost completely as a packet by moving the potential wells

cn **电荷耦合器件；CCD**（缩写词）
de **ladungsgekoppelte Schaltung**, f**; CCD** (Abkürzung)
es **dispositivo de acoplamiento de carga**
ja **電荷結合デバイス；CCD**
pl **przyrząd ze sprzężeniem ładunkowym; CCD** (akronim)
pt **dispositivo de acoplamento de carga; CCD** (abreviatura)
sv **laddningskopplad krets; CCD**

521-11-17

capteur d'image à transfert de charge, m

dispositif à transfert de charge dans lequel une image est convertie en paquets de charges électriques qui peuvent être transférés et qui constituent une représentation électrique de l'image

charge-transfer image sensor

charge-transfer device in which an image is converted into packets of electric charge that can be transferred as the electrical representation of the image

cn **电荷转移图像传感器**
de **Ladungsverschiebe-Bildabtaster**, m
es **sensor de imagen de transferencia de carga**
ja **電荷転送形イメージセンサ**
pl **analizator obrazu z przenoszeniem ładunku**
pt **sensor de imagem por transferência de carga**
sv **laddningsöverförande bildsensor**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-18

circuit intégré spécifique, m

circuit intégré conçu pour des applications spécifiques

application specific integrated circuit
ASIC (abbreviation)

integrated circuit designed for specific applications

cn **专用集成电路；ASIC**（缩写词）
de **ASIC-Schaltung**, f; **ASIC** (Abkürzung)
es **circuito integrado de aplicación específica**
ja **特定用途向けIC；ASIC**
pl **układ scalony specjalizowany; układ scalony na zamówienie; ASIC** (akronim)
pt **circuito integrado de aplicação específica; ASIC** (abreviatura)
sv **applikationsspecifik krets; ASIC**

521-11-19

circuit intégré semi-personnalisé, m

circuit intégré composé de circuits, cellules et macrocellules conçus préalablement et que l'on peut utiliser dans un procédé automatisé d'implantation de puces pour réaliser un circuit destiné à une application spécifique

semicustom integrated circuit

integrated circuit consisting of pre-designed circuits, cells and macro cells that can be used in an automated chip-layout process to produce a circuit for a specific application

cn **半定制集成电路**
de **integrierte Kundenschaltung mit Standardelementen**, f
es **circuito integrado semipersonalizado**
ja **セミカスタムIC**
pl **układ scalony projektowany z udziałem użytkownika**
pt **circuito integrado semipersonalizado**
sv **utgångsämne för ASIC**

521-11-20

circuit intégré prédiffusé, m

circuit intégré contenant un assemblage déterminé d'éléments de circuit utilisés pour former des macrocellules et des macrofonctions qui sont, ou peuvent être, interconnectés pour réaliser une fonction logique

gate array

integrated circuit containing a fixed topology of circuit elements used to form macro cells and macro functions that are or may be, interconnected to implement a logic function

cn **门阵列**
de **Gatterfeld**, n
es **matriz de puerta**
ja **ゲートアレイ**
pl **układ matrycowy; matryca bramek**
pt **circuito integrado pré-difundido**
sv **grindmatris**

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521-11-21

cellule (dans un semiconducteur), f

assemblage préalablement conçu d'éléments de circuit dont le schéma et les bornes d'interconnexion sont prévus pour réaliser une fonction dans un circuit intégré

cell (in a semiconductor)

predesigned combination of circuit elements with specific layout and interconnection terminals that implements a function in an integrated circuit

cn **单元**（半导体中）
de **Zelle** (in einem Halbleiter), f
es **célula**
ja **セル**
pl **komórka (układu scalonego)**
pt **célula**
sv **funktionscell**

521-11-22

macrocellule, f

ensemble de cellules interconnectées de manière spécifique

macro cell

collection of cells with specific interconnections

cn **宏单元**
de **Makrozelle**, f
es **macrocélula**
ja **マクロセル**
pl **makrokomórka**
pt **macrocélula macrocélula**
sv **makrocell**

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

– Page blanche –

– Blank Page –

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INDEX

FRANÇAIS 127

ENGLISH 141

CHINESE 153

DEUTSCH 157

ESPAÑOL 162

JAPANESE 167

POLSKI 175

PORTUGUÊS 189

SVENSKA 194

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INDEX

A

abrupte
jonction abrupte, f 521-02-73

accepteur
accepteur, m 521-02-39
énergie d'ionisation d'un accepteur, f... 521-02-44
niveau accepteur, m 521-02-41

accès
mémoire à accès direct, f..... 521-11-08
mémoire à accès séquentiel, f 521-11-12

accrochage
courant d'accrochage, m 521-08-11

accumulation
accumulation de porteurs de charge (dans un semiconducteur), f 521-02-62

activation
énergie d'activation des impuretés, f ... 521-02-05

adressable
mémoire adressable par le contenu, f.. 521-11-13

afficheur
afficheur optoélectronique, m 521-04-36

alliage
jonction par alliage, f..... 521-02-75
procédé par alliage, m 521-03-07

amorçage
courant d'amorçage par la gâchette, m 521-08-14
courant de non-amorçage par la gâchette, m 521-08-17
tension d'amorçage par la gâchette, f.. 521-08-15
tension de non-amorçage par la gâchette, f 521-08-16

angle
angle de Hall, m..... 521-09-03

anode
caractéristique d'anode, f..... 521-08-06
caractéristique (courant-tension) d'anode-cathode, f 521-08-06

apparente
résistance apparente directe, f 521-06-05
résistance apparente à l'état passant, f..... 521-08-13

appauvrissement
couche d'appauvrissement (d'un semiconducteur), f 521-02-82
fonctionnement en mode d'appauvrissement, m..... 521-07-10
transistor à effet de champ à appauvrissement, m..... 521-04-58

associative
mémoire associative, f..... 521-11-13

asymétrique
thyristor asymétrique, m 521-04-71

atome
atome de Bohr, m 521-01-06

avalanche
claquage par avalanche (d'une jonction PN), m 521-05-07
diode de redressement à avalanche, f. 521-04-20
photodiode à avalanche, f..... 521-04-44
tension d'avalanche, f..... 521-05-08

B

bande
bande de Bloch, f..... 521-02-25
bande de conduction, f 521-02-22
bande d'énergie (1), f..... 521-02-25
bande d'énergie (dans un semiconducteur) (2), f..... 521-02-26
bande d'excitation, f..... 521-02-28
bande d'impureté, f..... 521-02-37
bande interdite, f..... 521-02-30
bande partiellement occupée, f..... 521-02-27
bande permise, f..... 521-02-29
bande pleine, f..... 521-02-32
bande de surface, f..... 521-02-34
bande de valence, f 521-02-23
bande vide, f..... 521-02-33

barrière
barrière de potentiel (1), f 521-02-69
barrière de potentiel (d'une jonction PN) (2), f..... 521-02-70
barrière de Schottky, f 521-02-71

base
base, f..... 521-07-03
base commune, f..... 521-07-13
base commune inverse, f..... 521-07-16

bidirectionnel
thyristor diode bidirectionnel, m..... 521-04-66
thyristor triode bidirectionnel, m..... 521-04-67
transistor bidirectionnel, m..... 521-04-49

bipolaire
transistor bipolaire à jonctions, m 521-04-47

bloc
bloc de redressement (à semiconducteurs), m 521-04-21

blocable
thyristor blocable, m 521-04-68

blocage
tension de blocage (d'un transistor à effet de champ à déplétion), f 521-07-23

Bloch
bande de Bloch, f..... 521-02-25

bloqué
état bloqué, m..... 521-08-08
état bloqué en inverse (d'un thyristor bloqué en inverse), m. 521-08-09

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

thyristor diode bloqué en inverse, m 521-04-62
thyristor triode bloqué en inverse, m 521-04-63
vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f 521-08-18

Bohr
atome de Bohr, m 521-01-06

boîtier
boîtier, m..... 521-05-31

Boltzmann
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-05
relation de Boltzmann, f..... 521-01-04
statistique de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-03

borne
borne (d'un dispositif à semiconducteurs), f..... 521-05-02
borne de commande (d'ungénérateur de Hall), f 521-09-07
borne maîtresse, f..... 521-08-03
bornes Hall, f, pl..... 521-09-06

boucle
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f... 521-09-09
surface effective d'induction de la boucle de sortie, f..... 521-09-08

C

canal
canal (d'un transistor à effet de champ), m..... 521-07-06
transistor à effet de champ à canal N, m..... 521-04-56
transistor à effet de champ à canal P, m..... 521-04-57

capacité
capacité thermique, f 521-05-16
diode à capacité variable, f..... 521-04-07

capteur
capteur d'image à transfert de charge, m..... 521-11-17

caractéristique
caractéristique d'anode, f..... 521-08-06
caractéristique (courant-tension) d'anode-cathode, f 521-08-06
caractéristique (courant-tension) principale, f 521-08-05
courbe caractéristique d'une magnétorésistance, f..... 521-09-17

cathode
caractéristique (courant-tension) d'anode-cathode, f 521-08-06

célibataire
électron célibataire, m..... 521-01-18

cellule
cellule (dans un semiconducteur), f..... 521-11-21
cellule à effet photovoltaïque, f..... 521-04-34
cellule-mémoire, f 521-11-04
cellule photoconductrice, f 521-04-33

centre
centre de recombinaison, m 521-02-64

champ
champ électrique interne, m 521-02-81
champ induit (d'un générateur de Hall), m 521-09-10
tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif à effet Hall), f..... 521-09-15
transistor à effet de champ, m 521-04-52
transistor à effet de champ à appauvrissement, m 521-04-58
transistor à effet de champ à canal N, m..... 521-04-56
transistor à effet de champ à canal P, m..... 521-04-57
transistor à effet de champ à déplétion, m 521-04-58
transistor à effet de champ à enrichissement, m..... 521-04-59
transistor à effet de champ à grille isolé, m..... 521-04-54
transistor à effet de champ à jonction de grille, m 521-04-53
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
transistor à effet de champ métal-semiconducteur, m..... 521-04-60

chapelet
dispositif en chapelet, m 521-11-15

charge
accumulation de porteurs de charge (dans un semiconducteur), f 521-02-62
capteur d'image à transfert de charge, m..... 521-11-17
charge récupérée (d'une diode ou d'un thyristor), f 521-05-18
dispositif à couplage de charge, m 521-11-16
dispositif à transfert de charge, m..... 521-11-14
porteur (de charge) (dans un semiconducteur), m 521-02-51
région de charge d'espace, f 521-02-79
région de charge spatiale (d'une jonction PN), f 521-02-80

circuit
circuit équivalent, m..... 521-05-35
circuit intégré, m 521-10-03
circuit intégré à couches, m..... 521-10-06
circuit intégré multipuce, m..... 521-10-10
circuit intégré prédiffusé, m..... 521-11-20
circuit intégré semi-personnalisé, m 521-11-19
circuit intégré à semiconducteurs, m ... 521-10-05
circuit intégré spécifique, m 521-11-18
élément de circuit parasite, m..... 521-05-36
mémoire à circuit intégré, f 521-11-05
paramètre de circuit, m..... 521-05-34
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

claquage
claquage (d'une jonction PN polarisée en inverse), m 521-05-06
claquage par avalanche (d'une jonction PN), m 521-05-07
claquage par effet thermique (d'une jonction PN), m 521-05-11
claquage par effet Zener (d'une jonction PN), m 521-05-09

coefficient
coefficient de Hall, m 521-09-02
coefficient de magnétorésistance, m ... 521-09-18

collecteur
collecteur, m 521-07-05
collecteur commun, m..... 521-07-14
collecteur commun inverse, m 521-07-17
jonction collecteur, f..... 521-07-02

commande
borne de commande (d'un générateur de Hall), f 521-09-07
courant de commande (d'un générateur de Hall), m 521-09-11
sensibilité au courant de commande (d'une sonde de Hall), f..... 521-09-13
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f... 521-09-09
tension de commande induite (d'un dispositif à effet Hall), f..... 521-09-16
tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif à effet Hall), f..... 521-09-14

commun(e)
base commune, f..... 521-07-13
base commune inverse, f..... 521-07-16
collecteur commun, m..... 521-07-14
collecteur commun inverse, m 521-07-17
émetteur commun, m..... 521-07-15
émetteur commun inverse, m 521-07-18

commutation
diode de commutation, f 521-04-13
diode de commutation hyperfréquence, f..... 521-04-14

compensation
compensation au moyen d'impuretés, f 521-03-06

compensé
semiconducteur compensé, m..... 521-02-11

composé
semiconducteur composé, m..... 521-02-03

composition
composition stœchiométrique, f..... 521-02-46

concentration
zone de transition de la concentration des impuretés, f 521-02-67

conducteur
conducteur, m..... 521-02-16

conduction
bande de conduction, f 521-02-22
conduction par électrons, f..... 521-02-19
conduction intrinsèque, f..... 521-02-20
conduction ionique, f..... 521-02-21
conduction par trous, f 521-02-18
courant de conduction, m 521-02-15
électron de conduction, m..... 521-02-14

conductivité
conductivité intrinsèque, f 521-02-48
conductivité de type N, f 521-02-49
conductivité de type P, f..... 521-02-50
modulation de la conductivité (d'un semiconducteur), f 521-02-55

connexion
grille de connexion (d'un boîtier), f..... 521-05-32

constante
constante de diffusion (des porteurs de charge), f..... 521-02-61

contenu
mémoire adressable par le contenu, f . 521-11-13

Corbino
disque de Corbino, m 521-04-30

couche
couche (d'un circuit intégré à couches), f 521-10-07
couche d'appauvrissement (d'un semiconducteur), f 521-02-82
couche de déplétion, f 521-02-82
couche épaisse (d'un circuit intégré à couches), f..... 521-10-09
couche mince (d'un circuit intégré à couches), f 521-10-08
circuit intégré à couches, m..... 521-10-06

couplage
dispositif à couplage de charge, m 521-11-16

coupure
fréquence de coupure, f..... 521-05-20
fréquence de coupure résistive, f..... 521-06-04

courant
caractéristique (courant-tension) d'anode-cathode, f..... 521-08-06
caractéristique (courant-tension) principale, f 521-08-05
courant d'accrochage, m 521-08-11
courant d'amorçage par la gâchette, m 521-08-14
courant de non-amorçage par la gâchette, m 521-08-17
courant de commande (d'un générateur de Hall), m 521-09-11
courant de conduction, m 521-02-15
courant hypostatique, m 521-08-10
courant de maintien, m 521-08-10
courant principal, m 521-08-02
diode régulatrice de courant, f..... 521-04-18

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

fréquence du rapport de transfert unité de courant , f 521-07-22
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
sensibilité au courant de commande (d'une sonde de Hall), f..... 521-09-13
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f... 521-09-09
tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif à effet Hall), f..... 521-09-14
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f 521-07-20
vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f..... 521-08-19

courbe
courbe caractéristique d'une magnétorésistance, f..... 521-09-17

court-circuit
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19

cristal
cristal idéal, m..... 521-02-45

critique
vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f..... 521-08-19
vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f 521-08-18

croissance
croissance par la méthode de Czochralski, f 521-03-01
croissance d'un monocristal par fusion de zone, f 521-03-02
croissance par tirage (d'un monocristal), f 521-03-01
retard à la croissance, m 521-05-21
temps de croissance, m..... 521-05-22
vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f..... 521-08-19
vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f 521-08-18

Czochralski
croissance par la méthode de Czochralski, f 521-03-01

D

décharge
dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m..... 521-05-27

décroissance
retard à la décroissance, m 521-05-23
temps de décroissance, m..... 521-05-24

dégénéré
semiconducteur dégénéré, m 521-02-13
semiconducteur non dégénéré, m 521-02-12

DEL
DEL (abréviation)..... 521-04-39

déplétion
couche de déplétion, f 521-02-82
fonctionnement en mode de déplétion, m 521-07-10
transistor à effet de champ à déplétion, m 521-04-58

dépôt
dépôt en phase vapeur, m..... 521-03-15

descente
retard à la descente, m..... 521-05-23

détectrice
diode détectrice, f 521-04-11

diac
diac (abréviation) 521-04-66

diagramme
diagramme énergétique, m..... 521-01-13

différentielle
région de résistance différentielle négative, f..... 521-05-05

diffusion
constante de diffusion (des porteurs de charge), f..... 521-02-61
diffusion (dans un semiconducteur), f.. 521-02-59
jonction par diffusion, f..... 521-02-76
largeur de diffusion (des porteurs minoritaires), f..... 521-02-60
procédé par diffusion, m 521-03-08

diode
diode (à semiconducteurs), f 521-04-03
diode à capacité variable, f..... 521-04-07
diode de commutation, f 521-04-13
diode de commutation hyperfréquence, f..... 521-04-14
diode détectrice, f 521-04-11
diode électroluminescente, f..... 521-04-39
diode infrarouge, f..... 521-04-40
diode laser, f..... 521-04-37
diode de limitation hyperfréquence, f... 521-04-15
diode mélangeuse, f 521-04-08
diode modulatrice, f 521-04-10
diode pour multiplication de fréquence, f..... 521-04-09
diode de redressement (à semiconducteurs), f 521-04-19
diode de redressement à avalanche, f. 521-04-20
diode régulatrice de courant, f 521-04-18
diode régulatrice de tension, f..... 521-04-17
diode à retour rapide, f 521-04-12
diode de signal, f 521-04-04
diode de tension de référence, f 521-04-16
diode tunnel, f..... 521-04-05
diode unitunnel, f 521-04-06
module à diode laser, m 521-04-38
thyristor diode bidirectionnel, m..... 521-04-66
thyristor diode bloqué en inverse, m.... 521-04-62
thyristor diode passant en inverse, m .. 521-04-64

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

Dirac
fonction de Fermi-Dirac, f 521-01-16
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f..... 521-01-19
statistique de Fermi-Dirac, f..... 521-01-15

direct(e)
mémoire à accès direct, f..... 521-11-08
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
résistance apparente directe, f 521-06-05
sens direct (d'une jonction PN), m..... 521-05-03
temps de recouvrement direct, m 521-05-25
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f..... 521-07-20

discret
dispositif discret (à semiconducteurs), m 521-04-02

dispositif
dispositif en chapelet, m 521-11-15
dispositif à couplage de charge, m 521-11-16
dispositif discret (à semiconducteurs), m 521-04-02
dispositif à effet Hall, m..... 521-04-24
dispositif optoélectronique, m 521-04-31
dispositif photosensible (à semiconducteurs), m 521-04-41
dispositif à semiconducteurs, m..... 521-04-01
dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m..... 521-05-27
dispositif à transfert de charge, m..... 521-11-14

disque
disque de Corbino, m..... 521-04-30

distribution
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f..... 521-01-19
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-05

donneur
donneur, m 521-02-38
énergie d'ionisation d'un donneur, f..... 521-02-43
niveau donneur, m..... 521-02-40

dopage
dopage (d'un semiconducteur), m 521-03-05

drain
drain (d'un transistor à effet de champ), m..... 521-07-08

durée
durée de vie dans le matériau (des porteurs minoritaires), f..... 521-02-57

dynamique
mémoire vive dynamique, f..... 521-11-10

E

écart
écart énergétique, m..... 521-02-24

effective
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f... 521-09-09
surface effective d'induction de la boucle de sortie, f..... 521-09-08

effet
cellule à effet photovoltaïque, f..... 521-04-34
claquage par effet thermique (d'une jonction PN), m 521-05-11
claquage par effet Zener (d'une jonction PN), m 521-05-09
dispositif à effet Hall, m..... 521-04-24
effet Hall, m 521-09-01
effet magnétorésistant, m 521-02-84
effet photoconductif, m 521-01-22
effet photoélectrique, m 521-01-20
effet photoélectromagnétique, m 521-01-23
effet photovoltaïque, m 521-01-21
effet piézorésistant, m 521-02-85
effet tensorésistant, m 521-02-85
effet tunnel (dans une jonction PN), m 521-02-83
magnétomètre à effet Hall, m 521-04-28
modulateur à effet Hall, m..... 521-04-25
transistor à effet de champ, m 521-04-52
transistor à effet de champ à appauvrissement, m 521-04-58
transistor à effet de champ à canal N, m..... 521-04-56
transistor à effet de champ à canal P, m..... 521-04-57
transistor à effet de champ à déplétion, m 521-04-58
transistor à effet de champ à enrichissement, m..... 521-04-59
transistor à effet de champ à grille isolé, m..... 521-04-54
transistor à effet de champ à jonction de grille, m 521-04-53
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m 521-04-55
transistor à effet de champ métal-semiconducteur, m..... 521-04-60

électrique
champ électrique interne, m 521-02-81

électrode
électrode (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-01

électroluminescente
diode électroluminescente, f..... 521-04-39

électron
électron célibataire, m 521-01-18
électron de conduction, m..... 521-02-14
conduction par électrons, f..... 521-02-19

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

électrostatique
dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m 521-05-27
élément
élément de circuit parasite, m 521-05-36
élémentaire
semiconducteur élémentaire, m 521-02-02
émetteur
émetteur, m 521-07-04
émetteur commun, m 521-07-15
émetteur commun inverse, m 521-07-18
jonction émetteur, f 521-07-01
énergétique
diagramme énergétique, m 521-01-13
écart énergétique, m 521-02-24
énergie
bande d'énergie (1), f 521-02-25
bande d'énergie (dans un semiconducteur) (2), f 521-02-26
énergie d'activation des impuretés, f ... 521-02-05
énergie d'ionisation d'un accepteur, f... 521-02-44
énergie d'ionisation d'un donneur, f 521-02-43
niveau d'énergie, m 521-01-12
enrichissement
fonctionnement en mode d'enrichissement, m 521-07-11
transistor à effet de champ à enrichissement, m 521-04-59
épaisse
couche épaisse (d'un circuit intégré à couches), f 521-10-09
épitaxie
épitaxie, f 521-03-12
équivalent(e)
circuit équivalent, m 521-05-35
température équivalente interne (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-14
température virtuelle (équivalente) de jonction, f 521-05-15
espace
région de charge d'espace, f 521-02-79
état
état bloqué, m 521-08-08
état bloqué en inverse (d'un thyristor bloqué en inverse), m. 521-08-09
état passant, m 521-08-07
état de verrouillage, m 521-10-11
résistance apparente à l'état passant, f 521-08-13
vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f 521-08-19
vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f 521-08-18
excès
porteur en excès, m 521-02-54
excitation
bande d'excitation, f 521-02-28
exclusion
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m 521-01-14
extrinsèque
semiconducteur extrinsèque, m 521-02-08

F

Fermi
fonction de Fermi-Dirac, f 521-01-16
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f..... 521-01-19
niveau de Fermi, m 521-01-17
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m 521-01-14
statistique de Fermi, f 521-01-15
statistique de Fermi-Dirac, f..... 521-01-15
flottante
tension flottante, f 521-05-17
fonction
fonction de Fermi-Dirac, f 521-01-16
fonctionnement
fonctionnement en mode d'appauvrissement, m 521-07-10
fonctionnement en mode de déplétion, m 521-07-10
fonctionnement en mode d'enrichissement, m 521-07-11
sens inverse de fonctionnement, m 521-07-12
fréquence
diode pour multiplication de fréquence, f..... 521-04-09
fréquence de coupure, f..... 521-05-20
fréquence de coupure résistive, f..... 521-06-04
fréquence du rapport de transfert unité de courant , f 521-07-22
fréquence de transition , f 521-07-21
fréquence unité, f 521-07-22
fusion
croissance d'un monocristal par fusion de zone, f 521-03-02

G

gâchette
courant d'amorçage par la gâchette, m 521-08-14
courant de non-amorçage par la gâchette, m 521-08-17
gâchette, f..... 521-08-01
tension d'amorçage par la gâchette, f.. 521-08-15
tension de non-amorçage par la gâchette, f 521-08-16
générateur
générateur de Hall, m 521-04-26
grille
grille (d'un transistor à effet de champ), f..... 521-07-09
grille de connexion (d'un boîtier), f..... 521-05-32
transistor à effet de champ à grille isolé, m..... 521-04-54
transistor à effet de champ à jonction de grille, m..... 521-04-53

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

H

Hall
angle de Hall, m 521-09-03
bornes Hall, f, pl 521-09-06
coefficient de Hall, m 521-09-02
dispositif à effet Hall, m 521-04-24
effet Hall, m 521-09-01
générateur de Hall, m 521-04-26
magnétomètre à effet Hall, m 521-04-28
mobilité de Hall, f 521-09-04
modulateur à effet Hall, m 521-04-25
multiplicateur de Hall, m 521-04-27
sonde de Hall, f 521-04-28
tension de Hall, f 521-09-05

hyperfréquence
diode de commutation hyperfréquence, f 521-04-14
diode de limitation hyperfréquence, f ... 521-04-15

hypostatique
courant hypostatique, m 521-08-10

I

idéal
cristal idéal, m 521-02-45

image
capteur d'image à transfert de charge, m 521-11-17

imperfection
imperfection (d'un réseau cristallin), f .. 521-02-47

implantation
implantation ionique, f 521-03-14

impureté
bande d'impureté, f 521-02-37
compensation au moyen d'impuretés, f 521-03-06
énergie d'activation des impuretés, f ... 521-02-05
impureté, f 521-02-04
niveau d'impureté, m 521-02-36
zone de transition de la concentration des impuretés, f 521-02-67

inductance
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f ... 521-09-09

induction
surface effective d'induction de la boucle de sortie, f 521-09-08

induit(e)
champ induit (d'un générateur de Hall), m 521-09-10
tension de commande induite (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-16

infrarouge
diode infrarouge, f 521-04-40

intégré
circuit intégré, m 521-10-03
circuit intégré à couches, m 521-10-06
circuit intégré multipuce, m 521-10-10
circuit intégré prédiffusé, m 521-11-20
circuit intégré semi-personnalisé, m 521-11-19
circuit intégré à semiconducteurs, m ... 521-10-05
circuit intégré spécifique, m 521-11-18
mémoire à circuit intégré, f 521-11-05

interdite
bande interdite, f 521-02-30

interne
champ électrique interne, m 521-02-81
nombre quantique interne, m 521-01-11
température équivalente interne (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-14

intrinsèque
conduction intrinsèque, f 521-02-20
conductivité intrinsèque, f 521-02-48
semiconducteur intrinsèque, m 521-02-07

inverse
base commune inverse, f 521-07-16
collecteur commun inverse, m 521-07-17
émetteur commun inverse, m 521-07-18
état bloqué en inverse (d'un thyristor bloqué en inverse), m 521-08-09
sens inverse (d'une jonction PN), m 521-05-04
sens inverse de fonctionnement, m 521-07-12
temps de récupération inverse, m 521-05-26
thyristor diode bloqué en inverse, m 521-04-62
thyristor diode passant en inverse, m .. 521-04-64
thyristor triode bloqué en inverse, m 521-04-63
thyristor triode passant en inverse, m .. 521-04-65

ionique
conduction ionique, f 521-02-21
implantation ionique, f 521-03-14
semiconducteur ionique, m 521-02-06

ionisation
énergie d'ionisation d'un accepteur, f .. 521-02-44
énergie d'ionisation d'un donneur, f 521-02-43

isohypse
point isohypse (d'une diode tunnel), m 521-06-03

isolant
isolant, m 521-02-31

isolé
transistor à effet de champ à grille isolé, m 521-04-54

J

jonction
jonction, f 521-02-72
jonction abrupte, f 521-02-73
jonction par alliage, f 521-02-75
jonction collecteur, f 521-07-02
jonction par diffusion, f 521-02-76
jonction émetteur, f 521-07-01
jonction PN, f 521-02-78
jonction progressive, f 521-02-74
jonction par tirage, f 521-02-77

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

température virtuelle (équivalente) de jonction, f 521-05-15
transistor à effet de champ à jonction de grille, m 521-04-53
transistor bipolaire à jonctions, m 521-04-47

L

largeur
largeur de diffusion (des porteurs minoritaires), f 521-02-60
laser
diode laser, f 521-04-37
module à diode laser, m 521-04-38
limitation
diode de limitation hyperfréquence, f ... 521-04-15
limite
limite PN, f 521-02-65
local
niveau local, m 521-02-35
logique
matrice logique programmable, f 521-11-02
réseau logique programmable, m 521-11-01
loi
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f 521-01-19
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f 521-01-05

M

macrocellule
macrocellule, f 521-11-22
magnétique
sensibilité magnétique (d'une sonde de Hall), f 521-09-12
tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-15
magnétomètre
magnétomètre à effet Hall, m 521-04-28
magnétorésistance
coefficient de magnétorésistance, m ... 521-09-18
courbe caractéristique d'une magnétorésistance, f 521-09-17
magnétorésistance, f 521-04-29
rapport de magnétorésistance, m 521-09-19
sensibilité de magnétorésistance, f..... 521-09-20
magnétorésistant
effet magnétorésistant, m 521-02-84
maintien
courant de maintien, m 521-08-10
maîtresse
borne maîtresse, f..... 521-08-03
majoritaire
porteur majoritaire (dans une région semiconductrice), m..... 521-02-52
matériau
durée de vie dans le matériau (des porteurs minoritaires), f 521-02-57
matrice
matrice logique programmable, f 521-11-02
matrice prédiffusée programmable, f ... 521-11-03
Maxwell
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-05
statistique de Maxwell-Boltzmann, f 521-01-03
mélangeuse
diode mélangeuse, f 521-04-08
mémoire
cellule-mémoire, f 521-11-04
mémoire à accès direct, f..... 521-11-08
mémoire à accès séquentiel, f..... 521-11-12
mémoire adressable par le contenu, f . 521-11-13
mémoire associative, f..... 521-11-13
mémoire à circuit intégré, f 521-11-05
mémoire morte f 521-11-06
mémoire vive, f 521-11-07
mémoire vive dynamique, f..... 521-11-10
mémoire vive statique, f..... 521-11-09
mémoire volatile, f 521-11-11
mesa
procédé mesa, m..... 521-03-11
métal
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m 521-04-55
transistor à effet de champ métal-semiconducteur, m..... 521-04-60
méthode
croissance par la méthode de Czochralski, f 521-03-01
microalliage
procédé par microalliage, m 521-03-10
microassemblage
microassemblage, m 521-10-04
microélectronique
microélectronique, f 521-10-01
microstructure
microstructure, f..... 521-10-02
mince
couche mince (d'un circuit intégré à couches), f..... 521-10-08
minoritaire
porteur minoritaire (dans une région semiconductrice), m..... 521-02-53
mobilité
mobilité (d'un porteur de charge), f..... 521-02-58
mobilité de Hall, f 521-09-04
mode
fonctionnement en mode d'appauvrissement, m..... 521-07-10
fonctionnement en mode de déplétion, m 521-07-10
fonctionnement en mode d'enrichissement, m..... 521-07-11
modulateur
modulateur à effet Hall, m..... 521-04-25

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

modulation
modulation de la conductivité (d'un semiconducteur), f 521-02-55
modulatrice
diode modulatrice, f 521-04-10
module
module à diode laser, m 521-04-38
monocristal
croissance d'un monocristal par fusion de zone, f 521-03-02
montée
retard à la montée, m 521-05-21
temps de montée, m 521-05-22
morte
mémoire morte f 521-11-06
moyen
compensation au moyen d'impuretés, f 521-03-06
multiplicateur
multiplicateur de Hall, m 521-04-27
multiplication
diode pour multiplication de fréquence, f 521-04-09
multipuce
circuit intégré multipuce, m 521-10-10

N

N
conductivité de type N, f 521-02-49
semiconducteur type N, m 521-02-09
thyristor N, m 521-04-70
transistor à effet de champ à canal N, m 521-04-56
négative
région de résistance différentielle négative, f 521-05-05
neutre
région neutre, f 521-02-68
niveau
niveau accepteur, m 521-02-41
niveau donneur, m 521-02-40
niveau d'énergie, m 521-01-12
niveau de Fermi, m 521-01-17
niveau d'impureté, m 521-02-36
niveau local, m 521-02-35
niveau de surface, m 521-02-42
nivellement
nivellement par zone, m 521-03-04
nombre
nombre quantique (d'un électron dans un atome donné), m 521-01-07
nombre quantique interne, m 521-01-11
nombre quantique orbital, m 521-01-09
nombre quantique principal, m 521-01-08
nombre quantique secondaire, m 521-01-09
(nombre quantique de) spin, m 521-01-10
nul
tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-15
tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-14

O

occupée
bande partiellement occupée, f 521-02-27
optocoupleur
optocoupleur, m 521-04-45
optoélectronique
afficheur optoélectronique, m 521-04-36
dispositif optoélectronique, m 521-04-31
orbital
nombre quantique orbital, m 521-01-09
oxyde
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m 521-04-55

P

P
conductivité de type P, f 521-02-50
semiconducteur type P, m 521-02-10
thyristor P, m 521-04-69
transistor à effet de champ à canal P, m 521-04-57
paramètre
paramètre de circuit, m 521-05-34
parasite
élément de circuit parasite, m 521-05-36
partiellement
bande partiellement occupée, f 521-02-27
passant
état passant, m 521-08-07
résistance apparente à l'état passant, f 521-08-13
thyristor diode passant en inverse, m .. 521-04-64
thyristor triode passant en inverse, m .. 521-04-65
vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f 521-08-19
passivation
passivation de surface, f 521-03-13
pastille
pastille, f 521-05-30
Pauli
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m 521-01-14
pénétration
pénétration (entre deux jonctions PN), f 521-05-12
permise
bande permise, f 521-02-29
personnalisé
circuit intégré semi-personnalisé, m 521-11-19

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

petits
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
phase
dépôt en phase vapeur, m 521-03-15
photoconductif
effet photoconductif, m 521-01-22
photoconductrice
cellule photoconductrice, f 521-04-33
photocoupleur
photocoupleur, m 521-04-45
photodiode
photodiode, f 521-04-32
photodiode à avalanche, f 521-04-44
photoélectrique
effet photoélectrique, m 521-01-20
récepteur photoélectrique (à semiconducteurs), m 521-04-42
photoélectromagnétique
effet photoélectromagnétique, m 521-01-23
photoémetteur
photoémetteur, m 521-04-35
photorésistance
photorésistance, f 521-04-43
photosensible
dispositif photosensible (à semiconducteurs), m 521-04-41
photothyristor
photothyristor, m 521-04-72
phototransistor
phototransistor, m 521-04-51
photovoltaïque
cellule à effet photovoltaïque, f 521-04-34
effet photovoltaïque, m 521-01-21
pic
point de pic (d'une diode tunnel), m 521-06-01
piège
piège, m 521-02-63
piézorésistant
effet piézorésistant, m 521-02-85
planaire
procédé planaire, m 521-03-09
plaquette
plaquette, f 521-05-29
pleine
bande pleine, f 521-02-32
PN
jonction PN, f 521-02-78
limite PN, f 521-02-65
point
point isohypse (d'une diode tunnel), m 521-06-03
point de pic (d'une diode tunnel), m 521-06-01
point de retournement, m 521-08-12
point de vallée (d'une diode tunnel), m 521-06-02
porteur
accumulation de porteurs de charge (dans un semiconducteur), f 521-02-62
porteur (de charge) (dans un semiconducteur), m 521-02-51
porteur en excès, m 521-02-54
porteur majoritaire (dans une région semiconductrice), m 521-02-52
porteur minoritaire (dans une région semiconductrice), m 521-02-53
potentiel
barrière de potentiel (1), f 521-02-69
barrière de potentiel (d'une jonction PN) (2), f 521-02-70
prédiffusé
circuit intégré prédiffusé, m 521-11-20
prédiffusée
matrice prédiffusée programmable, f 521-11-03
principal(e)
caractéristique (courant-tension) principale, f 521-08-05
courant principal, m 521-08-02
nombre quantique principal, m 521-01-08
tension principale, f 521-08-04
principe
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m 521-01-14
procédé
procédé par alliage, m 521-03-07
procédé par diffusion, m 521-03-08
procédé mesa, m 521-03-11
procédé par microalliage, m 521-03-10
procédé planaire, m 521-03-09
programmable
matrice logique programmable, f 521-11-02
matrice prédiffusée programmable, f 521-11-03
réseau logique programmable, m 521-11-01
progressive
jonction progressive, f 521-02-74
puce
puce, f 521-05-30
pulvérisation
pulvérisation sous vide, f 521-03-17
purification
purification par zone, f 521-03-03

Q

quantifié
système non quantifié (de particules), m 521-01-01
système quantifié (de particules), m 521-01-02
quantique
nombre quantique (d'un électron dans un atome donné), m 521-01-07
nombre quantique interne, m 521-01-11
nombre quantique orbital, m 521-01-09
nombre quantique principal, m 521-01-08
nombre quantique secondaire, m 521-01-09
(nombre quantique de) spin, m 521-01-10

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

R

radiateur
radiateur, m 521-05-33
rapide
diode à retour rapide, f..... 521-04-12
rapport
fréquence du rapport de transfert unité de courant , f 521-07-22
rapport de magnétorésistance, m 521-09-19
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f 521-07-20
récepteur
récepteur photoélectrique (à semiconducteurs), m 521-04-42
recombinaison
centre de recombinaison, m 521-02-64
vitesse de recombinaison en surface, f 521-02-56
recouvrement
temps de recouvrement direct, m 521-05-25
récupération
temps de récupération inverse, m..... 521-05-26
récupérée
charge récupérée (d'une diode ou d'un thyristor), f 521-05-18
redressement
bloc de redressement (à semiconducteurs), m 521-04-21
diode de redressement (à semiconducteurs), f 521-04-19
diode de redressement à avalanche, f. 521-04-20
référence
diode de tension de référence, f 521-04-16
région
région de charge d'espace, f 521-02-79
région de charge spatiale (d'une jonction PN), f 521-02-80
région neutre, f 521-02-68
région de résistance différentielle négative, f 521-05-05
région de transition, f 521-02-66
régulatrice
diode régulatrice de courant, f 521-04-18
diode régulatrice de tension, f..... 521-04-17
relation
relation de Boltzmann, f 521-01-04
réseau
réseau logique programmable, m 521-11-01
résiduelle
tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif à effet Hall), f..... 521-09-15
tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif à effet Hall), f..... 521-09-14
résistance
région de résistance différentielle négative, f 521-05-05
résistance apparente directe, f 521-06-05
résistance apparente à l'état passant, f..... 521-08-13
résistance thermique (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-13
résistive
fréquence de coupure résistive, f..... 521-06-04
retard
retard à la croissance, m 521-05-21
retard à la décroissance, m 521-05-23
retard à la descente, m..... 521-05-23
retard à la montée, m 521-05-21
retour
diode à retour rapide, f 521-04-12
retournement
point de retournement, m..... 521-08-12

S

Schottky
barrière de Schottky, f 521-02-71
secondaire
nombre quantique secondaire, m 521-01-09
semi
circuit intégré semi-personnalisé, m 521-11-19
semiconducteur
circuit intégré à semiconducteurs, m ... 521-10-05
dispositif à semiconducteurs, m..... 521-04-01
semiconducteur, m 521-02-01
semiconducteur compensé, m..... 521-02-11
semiconducteur composé, m..... 521-02-03
semiconducteur dégénéré, m 521-02-13
semiconducteur non dégénéré, m 521-02-12
semiconducteur élémentaire, m..... 521-02-02
semiconducteur extrinsèque, m..... 521-02-08
semiconducteur intrinsèque, m..... 521-02-07
semiconducteur ionique, m..... 521-02-06
semiconducteur type N, m 521-02-09
semiconducteur type P, m 521-02-10
transistor à effet de champ métal-semiconducteur, m..... 521-04-60
thermoélément à semiconducteurs, m. 521-04-23
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
sens
sens direct (d'une jonction PN), m..... 521-05-03
sens inverse (d'une jonction PN), m 521-05-04
sens inverse de fonctionnement, m 521-07-12
sensibilité
sensibilité au courant de commande (d'une sonde de Hall), f..... 521-09-13
sensibilité magnétique (d'une sonde de Hall), f..... 521-09-12
sensibilité de magnétorésistance, f..... 521-09-20

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

sensible
dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m 521-05-27
séquentiel
mémoire à accès séquentiel, f 521-11-12
sérigraphie
sérigraphie, f 521-03-16
seuil
tension de seuil (d'un transistor à effet de champ à enrichissement), f .. 521-07-24
tension de seuil (d'une diode ou d'un thyristor), f 521-05-19
signal
diode de signal, f 521-04-04
signaux
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
Sommerfeld
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f 521-01-19
sonde
sonde de Hall, f 521-04-28
sortie
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
surface effective d'induction de la boucle de sortie, f 521-09-08
source
source (d'un transistor à effet de champ), f 521-07-07
spatiale
région de charge spatiale (d'une jonction PN), f 521-02-80
spécifique
circuit intégré spécifique, m 521-11-18
spin
(nombre quantique de) spin, m 521-01-10
statique
mémoire vive statique, f 521-11-09
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f 521-07-20
statistique
statistique de Fermi, f 521-01-15
statistique de Fermi-Dirac, f 521-01-15
statistique de Maxwell-Boltzmann, f 521-01-03
stœchiométrique
composition stœchiométrique, f 521-02-46
substrat
substrat, m 521-05-28
surface
bande de surface, f 521-02-34
niveau de surface, m 521-02-42
passivation de surface, f 521-03-13
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f ... 521-09-09
surface effective d'induction de la boucle de sortie, f 521-09-08
vitesse de recombinaison en surface, f 521-02-56
système
système non quantifié (de particules), m 521-01-01
système quantifié (de particules), m 521-01-02

T

température
température équivalente interne (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-14
température virtuelle (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-14
température virtuelle (équivalente) de jonction, f 521-05-15
temps
temps de croissance, m 521-05-22
temps de décroissance, m 521-05-24
temps de montée, m 521-05-22
temps de recouvrement direct, m 521-05-25
temps de récupération inverse, m 521-05-26
tension
caractéristique (courant-tension) d'anode-cathode, f 521-08-06
caractéristique (courant-tension) principale, f 521-08-05
diode régulatrice de tension, f 521-04-17
diode de tension de référence, f 521-04-16
tension d'amorçage par la gâchette, f .. 521-08-15
tension de non-amorçage par la gâchette, f 521-08-16
tension d'avalanche, f 521-05-08
tension de blocage (d'un transistor à effet de champ à déplétion), f 521-07-23
tension de commande induite (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-16
tension flottante, f 521-05-17
tension de Hall, f 521-09-05
tension principale, f 521-08-04
tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-15
tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif à effet Hall), f 521-09-14
tension de seuil (d'un transistor à effet de champ à enrichissement), f .. 521-07-24
tension de seuil (d'une diode ou d'un thyristor), f 521-05-19
tension de Zener, f 521-05-10
vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f 521-08-18
tensorésistant
effet tensorésistant, m 521-02-85
tétrode
transistor tétrode, m 521-04-50

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

thermique
capacité thermique, f 521-05-16
claquage par effet thermique (d'une jonction PN), m 521-05-11
résistance thermique (d'un dispositif à semiconducteurs), f 521-05-13

thermistance
thermistance, f 521-04-22

thermoélément
thermoélément à semiconducteurs, m. 521-04-23

thyristor
thyristor, m 521-04-61
thyristor asymétrique, m 521-04-71
thyristor blocable, m 521-04-68
thyristor diode bidirectionnel, m 521-04-66
thyristor diode bloqué en inverse, m 521-04-62
thyristor diode passant en inverse, m .. 521-04-64
thyristor N, m 521-04-70
thyristor P, m 521-04-69
thyristor triode bidirectionnel, m 521-04-67
thyristor triode bloqué en inverse, m 521-04-63
thyristor triode passant en inverse, m .. 521-04-65

tirage
croissance par tirage (d'un monocristal), f 521-03-01
jonction par tirage, f 521-02-77

tranche
tranche, f 521-05-29

transconductance
transconductance (d'un transistor à effet de champ), f .. 521-07-25

transfert
capteur d'image à transfert de charge, m 521-11-17
dispositif à transfert de charge, m 521-11-14
fréquence du rapport de transfert unité de courant , f 521-07-22
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m 521-07-19
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f 521-07-20

transistor
transistor, m 521-04-46
transistor bidirectionnel, m 521-04-49
transistor bipolaire à jonctions, m 521-04-47
transistor à effet de champ, m 521-04-52
transistor à effet de champ à appauvrissement, m 521-04-58
transistor à effet de champ à canal N, m 521-04-56
transistor à effet de champ à canal P, m 521-04-57
transistor à effet de champ à déplétion, m 521-04-58
transistor à effet de champ à enrichissement, m 521-04-59
transistor à effet de champ à grille isolé, m 521-04-54
transistor à effet de champ à jonction de grille, m 521-04-53
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m 521-04-55
transistor à effet de champ métal-semiconducteur, m 521-04-60
transistor tétrode, m 521-04-50
transistor unipolaire, m 521-04-48

transition
fréquence de transition , f 521-07-21
région de transition, f 521-02-66
zone de transition de la concentration des impuretés, f 521-02-67

triac
triac (abréviation) 521-04-67

triode
thyristor triode bidirectionnel, m 521-04-67
thyristor triode bloqué en inverse, m 521-04-63
thyristor triode passant en inverse, m .. 521-04-65

trou
conduction par trous, f 521-02-18
trou, m 521-02-17

tunnel
diode tunnel, f 521-04-05
effet tunnel (dans une jonction PN), m 521-02-83

type
conductivité de type N, f 521-02-49
conductivité de type P, f 521-02-50
semiconducteur type N, m 521-02-09
semiconducteur type P, m 521-02-10

U

unipolaire
transistor unipolaire, m 521-04-48

unité
fréquence du rapport de transfert unité de courant , f 521-07-22
fréquence unité, f 521-07-22

unitunnel
diode unitunnel, f 521-04-06

V

valence
bande de valence, f 521-02-23

valeur
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f 521-07-20

vallée
point de vallée (d'une diode tunnel), m 521-06-02

vapeur
dépôt en phase vapeur, m 521-03-15

variable
diode à capacité variable, f 521-04-07

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

verrouillage
état de verrouillage, m 521-10-11
vide
bande vide, f 521-02-33
pulvérisation sous vide, f 521-03-17
vie
durée de vie dans le matériau (des porteurs minoritaires), f 521-02-57
virtuelle
température virtuelle (d'un dispositif à semiconducteurs), f..... 521-05-14
température virtuelle (équivalente) de jonction, f 521-05-15
vitesse
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f..... 521-01-19
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-05
vitesse critique de croissance du courant à l'état passant, f..... 521-08-19
vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué, f 521-08-18
vitesse de recombinaison en surface, f 521-02-56
vive
mémoire vive, f 521-11-07
mémoire vive dynamique, f..... 521-11-10
mémoire vive statique, f..... 521-11-09
volatile
mémoire volatile, f..... 521-11-11

Z

Zener
claquage par effet Zener (d'une jonction PN), m 521-05-09
tension de Zener, f..... 521-05-10
zone
croissance d'un monocristal par fusion de zone, f 521-03-02
nivellement par zone, m..... 521-03-04
purification par zone, f 521-03-03
zone de transition de la concentration des impuretés, f 521-02-67

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INDEX

A

abrupt
abrupt junction 521-02-73
acceptor
acceptor 521-02-39
acceptor level 521-02-41
ionizing energy of acceptor 521-02-44
access
serial access memory 521-11-12
activation
impurity activation energy 521-02-05
addressable
content addressable memory 521-11-13
alloy
alloy technique 521-03-07
alloyed
alloyed junction 521-02-75
angle
Hall angle 521-09-03
angular
total angular momentum quantum number 521-01-11
anode
anode characteristic 521-08-06
anode-to-cathode (voltage-current) characteristic 521-08-06
application
application specific integrated circuit ... 521-11-18
area
effective induction area of the control current loop 521-09-09
effective induction area of the output loop 521-09-08
array
gate array 521-11-20
programmable gate array 521-11-03
programmable logic array 521-11-02
ASIC
ASIC (abbreviation) 521-11-18
associative
associative memory 521-11-13
asymmetrical
asymmetrical thyristor 521-04-71
atom
Bohr atom 521-01-06
avalanche
avalanche breakdown (of a PN junction) 521-05-07
avalanche photodiode 521-04-44
avalanche rectifier diode 521-04-20
avalanche voltage 521-05-08

B

backward
backward diode 521-04-06
band
Bloch band 521-02-25
conduction band 521-02-22
empty band 521-02-33
energy band 521-02-25
energy band (in a semiconductor) 521-02-26
excitation band 521-02-28
filled band 521-02-32
forbidden band 521-02-30
impurity band 521-02-37
partially occupied band 521-02-27
permitted band 521-02-29
surface band 521-02-34
valence band 521-02-23
barrier
potential barrier 521-02-69
potential barrier (of a PN junction) 521-02-70
Schottky barrier 521-02-71
base
base 521-07-03
common base 521-07-13
inverse common base 521-07-16
bi-directional
bi-directional diode thyristor 521-04-66
bi-directional transistor 521-04-49
bi-directional triode thyristor 521-04-67
bipolar
bipolar junction transistor 521-04-47
Bloch
Bloch band 521-02-25
blocking
reverse blocking diode thyristor 521-04-62
reverse blocking state (of a reverse blocking thyristor) 521-08-09
reverse blocking triode thyristor 521-04-63
Bohr
Bohr atom 521-01-06
Boltzmann
Boltzmann relation 521-01-04
boundary
PN boundary 521-02-65
breakdown
avalanche breakdown (of a PN junction) 521-05-07
breakdown (of a reverse-biased PN junction) 521-05-06
thermal breakdown (of a PN junction) . 521-05-11
Zener breakdown (of a PN junction) 521-05-09

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

breakover
breakover point 521-08-12
bucket-brigade
bucket-brigade device 521-11-15
bulk
bulk lifetime (of minority carriers) 521-02-57

C

capacitance
thermal capacitance 521-05-16
carrier
(charge) carrier (in a semiconductor) ... 521-02-51
carrier storage time 521-05-23
charge carrier storage (in a semiconductor) 521-02-62
excess carrier 521-02-54
majority carrier (in a semiconductor region) 521-02-52
minority carrier (in a semiconductor region) 521-02-53
cathode
anode-to-cathode (voltage-current) characteristic 521-08-06
CCD
CCD (abbreviation) 521-11-16
cell
cell (in a semiconductor) 521-11-21
macro cell 521-11-22
memory cell 521-11-04
photoconductive cell 521-04-33
photovoltaic cell 521-04-34
centre
recombination centre 521-02-64
channel
channel (of a field-effect transistor) 521-07-06
characteristic
anode characteristic 521-08-06
anode-to-cathode (voltage-current) characteristic 521-08-06
magnetoresistive characteristic curve .. 521-09-17
principal (voltage-current) characteristic 521-08-05
charge
(charge) carrier (in a semiconductor) ... 521-02-51
charge carrier storage (in a semiconductor) 521-02-62
recovered charge (of a diode or thyristor) 521-05-18
charge-coupled
charge-coupled device 521-11-16
charge-transfer
charge-transfer device 521-11-14
charge-transfer image sensor 521-11-17
chip
chip 521-05-30
circuit
application specific integrated circuit ... 521-11-18
circuit parameter 521-05-34
equivalent circuit 521-05-35
film integrated circuit 521-10-06
integrated circuit 521-10-03
integrated circuit memory 521-11-05
multi-chip integrated circuit 521-10-10
parasitic circuit element 521-05-36
semiconductor integrated circuit 521-10-05
semicustom integrated circuit 521-11-19
coefficient
Hall coefficient 521-09-02
magnetoresistive coefficient 521-09-18
collector
collector 521-07-05
collector junction 521-07-02
common collector 521-07-14
inverse common collector 521-07-17
common
common base 521-07-13
common collector 521-07-14
common emitter 521-07-15
inverse common base 521-07-16
inverse common collector 521-07-17
inverse common emitter 521-07-18
compensated
compensated semiconductor 521-02-11
compensation
impurity compensation 521-03-06
composition
stochiometric composition 521-02-46
compound
compound semiconductor 521-02-03
concentration
impurity concentration transition zone . 521-02-67
conducting
reverse conducting diode thyristor 521-04-64
reverse conducting triode thyristor 521-04-65
conduction
conduction band 521-02-22
conduction current 521-02-15
conduction electron 521-02-14
electron conduction 521-02-19
hole conduction 521-02-18
intrinsic conduction 521-02-20
ionic conduction 521-02-21
conductivity
conductivity modulation (of a semiconductor) 521-02-55
intrinsic conductivity 521-02-48
N-type conductivity 521-02-49
P-type conductivity 521-02-50
conductor
conductor 521-02-16

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

constant
diffusion constant (of charge carriers).. 521-02-61
content
content addressable memory 521-11-13
control
control current (of a Hall generator)..... 521-09-11
control current sensitivity (of a Hall probe) 521-09-13
control current terminal (of a Hall generator)..... 521-09-07
effective induction area of the control current loop 521-09-09
induced control voltage (of a Hall-effect device)..... 521-09-16
residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) 521-09-14
Corbino
Corbino disc..... 521-04-30
critical
critical rate of rise of off-state voltage .. 521-08-18
critical rate of rise of on-state current... 521-08-19
crystal
ideal crystal..... 521-02-45
current
conduction current 521-02-15
control current (of a Hall generator)..... 521-09-11
control current sensitivity (of a Hall probe) 521-09-13
control current terminal (of a Hall generator)..... 521-09-07
critical rate of rise of on-state current... 521-08-19
effective induction area of the control current loop 521-09-09
frequency of unity current transfer ratio..... 521-07-22
gate non-trigger current 521-08-17
gate trigger current 521-08-14
holding current..... 521-08-10
latching current 521-08-11
principal current 521-08-02
residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) 521-09-14
small-signal short-circuit forward current transfer ratio..... 521-07-19
static forward current transfer ratio 521-07-20
current-regulator
current-regulator diode 521-04-18
curve
magnetoresistive characteristic curve.. 521-09-17
cut-off
cut-off frequency..... 521-05-20
cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor) 521-07-23
resistive cut-off frequency..... 521-06-04
Czochralski
growing by Czochralski's method 521-03-01

D

degenerate
degenerate semiconductor 521-02-13
delay-time
delay-time..... 521-05-21
depletion
depletion layer (of a semiconductor).... 521-02-82
depletion mode operation 521-07-10
depletion type field-effect transistor 521-04-58
deposition
vapour-phase deposition technique..... 521-03-15
detector
(semiconductor) photoelectric detector 521-04-42
detector diode..... 521-04-11
device
(semiconductor) photosensitive device 521-04-41
bucket-brigade device 521-11-15
charge-coupled device 521-11-16
charge-transfer device..... 521-11-14
discrete (semiconductor) device..... 521-04-02
electrostatic-discharge-sensitive device 521-05-27
Hall effect device 521-04-24
optoelectronic device..... 521-04-31
programmable logic device..... 521-11-01
semiconductor device..... 521-04-01
diac
diac (abbreviation)..... 521-04-66
diagram
energy-level diagram 521-01-13
die
die..... 521-05-30
differential
negative differential resistance region . 521-05-05
diffused
diffused junction..... 521-02-76
diffusion
diffusion (in a semiconductor)..... 521-02-59
diffusion constant (of charge carriers) . 521-02-61
diffusion length (of minority carriers).... 521-02-60
diffusion technique..... 521-03-08
diode
(semiconductor) diode 521-04-03
(semiconductor) rectifier diode 521-04-19
avalanche rectifier diode..... 521-04-20
backward diode 521-04-06
bi-directional diode thyristor..... 521-04-66
current-regulator diode 521-04-18
detector diode..... 521-04-11
frequency-multiplication diode 521-04-09
infrared-emitting diode..... 521-04-40
laser diode..... 521-04-37
light-emitting diode 521-04-39
microwave limiting diode..... 521-04-15

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

microwave switching diode 521-04-14
mixer diode 521-04-08
modulator diode 521-04-10
reverse blocking diode thyristor 521-04-62
reverse conducting diode thyristor 521-04-64
signal diode 521-04-04
snap-off diode 521-04-12
step recovery diode 521-04-12
switching diode 521-04-13
tunnel diode 521-04-05
unitunnel diode 521-04-06
variable-capacitance diode 521-04-07
voltage-reference diode 521-04-16
voltage-regulator diode 521-04-17

direction
forward direction (of a PN junction)..... 521-05-03
inverse direction of operation..... 521-07-12
reverse direction (of a PN junction)..... 521-05-04

discrete
discrete (semiconductor) device 521-04-02

display
optoelectronic display 521-04-36

disc
Corbino disc..... 521-04-30

distribution
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law 521-01-19

donor
donor 521-02-38
donor level 521-02-40
ionizing energy of donor 521-02-43

doping
doping (of a semiconductor) 521-03-05

drain
drain (of a field-effect transistor) 521-07-08

drift
(drift) mobility (of a charge carrier)..... 521-02-58

dynamic
dynamic (read/write) memory 521-11-10

E

effect
Hall effect..... 521-09-01
Hall effect device 521-04-24
Hall effect magnetometer..... 521-04-28
magnetoresistive effect..... 521-02-84
photoconductive effect..... 521-01-22
photoelectric effect..... 521-01-20
photoelectromagnetic effect..... 521-01-23
photovoltaic effect..... 521-01-21
piezoresistive effect 521-02-85
tensoresistive effect..... 521-02-85
tunnel effect (in a PN junction)..... 521-02-83

effective
effective induction area of the control current loop 521-09-09
effective induction area of the output loop 521-09-08

electric
internal electric field..... 521-02-81

electrode
electrode (of a semiconductor device). 521-05-01

electron
conduction electron 521-02-14
electron conduction 521-02-19
lone electron 521-01-18

electrostatic-discharge-sensitive
electrostatic-discharge-sensitive device 521-05-27

element
memory element..... 521-11-04
parasitic circuit element 521-05-36

emitter
common emitter..... 521-07-15
emitter..... 521-07-04
emitter junction 521-07-01
inverse common emitter 521-07-18

empty
empty band..... 521-02-33

energy
energy band..... 521-02-25
energy band (in a semiconductor) 521-02-26
energy gap..... 521-02-24
energy level (of a particle) 521-01-12
impurity activation energy..... 521-02-05
ionizing energy of acceptor..... 521-02-44
ionizing energy of donor 521-02-43

energy-level
energy-level diagram 521-01-13

enhancement
enhancement mode operation 521-07-11
enhancement type field-effect transistor..... 521-04-59

epitaxy
epitaxy 521-03-12

equivalent
equivalent circuit..... 521-05-35
internal equivalent temperature (of a semiconductor device)..... 521-05-14
virtual (equivalent) junction temperature 521-05-15

excess
excess carrier 521-02-54

excitation
excitation band 521-02-28

exclusion
Pauli-Fermi exclusion principle 521-01-14

extrinsic
extrinsic semiconductor 521-02-08

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

F

fall
fall time 521-05-24
Fermi
Fermi level 521-01-17
Fermi statistics 521-01-15
Fermi-Dirac
Fermi-Dirac function 521-01-16
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law 521-01-19
Fermi-Dirac statistics 521-01-15
field
internal electric field 521-02-81
residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) 521-09-15
self field (of a Hall generator) 521-09-10
field-effect
depletion type field-effect transistor 521-04-58
enhancement type field-effect transistor 521-04-59
field-effect transistor 521-04-52
insulated-gate field-effect transistor 521-04-54
junction-gate field-effect transistor 521-04-53
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 521-04-55
N-channel field-effect transistor 521-04-56
P-channel field-effect transistor 521-04-57
filled
filled band 521-02-32
film
film (of a film integrated circuit) 521-10-07
film integrated circuit 521-10-06
thick film (of a film integrated circuit) 521-10-09
thin film (of a film integrated circuit) 521-10-08
first
first quantum number 521-01-08
floating
floating voltage 521-05-17
forbidden
forbidden band 521-02-30
forward
forward direction (of a PN junction) 521-05-03
forward recovery time 521-05-25
forward slope resistance 521-06-05
small-signal short-circuit forward current transfer ratio 521-07-19
static forward current transfer ratio 521-07-20
frame
lead frame (of a package) 521-05-32
frequency
cut-off frequency 521-05-20
frequency of unity current transfer ratio 521-07-22
resistive cut-off frequency 521-06-04
transition frequency 521-07-21
frequency-multiplication
frequency-multiplication diode 521-04-09
function
Fermi-Dirac function 521-01-16

G

gap
energy gap 521-02-24
gate
gate 521-08-01
gate (of a field-effect transistor) 521-07-09
gate array 521-11-20
gate non-trigger current 521-08-17
gate trigger current 521-08-14
gate trigger voltage 521-08-15
gate non-trigger voltage 521-08-16
programmable gate array 521-11-03
generator
Hall generator 521-04-26
growing
growing by Czochralski's method 521-03-01
growing by pulling (of a single crystal) 521-03-01
growing by zone melting (of a single crystal) 521-03-02
grown
grown junction 521-02-77

H

Hall
Hall angle 521-09-03
Hall coefficient 521-09-02
Hall effect 521-09-01
Hall effect device 521-04-24
Hall effect magnetometer 521-04-28
Hall generator 521-04-26
Hall mobility 521-09-04
Hall modulator 521-04-25
Hall multiplier 521-04-27
Hall probe 521-04-28
Hall terminals 521-09-06
Hall voltage 521-09-05
heat
heat sink 521-05-33
holding
holding current 521-08-10
hole
hole 521-02-17
hole conduction 521-02-18

I

ideal
ideal crystal 521-02-45
image
charge-transfer image sensor 521-11-17

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

imperfection
imperfection (of a crystal lattice) 521-02-47
implantation
ion implantation..... 521-03-14
impurity
impurity 521-02-04
impurity activation energy 521-02-05
impurity band 521-02-37
impurity compensation..... 521-03-06
impurity concentration transition zone . 521-02-67
impurity level..... 521-02-36
induced
induced control voltage (of a Hall-effect device)..... 521-09-16
induction
effective induction area of the control current loop 521-09-09
effective induction area of the output loop 521-09-08
infrared-emitting
infrared-emitting diode 521-04-40
insulant
insulant 521-02-31
insulated-gate
insulated-gate field-effect transistor..... 521-04-54
integrated
application specific integrated circuit ... 521-11-18
film integrated circuit..... 521-10-06
integrated circuit 521-10-03
integrated circuit memory 521-11-05
multi-chip integrated circuit 521-10-10
semiconductor integrated circuit 521-10-05
semicustom integrated circuit 521-11-19
internal
internal electric field 521-02-81
internal equivalent temperature (of a semiconductor device)..... 521-05-14
intrinsic
intrinsic conduction 521-02-20
intrinsic conductivity..... 521-02-48
intrinsic semiconductor 521-02-07
inverse
inverse common base..... 521-07-16
inverse common collector 521-07-17
inverse common emitter 521-07-18
inverse direction of operation..... 521-07-12
ion
ion implantation..... 521-03-14
ionic
ionic conduction 521-02-21
ionic semiconductor..... 521-02-06
ionizing
ionizing energy of acceptor..... 521-02-44
ionizing energy of donor 521-02-43

J

junction
abrupt junction 521-02-73
alloyed junction 521-02-75
bipolar junction transistor..... 521-04-47
collector junction..... 521-07-02
diffused junction..... 521-02-76
emitter junction 521-07-01
grown junction 521-02-77
junction 521-02-72
PN junction 521-02-78
progressive junction..... 521-02-74
virtual (equivalent) junction temperature 521-05-15
junction-gate
junction-gate field-effect transistor..... 521-04-53

L

laser
laser diode 521-04-37
laser-diode
laser-diode module 521-04-38
latching
latching current 521-08-11
latch-up
latch-up state 521-10-11
law
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law 521-01-19
Maxwell-Boltzmann velocity distribution law 521-01-05
layer
depletion layer (of a semiconductor).... 521-02-82
lead
lead frame (of a package)..... 521-05-32
LED
LED (abbreviation)..... 521-04-39
length
diffusion length (of minority carriers).... 521-02-60
level
acceptor level 521-02-41
donor level 521-02-40
energy level (of a particle) 521-01-12
Fermi level 521-01-17
impurity level..... 521-02-36
local level..... 521-02-35
surface level 521-02-42
levelling
zone levelling..... 521-03-04
lifetime
bulk lifetime (of minority carriers)..... 521-02-57
light-emitting
light-emitting diode 521-04-39
limiting
microwave limiting diode..... 521-04-15

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

local
local level 521-02-35
logic
programmable logic array 521-11-02
programmable logic device 521-11-01
lone
lone electron 521-01-18
loop
effective induction area of the control current loop 521-09-09
effective induction area of the output loop 521-09-08

M

macro
macro cell 521-11-22
magnetic
magnetic sensitivity (of a Hall probe) ... 521-09-12
residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) 521-09-15
magnetometer
Hall effect magnetometer 521-04-28
magnetoresistive
magnetoresistive characteristic curve .. 521-09-17
magnetoresistive coefficient 521-09-18
magnetoresistive effect 521-02-84
magnetoresistive ratio 521-09-19
magnetoresistive sensitivity 521-09-20
magnetoresistor
magnetoresistor 521-04-29
main
main terminal 521-08-03
majority
majority carrier (in a semiconductor region) 521-02-52
Maxwell-Boltzmann
Maxwell-Boltzmann statistics 521-01-03
Maxwell-Boltzmann velocity distribution law 521-01-05
melting
growing by zone melting (of a single crystal) 521-03-02
memory
associative memory 521-11-13
content addressable memory 521-11-13
dynamic (read/write) memory 521-11-10
integrated circuit memory 521-11-05
memory cell 521-11-04
memory element 521-11-04
random-access memory 521-11-08
read/write memory 521-11-07
read-only memory 521-11-06
serial access memory 521-11-12
static (read/write) memory 521-11-09
volatile memory 521-11-11
mesa
mesa technique 521-03-11
MESFET
MESFET (abbreviation) 521-04-60
metal-oxide-semiconductor
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 521-04-55
metal-semiconductor-field-effect
metal-semiconductor-field-effect transistor 521-04-60
method
growing by Czochralski's method 521-03-01
micro-alloy
micro-alloy technique 521-03-10
microassembly
microassembly 521-10-04
microcircuit
microcircuit 521-10-02
microelectronics
microelectronics 521-10-01
microwave
microwave limiting diode 521-04-15
microwave switching diode 521-04-14
minority
minority carrier (in a semiconductor region) 521-02-53
mixer
mixer diode 521-04-08
mobility
(drift) mobility (of a charge carrier) 521-02-58
Hall mobility 521-09-04
mode
depletion mode operation 521-07-10
enhancement mode operation 521-07-11
modulation
conductivity modulation (of a semiconductor) 521-02-55
modulator
Hall modulator 521-04-25
modulator diode 521-04-10
module
laser-diode module 521-04-38
momentum
total angular momentum quantum number 521-01-11
MOSFET
MOSFET (abbreviation) 521-04-55
multi-chip
multi-chip integrated circuit 521-10-10
multiplier
Hall multiplier 521-04-27

N

N-channel
N-channel field-effect transistor 521-04-56
negative
negative differential resistance region 521-05-05

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

neutral
neutral region 521-02-68
N-gate
N-gate thyristor 521-04-70
non-degenerate
non-degenerate semiconductor 521-02-12
non-quantized
non-quantized system (of particles) 521-01-01
non-trigger
gate non-trigger current 521-08-17
N-type
N-type conductivity 521-02-49
N-type semiconductor 521-02-09
number
first quantum number 521-01-08
orbital quantum number 521-01-09
principal quantum number 521-01-08
quantum number (of an electron in a given atom) 521-01-07
second quantum number 521-01-09
spin (quantum number) 521-01-10
total angular momentum quantum number 521-01-11

O

occupied
partially occupied band 521-02-27
off-state
critical rate of rise of off-state voltage .. 521-08-18
off-state 521-08-08
operation
depletion mode operation 521-07-10
enhancement mode operation 521-07-11
inverse direction of operation 521-07-12
optocoupler
optocoupler 521-04-45
optoelectronic
optoelectronic device 521-04-31
optoelectronic display 521-04-36
orbital
orbital quantum number 521-01-09
output
effective induction area of the output loop 521-09-08

P

package
package 521-05-31
parameter
circuit parameter 521-05-34
parasitic
parasitic circuit element 521-05-36
partially
partially occupied band 521-02-27
passivation
surface passivation 521-03-13
Pauli
Pauli principle 521-01-14
Pauli-Fermi
Pauli-Fermi exclusion principle 521-01-14
P-channel
P-channel field-effect transistor 521-04-57
peak
peak point (of a tunnel diode) 521-06-01
projected peak point (of a tunnel diode) 521-06-03
permitted
permitted band 521-02-29
P-gate
P-gate thyristor 521-04-69
photoconductive
photoconductive cell 521-04-33
photoconductive effect 521-01-22
photocoupler
photocoupler 521-04-45
photodiode
avalanche photodiode 521-04-44
photodiode 521-04-32
photoelectric
(semiconductor) photoelectric detector 521-04-42
photoelectric effect 521-01-20
photoelectromagnetic
photoelectromagnetic effect 521-01-23
photoemitter
photoemitter 521-04-35
photoresistor
photoresistor 521-04-43
photosensitive
(semiconductor) photosensitive device 521-04-41
photothyristor
photothyristor 521-04-72
phototransistor
phototransistor 521-04-51
photovoltaic
photovoltaic cell 521-04-34
photovoltaic effect 521-01-21
piezoresistive
piezoresistive effect 521-02-85
planar
planar technique 521-03-09
PLD
PLD (abbreviation) 521-11-01
PN
PN boundary 521-02-65
PN junction 521-02-78
point
breakover point 521-08-12
peak point (of a tunnel diode) 521-06-01
projected peak point (of a tunnel diode) 521-06-03
valley point (of a tunnel diode) 521-06-02

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

potential
potential barrier 521-02-69
potential barrier (of a PN junction) 521-02-70
principal
principal (voltage-current) characteristic 521-08-05
principal current 521-08-02
principal quantum number 521-01-08
principal voltage 521-08-04
principle
Pauli principle 521-01-14
Pauli-Fermi exclusion principle 521-01-14
probe
Hall probe 521-04-28
programmable
programmable gate array 521-11-03
programmable logic array 521-11-02
programmable logic device 521-11-01
progressive
progressive junction 521-02-74
projected
projected peak point (of a tunnel diode) 521-06-03
P-type
P-type conductivity 521-02-50
P-type semiconductor 521-02-10
pulling
growing by pulling (of a single crystal) 521-03-01
punch-through
punch-through (between two PN junctions) 521-05-12

Q

quantized
quantized system (of particles) 521-01-02
quantum
first quantum number 521-01-08
orbital quantum number 521-01-09
principal quantum number 521-01-08
quantum number (of an electron in a given atom) 521-01-07
second quantum number 521-01-09
spin (quantum number) 521-01-10
total angular momentum quantum number 521-01-11

R

RAM
RAM (abbreviation) 521-11-08
random-access
random-access memory 521-11-08
rate
critical rate of rise of off-state voltage .. 521-08-18
critical rate of rise of on-state current... 521-08-19
ratio
frequency of unity current transfer ratio 521-07-22
magnetoresistive ratio 521-09-19
small-signal short-circuit forward current transfer ratio 521-07-19
static forward current transfer ratio 521-07-20
read
dynamic (read/write) memory 521-11-10
read/write memory 521-11-07
static (read/write) memory 521-11-09
read-only
read-only memory 521-11-06
recombination
recombination centre 521-02-64
suface recombination velocity 521-02-56
recovered
recovered charge (of a diode or thyristor) 521-05-18
recovery
forward recovery time 521-05-25
reverse recovery time 521-05-26
step recovery diode 521-04-12
rectifier
(semiconductor) rectifier diode 521-04-19
(semiconductor) rectifier stack 521-04-21
avalanche rectifier diode 521-04-20
refining
zone refining 521-03-03
region
negative differential resistance region . 521-05-05
neutral region 521-02-68
space-charge region 521-02-79
space-charge region (of a PN junction) 521-02-80
transition region 521-02-66
relation
Boltzmann relation 521-01-04
residual
residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) 521-09-14
residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) 521-09-15
resistance
forward slope resistance 521-06-05
negative differential resistance region . 521-05-05
on-state slope resistance 521-08-13
thermal resistance 521-05-13
resistive
resistive cut-off frequency 521-06-04
reverse
reverse blocking diode thyristor 521-04-62
reverse blocking state (of a reverse blocking thyristor) 521-08-09
reverse blocking triode thyristor 521-04-63
reverse conducting diode thyristor 521-04-64

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

reverse conducting triode thyristor 521-04-65
reverse direction (of a PN junction)..... 521-05-04
reverse recovery time 521-05-26
rise
critical rate of rise of off-state voltage .. 521-08-18
critical rate of rise of on-state current..... 521-08-19
rise time 521-05-22
ROM
ROM (abbreviation) 521-11-06

S

Schottky
Schottky barrier..... 521-02-71
screen-printing
screen-printing technique 521-03-16
second
second quantum number 521-01-09
self
self field (of a Hall generator)..... 521-09-10
semiconductor
(semiconductor) diode 521-04-03
(semiconductor) photoelectric detector..... 521-04-42
(semiconductor) photosensitive device 521-04-41
(semiconductor) rectifier diode 521-04-19
(semiconductor) rectifier stack..... 521-04-21
compensated semiconductor..... 521-02-11
compound semiconductor..... 521-02-03
degenerate semiconductor 521-02-13
discrete (semiconductor) device 521-04-02
extrinsic semiconductor 521-02-08
intrinsic semiconductor 521-02-07
ionic semiconductor..... 521-02-06
non-degenerate semiconductor 521-02-12
N-type semiconductor..... 521-02-09
P-type semiconductor 521-02-10
semiconductor 521-02-01
semiconductor device 521-04-01
semiconductor integrated circuit 521-10-05
semiconductor thermoelement 521-04-23
single-element semiconductor 521-02-02
semicustom
semicustom integrated circuit 521-11-19
sensitivity
control current sensitivity (of a Hall probe) 521-09-13
magnetic sensitivity (of a Hall probe)... 521-09-12
magnetoresistive sensitivity 521-09-20
sensor
charge-transfer image sensor..... 521-11-17
serial
serial access memory..... 521-11-12
short-circuit
small-signal short-circuit forward current transfer ratio..... 521-07-19
signal
signal diode 521-04-04
single-element
single-element semiconductor..... 521-02-02
sink
heat sink 521-05-33
slope
forward slope resistance..... 521-06-05
on-state slope resistance..... 521-08-13
small-signal
small-signal short-circuit forward current transfer ratio 521-07-19
snap-off
snap-off diode..... 521-04-12
Sommerfeld
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law..... 521-01-19
source
source (of a field-effect transistor) 521-07-07
space-charge
space-charge region..... 521-02-79
space-charge region (of a PN junction)..... 521-02-80
specific
application specific integrated circuit ... 521-11-18
spin
spin (quantum number)..... 521-01-10
sputtering
sputtering..... 521-03-17
stack
(semiconductor) rectifier stack..... 521-04-21
state
critical rate of rise of on-state current .. 521-08-19
latch-up state 521-10-11
on-state..... 521-08-07
on-state slope resistance..... 521-08-13
reverse blocking state (of a reverse blocking thyristor)..... 521-08-09
static
static (read/write) memory 521-11-09
static forward current transfer ratio 521-07-20
statistics
Fermi statistics..... 521-01-15
Fermi-Dirac statistics 521-01-15
Maxwell-Boltzmann statistics..... 521-01-03
step
step recovery diode 521-04-12
stochiometric
stochiometric composition 521-02-46
storage
carrier storage time..... 521-05-23
charge carrier storage (in a semiconductor) 521-02-62
substrate
substrate..... 521-05-28

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

surface
surface band 521-02-34
surface level 521-02-42
surface passivation 521-03-13
surface recombination velocity..... 521-02-56
switching
microwave switching diode 521-04-14
switching diode 521-04-13
system
non-quantized system (of particles)..... 521-01-01
quantized system (of particles)..... 521-01-02

T

technique
alloy technique..... 521-03-07
diffusion technique..... 521-03-08
mesa technique 521-03-11
micro-alloy technique..... 521-03-10
planar technique 521-03-09
screen-printing technique 521-03-16
vapour-phase deposition technique..... 521-03-15
temperature
internal equivalent temperature (of a semiconductor device)..... 521-05-14
virtual (equivalent) junction temperature 521-05-15
virtual temperature..... 521-05-14
tensoresistive
tensoresistive effect..... 521-02-85
terminal(s)
control current terminal (of a Hall generator)..... 521-09-07
Hall terminals..... 521-09-06
main terminal 521-08-03
terminal(of a semiconductor device)..... 521-05-02
tetrode
tetrode transistor..... 521-04-50
thermal
thermal breakdown (of a PN junction).. 521-05-11
thermal capacitance..... 521-05-16
thermal resistance 521-05-13
thermistor
thermistor..... 521-04-22
thermoelement
semiconductor thermoelement 521-04-23
thick
thick film (of a film integrated circuit)..... 521-10-09
thin
thin film (of a film integrated circuit)..... 521-10-08
threshold
threshold voltage (of a diode or thyristor)..... 521-05-19
threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor)..... 521-07-24
thyristor
asymmetrical thyristor..... 521-04-71
bi-directional diode thyristor..... 521-04-66
bi-directional triode thyristor..... 521-04-67
N-gate thyristor..... 521-04-70
P-gate thyristor 521-04-69
reverse blocking diode thyristor..... 521-04-62
reverse blocking triode thyristor..... 521-04-63
reverse conducting diode thyristor..... 521-04-64
reverse conducting triode thyristor..... 521-04-65
thyristor..... 521-04-61
turn-off thyristor 521-04-68
time
carrier storage time..... 521-05-23
fall time 521-05-24
forward recovery time 521-05-25
reverse recovery time 521-05-26
rise time..... 521-05-22
total
total angular momentum quantum number..... 521-01-11
transconductance
transconductance (of a field-effect transistor)..... 521-07-25
transfer
frequency of unity current transfer ratio..... 521-07-22
small-signal short-circuit forward current transfer ratio 521-07-19
static forward current transfer ratio 521-07-20
transistor
bi-directional transistor 521-04-49
bipolar junction transistor..... 521-04-47
depletion type field-effect transistor..... 521-04-58
enhancement type field-effect transistor..... 521-04-59
field-effect transistor 521-04-52
insulated-gate field-effect transistor..... 521-04-54
junction-gate field-effect transistor..... 521-04-53
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 521-04-55
metal-semiconductor-field-effect transistor..... 521-04-60
N-channel field-effect transistor..... 521-04-56
P-channel field-effect transistor 521-04-57
tetrode transistor..... 521-04-50
transistor..... 521-04-46
unipolar transistor..... 521-04-48
transition
impurity concentration transition zone . 521-02-67
transition frequency 521-07-21
transition region..... 521-02-66
trap
trap 521-02-63
triac
triac (abbreviation)..... 521-04-67
trigger
gate trigger current 521-08-14
gate trigger voltage..... 521-08-15
gate non-trigger voltage..... 521-08-16

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

triode
bi-directional triode thyristor 521-04-67
reverse blocking triode thyristor 521-04-63
reverse conducting triode thyristor 521-04-65
tunnel
tunnel diode 521-04-05
tunnel effect (in a PN junction) 521-02-83
turn-off
turn-off thyristor 521-04-68
type
depletion type field-effect transistor 521-04-58
enhancement type field-effect transistor 521-04-59

U

unipolar
unipolar transistor 521-04-48
unitunnel
unitunnel diode 521-04-06
unity
frequency of unity current transfer ratio 521-07-22

V

valence
valence band 521-02-23
valley
valley point (of a tunnel diode) 521-06-02
vapour-phase
vapour-phase deposition technique 521-03-15
variable-capacitance
variable-capacitance diode 521-04-07
velocity
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law 521-01-19
surface recombination velocity 521-02-56
velocity-distribution
Maxwell-Boltzmann velocity distribution law 521-01-05
virtual
virtual (equivalent) junction temperature 521-05-15
virtual temperature 521-05-14
volatile
volatile memory 521-11-11
voltage
avalanche voltage 521-05-08
critical rate of rise of off-state voltage 521-08-18
cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor) 521-07-23
floating voltage 521-05-17
gate trigger voltage 521-08-15
gate non-trigger voltage 521-08-16
Hall voltage 521-09-05
induced control voltage (of a Hall-effect device) 521-09-16
principal voltage 521-08-04
residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) 521-09-14
residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) 521-09-15
threshold voltage (of a diode or thyristor) 521-05-19
threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor) 521-07-24
Zener voltage 521-05-10
voltage-current
anode-to-cathode (voltage-current) characteristic 521-08-06
principal (voltage-current) characteristic 521-08-05
voltage-reference
voltage-reference diode 521-04-16
voltage-regulator
voltage-regulator diode 521-04-17

W

wafer
wafer 521-05-29
write
dynamic (read/write) memory 521-11-10
read/write memory 521-11-07
static (read/write) memory 521-11-09

Z

Zener
Zener breakdown (of a PN junction) 521-05-09
Zener voltage 521-05-10
zero
residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) 521-09-14
residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) 521-09-15
zone
growing by zone melting (of a single crystal) 521-03-02
impurity concentration transition zone 521-02-67
zone levelling 521-03-04
zone refining 521-03-03

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

索 引

A

按内容访问存储器 521-11-13
ASIC(缩写词) 521-11-18

B

半导体 521-02-01
(半导体)二极管 521-04-03
(半导体)分立器件 521-04-02
(半导体)光电探测器 521-04-42
(半导体)光敏器件 521-04-41
半导体集成电路 521-10-05
半导体器件 521-04-01
半导体温差电器件 521-04-23
半导体整流堆 521-04-21
(半导体)整流二极管 521-04-19
半定制集成电路 521-11-19
倍频二极管 521-04-09
本征半导体 521-02-07
本征导电 521-02-20
本征电导率 521-02-48
变容二极管 521-04-07
表面钝化 521-03-13
表面复合速度 521-02-56
表面带 521-02-34
表面能级 521-02-42
玻尔原子 521-01-06
玻尔兹曼关系 521-01-04
薄膜(膜集成电路的) 521-10-08
补偿半导体 521-02-11
部分占据带 521-02-27
布洛赫带 521-02-25

C

掺杂 521-03-05
场效应晶体管 521-04-52
衬底 521-05-28
穿通(两个PN结间的) 521-05-12
传导电流 521-02-15
传导电子 521-02-14
串行存取存储器 521-11-12
磁电阻比 521-09-19
磁电阻灵敏度 521-09-20
磁(电)阻器 521-04-29
磁电阻特性曲线 521-09-17
磁电阻系数 521-09-18
磁(电)阻效应 521-02-84
磁灵敏度(霍尔探头的) 521-09-12
存储单元 521-11-04
CCD(缩写词) 521-11-16

D

单极晶体管 521-04-48
单位电流传输比频率 521-07-22
单元(半导体中) 521-11-21
单元素半导体 521-02-02
导带 521-02-22
导体 521-02-16
等效电路 521-05-35
等效结温 521-05-15
电导率调制(半导体的) 521-02-55
电荷耦合器件 521-11-16
电荷转移器件 521-11-14
电荷转移图像传感器 521-11-17
电极(半导体器件的) 521-05-01
电流调整二极管 521-04-18
电路参数 521-05-34
电压调整二极管 521-04-17
电压基准二极管 521-04-16
电子导电 521-02-19
电阻性截止频率 521-06-04
动态(读写)存储器 521-11-10
读写存储器 521-11-07
断态 521-08-08
断态电压临界上升率 521-08-18
多(数载流)子(半导体中) 521-02-52
多片集成电路 521-10-10
diac(缩写词) 521-04-66

F

发光二极管 521-04-39
发射结 521-07-01
发射区 521-07-04
反向(PN结的) 521-05-04
反向二极管 521-04-06
反向工作 521-07-12
反向共发射极 521-07-18
反向共基极 521-07-16
反向共集电极 521-07-17
反向恢复时间 521-05-26
反向阻断二极晶闸管 521-04-62
反向阻断二极闸流晶体管 521-04-62
反向阻断三极晶闸管 521-04-63
反向阻断三极闸流晶体管 521-04-63
反向阻断态
(反向阻断闸流晶体管的) 521-08-09
非本征半导体 521-02-08
非对称晶闸管 521-04-71
非对称闸流晶体管 521-04-71
非简并半导体 521-02-12
非量子化系统(粒子的) 521-01-01
费米-狄拉克函数 521-01-16
费米-狄拉克-索末菲速度分布律 521-01-19
费米-狄拉克统计 521-01-15
费米能级 521-01-17
费米统计 521-01-15
峰点(隧道二极管的) 521-06-01
封装 521-05-31
浮置电压 521-05-17
复合中心 521-02-64
负微分电阻区 521-05-05

G

感应控制电压(霍尔效应器件的) 521-09-16
共发射极 521-07-15
共基极 521-07-13
共集电极 521-07-14
沟道(场效应晶体管的) 521-07-06
孤电子 521-01-18

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

谷点(隧道二极管的) 521-06-02
关联存储器 521-11-13
管芯 521-05-30
光磁电效应 521-01-23
光电导电池 521-04-33
光电导效应 521-01-22
光电二极管 521-04-32
光电晶体管 521-04-51
光电耦合器 521-04-45
光电效应 521-01-20
光电子器件 521-04-31
光电子显示器件 521-04-36
光发射器件 521-04-35
光伏电池 521-04-34
光伏效应 521-01-21
光控晶闸管 521-04-72
光敏电阻器 521-04-43
光敏闸流晶体管 521-04-72
光生伏打电池 521-04-34
光生伏打效应 521-01-21
轨道量子数 521-01-09
过渡区 521-02-66
过剩载流子 521-02-54

H

耗尽层(半导体的) 521-02-82
耗尽工作模式 521-07-10
耗尽型场效应晶体管 521-04-58
合金工艺 521-03-07
合金结 521-02-75
宏单元 521-11-22
红外发光二极管 521-04-40
厚膜(膜集成电路的) 521-10-09
戽链器件 521-11-15
化合物半导体 521-02-03
缓变结 521-02-74
恢复电荷(二极管或闸流晶体管的) 521-05-18
混频二极管 521-04-08
霍尔乘法器 521-04-27
霍尔电压 521-09-05
霍尔端 521-09-06
霍尔发生器 521-04-26
霍尔角 521-09-03
霍尔迁移率 521-09-04
霍尔探头 521-04-28
霍尔调制器 521-04-25
霍尔系数 521-09-02
霍尔效应 521-09-01
霍尔效应磁强计 521-04-28
霍尔效应器件 521-04-24

J

击穿(反向偏置PN结的) 521-05-06
激发带 521-02-28
激光二极管 521-04-37
激光二极管模块 521-04-38
基片 521-05-28
基区 521-07-03
集成电路 521-10-03
集成电路存储器 521-11-05
集电结 521-07-02
集电区 521-07-05
寄生电路元件 521-05-36
价带 521-02-23
简并半导体 521-02-13
检波二极管 521-04-11
溅射 521-03-17
阶跃恢复二极管 521-04-12
结 521-02-72
结栅场效应晶体管 521-04-53
截止电压
(耗尽型场效应晶体管的) 521-07-23
截止频率 521-05-20
金属-半导体场效应晶体管 521-04-60
金属氧化物半导体场效应晶体管 521-04-55
禁带 521-02-30
晶体管 521-04-46
晶(圆)片 521-05-29
晶闸管 521-04-61
静电放电敏感器件 521-05-27
静态(读写)存储器 521-11-09
静态正向电流传输比 521-07-20
局部能级 521-02-35
绝缘栅场效应晶体管 521-04-54
绝缘物 521-02-31

K

开关二极管 521-04-13
科尔比诺圆盘 521-04-30
可编程逻辑器件 521-11-01
可编程逻辑阵列 521-11-02
可编程门阵列 521-11-03
可关断晶闸管 521-04-68
可关断闸流晶体管 521-04-68
空带 521-02-33
空间电荷区 521-02-79
空间电荷区(PN结的) 521-02-80
空穴 521-02-17
空穴导电 521-02-18
控制电流(霍尔发生器的) 521-09-11
控制电流端(霍尔发生器的) 521-09-07
控制电流回路有效感应面积 521-09-09
控制电流灵敏度(霍尔探头的) 521-09-13
跨导(场效应晶体管的) 521-07-25
扩散(半导体中) 521-02-59
扩散长度(少数载流子的) 521-02-60
扩散常数(载流子的) 521-02-61
扩散工艺 521-03-08
扩散结 521-02-76

L

离子半导体 521-02-06
离子导电 521-02-21
离子注入 521-03-14
理想晶体 521-02-45
理想配比成份 521-02-46
量子化系统(粒子的) 521-01-02
量子数(给定原子中电子的) 521-01-07
零磁场剩余电压(霍尔探头的) 521-09-15
零控制电流剩余电压(霍尔探头的) 521-09-14
漏区(场效应晶体管的) 521-07-08
LED(缩写词) 521-04-39

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

M

麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布率 521-01-05
麦克斯韦-玻尔兹曼统计 521-01-03
满带 521-02-32
门极 521-08-01
门极不触发电流 521-08-17
门极不触发电压 521-08-16
门极触发电流 521-08-14
门极触发电压 521-08-15
门阵列 521-11-20
膜（ 膜集成电路的 ） 521-10-07
膜集成电路 521-10-06
MESFET(缩写词) 521-04-60
MOSFET(缩写词) 521-04-55

N

内部等效温度（ 半导体器件的 ） 521-05-14
能带 521-02-25
能带（ 半导体中 ） 521-02-26
能级（ 粒子的 ） 521-01-12
能级图 521-01-13
内建电场 521-02-81
能隙 521-02-24
逆导二极晶闸管 521-04-64
逆导二极闸流晶体管 521-04-64
逆导三极晶闸管 521-04-65
逆导三极闸流晶体管 521-04-65
N沟道场效应晶体管 521-04-56
N门极晶闸管 521-04-70
N栅闸流晶体管 521-04-70
N型半导体 521-02-09
N型电导率 521-02-49

P

泡利-费米不相容原理 521-01-14
泡利原理 521-01-14
（ 漂移 ）迁移率（ 载流子的 ） 521-02-58
平面工艺 521-03-09
P沟道场效应晶体管 521-04-57
P门极晶闸管 521-04-69
P栅闸流晶体管 521-04-69
P型半导体 521-02-10
P型电导率 521-02-50
PLD（ 缩写词 ） 521-11-01
PN结 521-02-78
PN界面 521-02-65

Q

齐纳电压 521-05-10
齐纳击穿 521-05-09
汽相淀积工艺 521-03-15
切克劳斯基法生长 521-03-01
擎住电流 521-08-11
区熔生长（ 单晶的 ） 521-03-02
区熔提纯 521-03-03
区熔夷平 521-03-04
缺陷（ 晶格的 ） 521-02-47

R

热沉 521-05-33
热击穿（ PN结的 ） 521-05-11
热敏电阻器 521-04-22
热容 521-05-16
热阻 521-05-13
RAM（ 缩写词 ） 521-11-08
ROM（ 缩写词 ） 521-11-06

S

栅极 521-08-01
栅极不触发电流 521-08-17
栅极不触发电压 521-08-16
栅极触发电流 521-08-14
栅极触发电压 521-08-15
栅区（ 场效应晶体管的 ） 521-07-09
上升时间 521-05-22
少（ 数载流 ）子（ 半导体中 ） 521-02-53
生长结 521-02-77
施主 521-02-38
施主电离能 521-02-43
施主能级 521-02-40
势垒 521-02-69
势垒（ PN结的 ） 521-02-70
受主 521-02-39
受主电离能 521-02-44
受主能级 521-02-41
输出回路有效感应面积 521-09-08
双极（ 结型 ）晶体管 521-04-47
双向二极晶闸管 521-04-66
双向二极闸流晶体管 521-04-66
双向晶体管 521-04-49
双向三极晶闸管 521-04-67
双向三极闸流晶体管 521-04-67
丝网印刷工艺 521-03-16
四极晶体管 521-04-50
随机存取存储器 521-11-08
隧道二极管 521-04-05
隧道效应（ PN结中 ） 521-02-83
锁定态 521-10-11

T

台面工艺 521-03-11
特征频率 521-07-21
体寿命（ 少数载流子的 ） 521-02-57
调制二极管 521-04-10
通态 521-08-07
通态电流临界上升率 521-08-19
通态斜率电阻 521-08-13
投影峰点(隧道二极管的) 521-06-03
突变结 521-02-73
triac(缩写词) 521-04-67

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

W

外壳 521-05-31
外延 521-03-12
微波开关二极管 521-04-14
微波限幅二极管 521-04-15
微电路 521-10-02
微电子学 521-10-01
微合金工艺 521-03-10
微组件 521-10-04
维持电流 521-08-10

X

下降时间 521-05-24
陷阱 521-02-63
肖特基势垒 521-02-71
小信号短路正向电流传输比 521-07-19
芯片 521-05-30
信号二极管 521-04-04
雪崩电压 521-05-08
雪崩光电二极管 521-04-44
雪崩击穿(半导体PN结的) 521-05-07
雪崩整流二极管 521-04-20

Y

压阻效应 521-02-85
延迟时间 521-05-21
阳极特性 521-08-06
阳极-阴极(电压-电流)特性 521-08-06
易失性存储器 521-11-11
引出端(半导体器件的) 521-05-02
引线框架(封装的) 521-05-32
有效结温 521-05-15
有效温度 521-05-14
阈值电压
(二极管或闸流晶体管的) 521-05-19
阈值电压
(增强型场效应晶体管的) 521-07-24
源区(场效应晶体管的) 521-07-07
允带 521-02-29

Z

杂质 521-02-04
杂质补偿 521-03-06
杂质带 521-02-37
杂质激活能 521-02-05
杂质能级 521-02-36
杂质浓度过渡区 521-02-67
载流子(半导体中) 521-02-51
载流子贮存(半导体中) 521-02-62
载流子贮存时间 521-05-23
增强工作模式 521-07-11
增强型场效应晶体管 521-04-59
闸流晶体管 521-04-61
正向(PN结的) 521-05-03
正向恢复时间 521-05-25
正向斜率电阻 521-06-05
直拉生长(单晶的) 521-03-01
只读存储器 521-11-06
中性区 521-02-68
主电流 521-08-02
主电压 521-08-04
主(电压-电流)特性 521-08-05
主端子 521-08-03
主量子数 521-01-08
专用集成电路 521-11-18
转折点 521-08-12
自建场(霍尔发生器的) 521-09-10
自旋(量子数) 521-01-10
总角动量量子数 521-01-11

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abfallzeit, f ... 521-05-24
abrupter Übergang, m ... 521-02-73
Abscheidung aus der Gasphase, f ... 521-03-15
Abschnürspannung (eines Feldeffekt-transistors vom Verarmungstyp), f ... 521-07-23
Akzeptor, m ... 521-02-39
Akzeptor-Ionisierungsenergie, f ... 521-02-44
Akzeptorniveau, n ... 521-02-41
allmählicher Übergang, m ... 521-02-74
Anoden-Kathoden-Kennlinie, f ... 521-08-06
Anoden-Kathoden-Spannungs-Strom-Charakteristik, f ... 521-08-06
Anodenkennlinie, f ... 521-08-06
anodenseitig steuerbarer Thyristor, m ... 521-04-70
Anregungsband, n ... 521-02-28
Anreicherungsbetrieb, m ... 521-07-11
Anschluss, m ... 521-05-02
Anschlusspunkt, m ... 521-05-02
Anstiegszeit, f ... 521-05-22
ASIC (Abkürzung) ... 521-11-18
ASIC-Schaltung, f ... 521-11-18
Assoziativspeicher, m ... 521-11-13
asymmetrischer Thyristor, m ... 521-04-71
Ausschaltthyristor, m ... 521-04-68

B

Bahndrehimpulsquantenzahl, f ... 521-01-09
Basis, f ... 521-07-03
Basisschaltung, f ... 521-07-13
Basiszone, f ... 521-07-03
BBD (Abkürzung) ... 521-11-15
Bezugsdiode, f ... 521-04-16
bidirektionaler Transistor, m ... 521-04-49
Bipolartransistor, m ... 521-04-47
Bloch-Energieband, n ... 521-02-25
Bohr-Atommodell, n ... 521-01-06
Boltzmann-Beziehung, f ... 521-01-04

C

CAM (Abkürzung) ... 521-11-13
CCD (Abkürzung) ... 521-11-16
Chip, m ... 521-05-30
Corbino-Scheibe, f ... 521-04-30
CTD (Abkürzung) ... 521-11-14

D

Defektelektron, n ... 521-02-17
Detektordiode, f ... 521-04-11
Diac (Abkürzung) ... 521-04-66
Dickschicht (einer integrierten Schichtschaltung), f ... 521-10-09
diffundierter Übergang, m ... 521-02-76
Diffusion, f ... 521-02-59
Diffusionskoeffizient (von Ladungsträgern), m ... 521-02-61
Diffusionslänge (von Minoritätsträgern), f ... 521-02-60
Diffusionstechnik, f ... 521-03-08
Diode, f ... 521-04-03
Donator, m ... 521-02-38
Donator-Ionisierungsenergie, f ... 521-02-43
Donatorniveau, n ... 521-02-40
doppeltgerichtete Thyristordiode, f ... 521-04-66
doppeltgerichtete Thyristortriode, f ... 521-04-67
dotieren (eines Halbleiters) (Verb) ... 521-03-05
Drain (eines Feldeffekttransistors), m ... 521-07-08
Drainzone (eines Feldeffekttransistors), m ... 521-07-08
Driftbeweglichkeit (eines Ladungsträgers), f ... 521-02-58
Dünnschicht (einer integrierten Schichtschaltung), f ... 521-10-08
Durchbruch (eines in Sperrrichtung vorgespannten PN-Übergangs), m ... 521-05-06
Durchgriff (zwischen zwei PN-Übergängen), m ... 521-05-12
Durchlassrichtung (eines PN-Übergangs), f ... 521-05-03
Durchlassverzögerungszeit, f ... 521-05-25
Durchlasszustand, m ... 521-08-07
dynamischer Schreib-Lese-Speicher, m ... 521-11-10
dynamischer Speicher, m ... 521-11-10

E

Eigenfeld (eines Hallgeräts), n ... 521-09-10
Eigenhalbleiter, m ... 521-02-07
Eigenleitfähigkeit, f ... 521-02-48
Eigenleitung, f ... 521-02-20
Eimerkettenschaltung, f ... 521-11-15
Einkristallziehen durch Zonenschmelzen, n ... 521-03-02
Einkristallziehen nach Czochralski, n ... 521-03-01
Einraststrom, m ... 521-08-11
Einraststromstärke, f ... 521-08-11
Einrastzustand, m ... 521-10-11
Einsfrequenz, f ... 521-07-22
Einzelbauelement, n ... 521-04-02
Einzelelektron, n ... 521-01-18
Einzelelement-Halbleiter, m ... 521-02-02
Einzelhalbleiterbauelement, n ... 521-04-02
Elektrode (eines Halbleiterbauelements), f ... 521-05-01
Elektronenleitung, f ... 521-02-19
elektrostatisch gefährdetes Bauelement, n ... 521-05-27
Emitter, m ... 521-07-04
Emitter-Basis-Zonenübergang, m ... 521-07-01
Emitterschaltung, f ... 521-07-15
Emitterübergang, m ... 521-07-01
Emitterzone, f ... 521-07-04

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

Empfindlichkeit eines Magnetowiderstands, f ... 521-09-20
Energieband (in einem Halbleiter), n ... 521-02-26
Energielücke, f ... 521-02-24
Energieniveau (eines Teilchens), n ... 521-01-12
Energieniveau-Diagramm, n ... 521-01-13
entarteter Halbleiter, m ... 521-02-13
Entdämpfungsfrequenz, f ... 521-06-04
Entladeverzug, m ... 521-05-23
Epitaxie, f ... 521-03-12
erlaubtes Band, n ... 521-02-29
Ersatzschaltung, f ... 521-05-35
Ersatz-Sperrschichttemperatur, f ... 521-05-15
Ersatztemperatur (eines Halbleiterbauelements), f ... 521-05-14
Ersatzwiderstand, m ... 521-08-13

F

Feldeffekttransistor mit Metall-Halbleiter, m ... 521-04-60
Feldeffekttransistor mit Metalloxid-Halbleiter, m ... 521-04-55
Feldeffekttransistor vom Anreicherungstyp, m ... 521-04-59
Feldeffekttransistor vom Verarmungstyp, m ... 521-04-58
Feldeffekttransistor, m ... 521-04-52
Fermi-Dirac-Funktion, f ... 521-01-16
Fermi-Dirac-Sommerfeld-Geschwindigkeitsverteilung, f ... 521-01-19
Fermi-Dirac-Statistik, f ... 521-01-15
Fermi-Niveau, n ... 521-01-17
Fermi-Statistik, f ... 521-01-15
Festspeicher, m ... 521-11-06
Festwertspeicher, m ... 521-11-06
flüchtiger Speicher, m ... 521-11-11
Frequenzvervielfacherdiode, f ... 521-04-09

G

Gate (eines Feldeffekttransistors), n ... 521-07-09
Gatezone (eines Feldeffekttransistors), m ... 521-07-09
Gatterfeld, n ... 521-11-20
gefülltes Band, n ... 521-02-32
Gehäuse, n ... 521-05-31
Gehäuserahmen, m ... 521-05-32
Gesamtdrehimpulsquantenzahl, f ... 521-01-11
gezogener Übergang, m ... 521-02-77
Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m ... 521-06-01
Gitterstörstelle, f ... 521-02-47
Gleichstromverhältnis, n ... 521-07-20
Grenzfrequenz, f ... 521-05-20
GTO-Thyristor, m ... 521-04-68

H

Haftstelle, f ... 521-02-63
Halbleiter, m ... 521-02-01
Halbleiterbauelement, n ... 521-04-01
Halbleiter-Detektordiode, f ... 521-04-11
Halbleiterdiode, f ... 521-04-03
Halbleiter-Gleichrichterbaugruppe, f ... 521-04-21
Halbleiter-Gleichrichterdiode, f ... 521-04-19
Halbleiter-Modulationsdiode, f ... 521-04-10
Halbleiter-Thermoelement, n ... 521-04-23
Hallanschlüsse, m, pl ... 521-09-06
Hallbeweglichkeit, f ... 521-09-04
Halleffekt, m ... 521-09-01
Halleffekt-Bauelement, n ... 521-04-24
Halleffekt-Magnetometer, m ... 521-04-28
Hallgenerator, m ... 521-04-26
Hallkoeffizient, m ... 521-09-02
Hallmodulator, m ... 521-04-25
Hallmultiplikator, m ... 521-04-27
Hallsonde, f ... 521-04-28
Hallspannung, f ... 521-09-05
Hallwinkel, m ... 521-09-03
Haltestrom, m ... 521-08-10
Haltestromstärke, f ... 521-08-10
Hauptanschluss, m ... 521-08-03
Hauptkennlinie, f ... 521-08-05
Hauptquantenzahl, f ... 521-01-08
Hauptspannung, f ... 521-08-04
Hauptstrom, m ... 521-08-02
Haupt-Strom-Spannungs-Charakteristik, f ... 521-08-05
höchste nichtzündende Steuerspannung, f ... 521-08-16
höchster nichtzündender Steuerstrom, m ... 521-08-17
Höckerpunkt (einer Tunneldiode), m ... 521-06-01

I

Idealkristall, m ... 521-02-45
IGFET (Abkürzung) ... 521-04-54
induktive Restfläche des Hallstromkreises, f ... 521-09-08
induktive Restfläche des Steuerstromkreises, f ... 521-09-09
induzierte Steuerspannung (eines Halleffekt-Bauelements), f ... 521-09-16
infrarotemittierende Diode, f ... 521-04-40
inhaltsadressierbarer Speicher, m ... 521-11-13
inneres elektrisches Feld, n ... 521-02-81
integrierte Halbleiterschaltung, f ... 521-10-05
integrierte Kundenschaltung mit Standardelementen, f ... 521-11-19
integrierte Mehrchipschaltung, f ... 521-10-10
integrierte Schaltung, f ... 521-10-03
integrierte Schichtschaltung, f ... 521-10-06
integrierte Speicherschaltung, f ... 521-11-05
inverse Basisschaltung, f ... 521-07-16
inverse Emitterschaltung, f ... 521-07-18
inverse Kollektorschaltung, f ... 521-07-17
inverser Betrieb, m ... 521-07-12
Ionenhalbleiter, m ... 521-02-06
Ionenimplantation, f ... 521-03-14
Ionenleitung, f ... 521-02-21

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

IRED (Abkürzung) 521-04-40
isolierendes Medium (in der Halbleitertechnik), n 521-02-31
Isolierschicht-Feldeffekttransistor, m 521-04-54

K

Kanal (eines Feldeffekttransistors), m 521-07-06
Kapazitätsdiode, f 521-04-07
Kapazitätsvariationsdiode, f 521-04-07
kathodenseitig steuerbarer Thyristor, m . 521-04-69
Kennlinie eines Magnetowiderstands, f .. 521-09-17
Kipppunkt, m 521-08-12
Kollektor, m 521-07-05
Kollektor-Basis-Zonenübergang, m 521-07-02
Kollektorschaltung, f 521-07-14
Kollektorübergang, m 521-07-02
Kollektorzone, f 521-07-05
Kompensations-Halbleiter, m 521-02-11
kritische Spannungssteilheit, f 521-08-18
kritische Stromsteilheit, f 521-08-19
Kühlkörper, m 521-05-33
Kurzschluss-Stromübersetzung (bei kleiner Ansteuerung), f 521-07-19

L

ladungsgekoppelte Schaltung, f 521-11-16
Ladungsträger (in einem Halbleiter), m .. 521-02-51
Ladungsträgerspeicherung (in einem Halbleiter), f 521-02-62
Ladungsverschiebe-Bildabtaster, m 521-11-17
Ladungsverschiebeschaltung, f 521-11-14
Laserdiode, f 521-04-37
Laserdiodenmodul, n 521-04-38
Latch-up-Zustand, m 521-10-11
Lawinendurchbruch (eines PN-Übergangs), m 521-05-07
Lawinendurchbruchspannung, f 521-05-08
Lawinen-Gleichrichterdiode, f 521-04-20
Lawinen-Photodiode, f 521-04-44
LED (Abkürzung) 521-04-39
leeres Band, n 521-02-33
legierter Übergang, m 521-02-75
Legierungstechnik, f 521-03-07
Leiter (in der Halbleitertechnik), m 521-02-16
Leitfähigkeitsmodulation (eines Halbleiters), f 521-02-55
Leitungsband, n 521-02-22
Leitungselektron, n 521-02-14
Leitungsstrom, m 521-02-15
lichtemittierende Diode, f 521-04-39
lichtempfindliches Halbleiter-bauelement, n 521-04-41
Loch, n 521-02-17
Löcherleitung, f 521-02-18
lokales Niveau, n 521-02-35

M

magnetische Empfindlichkeit (einer Hallsonde), f 521-09-12
Magnetowiderstand, m 521-04-29
Magnetowiderstandseffekt, m 521-02-84
Majoritätsträger (in einer Halbleiterzone), m 521-02-52
Makrozelle, f 521-11-22
Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeits-verteilung, f 521-01-05
Maxwell-Boltzmann-Statistik, f 521-01-03
Mesatechnik, f 521-03-11
MESFET (Abkürzung) 521-04-60
Mikroelektronik, f 521-10-01
Mikrolegierungstechnik, f 521-03-10
Mikroschaltung, f 521-10-02
Mikrowellen-Begrenzerdiode, f 521-04-15
Mikrowellen-Schaltdiode, f 521-04-14
Minoritätsträger (in einer Halbleiterzone), m 521-02-53
Mischerdiode, f 521-04-08
Modulationsdiode, f 521-04-10
MOSFET (Abkürzung) 521-04-55

N

negativer differentieller Widerstandsbereich, m 521-05-05
neutrale Zone, f 521-02-68
N-Halbleiter, m 521-02-09
nichtentarteter Halbleiter, m 521-02-12
nichtquantisiertes System (von Teilchen), n 521-01-01
N-Kanal-Feldeffekttransistor, m 521-04-56
N-Leitfähigkeit, f 521-02-49

O

Oberflächenband, n 521-02-34
Oberflächenniveau, n 521-02-42
Oberflächenpassivierung, f 521-03-13
Oberflächen-Rekombinations-geschwindigkeit, f 521-02-56
optoelektronische Anzeige, f 521-04-36
optoelektronisches Halbleiter-bauelement, n 521-04-31
Optokoppler, m 521-04-45
örtliches Niveau, n 521-02-35

P

parasitäres Schaltungselement, n 521-05-36
Pauli-Prinzip, n 521-01-14
P-Halbleiter, m 521-02-10
Photodiode, f 521-04-32
Photoeffekt, m 521-01-20
photoelektrische Zelle, f 521-04-33
photoelektrischer Effekt, m 521-01-20
photoelektrischer Halbleiter-empfänger, m 521-04-42

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

photoelektromagnetischer Effekt, m 521-01-23
Photoelement, n 521-04-34
photoempfindliches Halbleiter-bauelement, n 521-04-41
Photoleiteffekt, m 521-01-22
photoleitfähige Halbleiterzelle, f 521-04-43
Photothyristor, m 521-04-72
Phototransistor, m 521-04-51
photovoltaische Zelle, f 521-04-34
photovoltaischer Effekt, m 521-01-21
Photowiderstand, m 521-04-43
Piezowiderstandseffekt, m 521-02-85
P-Kanal-Feldeffekttransistor, m 521-04-57
PLA (Abkürzung) 521-11-02
Planartechnik, f 521-03-09
P-Leitfähigkeit, f 521-02-50
PN-Grenzfläche, f 521-02-65
PN-Übergang, m 521-02-78
Potentialschwelle eines PN-Übergangs, f 521-02-70
Potentialschwelle, f 521-02-69
programmierbare Logik-Anordnung, f 521-11-02
programmierbare Logik-Schaltung, f 521-11-01
programmierbares Gatterfeld, n 521-11-03
projizierter Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m 521-06-03
projizierter Höckerpunkt (einer Tunneldiode), m 521-06-03

Q

Quantenzahl (eines Elektrons in einem gegebenen Atom), f 521-01-07
quantisiertes System (von Teilchen), n 521-01-02

R

RAM (Abkürzung) 521-11-08
Raumladungszone eines PN-Übergangs, f 521-02-80
Raumladungszone, f 521-02-79
Rekombinationszentrum, n 521-02-64
Restspannung bei Magnetfeld null (eines Halleffekt-Bauelements), f 521-09-15
Restspannung bei Steuerstrom null (einer Hallsonde), f 521-09-14
ROM (Abkürzung) 521-11-06
rückwärts leitende Thyristordiode, f 521-04-64
rückwärts leitende Thyristortriode, f 521-04-65
rückwärts sperrende Thyristordiode, f 521-04-62
rückwärts sperrende Thyristortriode, f 521-04-63
Rückwärtsrichtung (eines PN-Übergangs), f 521-05-04
Rückwärts-Sperrzustand (eines rückwärts sperrenden Thyristors), m 521-08-09

S

Schaltdiode, f 521-04-13
Schaltungsparameter, m 521-05-34
Schicht (einer integrierten Schichtschaltung), f 521-10-07
Schottky-Barriere, f 521-02-71
Schreib-Lese-Speicher, m 521-11-07
Schwebespannung, f 521-05-17
Schwellenspannung (einer Diode oder eines Thyristors), f 521-05-19
Schwellenspannung (eines Feldeffekt-transistors vom Anreicherungstyp), f 521-07-24
Siebdrucktechnik, f 521-03-16
Signaldiode, f 521-04-04
Source (eines Feldeffekttransistors), f 521-07-07
Sourcezone (eines Feldeffekttransistors), m 521-07-07
Spannungsreferenzdiode, f 521-04-16
Spannungsstabilisatordiode, f 521-04-17
Spannungswiderstandseffekt, m 521-02-85
Speicher mit seriellem Zugriff, m 521-11-12
Speicher mit wahlfreiem Zugriff, m 521-11-08
Speicherelement, n 521-11-04
Speicherschaltdiode, f 521-04-12
Speicherzeit, f 521-05-23
Sperrrichtung (eines PN-Übergangs), f 521-05-04
Sperrschicht-Feldeffekttransistor, m 521-04-53
Sperrschicht-Photoeffekt, m 521-01-21
Sperrschichttransistor, m 521-04-47
Sperrverzögerungsladung (einer Diode oder eines Thyristors), f 521-05-18
Sperrverzögerungszeit, f 521-05-26
Spin, m 521-01-10
Spinquantenzahl, f 521-01-10
statischer Schreib-Lese-Speicher, m 521-11-09
statischer Speicher, m 521-11-09
Steilheit (eines Feldeffekttransistors), f 521-07-25
Steueranschluss, m 521-08-01
Steueranschluss (eines Hallgenerators), m 521-09-07
Steuerstrom (eines Hallgenerators), m 521-09-11
Steuerstromempfindlichkeit (einer Hallsonde), f 521-09-13
stöchiometrische Zusammensetzung, f 521-02-46
Störstelle, f 521-02-04
Störstellen-Aktivierungsenergie, f 521-02-05
Störstellenband, n 521-02-37
Störstellen-Haftstelle, f 521-02-63
Störstellen-Halbleiter, m 521-02-08
Störstellenkompensation, f 521-03-06
Störstellenniveau, n 521-02-36
strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement, n 521-04-35
Stromstabilisatordiode, f 521-04-18
Stromverstärkungsfaktor (bei kleiner Ansteuerung), m 521-07-19
Substrat, n 521-05-28

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

T

Talpunkt (einer Tunneldiode), m 521-06-02
teilweise besetztes Band, n 521-02-27
thermischer Durchbruch (eines PN-Übergangs), m 521-05-11
thermischer Widerstand, m 521-05-13
Thermistor, m 521-04-22
Thyristor, m 521-04-61
Träger (in einem Halbleiter), m 521-02-51
Transistor, m 521-04-46
Transistortetrode, f 521-04-50
Transitfrequenz, f 521-07-21
Triac (Abkürzung) 521-04-67
Tunneldiode, f 521-04-05
Tunneleffekt (in einem PN-Übergang), m 521-02-83

U

Übergang, m 521-02-72
Übergangszone der Störstellendichte, f .. 521-02-67
Übergangszone, f 521-02-66
Überschussladungsträger, m 521-02-54
Überschussträger, m 521-02-54
Unipolartransistor, m 521-04-48
Unitunneldiode, f 521-04-06

V

Valenzband, n 521-02-23
Verarmungsbetrieb, m 521-07-10
Verarmungsschicht (eines Halbleiters), f 521-02-82
Verbindungshalbleiter, m 521-02-03
verbotenes Band, n 521-02-30
Verzögerungszeit, f 521-05-21
Volumenlebensdauer (von Minoritätsträgern), f 521-02-57
Vorwärts-Ersatzwiderstand, m 521-06-05
Vorwärtsrichtung (eines PN-Übergangs), f 521-05-03
Vorwärts-Sperrzustand, m 521-08-08

W

Wafer, m 521-05-29
Wärmekapazität, f 521-05-16
Wärmewiderstand, m 521-05-13
Widerstandskoeffizient eines Magnetowiderstands, m 521-09-18
Widerstandsverhältnis eines Magnetowiderstands, n 521-09-19

Z

Zelle (in einem Halbleiter), f 521-11-21
Zener-Durchbruch (eines PN-Übergangs), m 521-05-09
Zener-Spannung, f 521-05-10
Zerstäubung, f 521-03-17
Zonennivellieren, n 521-03-04
Zonenreinigen, n 521-03-03
Zündspannung, f 521-08-15
Zündstrom, m 521-08-14
zusammengesetzte Mikroschaltung, f 521-10-04
Zweirichtungs-Thyristordiode, f 521-04-66
Zweirichtungs-Thyristortriode, f 521-04-67
Zweirichtungstransistor, m 521-04-49

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INDICE

A

aceptador 521-02-39
acumulación de portadores de carga (en un semiconductor aislante)..... 521-02-62
aislante 521-02-31
ángulo de Hal 521-09-03
átomo de Bohr 521-01-06

B

banda de Bloch..... 521-02-25
banda de conducción 521-02-22
banda de energía 521-02-25
banda de energía (en un semiconductor)..... 521-02-26
banda de excitación..... 521-02-28
banda de impureza..... 521-02-37
banda de superficie 521-02-34
banda de valencia 521-02-23
banda llena..... 521-02-32
banda parcialmente ocupada 521-02-27
banda permitida..... 521-02-29
banda reservada..... 521-02-30
banda vacía..... 521-02-33
barrera de Schottky 521-02-71
barrera de potencial..... 521-02-69
barrera de potencial (de una unión PN).. 521-02-70
base..... 521-07-03
base común..... 521-07-13
base común inversa 521-07-16
bloque semiconductor rectificador..... 521-04-21
borne (de un dispositivo semiconductor) 521-05-02
bornes de control de corriente (de un generador de Hall)..... 521-09-07
bornes de Hall 521-09-06
bornes principales 521-08-03

C

campo eléctrico interno 521-02-81
campo inducido (de un generador de Hall)..... 521-09-10
canal (de un transistor de efecto de campo)..... 521-07-06
capa de agotamiento (de un semiconductor)..... 521-02-82
capacidad térmica 521-05-16
característica de ánodo 521-08-06
característica (corriente-tensión) de ánodo cátodo.... 521-08-06
característica (corriente-tensión) principal 521-08-05
carga recuperada (de un diodo o tiristor)..... 521-05-18
célula..... 521-11-21
célula de memoria 521-11-04
célula fotoconductora 521-04-33
célula fotovoltaica..... 521-04-34
centro de recombinación 521-02-64
chip..... 521-05-30
circuito equivalente..... 521-05-35
circuito integrado 521-10-03
circuito integrado de aplicación específica..... 521-11-18
circuito integrado de película..... 521-10-06
circuito integrado multichip 521-10-10
circuito integrado semiconductor..... 521-10-05
circuito integrado semipersonalizado 521-11-19
coeficiente de Hall 521-09-02
coeficiente de magnetorresistencia 521-09-18
colector..... 521-07-05
colector común 521-07-14
colector común inverso..... 521-07-17
compensación por impurezas..... 521-03-06
composición estequiométrica 521-02-46
conducción intrínseca..... 521-02-20
conducción iónica..... 521-02-21
conducción por electrones..... 521-02-19
conducción por huecos..... 521-02-18
conductividad intrínseca..... 521-02-48
conductividad tipo N 521-02-49
conductividad tipo P 521-02-50
conductor..... 521-02-16
constante de difusión (de portadores de carga)..... 521-02-61
corriente de conducción 521-02-15
corriente de control (de un generador de Hall)..... 521-09-11
corriente de disparo de puerta..... 521-08-14
corriente de mantenimiento..... 521-08-10
corriente de no disparo de puerta..... 521-08-17
corriente de retención..... 521-08-11
corriente principal 521-08-02
crecimiento de un monocristal por fusión de zona 521-03-02
crecimiento por el método de Czochralski 521-03-01
crecimiento por extracción (de un monocristal)..... 521-03-01
cristal ideal 521-02-45
curva característica de una magnetorresistencia 521-09-17

D

deposición en fase vapor..... 521-03-15
diac (en abreviatura) 521-04-66
diagrama energético..... 521-01-13
difusión (en un semiconductor) 521-02-59
diodo 521-04-03
diodo de capacidad variable..... 521-04-07
diodo de conmutación 521-04-13
diodo de conmutación de microondas.... 521-04-14
diodo de limitación de microondas 521-04-15
diodo de retorno rápido 521-04-13

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

diodo de señal 521-04-04
diodo de tensión de referencia 521-04-16
diodo detector 521-04-11
diodo electroluminiscente 521-04-39
diodo infrarrojo 521-04-40
diodo láser 521-04-37
diodo mezclador 521-04-08
diodo modulador 521-04-10
diodo para multiplicación de frecuencia .. 521-04-09
diodo rectificador 521-04-19
diodo rectificador de avalancha 521-04-20
diodo regulador de corriente 521-04-18
diodo regulador de tensión 521-04-17
diodo (semiconductor) 521-04-03
diodo semiconductor rectificador 521-04-19
diodo túnel 521-04-05
diodo unitúnel 521-04-06
disco de Corbino 521-04-30
dispositivo de acoplamiento de carga 521-11-16
dispositivo de efecto Hall 521-04-24
dispositivo de transferencia de carga 521-11-14
dispositivo discreto 521-04-02
dispositivo en serie 521-11-15
dispositivo fotosensible 521-04-41
dispositivo optoelectrónico 521-04-31
dispositivo semiconductor 521-04-01
dispositivo semiconductor discreto 521-04-02
dispositivo semiconductor fotosensible .. 521-04-41
dispositivo sensible a las descargas electrostáticas 521-05-27
donador 521-02-38
dopado (de un semiconductor) 521-03-05

E

efecto fotoconductivo 521-01-22
efecto fotoeléctrico 521-01-20
efecto fotoelectromagnético 521-01-23
efecto fotovoltaico 521-01-21
efecto Hall 521-09-01
efecto magnetorresistente 521-02-84
efecto piezorresistente 521-02-85
efecto tensorresistente 521-02-85
efecto túnel (en una unión PN) 521-02-83
electrodo (de un dispositivo semiconductor) 521-05-01
electrón suelto 521-01-18
electrones de conducción 521-02-14
elemento de circuito parásito 521-05-36
emisor 521-07-04
emisor común 521-07-15
emisor común inverso 521-07-18
energía de activación de impurezas 521-02-05
energía de ionización de un aceptador ... 521-02-44
energía de ionización de un donador 521-02-43
envase 521-05-31
epítaxis 521-03-12
espin 521-01-10
estadística de Fermi 521-01-15
estadística de Fermi-Dirac 521-01-15
estadística de Maxwell-Boltzmann 521-01-03
estado bloqueado 521-08-08
estado bloqueado en sentido inverso (de un tiristor bloqueado en sentido inverso) 521-08-09
estado conductor 521-08-07
estado de bloqueo 521-10-11

F

fotoacoplador 521-04-45
fotodiodo 521-04-32
fotodiodo de avalancha 521-04-44
fotoemisor 521-04-35
fotorresistencia 521-04-43
fototiristor 521-04-72
fototransistor 521-04-51
frecuencia de corte 521-05-20
frecuencia de corte resistiva 521-06-04
frecuencia de relación de transferencia unidad de corriente ... 521-07-22
frecuencia de transición 521-07-21
fuente (de un transistor de efecto de campo) 521-07-07
función de Fermi-Dirac 521-01-16
funcionamiento en modo de agotamiento 521-07-10
funcionamiento en modo de enriquecimiento 521-07-11

G

generador Hall 521-04-26

H

hueco 521-02-17

I

imperfección (de un sólido cristalino) 521-02-47
implantación iónica 521-03-14
impurezas 521-02-04

L

ley de distribución de las velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfedl 521-01-19
ley de distribución de las velocidades de Maxwell-Boltzmann 521-01-05
límite PN 521-02-65
longitud de difusión (de portadores minoritarios) 521-02-60

M

macrocélula 521-11-22
magnetómetro de efecto Hall 521-04-28
magnetorresistencia 521-04-29
matriz de puerta 521-11-20
matriz de puerta programable 521-11-03
matriz lógica programable 521-11-02

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

memoria asociativa 521-11-13
memoria de acceso directo 521-11-08
memoria de acceso secuencial 521-11-12
memoria de circuito integrado 521-11-05
memoria de lectura/escritura 521-11-07
memoria de lectura/escritura dinámica ... 521-11-10
memoria de lectura/escritura estática 521-11-09
memoria de sólo lectura 521-11-06
memoria direccionable por el contenido . 521-11-13
memoria volátil 521-11-11
microcircuito 521-10-02
microconjunto 521-10-04
microelectrónica 521-10-01
modulación de la conductividad (de un semiconductor) 521-02-55
módulo de diodo láser 521-04-38
movilidad de Hall 521-09-04
movilidad (de un portador de carga) 521-02-58
multiplicador Hall 521-04-27

N

nivel aceptador 521-02-41
nivel de energía (de una partícula) 521-01-12
nivel de Fermi 521-01-17
nivel de impureza 521-02-36
nivel de superficie 521-02-42
nivel donador 521-02-40
nivel energético (de una partícula) 521-01-12
nivelación local 521-02-35
nivelación por zona 521-03-04
número cuántico (de un electrón de un átomo dado) 521-01-07
número cuántico interno 521-01-11
número cuántico principal 521-01-08
número cuántico secundario 521-01-09

O

oblea 521-05-29
optoacoplador 521-04-45

P

pantalla optoelectrónica 521-04-36
parámetro de circuito 521-05-34
pastilla 521-05-30
película (de un circuito integrado de película) 521-10-07
película delgada (de un circuito integrado de película) ... 521-10-08
película gruesa (de un circuito integrado de película) ... 521-10-09
penetración (entre dos uniones PN) 521-05-12
perforación (de una unión PN polarizada en inversa) 521-05-06
perforación por avalancha (de una unión PN) 521-05-07
perforación por efecto térmico (de una unión PN) 521-05-11
perforación por efecto Zener (de una unión PN) 521-05-09
plaqueta 521-05-29
portador 521-02-51
portador (de carga) (en un semiconductor) 521-02-51
portador en exceso 521-02-54
portador mayoritario (en una región semiconductora) 521-02-52
portador minoritario (en una región semiconductora) 521-02-53
principio de exclusión de Pauli-Fermi 521-01-14
puerta 521-08-01
pulverización en vacío 521-03-17
punta de pico (de un diodo túnel) 521-06-01
punta de pico proyectada (de un diodo túnel) 521-06-03
punta de valle (de un diodo túnel) 521-06-02
punto de retorno 521-08-12
purificación por zona 521-03-03

R

radiador 521-05-33
receptor fotoeléctrico 521-04-42
receptor semiconductor fotoeléctrico 521-04-42
red lógica programable 521-11-01
región de carga de espacio 521-02-79
región de carga de espacio (de una unión PN) 521-02-80
región de resistencia diferencial negativa 521-05-05
región de transición 521-02-66
región neutra 521-02-68
rejilla (de un transistor de efecto de campo) 521-07-09
rejilla de conexión (de un envase) 521-05-32
relación de Boltzmann 521-01-04
relación de magnetorresistencia 521-09-19
relación de transferencia directa de corriente en pequeñas señales, con salida en cortocircuito 521-07-19
resistencia aparente directa 521-06-05
resistencia aparente en estado conductor 521-08-13
resistencia térmica (de un dispositivo semiconductor) 521-05-13
retardo de caída 521-05-23
retardo de subida 521-05-21

S

semiconductor 521-02-01
semiconductor compensado 521-02-11
semiconductor compuesto 521-02-03
semiconductor degenerado 521-02-13
semiconductor elemental 521-02-02
semiconductor extrínseco 521-02-08
semiconductor intrínseco 521-02-07

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

semiconductor iónico 521-02-06
semiconductor no degenerado 521-02-12
semiconductor tipo N 521-02-09
semiconductor tipo P 521-02-10
sensibilidad a la corriente de control (de una sonda de Hall) 521-09-13
sensibilidad de magnetorresistencia 521-09-20
sensibilidad magnética (de una sonda de Hall) 521-09-12
sensor de imagen de transferencia de carga 521-11-17
sentido directo (de una unión PN) 521-05-03
sentido inverso (de una unión PN) 521-05-04
sentido inverso de funcionamiento 521-07-12
separación energética 521-02-24
serigrafía 521-03-16
sistema cuantificado (de partículas) 521-01-02
sistema no cuantificado (de partículas) .. 521-01-01
sonda de Hall 521-04-28
substrato 521-05-28
sumidero (de un transistor de efecto de campo) 521-07-08
superficie efectiva de inducción del bucle de la corriente de control 521-09-09
superficie efectiva de inducción del bucle de salida 521-09-08

T

técnica de aleación 521-03-07
técnica de difusión 521-03-08
técnica de microaleación 521-03-10
técnica mesa 521-03-11
técnica planar 521-03-09
temperatura equivalente interna (de un dispositivo semiconductor) 521-05-14
temperatura virtual (de un dispositivo semiconductor) 521-05-14
temperatura virtual (equivalente) de unión 521-05-15
tensión de avalancha 521-05-08
tensión de bloqueo (de un transistor de efecto de campo de agotamiento) .. 521-07-23
tensión de control inducida (de un dispositivo de efecto Hall) 521-09-16
tensión de disparo de puerta 521-08-15
tensión de Hall 521-09-05
tensión de no disparo de puerta 521-08-16
tensión de umbral (de un diodo o tiristor) 521-05-19
tensión de umbral (de un transistor de efecto de campo de enriquecimiento) 521-07-24
tensión de Zener 521-05-10
tensión flotante 521-05-17
tensión principal 521-08-04
tensión residual para una corriente de control nula (de un dispositivo de efecto Hall) 521-09-14
tensión residual para un campo magnético nulo (de un dispositivo de efecto Hall) 521-09-15
termistancia 521-04-22
termoelemento semiconductor 521-04-23
tiempo de caída 521-05-24
tiempo de recuperación directa 521-05-25
tiempo de recuperación inversa 521-05-26
tiempo de subida 521-05-22
tiristor 521-04-61
tiristor asimétrico 521-04-71
tiristor bloqueable 521-04-68
tiristor diodo bidireccional 521-04-66
tiristor diodo bloqueado en inversa 521-04-62
tiristor diodo conductor en inversa 521-04-64
tiristor N 521-04-70
tiristor P 521-04-69
tiristor triodo bidimensional 521-04-67
tiristor triodo bloqueado en inversa 521-04-63
tiristor triodo conductor en inversa 521-04-65
trampa 521-02-63
transconductancia (de un transistor de efecto de campo) . 521-07-25
transistor 521-04-46
transistor bidireccional 521-04-49
transistor bipolar de unión 521-04-47
transistor de efecto de campo 521-04-52
transistor de efecto de campo de agotamiento 521-04-58
transistor de efecto de campo de canal N 521-04-56
transistor de efecto de campo de canal P 521-04-57
transistor de efecto de campo de enriquecimiento 521-04-59
transistor de efecto de campo de metal-óxido semiconductor 521-04-55
transistor de efecto de campo de metal-semiconductor 521-04-60
transistor de efecto de campo de rejilla aislada 521-04-54
transistor de efecto de campo de unión de rejilla 521-04-53
transistor tetrodo 521-04-50
transistor unipolar 521-04-48
triac (en abreviatura) 521-04-67

U

unión 521-02-72
unión abrupta 521-02-73
unión colector 521-07-02
unión emisor 521-07-01
unión gradual 521-02-74
unión PN 521-02-78
unión por aleación 521-02-75
unión por difusión 521-02-76
unión por extracción 521-02-77

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

V

valor estático de la relación
de transferencia directa de corriente ... 521-07-20
velocidad crítica de crecimiento
de la corriente de estado conductor..... 521-08-19
velocidad crítica de crecimiento
de la tensión de estado bloqueado..... 521-08-18
velocidad de recombinación
en superficie 521-02-56
vida media en el material
(de portadores minoritarios)..... 521-02-57

Z

zona de transición de la concentración
de impurezas 521-02-67

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

521 章
（半導体デバイス及び集積回路）

あ

集積回路；IC shuuseki-kairo; IC 521-10-03
集積回路メモリ；ICメモリ
shuuseki-kairo-memori; IC-memori..... 521-11-05
アクセプター akuseputaa 521-02-39
アクセプター準位 akuseputaa-jun'i..... 521-02-41
アクセプターのイオン化エネルギー
akuseputaa no ionka-enerugii 521-02-44
（与えられた原子内の電子の）量子数
(ataerareta genshinai no denshi no)
ryooshisuu 521-01-07
圧抵抗効果 atsu-teikoo-kooka 521-02-85
（膜集積回路の）厚膜
(maku-shuuseki-kairo no) atsumaku 521-10-09
（電圧-電流）アノード-カソード特性；
アノード特性
(den'atsu-denryuu) anoodo-kasoodo-
tokusei; anoodo-tokusei..... 521-08-06
アバランシェ形整流ダイオード
abaranshe-gata-seiryuu-daioodo..... 521-04-20
（半導体のPN接合の）アバランシェ降伏
(handootai no PN-setsugoo no)
abaranshe-koofuku..... 521-05-07
アバランシェ電圧 abaranshe-den'atsu 521-05-08
アバランシェフォトダイオード
abaranshe-foto-daioodo 521-04-44

い

イオン性半導体 ionsei-handootai 521-02-06
イオン注入 ion-chuunyuu 521-03-14
イオン伝導 ion-dendoo..... 521-02-21
（電荷の）（ドリフト）移動度
(denka no)(dorifuto) idoodo 521-02-58

う

ウェーハ weeha..... 521-05-29

え

特定用途向け IC；ASIC
tokutei-yootomuke-IC; eeshikku 521-11-18
N形伝導度 N-gata-dendoodo..... 521-02-49
N形半導体 N-gata-handootai..... 521-02-09
Nゲートサイリスタ N-geeto-sairisuta..... 521-04-70
Nチャネル電界効果トランジスタ
N-chaneru-denkaikooka-toranjisuta 521-04-56
エネルギーギャップ enerugii-gyappu..... 521-02-24
(粒子の）エネルギー準位
(ryuushi no) enerugii-jun'i 521-01-12
エネルギー準位図 enerugii-jun'izu..... 521-01-13
エネルギー帯；ブロッホ帯
enerugii-tai; burohho-tai..... 521-02-25
（半導体中の）エネルギー帯
(handootai-chuu no) enerugii-tai..... 521-02-26
エピタキシー epitakishii 521-03-12
エミッタ emitta 521-07-04
エミッタ接地 emitta-setchi..... 521-07-15
エミッタ接合 emitta-setsugoo 521-07-01
発光ダイオード；LED
hakkoo-daioodo; LED 521-04-39
エンハンスメント形電界効果トランジスタ
enhansumento-gata-denkaikooka-
toranjisuta..... 521-04-59
（エンハンスメント形電界効果トランジスタの）しきい値電圧
(enhansumento-gata-denkaikooka-toranjisuta
no) shiki'ichi-den'atsu 521-07-24
エンハンスメントモード動作
enhansumento-moodo-doosa..... 521-07-11

お

オフ状態 ofu-jootai 521-08-08
オン状態 on-jootai 521-08-07
オン状態勾配抵抗
on-jootai-koobai-teikoo 521-08-13

か

外因性半導体 gai'insei-handootai 521-02-08
階段接合 kaidan-setsugoo..... 521-02-73
（ダイオードやサイリスタの）回復電荷
(daioodo ya sairisuta no) kaifuku-denka.... 521-05-18
回路パラメータ kairo-parameeta 521-05-34
化学量論組成 kagaku-ryooron-sosei..... 521-02-46
（半導体中の）拡散
(handootai-chuu no) kakusan 521-02-59
拡散技術 kakusan-gijutsu 521-03-08
（電荷の）拡散定数
(denka no) kakusan-joosuu 521-02-61
拡散接合 kakusan-setsugoo 521-02-76
（少数キャリアの）拡散長
(shoosuu-kyaria no) kakusan-choo..... 521-02-60
化合物半導体 kagoobutsu-handootai..... 521-02-03
過剰キャリア kajoo-kyaria..... 521-02-54
仮想温度；（半導体デバイスの）内部等価温度
kasoo-ondo; (handootai-debaisu no)
naibu-tooka-ondo..... 521-05-14
仮想（等価）接合温度
kasoo (tooka) setsugoo-ondo 521-05-15
価電子帯 kadenshi-tai..... 521-02-23
可変容量ダイオード
kahen-yooryoo-daioodo..... 521-04-07
半導体感光性デバイス；感光性デバイス
handootai-kankoosei-debaisu;
kankoosei-debaisu..... 521-04-41
完全結晶 kanzen-kesshoo 521-02-45

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

き

基準電圧ダイオード
kijun-den'atsu-daioodo 521-04-16
寄生回路素子 kisei-kairo-soshi 521-05-36
気相成長技術 kisoo-seichoo-gijutsu 521-03-15
軌道量子数；第 2量子数
kidoo-ryooshisuu; daini-ryooshisuu 521-01-09
揮発性メモリ kihatsusei-memori 521-11-11
基板 kiban 521-05-28
逆阻止2端子サイリスタ
gyaku-soshi-2tanshi-sairisuta 521-04-62
逆阻止3端子サイリスタ
gyaku-soshi-3tanshi-sairisuta 521-04-63
（逆阻止サイリスタの）逆阻止状態
(gyaku-soshi-sairisuta no)
gyaku-soshi-jootai 521-08-09
逆導通2端子サイリスタ
gyaku-dootsuu-2tanshi-sairisuta 521-04-64
逆導通3端子サイリスタ
gyaku-dootsuu-3tanshi-sairisuta 521-04-65
（逆バイアスされたPN接合の）降伏
(gyaku-baiasu sareta PN-setsugoo no)
koofuku 521-05-06
（PN接合の）逆方向
(PN-setsugoo no) gyaku-hookoo 521-05-04
逆方向エミッタ接地
gyakuhookoo-emitta-setchi 521-07-18
逆方向回復時間
gyakuhookoo-kaifuku-jikan 521-05-26
逆方向コレクタ接地
gyakuhookoo-korekuta-setchi 521-07-17
逆方向動作 gyakuhookoo-doosa 521-07-12
逆方向ベース接地
gyakuhookoo-beesu-setchi 521-07-16
局在準位 kyokuzai-jun'i 521-02-35
許容帯 kyoyoo-tai 521-02-29
禁制帯 kinsei-tai 521-02-30
金属-酸化物-半導体電界効果トランジスタ；
MOSFET
kinzoku-sankabutsu-handootai-
denkaikooka-toranjisuta; MOSFET 521-04-55
金属半導体電界効果トランジスタ；MESFET
kinzoku-handootai-denkaikooka-toranjisuta;
mesu-FET; mesu-fetto 521-04-60

く

空間電荷領域 kuukan-denka-ryooiki 521-02-79
（PN接合の）空間電荷領域
(PN-setsugoo no) kuukan-denka-ryooiki ... 521-02-80
空帯 kuu-tai 521-02-33
（半導体の）空乏層
(handootai no) kuuboosoo 521-02-82

け

傾斜接合 keisha-setsugoo 521-02-74
（電界効果トランジスタの）ゲート
(denkai-kooka-toranjisuta no) geeto 521-07-09
ゲート geeto 521-08-01
ゲートアレイ geeto-arei 521-11-20
ゲートトリガ電圧 geeto-toriga-den'atsu ... 521-08-15
ゲートトリガ電流 geeto-toriga-denryuu 521-08-14
ゲート非トリガ電圧
geeto-hitoriga-den'atsu 521-08-16
ゲート非トリガ電流
geeto-hitoriga-denryuu 521-08-17
（結晶格子の）不完全性
(kesshoo-kooshi no) fukanzen-sei 521-02-47
検波ダイオード kempa-daioodo 521-04-11

こ

光起電力効果 kookidenyroku-kooka 521-01-21
合金技術 gookin-gijutsu 521-03-07
合金接合 gookin-setsugoo 521-02-75
光電効果 kooden-kooka 521-01-20
光電磁効果 koodenji-kooka 521-01-23
光電子ディスプレイ
koodenshi-disupurei 521-04-36
光電子デバイス koodenshi-debaisu 521-04-31
光電池 koodenchi 521-04-34
半導体光電ディテクタ；光電ディテクタ
handootai-kooden-ditekuta; kooden-ditekuta ... 521-04-42
光導電セル koodooden-seru 521-04-33
光導電効果 koodooden-kooka 521-01-22
（逆バイアスされたＰＮ接合の）降伏
(gyaku-baiasu sareta PN-setsugoo no)
koofuku 521-05-06
個別半導体デバイス；個別デバイス
kobetsu-handootai debaisu;
kobetsu-debaisu 521-04-02
孤立電子 koritsu-denshi 521-01-18
コルビーノディスク korubiino-disuku 521-04-30
コレクタ korekuta 521-07-05
コレクタ接合 korekuta-setsugoo 521-07-02
コレクタ接地 korekuta-setchi 521-07-14

さ

サーミスタ saamisuta 521-04-22
再結合中心 saiketsugoo-chuushin 521-02-64
サイリスタ sairisuta 521-04-61

し

電荷結合デバイス； CCD
denka-ketsugoo-debaisu; CCD 521-11-16
（ダイオードやサイリスタの）しきい値電圧
(daioodo ya sairisuta no) shiki'ichi-den'atsu .. 521-05-19

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

（エンハンスメント形電界効果トランジスタの）しきい値電圧
(enhansumento-gata-denkaikooka-toranjisuta no) shiki'ichi-den'atsu 521-07-24
（ホール探針の）磁気感度
(hooru-tanshin no) jiki-kando 521-09-12
磁気抵抗感度 jikiteikoo-kando 521-09-20
磁気抵抗器 jiki-teikooki 521-04-29
磁気抵抗係数 jikiteikoo-keisuu 521-09-18
磁気抵抗効果 jiki-teikoo-kooka 521-02-84
磁気抵抗特性曲線
jikiteikoo-tokusei-kyokusen 521-09-17
磁気抵抗比 jikiteikoo-hi 521-09-19
シグナルダイオード shigunaru-daioodo 521-04-04
（ホール発電器の）自己磁界
(hooru-hatsudenki no) jiko-jikai 521-09-10
遮断周波数 shadan-shuuhasuu 521-05-20
（デプレッション形電界効果トランジスタの）遮断電圧
(depuresshon-gata-denkaikooka-toranjisuta no) shadan-den'atsu 521-07-23
集積回路；IC shuuseki-kairo; IC 521-10-03
集積回路メモリ；ICメモリ
shuuseki-kairo-memori; IC-memori 521-11-05
周波数逓倍ダイオード
shuuhasuu-teibai-daioodo 521-04-09
充満帯 juuman-tai 521-02-32
縮退形半導体 shukutaigata-handootai 521-02-13
主端子 shu-tanshi 521-08-03
出力ループの実効誘導面積
shutsuryoku-ruupu no jikkoo-yuudoo-menseki 521-09-08
主電圧 shu-den'atsu 521-08-04
主（電圧-電流）特性
shu (den'atsu-denryuu) tokusei 521-08-05
主電流 shu-denryuu 521-08-02
主量子数；第1量子数
shu-ryooshisuu; dai'ichi-ryooshisuu 521-01-08
（PN接合の）順方向
(PN-setsugoo no) jun-hookoo 521-05-03
順方向回復時間 junhookoo-kaifuku-jikan 521-05-25
順方向勾配抵抗
junhookoo-koobai-teikoo 521-06-05
小信号短絡回路順方向電流伝達比
shoo-shingoo-tanrakukairo-junhookoo-denryuu-dentatsuhi 521-07-19
（半導体領域中の）少数キャリア
(handootai-ryoo'ikichuu no) shoosuu-kyaria 521-02-53
（少数キャリアの）拡散長
(shoosuu-kyaria no) kakusan-choo 521-02-60
（少数キャリアの）バルク寿命
(shoosuu-kyaria no) baruku-jumyoo 521-02-57
ショットキー障壁 Shottokii-shooheki 521-02-71
シリアルアクセスメモリ
shiriaru-akusesu-memori 521-11-12
真性伝導 shinsei-dendoo 521-02-20
真性伝導度 shinsei-dendoodo 521-02-48
真性半導体 shinsei-handootai 521-02-07

す

随時アクセス可能なメモリ；RAM
zuiji-akusesu-kanoo na memori; ramu 521-11-08
スイッチングダイオード
suitchingu-daioodo 521-04-13
スクリーン印刷技術
sukuriin-insatsu-gijutsu 521-03-16
スタティックリード／ライトメモリ；スタティックメモリ
sutatikku-riido/raito-memori; sutatikku-memri 521-11-09
スナップオフダイオード；ステップリカバリダイオード
sunappu-ofu-daioodo; suteppu-rikabari-daioodo 521-04-12
スパッタリング supattaringu 521-03-17
スピン（量子数） supin (ryooshi-suu) 521-01-10

せ

（ホール発電器の）制御電流
(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu 521-09-11
（ホール発電器の）制御電流感度
(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu-kando 521-09-13
（ホール発電器の）制御電流端子
(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu-tanshi 521-09-07
制御電流ループの実効誘導面積
seigyo-denryuu-ruupu no jikkoo-yuudoo-menseki 521-09-09
正孔 seikoo 521-02-17
成長接合 seichoo-setsugoo 521-02-77
静的順方向電流伝達比
seiteki-junhookoo-denryuu-dentatsuhi 521-07-20
静電気放電に敏感なデバイス
seedenki-hooden ni binkan na debaisu 521-05-27
半導体整流ダイオード；整流ダイオード
handootai-seiryuu-daioodo; seiryuu-daioodo 521-04-19
赤外線発光ダイオード
sekigaisen-hakkoo-daioodo 521-04-40
絶縁ゲート電界効果トランジスタ
zetsuen-geeto-denkaikooka-toranjisuta 521-04-54
絶縁体 zetsuen-tai 521-02-31
接合 setsugoo 521-02-72
バイポーラトランジスタ；接合形トランジスタ
baipoora-toranjisuta; setsugoogata-toranjisuta 521-04-47
接合ゲート電界効果トランジスタ
setsugoo-geeto-denkaikooka-toranjisuta 521-04-53
セミカスタムＩＣ semi-kasutamu-IC 521-11-19
セル seru 521-11-21
（ホール効果デバイスの）ゼロ磁場の残留電圧
(hooru-kooka debaisu no) zero-jiba no zanryuu-den'atsu 521-09-15
（ホール効果探針の）ゼロ電流制御の残留電圧
(hooru-kooka tanshin no) zero-denryuu-seigyo no zanryuu-den'atsu 521-09-14
遷移周波数 sen'i-shuuhasuu 521-07-21
遷移領域 sen'i-ryooiki 521-02-66

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

そ

（電界効果トランジスタの）ソース
(denkai-kooka-toranjisuta no) soosu..... 521-07-07
総角運動量量子数
soo-kaku'undooryoo-ryooshisuu..... 521-01-11
（電界効果トランジスタの）
相互コンダクタンス
(denkaikooka-toranjisuta no)
soogo-kondakutansu 521-07-25
双方向2端子サイリスタ；ダイアック
soohookoo-2tanshi-sairisuta; dai'akku..... 521-04-66
双方向3端子サイリスタ；トライアック
soohookoo-3tanshi-sairisuta; torai'akku..... 521-04-67
双方向トランジスタ
soo-hookoo-toranjisuta..... 521-04-49

た

ターンオフサイリスタ
taan-ohu-sairisuta..... 521-04-68
双方向2端子サイリスタ；ダイアック
soohookoo-2tanshi-sairisuta; dai'akku..... 521-04-66
帯域均質化 tai'iki-kinshitsuka..... 521-03-04
帯域精製 tai'iki-seisei..... 521-03-03
（単結晶の）帯域溶融成長
(tankkeshoo no) tai'iki-yooyuu-seichoo..... 521-03-02
主量子数；第１量子数
shu-ryooshisuu; dai'ichi-ryooshisuu..... 521-01-08
半導体ダイオード；ダイオード
handootai-daioodo; daioodo..... 521-04-03
（ダイオードやサイリスタの）回復電荷
(daioodo ya sairisuta no) kaifuku-denka.... 521-05-18
（ダイオードやサイリスタの）しきい値電圧
(daioodo ya sairisuta no) shiki'ichi-den'atsu .. 521-05-19
ダイナミックリード／ライトメモリ；
ダイナミックメモリ
dainamikku-riido/raito-memori;
dainamikku-memori 521-11-10
軌道量子数；第2量子数
kidoo-ryooshisuu; daini-ryooshisuu 521-01-09
（半導体領域中の）多数キャリア
(handootai-ryoo'ikichuu no) tasuu-kyaria .. 521-02-52
立ち上がり時間 tachiagari-jikan 521-05-22
立ち下がり時間 tachisagari-jikan..... 521-05-24
（トンネルダイオードの）谷点
(tonneru-daioodo no) tani-ten..... 521-06-02
単元素半導体 tangenso-handootai 521-02-02
単位電流伝達比周波数
tan'i-denryuu-dentatsuhi-shuuhasuu 521-07-22
（単結晶の）帯域溶融成長
(tankkeshoo no) tai'iki-yooyuu-seichoo..... 521-03-02
（単結晶の）引き上げ成長；
チョクラルスキー法による成長
(tankkeshoo no) hikiage-seichoo;
chokurarusukii-hoo ni yoru seichoo)..... 521-03-01
（半導体デバイスの）端子
(handootai-debaisu no) tanshi..... 521-05-02

ち

遅延時間 chien-jikan..... 521-05-21
チップ；ダイ chippu; dai..... 521-05-30
（電界効果トランジスタの）チャネル
(denkai-kooka-toranjisuta no) chaneru 521-07-06
中性領域 chuusei-ryooiki..... 521-02-68
超小形回路 chookogata-kairo..... 521-10-02
（単結晶の）引き上げ成長；
チョクラルスキー法による成長
(tankkeshoo no) hikiage-seichoo;
chokurarusukii-hoo ni yoru seichoo..... 521-03-01

つ

（PN接合の）ツェナー降伏
(PN-setsugoo no) tsenaa-koofuku..... 521-05-09
ツェナー電圧 tsenaa-den'atsu..... 521-05-10

て

抵抗遮断周波数
teikoo-shadan-shuuhasuu..... 521-06-04
定電圧ダイオード tei-den'atsu-daioodo..... 521-04-17
定電流ダイオード tei-denryuu-daioodo..... 521-04-18
デプレッション形電界効果トランジスタ
depuresshon-gata-denkaikooka-toranjisuta ... 521-04-58
（デプレッション形電界効果トランジスタの）
遮断電圧
(depuresshon-gata-denkaikooka-
toranjisuta no) shadan-den'atsu 521-07-23
デプレッションモード動作
depuresshon-mode-doosa..... 521-07-10
（電圧-電流）アノード-カソード特性；
アノード特性
(den'atsu-denryuu) anoodo-kasoodo-
tokusei; anoodo-tokusei..... 521-08-06
電界効果トランジスタ
denkai-kooka-toranjisuta 521-04-52
（電界効果トランジスタの）ゲート
(denkai-kooka-toranjisuta no) geeto 521-07-09
（電界効果トランジスタの）
相互コンダクタンス
(denkaikooka-toranjisuta no)
soogo-kondakutansu 521-07-25
（電界効果トランジスタの）ソース
(denkai-kooka-toranjisuta no) soosu..... 521-07-07
（電界効果トランジスタの）チャネル
(denkai-kooka-toranjisuta no) chaneru 521-07-06
（電界効果トランジスタの）ドレイン
(denkai-kooka-toranjisuta no) dorein 521-07-08
（半導体中の）電荷キャリア；キャリア
(handootai-chuu no) denka kyaria; kyaria.. 521-02-51
電荷結合デバイス； CCD
denka-ketsugoo-debaisu; CCD..... 521-11-16

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

（半導体中の）電荷蓄積
(handootai-chuu no) denka-chikuseki..... 521-02-62
電荷蓄積時間 denka-chikuseki-jikan..... 521-05-23
電荷転送形イメージセンサ
denka-tensoogata-imeejisensa..... 521-11-17
電荷転送デバイス
denka-tensoo-debaisu 521-11-14
（電荷の）拡散定数
(denka no) kakusan-joosuu 521-02-61
（電荷の）（ドリフト）移動度
(denka no)(dorifuto) idoodo 521-02-58
（半導体デバイスの）電極
(handootai-debaisu no) denkyoku 521-05-01
電子伝導 denshi-dendoo 521-02-19
伝導帯 dendoo-tai..... 521-02-22
伝導電子 dendoo-denshi 521-02-14
伝導電流 dooden-denryuu 521-02-15
（半導体の）伝導度変調
(handootai no) dendoodo-henchoo..... 521-02-55

と

（トンネルダイオードの）投影ピーク点
(tonneru-daioodo no) tooei-piiku-ten..... 521-06-03
等価回路 tooka-kairo 521-05-35
導体 dootai 521-02-16
（半導体の）ドーピング
(handootai no) doopingu..... 521-03-05
特定用途向けIC；ASIC
tokutei-yootomuke-IC; eeshikku 521-11-18
ドナー donaa..... 521-02-38
ドナー準位 donaa-jun'i 521-02-40
ドナーのイオン化エネルギー
donaa no ionka-enerugii..... 521-02-43
双方向3端子サイリスタ；トライアック
soohookoo-3tanshi-sairisuta; torai'akku..... 521-04-67
トラップ torappu..... 521-02-63
トランジシタ toranjisuta 521-04-46
（電荷の）（ドリフト）移動度
(denka no)(dorifuto) idoodo 521-02-58
（電界効果トランジスタの）ドレイン
(denkai-kooka-toranjisuta no) dorein 521-07-08
（PN接合中の）トンネル効果
(PN-setsugoo no) tonneru-kooka..... 521-02-83
トンネルダイオード tonneru-daioode 521-04-05
（トンネルダイオードの）谷点
(tonneru-daioodo no) tani-ten 521-06-02
（トンネルダイオードの）投影ピーク点
(tonneru-daioodo no) tooei-piiku-ten..... 521-06-03
（トンネルダイオードの）ピーク点
(tonneru-daioodo no) piiku-ten 521-06-01

な

内部電界 naibu-denkai..... 521-02-81
仮想温度；
（半導体デバイスの）内部等価温度
kasoo-ondo;
(handootai-debaisu no) naibu-tooka-ondo. 521-05-14

ね

熱抵抗 netsu-teikoo 521-05-13
（PN接合の）熱破壊
(PN-setsugoo no) netsu-hakai..... 521-05-11
熱容量 netsu-yooryoo 521-05-16

は

バイポーラトランジスタ；
接合形トランジスタ
baipoora-toranjisuta;
setsugoogata-toranjisuta 521-04-47
パウリ‐フェルミの排他律；パウリの原理
pauri‐ferumi no haitaritsu; pauri no genri. 521-01-14
（膜集積回路の）薄膜
(maku-shuuseki-kairo no) hakumaku..... 521-10-08
バケットブリゲードデバイス
bakketo-burigeedo-debaisu 521-11-15
ユニトンネルダイオード；
バックワードダイオード
yunitonneru-daioodo; bakkuwaado‐daioodo.. 521-04-06
パッケージ pakkeeji 521-05-31
（パッケージの）リードフレーム
(pakkeeji no) riido-fureemu..... 521-05-32
発光ダイオード； LED
hakkoo-daioodo; LED..... 521-04-39
（少数キャリアの）バルク寿命
(shoosuu-kyaria no) baruku-jumyoo 521-02-57
（2つのPN接合間の）パンチスルー
(futatsu no PN-setsugoo-kan no)
panchi-suruu..... 521-05-12
半導体 handootai..... 521-02-01
半導体集積回路；半導体IC
handootai-shuuseki-kairo; handootai-IC.... 521-10-05
半導体感光性デバイス； 感光性デバイス
handootai-kankoosei-debaisu;
kankoosei-debaisu..... 521-04-41
半導体光電ディテクタ；光電ディテクタ
handootai-kooden-ditekuta; kooden-ditekuta ... 521-04-42
半導体集積回路；半導体IC
handootai-shuuseki-kairo; handootai-IC.... 521-10-05
半導体整流スタック
handootai-seiryuu-sutakku 521-04-21
半導体整流ダイオード；整流ダイオード
handootai-seiryuu-daioodo; seiryuu-daioodo ... 521-04-19
半導体ダイオード；ダイオード
handootai-daioodo; daioodo..... 521-04-03
（半導体中の）エネルギー帯
(handootai-chuu no) enerugii-tai..... 521-02-26
（半導体中の）拡散
(handootai-chuu no) kakusan 521-02-59
（半導体中の）電荷キャリア；キャリア
(handootai-chuu no) denka kyaria; kyaria.. 521-02-51
（半導体中の）電荷蓄積
(handootai-chuu no) denka-chikuseki..... 521-02-62
半導体デバイス handootai-debaisu..... 521-04-01
（半導体デバイスの）端子
(handootai-debaisu no) tanshi 521-05-02
（半導体デバイスの）電極
(handootai-debaisu no) denkyoku 521-05-01

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

仮想温度；
（半導体デバイスの）内部等価温度
kasoo-ondo;
(handootai-debaisu no) naibu-tooka-ondo 521-05-14
半導体熱変換素子
handootai-netsu-henkansoshi 521-04-23
（半導体のＰＮ接合の）アバランシェ降伏
(handootai no PN-setsugoo no)
abaranshe-koofuku..... 521-05-07
（半導体の）空乏層
(handootai no) kuuboosoo..... 521-02-82
（半導体の）伝導度変調
(handootai no) dendoodo-henchoo..... 521-02-55
（半導体の）ドーピング
(handootai no) doopingu..... 521-03-05
（半導体領域中の）少数キャリア
(handootai-ryoo'ikichuu no) shoosuu-kyaria..... 521-02-53
（半導体領域中の）多数キャリア
(handootai-ryoo'ikichuu no) tasuu-kyaria .. 521-02-52

ひ

PN境界 PN-kyookai..... 521-02-65
PN接合 PN-setsugoo..... 521-02-78
（PN接合の）逆方向
(PN-setsugoo no) gyaku-hookoo..... 521-05-04
（PN接合の）順方向
(PN-setsugoo no) jun-hookoo..... 521-05-03
（PN接合の）ツェナー降伏
(PN-setsugoo no) tsenaa-koofuku..... 521-05-09
（PN接合中の）トンネル効果
(PN-setsugoo no) tonneru-kooka..... 521-02-83
（PN接合の）熱破壊
(PN-setsugoo no) netsu-hakai..... 521-05-11
（PN接合の）ポテンシャル障壁
(PN-setsugoo no) potensharu-shooheki.... 521-02-70
プログラマブルロジックアレイ；PLA
puroguramaburu-rojikku-arei; PLA..... 521-11-02
P形伝導度 P-gata-dendoodo 521-02-50
P形半導体 P-gata-handootai 521-02-10
（トンネルダイオードの）ピーク点
(tonneru-daioodo no) piiku-ten 521-06-01
Pゲートサイリスタ P-geeto-sairisuta 521-04-69
Pチャネル電界効果トランジスタ
P-chaneru-denkaikooka-toranjisuta 521-04-57
ヒートシンク hiito-shinku..... 521-05-33
（PN接合の）空間電荷領域
(PN-setsugoo no) kuukan-denka-ryooiki ... 521-02-80
（単結晶の）引き上げ成長；
チョクラルスキー法による成長
(tankkeshoo no) hikiage-seichoo;
chokurarusukii-hoo ni yoru seichoo 521-03-01
非縮退形半導体
hishukutaigata-handootai 521-02-12
微小合金技術 bishoo-gookin-gijutsu 521-03-10
非対称サイリスタ hitaishoo-sairisuta..... 521-04-71
表面再結合速度
hyoomen-saiketsugoo-sokudo..... 521-02-56
表面準位 hyoomen-jun'i..... 521-02-42
表面帯 hyoomen-tai..... 521-02-34
表面保護 hyoomen-hogo 521-03-13
（粒子の）非量子化系
(ryuushi no) hi-ryooshika-kei 521-01-01

ふ

フェルミ準位 ferumi-jun'i..... 521-01-17
フェルミ‐ディラック関数
ferumi-dirakku-kansuu..... 521-01-16
フェルミ‐ディラック‐ゾンマーフェルト
速度分布則
ferumi-dirakku-zommaaferuto-
sokudo-bumpusoku 521-01-19
フェルミ‐ディラック統計；フェルミ統計
ferumi-dirakku-tookei; ferumi-tookei 521-01-15
フォトエミッタ foto-emitta 521-04-35
フォトカプラ；オプトカプラ
foto-kapura; oputo-kapura 521-04-45
フォトサイリスタ foto-sairisuta 521-04-72
フォトダイオード foto-daioodo..... 521-04-32
フォトトランジスタ foto-toranjisuta..... 521-04-51
フォトレジスタ foto-rejisuta..... 521-04-43
（結晶格子の）不完全性
(kesshoo-kooshi no) fukanzen-sei..... 521-02-47
不純物 fujunbutsu 521-02-04
不純物活性化エネルギー
fujunbutsu-kasseika-enerugii..... 521-02-05
不純物準位 fujunbutsu-jun'i..... 521-02-36
不純物帯 fujunbutsu-tai..... 521-02-37
不純物濃度遷移領域
fujunbutsu-noodo-sen'i-ryooiki..... 521-02-67
不純物補償 fujunbutsu-hoshoo 521-03-06
負性微分抵抗領域
fusei-bibun-teikoo-ryooiki..... 521-05-05
（2つのPN接合間の）パンチスルー
(futatsu no PN-setsugoo-kan no)
panchi-suruu..... 521-05-12
部分占有帯 bubun-senyuu-tai..... 521-02-27
浮遊電圧 fuyuu-den'atsu..... 521-05-17
ブレークオーバー点 bureeku-oobaa-ten... 521-08-12
プレーナ技術 pureena-gijutsu 521-03-09
プログラマブルゲートアレイ
puroguramaburu-geeto-arei 521-11-03
プログラマブルロジックアレイ；PLA
puroguramaburu-rojikku-arei; PLA..... 521-11-02
プログラマブルロジックデバイス
puroguramaburu-rojikku-debaisu (PLD) 521-11-01
エネルギー帯；ブロッホ帯
enerugii-tai; burohho-tai..... 521-02-25

へ

ベース beesu..... 521-07-03
ベース接地 beesu-setchi 521-07-13
変調ダイオード henchoo-daioodo..... 521-04-10

ほ

ボーア原子 booa-genshi..... 521-01-06
ホール移動度 hooru-idoodo..... 521-09-04
ホール角 hooru-kaku 521-09-03
ホール係数 hooru-keisuu..... 521-09-02
ホール効果 hooru-kooka..... 521-09-01
ホール探針；ホール効果磁力計
hooru-tanshin; hooru-kooka-jiryokukei..... 521-04-28

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

（ホール効果探針の）ゼロ電流制御の残留電圧 (hooru-kooka tanshin no) zero-denryuu-seigyo no zanryuu-den'atsu 521-09-14
ホール効果デバイス hooru-kooka-debaisu 521-04-24
（ホール効果デバイスの）ゼロ磁場の残留電圧 (hooru-kooka debaisu no) zero-jiba no zanryuu-den'atsu 521-09-15
（ホール効果デバイスの）誘導制御電圧 (hooru-kooka debaisu no) yuudoo-seigyo-den'atsu 521-09-16
ホール端子 hooru-tanshi 521-09-06
ホール探針；ホール効果磁力計 hooru-tanshin; hooru-kooka-jiryokukei 521-04-28
（ホール探針の）磁気感度 (hooru-tanshin no) jiki-kando 521-09-12
ホール逓倍器 hooru-teibaiki 521-04-27
ホール電圧 hooru-den'atsu 521-09-05
ホール伝導 hooru-dendoo 521-02-18
ホール発電器 hooru-hatsudenki 521-04-26
（ホール発電器の）自己磁界 (hooru-hatsudenki no) jiko-jikai 521-09-10
（ホール発電器の）制御電流 (hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu 521-09-11
（ホール発電器の）制御電流感度 (hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu-kando 521-09-13
（ホール発電器の）制御電流端子 (hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu-tanshi ... 521-09-07
ホール変調器 hooru-henchooki 521-04-25
保持電流 hoji-denryuu 521-08-10
補償形半導体 hoshoogata-handootai 521-02-11
ポテンシャル障壁 potensharu-shooheki ... 521-02-69
（PN接合の）ポテンシャル障壁 (PN-setsugoo no) potensharu-shooheki 521-02-70
ボルツマン関係 borutsuman-kankei 521-01-04

ま

マイクロアセンブリ maikuro-asemburi 521-10-04
マイクロエレクトロニクス maikuro-erekutoronikusu 521-10-01
マイクロ波スイッチングダイオード maikuroha-suitchingu-daioodo 521-04-14
マイクロ波制限ダイオード maikuroha-seigen-daioodo 521-04-15
（膜集積回路の）膜 (maku-shuuseki-kairo no) maku 521-10-07
膜集積回路 maku-shuuseki-kairo 521-10-06
（膜集積回路の）厚膜 (maku-shuuseki-kairo no) atsumaku 521-10-09
（膜集積回路の）薄膜 (maku-shuuseki-kairo no) hakumaku 521-10-08
（膜集積回路の）膜 (maku-shuuseki-kairo no) maku 521-10-07
マクロセル makuro-seru 521-11-22
マックスウェル－ボルツマン速度分布則 makkusuweru-borutsuman-sokudobumpusoku 521-01-05
マックスウェル－ボルツマン統計 makkusuweru-borutsuman-tookei 521-01-03
マルチチップ集積回路 maruchi-chippu-shuuseki-kairo 521-10-10

み

ミクサーダイオード mikusaa-daioodo 521-04-08

め

メサ技術 mesa-gijutsu 521-03-11
金属半導体電界効果トランジスタ；MESFET kinzoku-handootai-denkaikooka-toranjisuta; mesu-FET; mesu-fetto 521-04-60
メモリセル；メモリ素子 memori-seru; memori-soshi 521-11-04

も

金属-酸化物-半導体電界効果トランジスタ MOSFET kinzoku-sankabutsu-handootai-denkaikooka-toranjisuta; MOSFET 521-04-55

ゆ

（ホール効果デバイスの）誘導制御電圧 (hooru-kooka debaisu no) yuudoo-seigyo-den'atsu 521-09-16
ユニトンネルダイオード；バックワードダイオード yunitonneru-daioodo; bakkuwaado-daioodo 521-04-06
ユニポーラトランジスタ yunipoora-toranjisuta 521-04-48

よ

読み出し専用メモリ；ROM yomidashi-sen'yoo-memori; romu 521-11-06
4極管動作トランジスタ 4kyokukan-doosa-toranjisuta 521-04-50

ら

ラッチアップ状態 ratchi'appu-jootai 521-10-11
ラッチング電流 ratchingu-denryuu 521-08-11
随時アクセス可能なメモリ；RAM zuiji-akusesu-kanou na memori; ramu 521-11-08

り

リード／ライトメモリ riido/raito-memori 521-11-07
（パッケージの）リードフレーム (pakkeeji no) riido-fureemu 521-05-32
(粒子の）エネルギー準位 (ryuushi no) enerugii-jun'i 521-01-12
（粒子の）非量子化系 (ryuushi no) hi-ryooshika-kei 521-01-01
（粒子の）量子化系 (ryuushi no) ryooshika-kei 521-01-02
（与えられた原子内の電子の）量子数 (ataerareta genshinai no denshi no) ryooshisuu 521-01-07

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

スピン（量子数） supin (ryooshi-suu) 521-01-10
臨界オフ電圧上昇率
rinkai-ofu-den'atsu-jooshooritsu..... 521-08-18
臨界オン電流上昇率
rinkai-on-denryuu-jooshooritsu 521-08-19

れ

励起帯 reiki-tai 521-02-28
レーザダイオード reeza-daioodo 521-04-37
レーザダイオードモジュール
reeza-daioodo-mojuuru 521-04-38
連想メモリ；アソシエイティブメモリ
rensoo-memori; asoshieitibu-memori 521-11-13

ろ

読み出し専用メモリ；ROM
yomidashi-sen'yoo-memori; romu..... 521-11-06

2

（2つのPN接合間の）パンチスルー
(futatsu no PN-setsugoo-kan no)
panchi-suruu..... 521-05-12

4

4極管動作トランジスタ
4kyokukan-doosa-toranjisuta..... 521-04-50

A

特定用途向けIC；ASIC
tokutei-yootomuke-IC; eeshikku 521-11-18

C

電荷結合デバイス； CCD
denka-ketsugoo-debaisu; CCD..... 521-11-16

I

集積回路；IC shuuseki-kairo; IC 521-10-03
集積回路メモリ；ICメモリ
shuuseki-kairo-memori; IC-memori..... 521-11-05

L

発光ダイオード；LED
hakkoo-daioodo; LED..... 521-04-39

M

金属半導体電界効果トランジスタ；MESFET
kinzoku-handootai-denkaikooka-toranjisuta;
mesu-FET; mesu-fetto 521-04-60

金属-酸化物-半導体電界効果トランジスタ；
MOSFET
kinzoku-sankabutsu-handootai-
denkaikooka-toranjisuta; MOSFET..... 521-04-55

N

N形伝導度 N-gata-dendoodo..... 521-02-49
N形半導体 N-gata-handootai..... 521-02-09
Nゲートサイリスタ N-geeto-sairisuta..... 521-04-70
Nチャネル電界効果トランジスタ
N-chaneru-denkaikooka-toranjisuta 521-04-56

P

プログラマブルロジックアレイ；PLA
puroguramaburu-rojikku-arei; PLA..... 521-11-02
PN境界 PN-kyookai..... 521-02-65
PN接合 PN-setsugoo..... 521-02-78
（PN接合の）逆方向
(PN-setsugoo no) gyaku-hookoo..... 521-05-04
（PN接合の）空間電荷領域
(PN-setsugoo no) kuukan-denka-ryooiki ... 521-02-80
（PN接合の）順方向
(PN-setsugoo no) jun-hookoo..... 521-05-03
（PN接合の）ツェナー降伏
(PN-setsugoo no) tsenaa-koofuku..... 521-05-09
（PN接合中の）トンネル効果
(PN-setsugoo no) tonneru-kooka..... 521-02-83
（PN接合の）熱破壊
(PN-setsugoo no) netsu-hakai..... 521-05-11
（PN接合の）ポテンシャル障壁
(PN-setsugoo no) potensharu-shooheki.... 521-02-70
P形伝導度 P-gata-dendoodo..... 521-02-50
P形半導体 P-gata-handootai 521-02-10
Pゲートサイリスタ
P-geeto-sairisuta 521-04-69
Pチャネル電界効果トランジスタ
P-chaneru-denkaikooka-toranjisuta 521-04-57

R

随時アクセス可能なメモリ；RAM
zuiji-akusesu-kanou na memori; ramu..... 521-11-08
読み出し専用メモリ；ROM
yomidashi-sen'yoo-memori; romu..... 521-11-06

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

INDEKS ALFABETYCZNY

A

akceptor
akceptor 521-02-39
energia jonizacji akceptora 521-02-44
akceptorowy
poziom akceptorowy 521-02-41
aktywacja
energia aktywacji domieszek 521-02-05
akumulacja
akumulacja nośników ładunku (w półprzewodniku) 521-02-62
analizator
analizator obrazu z przenoszeniem ładunku 521-11-17
anodowy
charakterystyka anodowa 521-08-06
ASIC
ASIC (akronim) 521-11-18
asymetryczny
tyrystor asymetryczny 521-04-71
atom
atom Bohra 521-01-06
ażur
ażur 521-05-32

B

bariera
bariera potencjału 521-02-69
bariera potencjału (złącza PN) 521-02-70
bariera Schottky'ego 521-02-71
baza
baza 521-07-03
baza wspólna 521-07-13
baza wspólna odwrócona 521-07-16
BBD
BBD (akronim) 521-11-15
bezpośredni
pamięć o dostępie bezpośrednim 521-11-08
bipolarny
tranzystor bipolarny złączowy 521-04-47
Bloch
pasmo Blocha 521-02-25
blokowanie
czas odzyskania blokowania 521-05-26
prędkość krytyczna wzrostu napięcia blokowania 521-08-18
stan blokowania 521-08-08
blokujący
tyrystor diodowy blokujący wstecznie . 521-04-62
tyrystor triodowy blokujący wstecznie . 521-04-63
Bohr
atom Bohra 521-01-06
Boltzmann
prawo rozkładu prędkości Maxwella-Boltzmanna 521-01-05
rozkład Maxwella-Boltzmanna 521-01-03
zależność Boltzmanna 521-01-04
bramka
bramka (tyrystora) 521-08-01
bramka (tranzystora polowego) 521-07-09
matryca bramek 521-11-20
matryca bramek programowalna 521-11-03
napięcie nieprzełączające bramki 521-08-16
napięcie przełączające bramki 521-08-15
prąd nieprzełączający bramki 521-08-17
prąd przełączający bramki 521-08-14
tranzystor polowy z bramką izolowaną 521-04-54
tranzystor polowy z bramką złączową 521-04-53
tranzystor polowy złączowy z bramką metalową 521-04-60
tyrystor z bramką typu N 521-04-70
tyrystor z bramką typu P 521-04-69

C

całkowity
liczba kwantowa całkowitego momentu kątowego 521-01-11
CCD
CCD (akronim) 521-11-16
centrum
centrum rekombinacji 521-02-64
charakterystyka
charakterystyka anodowa 521-08-06
charakterystyka główna napięciowo-prądowa) 521-08-05
charakterystyka magnetorezystora 521-09-17
cienki
warstwa cienka (układu scalonego warstwowego) 521-10-08
cieplny
pojemność cieplna 521-05-16
przebicie cieplne (złącza PN) 521-05-11
rezystancja cieplna (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-13
czas
czas gromadzenia ładunku 521-05-23
czas narastania 521-05-22
czas odzyskania blokowania 521-05-26
czas opadania 521-05-24
czas opóźnienia 521-05-21
czas ustalania się stanu przewodzenia 521-05-25
czas życia objętościowy (nośnika mniejszościowego) 521-02-57
częstotliwość
częstotliwość graniczna (jednostkowej wartości współczynnika przenoszenia prądowego) 521-07-22

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

częstotliwość graniczna rezystywnościowa 521-06-04
częstotliwość odcięcia 521-05-20
częstotliwość przejścia 521-07-21
dioda mnożnika częstotliwości 521-04-09
Czochralski
metoda monokrystalizacji Czochralskiego 521-03-01
czułość
czułość magnetyczna (sondy Halla) ... 521-09-12
czułość prądowa (sondy Halla) 521-09-13
czułość rezystancyjna magnetorezystora 521-09-20

D

defekt
defekt (sieci krystalicznej) 521-02-47
detekcyjny
dioda detekcyjna 521-04-11
detektor
detektor fotoelektryczny (półprzewodnikowy) 521-04-42
diak
diak 521-04-66
dioda
dioda detekcyjna 521-04-11
dioda elektroluminescencyjna 521-04-39
dioda emitująca w (zakresie) podczerwieni 521-04-40
dioda komutacyjna 521-04-13
dioda laserowa 521-04-37
dioda ładunkowa 521-04-12
dioda mieszająca 521-04-08
dioda ograniczająca mikrofalowa..... 521-04-15
dioda przełączająca mikrofalowa 521-04-14
dioda mnożnika częstotliwości 521-04-09
dioda modulacyjna 521-04-10
dioda na podczerwień 521-04-40
dioda o zmiennej pojemności 521-04-07
dioda odniesienia 521-04-16
dioda odwrotna 521-04-06
dioda parametryczna 521-04-07
dioda (półprzewodnikowa) 521-04-03
dioda prostownicza lawinowa 521-04-20
dioda prostownicza (półprzewodnikowa) 521-04-19
dioda przełączająca 521-04-13
dioda stabilizacyjna 521-04-16
dioda stabilizująca napięcie 521-04-17
dioda stabilizująca prąd 521-04-18
dioda sygnałowa 521-04-04
dioda świecąca 521-04-39
dioda tunelowa 521-04-05
dioda wsteczna 521-04-06
dioda Zenera 521-04-17
moduł diody laserowej 521-04-38
diodowy
tyrystor diodowy blokujący wstecznie . 521-04-62
tyrystor diodowy dwukierunkowy 521-04-66
tyrystor diodowy przewodzący wstecznie 521-04-64
Dirac
funkcja Fermiego-Diraca 521-01-16
prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda 521-01-19
rozkład Fermiego-Diraca 521-01-15
długość
długość dyfuzji (nośników mniejszościowych) 521-02-60
dolina
dolina (diody tunelowej)..... 521-06-02
dolinowy
punkt dolinowy (diody tunelowej) 521-06-02
domieszka
domieszka 521-02-04
energia aktywacji domieszek 521-02-05
obszar zmiany koncentracji domieszek 521-02-67
domieszkowanie
domieszkowanie (półprzewodnika) 521-03-05
domieszkowy
kompensacja domieszkowa 521-03-06
pasmo domieszkowe 521-02-37
poziom domieszkowy 521-02-36
donor
donor 521-02-38
energia jonizacji donora 521-02-43
donorowy
poziom donorowy 521-02-40
dostęp
pamięć o dostępie bezpośrednim 521-11-08
pamięć o dostępie swobodnym 521-11-08
pamięć o dostępie szeregowym 521-11-12
dozwolony
pasmo dozwolone 521-02-29
dren
dren (tranzystora polowego) 521-07-08
drugi
liczba kwantowa druga 521-01-09
dwukierunkowy
tranzystor dwukierunkowy 521-04-49
tyrystor diodowy dwukierunkowy 521-04-66
tyrystor triodowy dwukierunkowy 521-04-67
dyfuzja
długość dyfuzji (nośników mniejszościowych) 521-02-60
dyfuzja (w półprzewodniku) 521-02-59
stała dyfuzji (nośników ładunku) 521-02-61
dyfuzyjny
technika dyfuzyjna 521-03-08
złącze dyfuzyjne 521-02-76

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

dynamiczny
pamięć dynamiczna (o zmiennej zawartości) 521-11-10
rezystancja dynamiczna przewodzenia 521-08-13
dyskretny
przyrząd (półprzewodnikowy) dyskretny 521-04-02
działanie
kierunek działania wsteczny 521-07-12
dziura
dziura 521-02-17
dziurowy
przewodzenie dziurowe 521-02-18

E

elektroda
elektroda (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-01
elektroluminescencyjny
dioda elektroluminescencyjna 521-04-39
przyrząd elektroluminescencyjny 521-04-35
elektron
elektron przewodzenia 521-02-14
elektron samotny 521-01-18
elektronowy
przewodzenie elektronowe 521-02-19
elektrostatyczny
przyrząd wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne 521-05-27
elektryczny
pole elektryczne wewnętrzne 521-02-81
element
element pamięci 521-11-04
element pasożytniczy układu 521-05-36
emiter
emiter 521-07-04
emiter wspólny 521-07-15
emiter wspólny odwrócony 521-07-18
złącze emitera 521-07-01
emitujący
dioda emitująca w (zakresie) podczerwieni 521-04-40
energetyczny
odstęp energetyczny 521-02-24
pasmo energetyczne 521-02-25
pasmo energetyczne (w półprzewodniku) 521-02-26
poziom energetyczny (cząstki) 521-01-12
wykres poziomów energetycznych (cząstek) 521-01-13
energia
energia aktywacji domieszek 521-02-05
energia jonizacji akceptora 521-02-44
energia jonizacji donora 521-02-43
epitaksja
epitaksja 521-03-12

F

faza
osadzanie z fazy lotnej 521-03-15
Fermi
funkcja Fermiego-Diraca 521-01-16
poziom Fermiego 521-01-17
prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda 521-01-19
rozkład Fermiego-Diraca 521-01-15
zasada Pauliego-Fermiego 521-01-14
fotodioda
fotodioda 521-04-32
fotodioda lawinowa 521-04-44
fotoelektryczny
detektor fotoelektryczny (półprzewodnikowy) 521-04-42
przyrząd fotoelektryczny (półprzewodnikowy) 521-04-41
zjawisko fotoelektryczne 521-01-20
fotoelement
fotoelement (półprzewodnikowy) 521-04-41
fotokomórka
fotokomórka 521-04-33
fotokonduktywny
zjawisko fotokonduktywne 521-01-22
fotomagnetoelektryczny
zjawisko fotomagnetoelektryczne 521-01-23
fotonowy
sprzęgacz fotonowy 521-04-45
fotoogniwo
fotoogniwo 521-04-34
fotoprzewodzący
komórka fotoprzewodząca 521-04-33
fotorezystor
fotorezystor 521-04-43
fototranzystor
fototranzystor 521-04-51
fototyrystor
fototyrystor 521-04-72
fotowoltaiczny
komórka fotowoltaiczna 521-04-34
zjawisko fotowoltaiczne 521-01-21
funkcja
funkcja Fermiego-Diraca 521-01-16

G

generator
generator Halla 521-04-26
główny
charakterystyka główna (napięciowo-prądowa) 521-08-05
końcówka główna 521-08-03
liczba kwantowa główna 521-01-08
napięcie główne 521-08-04
prąd główny 521-08-02
granica
granica PN 521-02-65

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

graniczny
częstotliwość graniczna (jednostkowej wartości współczynnika przenoszenia prądowego) 521-07-22
częstotliwość graniczna rezystywnościowa 521-06-04
gromadzenie
czas gromadzenia ładunku 521-05-23
gruby
warstwa gruba (układu scalonego warstwowego) 521-10-09

H

Hall
generator Halla 521-04-26
kąt Halla 521-09-03
napięcie Halla 521-09-05
ruchliwość Halla 521-09-04
sonda Halla 521-04-28
współczynnik Halla 521-09-02
zjawisko Halla 521-09-01
hallotron
hallotron 521-04-24
końcówki hallotronu 521-09-06
końcówka prądu sterującego hallotronu 521-09-07
powierzchnia skuteczna pętli wyjściowej hallotronu 521-09-08
hallotronowy
magnetometr hallotronowy 521-04-28
mnożnik hallotronowy 521-04-27
modulator hallotronowy 521-04-25

I

idealny
kryształ idealny 521-02-45
implantacja
implantacja jonów 521-03-14
indukowany
napięcie sterujące indukowane (hallotronu) 521-09-16
pole indukowane (generatora Halla) ... 521-09-10
izolator
izolator 521-02-31
izolowany
tranzystor polowy z bramką izolowaną 521-04-54

J

jon
implantacja jonów 521-03-14
jonizacja
energia jonizacji akceptora 521-02-44
energia jonizacji donora 521-02-43
jonowy
półprzewodnik jonowy 521-02-06
przewodzenie jonowe 521-02-21

K

kanał
kanał (tranzystora polowego) 521-07-06
tranzystor polowy z kanałem N 521-04-56
tranzystor polowy z kanałem P 521-04-57
tranzystor polowy z kanałem wzbogaconym 521-04-59
tranzystor polowy z kanałem zubożonym 521-04-58
kąt
kąt Halla 521-09-03
kątowy
liczba kwantowa całkowitego momentu kątowego 521-01-11
kierunek
kierunek działania wsteczny 521-07-12
kierunek przewodzenia (złącza PN) ... 521-05-03
kierunek zaporowy (złącza PN) 521-05-04
kolektor
kolektor 521-07-05
kolektor wspólny 521-07-14
kolektor wspólny odwrócony 521-07-17
złącze kolektora 521-07-02
komórka
komórka fotoprzewodząca 521-04-33
komórka fotowoltaiczna 521-04-34
komórka pamięci 521-11-04
komórka (układu scalonego) 521-11-21
kompensacja
kompensacja domieszkowa 521-03-06
komutacyjny
dioda komutacyjna 521-04-13
koncentracja
obszar zmiany koncentracji domieszek 521-02-67
końcówka
końcówka główna 521-08-03
końcówka prądu sterującego hallotronu 521-09-07
końcówka (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-02
końcówki hallotronu 521-09-06
kryształ
kryształ idealny 521-02-45
krytyczny
prędkość krytyczna wzrostu napięcia blokowania 521-08-18
prędkość krytyczna wzrostu napięcia przewodzenia 521-08-19
kwantowany
układ kwantowany (cząstek) 521-01-02
kwantowy
liczba kwantowa całkowitego momentu kątowego 521-01-11
liczba kwantowa druga 521-01-09
liczba kwantowa (elektronu w danym atomie) 521-01-07

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

liczba kwantowa główna 521-01-08
liczba kwantowa orbitalna 521-01-09
liczba kwantowa pierwsza 521-01-08

L

laserowy
dioda laserowa 521-04-37
moduł diody laserowej 521-04-38
lawinowy
dioda prostownicza lawinowa 521-04-20
fotodioda lawinowa 521-04-44
napięcie przebicia lawinowego 521-05-08
przebicie lawinowe (złącza półprzewodnikowego PN) 521-05-07
LED
LED (akronim) 521-04-39
liczba
liczba kwantowa całkowitego momentu kątowego 521-01-11
liczba kwantowa druga 521-01-09
liczba kwantowa (elektronu w danym atomie) 521-01-07
liczba kwantowa główna 521-01-08
liczba kwantowa orbitalna 521-01-09
liczba kwantowa pierwsza 521-01-08
liczba spinowa 521-01-10
logiczny
matryca logiczna programowalna 521-11-02
przyrząd logiczny programowalny 521-11-01
lokalny
poziom lokalny 521-02-35
lotny
osadzanie z fazy lotnej 521-03-15

Ł

ładunek
akumulacja nośników ładunku (w półprzewodniku) 521-02-62
analizator obrazu z przenoszeniem ładunku 521-11-17
czas gromadzenia ładunku 521-05-23
ładunek odzyskiwany (diody lub tyrystora) 521-05-18
nośnik ładunku (w półprzewodniku) 521-02-51
obszar ładunku przestrzennego 521-02-79
obszar ładunku przestrzennego (złącza PN) 521-02-80
przyrząd z przenoszeniem ładunku 521-11-14
ładunkowy
dioda ładunkowa 521-04-12
przyrząd ze sprzężeniem ładunkowym 521-11-16
łańcuchowy
przyrząd łańcuchowy 521-11-15

M

magnetometr
magnetometr hallotronowy 521-04-28
magnetorezystancja
współczynnik magnetorezystancji 521-09-18
magnetorezystor
charakterystyka magnetorezystora 521-09-17
czułość rezystancyjna magnetorezystora 521-09-20
magnetorezystor 521-04-29
magnetorezystor tarczowy 521-04-30
wskaźnik rezystancji magnetorezystora 521-09-19
magnetorezystywny
zjawisko magnetorezystywne 521-02-84
magnetyczny
czułość magnetyczna (sondy Halla) ... 521-09-12
napięcie szczątkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu) 521-09-15
makrokomórka
makrokomórka 521-11-22
małosygnałowy
współczynnik zwarciowy małosygnałowy przenoszenia prądowego 521-07-19
matryca
matryca bramek 521-11-20
matryca bramek programowalna 521-11-03
matryca logiczna programowalna 521-11-02
matrycowy
układ matrycowy 521-11-20
układ matrycowy programowalny 521-11-03
Maxwell
prawo rozkładu prędkości Maxwella-Boltzmanna 521-01-05
rozkład Maxwella-Boltzmanna 521-01-03
mesa
technika "mesa" 521-03-11
MESFET
MESFET (akronim) 521-04-60
metalowy
tranzystor polowy złączowy z bramką metalową 521-04-60
metoda
metoda monokrystalizacji Czochralskiego 521-03-01
metoda monokrystalizacji strefowej 521-03-02
mieszający
dioda mieszająca 521-04-08
mikroelektronika
mikroelektronika 521-10-01
mikrofalowy
dioda ograniczająca mikrofalowa..... 521-04-15
dioda przełączająca mikrofalowa..... 521-04-14
mikrostop
technika mikrostopu 521-03-10

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

mikroukład
mikroukład 521-10-02
mikrozespół
mikrozespół 521-10-04
mniejszościowy
nośnik mniejszościowy (w obszarze półprzewodnika) 521-02-53
mnożnik
dioda mnożnika częstotliwości 521-04-09
mnożnik hallotronowy 521-04-27
modulacja
modulacja przewodnictwa (półprzewodnika) 521-02-55
modulacyjny
dioda modulacyjna 521-04-10
modulator
modulator hallotronowy 521-04-25
moduł
moduł diody laserowej 521-04-38
moment
liczba kwantowa całkowitego momentu kątowego 521-01-11
monokrystalizacja
metoda monokrystalizacji Czochralskiego 521-03-01
metoda monokrystalizacji strefowej 521-03-02
montażowy
pasek montażowy 521-05-32
MOS
tranzystor (polowy) MOS 521-04-55

N

N
półprzewodnik typu N 521-02-09
przewodnictwo typu N 521-02-49
tranzystor polowy z kanałem N 521-04-56
tyrystor z bramką typu N 521-04-70
nachyleniowy
rezystancja nachyleni(ow)a 521-06-05
nadmiarowy
nośnik nadmiarowy 521-02-54
napięcie
dioda stabilizująca napięcie 521-04-17
napięcie główne 521-08-04
napięcie Halla 521-09-05
napięcie nieprzełączające bramki 521-08-16
napięcie odcięcia (tranzystora polowego z kanałem zubożonym) 521-07-23
napięcie płynące 521-05-17
napięcie progowe (diody lub tyrystora) 521-05-19
napięcie progowe (tranzystora polowego z kanałem wzbogaconym) 521-07-24
napięcie przebicia lawinowego 521-05-08
napięcie przełączające bramki 521-08-15
napięcie sterujące indukowane (hallotronu) 521-09-16
napięcie szczątkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu) 521-09-15
napięcie szczątkowe przy prądzie sterującym zerowym (sondy Halla) .. 521-09-14
napięcie Zenera 521-05-10
prędkość krytyczna wzrostu napięcia blokowania 521-08-18
prędkość krytyczna wzrostu napięcia przewodzenia 521-08-19
napięciowy
charakterystyka główna (napięciowo-prądowa) 521-08-05
napylanie
napylanie 521-03-17
narastanie
czas narastania 521-05-22
neutralny
obszar neutralny 521-02-68
niekwantowany
układ niekwantowany (cząstek) 521-01-01
nieprzełączający
napięcie nieprzełączające bramki 521-08-16
prąd nieprzełączający bramki 521-08-17
niesamoistny
półprzewodnik niesamoistny 521-02-08
nietrwały
pamięć nietrwała 521-11-11
niezdegenerowany
półprzewodnik niezdegenerowany 521-02-12
nośnik
akumulacja nośników ładunku (w półprzewodniku) 521-02-62
nośnik ładunku (w półprzewodniku) 521-02-51
nośnik mniejszościowy (w obszarze półprzewodnika) 521-02-53
nośnik nadmiarowy 521-02-54
nośnik większościowy (w obszarze półprzewodnika) 521-02-52

O

objętościowy
czas życia objętościowy (nośnika mniejszościowego) 521-02-57
obraz
analizator obrazu z przenoszeniem ładunku 521-11-17
obszar
obszar ładunku przestrzennego 521-02-79
obszar ładunku przestrzennego (złącza PN) 521-02-80
obszar neutralny 521-02-68
obszar przejścia 521-02-66
obszar ujemnej rezystancji różniczkowej 521-05-05
obszar zmiany koncentracji domieszek 521-02-67
obudowa
obudowa 521-05-31

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

oczyszczanie
oczyszczanie strefowe 521-03-03
odcięcie
częstotliwość odcięcia 521-05-20
napięcie odcięcia (tranzystora polowego z kanałem zubożonym) 521-07-23
odniesienie
dioda odniesienia 521-04-16
odstęp
odstęp energetyczny 521-02-24
odwrotny
dioda odwrotna 521-04-06
odwrócony
baza wspólna odwrócona 521-07-16
emiter wspólny odwrócony 521-07-18
kolektor wspólny odwrócony 521-07-17
odzyskanie
czas odzyskania blokowania 521-05-26
odzyskiwany
ładunek odzyskiwany (diody lub tyrystora) 521-05-18
ograniczający
dioda ograniczająca mikrofalowa..... 521-04-15
opadanie
czas opadania 521-05-24
opóźnienie
czas opóźnienia 521-05-21
optoelektroniczny
przyrząd optoelektroniczny 521-04-31
wyświetlacz optoelektroniczny 521-04-36
orbitalny
liczba kwantowa orbitalna 521-01-09
osadzanie
osadzanie z fazy lotnej 521-03-15

P

P
półprzewodnik typu P 521-02-10
przewodnictwo typu P 521-02-50
tranzystor polowy z kanałem P 521-04-57
tyrystor z bramką typu P 521-04-69
pamięć
element pamięci 521-11-04
komórka pamięci 521-11-04
pamięć dynamiczna (o zmiennej zawartości) 521-11-10
pamięć nietrwała 521-11-11
pamięć o dostępie bezpośrednim 521-11-08
pamięć o dostępie swobodnym 521-11-08
pamięć o dostępie szeregowym 521-11-12
pamięć o zmiennej zawartości 521-11-07
pamięć półprzewodnikowa scalona 521-11-05
pamięć skojarzeniowa 521-11-13
pamięć stała 521-11-06
pamięć statyczna (o zmiennej zawartości) 521-11-09
pamięć ulotna 521-11-11
układ (pamięciowy) scalony 521-11-05
parametr
parametry układu 521-05-34
parametryczny
dioda parametryczna 521-04-07
pasek
pasek montażowy 521-05-32
pasmo
pasmo Blocha 521-02-25
pasmo domieszkowe 521-02-37
pasmo dozwolone 521-02-29
pasmo energetyczne 521-02-25
pasmo energetyczne (w półprzewodniku) 521-02-26
pasmo pobudzenia 521-02-28
pasmo powierzchniowe 521-02-34
pasmo przewodzenia 521-02-22
pasmo puste 521-02-33
pasmo walencyjne 521-02-23
pasmo zabronione 521-02-30
pasmo zapełnione 521-02-32
pasmo zapełnione częściowo 521-02-27
pasożytniczy
element pasożytniczy układu 521-05-36
pasywacja
pasywacja powierzchniowa 521-03-13
Pauli
zakaz Pauliego 521-01-14
zasada Pauliego-Fermiego 521-01-14
pętla
powierzchnia skuteczna pętli prądu sterującego 521-09-09
powierzchnia skuteczna pętli wyjściowej hallotronu 521-09-08
pierwiastkowy
półprzewodnik pierwiastkowy 521-02-02
pierwszy
liczba kwantowa pierwsza 521-01-08
piezorezystywny
zjawisko piezorezystywne 521-02-85
planarny
technika planarna 521-03-09
PLD
PLD (akronim) 521-11-01
płynący
napięcie płynące 521-05-17
płytka
płytka 521-05-29
PN
granica PN 521-02-65
złącze PN 521-02-78
pobudzenie
pasmo pobudzenia 521-02-28
podczerwień
dioda emitująca w (zakresie) podczerwieni 521-04-40
dioda na podczerwień 521-04-40
podłoże
podłoże 521-05-28

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

podtrzymywanie
prąd podtrzymywania 521-08-10
pojemność
dioda o zmiennej pojemności 521-04-07
pojemność cieplna 521-05-16
pole
napięcie szczątkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu) 521-09-15
pole elektryczne wewnętrzne 521-02-81
pole indukowane (generatora Halla) ... 521-09-10
polowy
tranzystor polowy 521-04-52
tranzystor (polowy) MOS 521-04-55
tranzystor polowy tlenkowy 521-04-55
tranzystor polowy z bramką izolowaną 521-04-54
tranzystor polowy z bramką złączową 521-04-53
tranzystor polowy z kanałem N 521-04-56
tranzystor polowy z kanałem P 521-04-57
tranzystor polowy z kanałem wzbogaconym 521-04-59
tranzystor polowy z kanałem zubożonym 521-04-58
tranzystor polowy złączowy z bramką metalową 521-04-60
potencjał
bariera potencjału 521-02-69
bariera potencjału (złącza PN) 521-02-70
powierzchnia
powierzchnia skuteczna pętli prądu sterującego 521-09-09
powierzchnia skuteczna pętli wyjściowej hallotronu 521-09-08
powierzchniowy
pasmo powierzchniowe 521-02-34
pasywacja powierzchniowa 521-03-13
poziom powierzchniowy 521-02-42
prędkość rekombinacji powierzchniowej 521-02-56
poziom
poziom akceptorowy 521-02-41
poziom domieszkowy 521-02-36
poziom donorowy 521-02-40
poziom energetyczny (cząstki) 521-01-12
poziom Fermiego 521-01-17
poziom lokalny 521-02-35
poziom powierzchniowy 521-02-42
wykres poziomów energetycznych (cząstek) 521-01-13
pozorny
temperatura pozorna (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-14
temperatura pozorna złącza 521-05-15
półprzewodnik
półprzewodnik 521-02-01
półprzewodnik jonowy 521-02-06
półprzewodnik niesamoistny 521-02-08
półprzewodnik niezdegenerowany 521-02-12
półprzewodnik pierwiastkowy 521-02-02
półprzewodnik samoistny 521-02-07
półprzewodnik skompensowany 521-02-11
półprzewodnik typu N 521-02-09
półprzewodnik typu P 521-02-10
półprzewodnik zdegenerowany 521-02-13
półprzewodnik złożony 521-02-03
półprzewodnikowy
detektor fotoelektryczny (półprzewodnikowy) 521-04-42
dioda (półprzewodnikowa) 521-04-03
dioda prostownicza (półprzewodnikowa) 521-04-19
fotoelement (półprzewodnikowy) 521-04-41
pamięć półprzewodnikowa scalona 521-11-05
przyrząd fotoelektryczny (półprzewodnikowy) 521-04-41
przyrząd półprzewodnikowy 521-04-01
przyrząd (półprzewodnikowy) dyskretny 521-04-02
stos prostowniczy (półprzewodnikowy) 521-04-21
termoelement półprzewodnikowy 521-04-23
układ scalony półprzewodnikowy 521-10-05
praca
tryb pracy ze wzbogaceniem 521-07-11
tryb pracy ze zubożeniem 521-07-10
prawo
prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda 521-01-19
prawo rozkładu prędkości Maxwella-Boltzmanna 521-01-05
prąd
dioda stabilizująca prąd 521-04-18
końcówka prądu sterującego hallotronu 521-09-07
napięcie szczątkowe przy prądzie sterującym zerowym (sondy Halla) .. 521-09-14
powierzchnia skuteczna pętli prądu sterującego 521-09-09
prąd główny 521-08-02
prąd nieprzełączający bramki 521-08-17
prąd podtrzymywania 521-08-10
prąd przełączający bramki 521-08-14
prąd przewodzenia 521-02-15
prąd sterujący (generatora Halla) 521-09-11
prąd zatrzaskiwania 521-08-11
prądowy
charakterystyka główna (napięciowo-prądowa) 521-08-05
czułość prądowa (sondy Halla) 521-09-13
współczynnik statyczny przenoszenia prądowego 521-07-20
współczynnik zwarciowy małosygnałowy przenoszenia prądowego 521-07-19
prędkość
prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda 521-01-19
prawo rozkładu prędkości Maxwella-Boltzmanna 521-01-05

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

prędkość krytyczna wzrostu napięcia blokowania 521-08-18
prędkość krytyczna wzrostu napięcia przewodzenia 521-08-19
prędkość rekombinacji powierzchniowej 521-02-56
progowy
napięcie progowe (diody lub tyrystora) 521-05-19
napięcie progowe (tranzystora polowego z kanałem wzbogaconym) 521-07-24
programowalny
matryca bramek programowalna 521-11-03
matryca logiczna programowalna 521-11-02
przyrząd logiczny programowalny 521-11-01
układ matrycowy programowalny 521-11-03
projektowany
układ scalony projektowany z udziałem użytkownika 521-11-19
prostowniczy
dioda prostownicza lawinowa 521-04-20
dioda prostownicza (półprzewodnikowa) 521-04-19
stos prostowniczy (półprzewodnikowy) 521-04-21
przebicie
napięcie przebicia lawinowego 521-05-08
przebicie cieplne (złącza PN) 521-05-11
przebicie lawinowe (złącza półprzewodnikowego PN) 521-05-07
przebicie Zenera (złącza PN) 521-05-09
przebicie (złącza PN spolaryzowanego wstecznie) 521-05-06
przejście
częstotliwość przejścia 521-07-21
obszar przejścia 521-02-66
przejściowy
złącze przejściowe stopniowane 521-02-74
przełączający
dioda przełączająca mikrofalowa 521-04-14
dioda przełączająca 521-04-13
napięcie przełączające bramki 521-08-15
prąd przełączający bramki 521-08-14
przełączanie
punkt przełączania 521-08-12
przenoszenie
analizator obrazu z przenoszeniem ładunku 521-11-17
przyrząd z przenoszeniem ładunku 521-11-14
współczynnik statyczny przenoszenia prądowego 521-07-20
współczynnik zwarciowy małosygnałowy przenoszenia prądowego 521-07-19
przestrzenny
obszar ładunku przestrzennego 521-02-79
obszar ładunku przestrzennego (złącza PN) 521-02-80
przesunięty
punkt szczytowy przesunięty (diody tunelowej) 521-06-03
przewodnictwo
modulacja przewodnictwa (półprzewodnika) 521-02-55
przewodnictwo samoistne 521-02-48
przewodnictwo typu N 521-02-49
przewodnictwo typu P 521-02-50
przewodnik
przewodnik 521-02-16
przewodzący
tyrystor diodowy przewodzący wstecznie 521-04-64
tyrystor triodowy przewodzący wstecznie 521-04-65
przewodzenie
czas ustalania się stanu przewodzenia 521-05-25
elektron przewodzenia 521-02-14
kierunek przewodzenia (złącza PN) ... 521-05-03
pasmo przewodzenia 521-02-22
prąd przewodzenia 521-02-15
prędkość krytyczna wzrostu napięcia przewodzenia 521-08-19
przewodzenie dziurowe 521-02-18
przewodzenie elektronowe 521-02-19
przewodzenie jonowe 521-02-21
przewodzenie samoistne 521-02-20
rezystancja dynamiczna przewodzenia 521-08-13
stan przewodzenia 521-08-07
przyrząd
przyrząd elektroluminescencyjny 521-04-35
przyrząd fotoelektryczny (półprzewodnikowy) 521-04-41
przyrząd logiczny programowalny 521-11-01
przyrząd łańcuchowy 521-11-15
przyrząd optoelektroniczny 521-04-31
przyrząd półprzewodnikowy 521-04-01
przyrząd (półprzewodnikowy) dyskretny 521-04-02
przyrząd wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne 521-05-27
przyrząd z przenoszeniem ładunku 521-11-14
przyrząd ze sprzężeniem ładunkowym 521-11-16
pułapka
pułapka 521-02-63
punkt
punkt dolinowy (diody tunelowej) 521-06-02
punkt przełączania 521-08-12
punkt szczytowy (diody tunelowej) 521-06-01
punkt szczytowy przesunięty (diody tunelowej) 521-06-03
pusty
pasmo puste 521-02-33

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

R

radiator
radiator 521-05-33
RAM
RAM (akronim) 521-11-08
rekombinacja
centrum rekombinacji 521-02-64
prędkość rekombinacji powierzchniowej 521-02-56
rezystancja
obszar ujemnej rezystancji różniczkowej 521-05-05
rezystancja cieplna (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-13
rezystancja dynamiczna przewodzenia 521-08-13
rezystancja nachyleni(ow)a 521-06-05
wskaźnik rezystancji magnetorezystora 521-09-19
rezystancyjny
czułość rezystancyjna magnetorezystora 521-09-20
rezystywnościowy
częstotliwość graniczna rezystywnościowa 521-06-04
ROM
ROM (akronim) 521-11-06
rozkład
prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda 521-01-19
prawo rozkładu prędkości Maxwella-Boltzmanna 521-01-05
rozkład Fermiego-Diraca 521-01-15
rozkład Maxwella-Boltzmanna 521-01-03
różniczkowy
obszar ujemnej rezystancji różniczkowej 521-05-05
ruchliwość
ruchliwość Halla 521-09-04
ruchliwość (nośnika ładunku) 521-02-58

S

samoistny
półprzewodnik samoistny 521-02-07
przewodnictwo samoistne 521-02-48
przewodzenie samoistne 521-02-20
samotny
elektron samotny 521-01-18
scalony
komórka (układu scalonego) 521-11-21
pamięć półprzewodnikowa scalona 521-11-05
układ (pamięciowy) scalony 521-11-05
układ scalony 521-10-03
układ scalony na zamówienie 521-11-18
układ scalony półprzewodnikowy 521-10-05
układ scalony projektowany z udziałem użytkownika 521-11-19
układ scalony specjalizowany 521-11-18
układ scalony warstwowy 521-10-06
układ scalony wielostrukturowy 521-10-10
Schottky
bariera Schottky'ego 521-02-71
sitodruk
technika sitodruku 521-03-16
skład
skład stechiometryczny 521-02-46
skojarzeniowy
pamięć skojarzeniowa 521-11-13
skokowy
złącze skokowe 521-02-73
skompensowany
półprzewodnik skompensowany 521-02-11
skrośny
zwarcie skrośne (między dwoma złączami PN) 521-05-12
skuteczny
powierzchnia skuteczna pętli prądu sterującego 521-09-09
powierzchnia skuteczna pętli wyjściowej hallotronu 521-09-08
Sommerfeld
prawo rozkładu prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda 521-01-19
sonda
sonda Halla 521-04-28
specjalizowany
układ scalony specjalizowany 521-11-18
spin
liczba spinowa 521-01-10
spin 521-01-10
sprzęgacz
sprzęgacz fotonowy 521-04-45
sprzężenie
przyrząd ze sprzężeniem ładunkowym 521-11-16
stabilizacyjny
dioda stabilizacyjna 521-04-16
stabilizujący
dioda stabilizująca napięcie 521-04-17
dioda stabilizująca prąd 521-04-18
stały
stała dyfuzji (nośników ładunku) 521-02-61
pamięć stała 521-11-06
stan
czas ustalania się stanu przewodzenia 521-05-25
stan blokowania 521-08-08
stan przewodzenia 521-08-07
stan włączenia 521-08-07
stan wyłączenia 521-08-08
stan zatrzaśnięcia 521-10-11
stan zaworowy (tyrystora blokującego wstecznie) 521-08-09

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

statyczny
pamięć statyczna (o zmiennej zawartości) 521-11-09
współczynnik statyczny przenoszenia prądowego 521-07-20
stechiometryczny
skład stechiometryczny 521-02-46
sterujący
końcówka prądu sterującego hallotronu 521-09-07
napięcie sterujące indukowane (hallotronu) 521-09-16
napięcie szczątkowe przy prądzie sterującym zerowym (sondy Halla) .. 521-09-14
powierzchnia skuteczna pętli prądu sterującego 521-09-09
prąd sterujący (generatora Halla) 521-09-11
stopniowany
złącze przejściowe stopniowane 521-02-74
stopowy
technika stopowa 521-03-07
złącze stopowe 521-02-75
stos
stos prostowniczy (półprzewodnikowy) 521-04-21
strefowy
metoda monokrystalizacji strefowej 521-03-02
oczyszczanie strefowe 521-03-03
wyrównywanie strefowe 521-03-04
struktura
struktura 521-05-30
swobodny
pamięć o dostępie swobodnym 521-11-08
sygnałowy
dioda sygnałowa 521-04-04
szczątkowy
napięcie szczątkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu) 521-09-15
napięcie szczątkowe przy prądzie sterującym zerowym (sondy Halla) .. 521-09-14
szczyt
szczyt (diody tunelowej)..... 521-06-01
szczytowy
punkt szczytowy (diody tunelowej) 521-06-01
punkt szczytowy przesunięty (diody tunelowej) 521-06-03
szeregowy
pamięć o dostępie szeregowym 521-11-12
świecący
dioda świecąca 521-04-39

T

tarczowy
magnetorezystor tarczowy 521-04-30
technika
technika dyfuzyjna 521-03-08
technika "mesa" 521-03-11
technika mikrostopu 521-03-10
technika planarna 521-03-09
technika sitodruku 521-03-16
technika stopowa 521-03-07
temperatura
temperatura pozorna (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-14
temperatura pozorna złącza 521-05-15
tensorezystywny
zjawisko tensorezystywne 521-02-85
termistor
termistor 521-04-22
termoelement
termoelement półprzewodnikowy 521-04-23
tetrodowy
tranzystor tetrodowy 521-04-50
tlenkowy
tranzystor polowy tlenkowy 521-04-55
transkonduktancja
transkonduktancja (tranzystora polowego) 521-07-25
transoptor
transoptor 521-04-45
tranzystor
tranzystor 521-04-46
tranzystor bipolarny złączowy 521-04-47
tranzystor dwukierunkowy 521-04-49
tranzystor polowy 521-04-52
tranzystor (polowy) MOS 521-04-55
tranzystor polowy tlenkowy 521-04-55
tranzystor polowy z bramką izolowaną 521-04-54
tranzystor polowy z bramką złączową 521-04-53
tranzystor polowy z kanałem N 521-04-56
tranzystor polowy z kanałem P 521-04-57
tranzystor polowy z kanałem wzbogaconym 521-04-59
tranzystor polowy z kanałem zubożonym 521-04-58
tranzystor polowy złączowy z bramką metalową 521-04-60
tranzystor tetrodowy 521-04-50
tranzystor unipolarny 521-04-48
triak
triak 521-04-67
triodowy
tyrystor triodowy blokujący wstecznie . 521-04-63
tyrystor triodowy dwukierunkowy 521-04-67
tyrystor triodowy przewodzący wstecznie 521-04-65
tryb
tryb pracy ze wzbogaceniem 521-07-11
tryb pracy ze zubożeniem 521-07-10
tunelowy
dioda tunelowa 521-04-05
zjawisko tunelowe (w złączu PN) 521-02-83
typ
półprzewodnik typu N 521-02-09
półprzewodnik typu P 521-02-10
przewodnictwo typu N 521-02-49
przewodnictwo typu P 521-02-50

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

tyrystor z bramką typu N 521-04-70
tyrystor z bramką typu P 521-04-69
tyrystor
bramka (tyrystora) 521-08-01
tyrystor 521-04-61
tyrystor asymetryczny 521-04-71
tyrystor diodowy blokujący wstecznie . 521-04-62
tyrystor diodowy dwukierunkowy 521-04-66
tyrystor diodowy przewodzący wstecznie 521-04-64
tyrystor triodowy blokujący wstecznie . 521-04-63
tyrystor triodowy dwukierunkowy 521-04-67
tyrystor triodowy przewodzący wstecznie 521-04-65
tyrystor wyłączający 521-04-68
tyrystor z bramką typu N 521-04-70
tyrystor z bramką typu P 521-04-69

U

udział
układ scalony projektowany z udziałem użytkownika 521-11-19
ujemny
obszar ujemnej rezystancji różniczkowej 521-05-05
ujście
ujście (tranzystora polowego) 521-07-08
układ
element pasożytniczy układu 521-05-36
komórka (układu scalonego) 521-11-21
parametry układu 521-05-34
układ kwantowany (cząstek) 521-01-02
układ matrycowy 521-11-20
układ matrycowy programowalny 521-11-03
układ niekwantowany (cząstek) 521-01-01
układ (pamięciowy) scalony 521-11-05
układ scalony 521-10-03
układ scalony na zamówienie 521-11-18
układ scalony półprzewodnikowy 521-10-05
układ scalony projektowany z udziałem użytkownika 521-11-19
układ scalony specjalizowany 521-11-18
układ scalony warstwowy 521-10-06
układ scalony wielostrukturowy 521-10-10
układ zastępczy 521-05-35
ulotny
pamięć ulotna 521-11-11
unipolarny
tranzystor unipolarny 521-04-48
ustalanie
czas ustalania się stanu przewodzenia 521-05-25
użytkownik
układ scalony projektowany z udziałem użytkownika 521-11-19

W

walencyjny
pasmo walencyjne 521-02-23
warikap
warikap 521-04-07
warstwa
warstwa cienka (układu scalonego warstwowego) 521-10-08
warstwa gruba (układu scalonego warstwowego) 521-10-09
warstwa (układu scalonego warstwowego) 521-10-07
warstwa zubożona (w półprzewodniku) 521-02-82
warstwowy
układ scalony warstwowy 521-10-06
wewnętrzny
pole elektryczne wewnętrzne 521-02-81
wielostrukturowy
układ scalony wielostrukturowy 521-10-10
większościowy
nośnik większościowy (w obszarze półprzewodnika) 521-02-52
włączenie
stan włączenia 521-08-07
wrażliwy
przyrząd wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne 521-05-27
wskaźnik
wskaźnik rezystancji magnetorezystora 521-09-19
wspólny
baza wspólna 521-07-13
baza wspólna odwrócona 521-07-16
emiter wspólny 521-07-15
emiter wspólny odwrócony 521-07-18
kolektor wspólny 521-07-14
kolektor wspólny odwrócony 521-07-17
współczynnik
współczynnik Halla 521-09-02
współczynnik magnetorezystancji 521-09-18
współczynnik statyczny przenoszenia prądowego 521-07-20
współczynnik zwarciowy małosygnałowy przenoszenia prądowego 521-07-19
wstecznie
tyrystor diodowy blokujący wstecznie . 521-04-62
tyrystor diodowy przewodzący wstecznie 521-04-64
tyrystor triodowy blokujący wstecznie . 521-04-63
tyrystor triodowy przewodzący wstecznie 521-04-65
wsteczny
dioda wsteczna 521-04-06
kierunek działania wsteczny 521-07-12
wyciągany
złącze wyciągane 521-02-77

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

wyjściowy
powierzchnia skuteczna pętli wyjściowej hallotronu 521-09-08
wykres
wykres poziomów energetycznych (cząstek) 521-01-13
wyładowanie
przyrząd wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne 521-05-27
wyłączający
tyrystor wyłączający 521-04-68
wyłączenie
stan wyłączenia 521-08-08
wyprowadzenie
wyprowadzenie (przyrządu półprzewodnikowego) 521-05-02
wyrównywanie
wyrównywanie strefowe 521-03-04
wyświetlacz
wyświetlacz optoelektroniczny 521-04-36
wzbogacenie
tryb pracy ze wzbogaceniem 521-07-11
wzbogacony
tranzystor polowy z kanałem wzbogaconym 521-04-59
wzrost
prędkość krytyczna wzrostu napięcia blokowania 521-08-18
prędkość krytyczna wzrostu napięcia przewodzenia 521-08-19

Z

zabroniony
pasmo zabronione 521-02-30
zakaz
zakaz Pauliego 521-01-14
zakres
dioda emitująca w (zakresie) podczerwieni 521-04-40
zależność
zależność Boltzmanna 521-01-04
zamówienie
układ scalony na zamówienie 521-11-18
zanieczyszczenie
zanieczyszczenie 521-02-04
zapełniony
pasmo zapełnione 521-02-32
pasmo zapełnione częściowo 521-02-27
zaporowy
kierunek zaporowy (złącza PN) 521-05-04
zasada
zasada Pauliego-Fermiego 521-01-14
zastępczy
układ zastępczy 521-05-35
zatrzaskiwanie
prąd zatrzaskiwania 521-08-11
zatrzaśnięcie
stan zatrzaśnięcia 521-10-11
zawartość
pamięć dynamiczna (o zmiennej zawartości) 521-11-10
pamięć o zmiennej zawartości 521-11-07
pamięć statyczna (o zmiennej zawartości) 521-11-09
zaworowy
stan zaworowy (tyrystora blokującego wstecznie) 521-08-09
zdegenerowany
półprzewodnik zdegenerowany 521-02-13
Zener
dioda Zenera 521-04-17
napięcie Zenera 521-05-10
przebicie Zenera (złącza PN) 521-05-09
zerowy
napięcie szczątkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu) 521-09-15
napięcie szczątkowe przy prądzie sterującym zerowym (sondy Halla) 521-09-14
zjawisko
zjawisko fotoelektryczne 521-01-20
zjawisko fotokonduktywne 521-01-22
zjawisko fotomagnetoelektryczne 521-01-23
zjawisko fotowoltaiczne 521-01-21
zjawisko Halla 521-09-01
zjawisko magnetorezystywne 521-02-84
zjawisko piezorezystywne 521-02-85
zjawisko tensorezystywne 521-02-85
zjawisko tunelowe (w złączu PN) 521-02-83
złącze
temperatura pozorna złącza 521-05-15
złącze 521-02-72
złącze dyfuzyjne 521-02-76
złącze emitera 521-07-01
złącze kolektora 521-07-02
złącze PN 521-02-78
złącze przejściowe stopniowane 521-02-74
złącze skokowe 521-02-73
złącze stopowe 521-02-75
złącze wyciągane 521-02-77
złączowy
tranzystor bipolarny złączowy 521-04-47
tranzystor polowy z bramką złączową 521-04-53
tranzystor polowy złączowy z bramką metalową 521-04-60
złożony
półprzewodnik złożony 521-02-03
zmiana
obszar zmiany koncentracji domieszek 521-02-67
zmienna
dioda o zmiennej pojemności 521-04-07
pamięć dynamiczna (o zmiennej zawartości) 521-11-10
pamięć o zmiennej zawartości 521-11-07
pamięć statyczna (o zmiennej zawartości) 521-11-09

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

zubożenie
tryb pracy ze zubożeniem 521-07-10
zubożony
tranzystor polowy z kanałem zubożonym 521-04-58
warstwa zubożona (w półprzewodniku) 521-02-82
zwarcie
zwarcie skrośne (między dwoma złączami PN) 521-05-12
zwarciowy
współczynnik zwarciowy małosygnałowy przenoszenia prądowego 521-07-19

Ź

źródło
źródło (tranzystora polowego) 521-07-07

Ż

życie
czas życia objętościowy (nośnika mniejszościowego) 521-02-57

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

ÍNDICE

A

aceitador ... 521-02-39
acumulação de portadores de carga (num semicondutor) ... 521-02-62
ângulo de Hall ... 521-09-03
armadilha ... 521-02-63
ASIC *(abreviatura)* ... 521-11-18
átomo de Bohr ... 521-01-06

B

banda cheia ... 521-02-32
banda de Bloch ... 521-02-25
banda de condução ... 521-02-22
banda de energia ... 521-02-25
banda de energia (num semicondutor) ... 521-02-26
banda de excitação ... 521-02-28
banda de impureza ... 521-02-37
banda de superfície ... 521-02-34
banda de valência ... 521-02-23
banda parcialmente ocupada ... 521-02-27
banda permitida ... 521-02-29
banda proibida ... 521-02-30
banda vazia ... 521-02-33
barreira de potencial ... 521-02-69
barreira de potencial (de uma junção PN) ... 521-02-70
barreira de Schottky ... 521-02-71
base ... 521-07-03
(montagem de) base comum ... 521-07-13
(montagem de) base comum inversa ... 521-07-16
bloco rectificador semicondutor ... 521-04-21
bolacha ... 521-05-29
buraco ... 521-02-17

C

camada de depleção (de um semicondutor) ... 521-02-82
campo eléctrico interno ... 521-02-81
campo induzido (de um gerador de Hall) ... 521-09-10
canal (de um transistor de efeito de campo) ... 521-07-06
capacidade térmica ... 521-05-16
característica (corrente-tensão) de ânodo-cátodo ... 521-08-06
característica (corrente-tensão) principal ... 521-08-05
carga recuperada (de um díodo ou de um tiristor) ... 521-05-18
CCD *(abreviatura)* ... 521-11-16
célula ... 521-11-21
célula de memória ... 521-11-04
célula fotocondutiva ... 521-04-33
célula fotovoltaica ... 521-04-34
centro de recombinação ... 521-02-64
chipe ... 521-05-30
circuito equivalente ... 521-05-35
circuito integrado ... 521-10-03
circuito integrado de aplicação específica ... 521-11-18
circuito integrado em películas ... 521-10-06
circuito integrado multichipe ... 521-10-10
circuito integrado pré-difundido ... 521-11-20
circuito integrado semicondutor ... 521-10-05
circuito integrado semipersonalizado ... 521-11-19
coeficiente de Hall ... 521-09-02
coeficiente de magneto-resistência ... 521-09-18
colector ... 521-07-05
(montagem de) colector comum ... 521-07-14
(montagem de) colector comum inverso ... 521-07-17
compensação por impurezas ... 521-03-06
composição estequiométrica ... 521-02-46
comprimento de difusão (dos portadores minoritários) ... 521-02-60
condução intrínseca ... 521-02-20
condução iónica ... 521-02-21
condução por buracos ... 521-02-18
condução por electrões ... 521-02-19
condutividade de tipo N ... 521-02-49
condutividade de tipo P ... 521-02-50
condutividade intrínseca ... 521-02-48
condutor ... 521-02-16
constante de difusão (dos portadores de carga) ... 521-02-61
corrente de comando (de um gerador de Hall) ... 521-09-11
corrente de condução ... 521-02-15
corrente de disparo de porta ... 521-08-14
corrente de manutenção ... 521-08-10
corrente de não-disparo de porta ... 521-08-17
corrente de retenção ... 521-08-11
corrente principal ... 521-08-02
crescimento de um monocristal por fusão de zona ... 521-03-02
crescimento pelo método de Czochralski ... 521-03-01
crescimento por extracção (de um monocristal) ... 521-03-01
cristal ideal ... 521-02-45
curva característica magneto-resistiva ... 521-09-17

D

dador ... 521-02-38
depósito em fase vapor ... 521-03-15
diac *(abreviatura)* ... 521-04-66
diagrama de níveis de energia ... 521-01-13
diagrama energético ... 521-01-13
difusão (num semicondutor) ... 521-02-59
díodo ... 521-04-03
díodo de capacidade variável ... 521-04-07
díodo de comutação ... 521-04-13

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

díodo de comutação hiperfrequência 521-04-14
díodo de limitação hiperfrequência..... 521-04-15
díodo de retorno rápido 521-04-12
díodo de sinal 521-04-04
díodo de tensão de referência..... 521-04-16
díodo detector 521-04-11
díodo emissor de infravermelho 521-04-40
díodo emissor de luz 521-04-39
díodo laser..... 521-04-37
díodo misturador..... 521-04-08
díodo modulador..... 521-04-10
díodo para multiplicação de frequência .. 521-04-09
díodo rectificador (semicondutor) 521-04-19
díodo rectificador de avalanche..... 521-04-20
díodo regulador de corrente 521-04-18
díodo regulador de tensão..... 521-04-17
díodo semicondutor 521-04-03
díodo túnel..... 521-04-05
díodo unitúnel..... 521-04-06
disco de Corbino..... 521-04-30
dispositivo de acoplamento de carga 521-11-16
dispositivo de efeito Hall..... 521-04-24
dispositivo de transferência de carga 521-11-14
dispositivo discreto 521-04-02
dispositivo em colar 521-11-15
dispositivo lógico programável 521-11-01
dispositivo optoelectrónico 521-04-31
dispositivo semicondutor 521-04-01
dispositivo semicondutor discreto..... 521-04-02
dispositivo semicondutor foto-sensível ... 521-04-41
dispositivo sensível às descargas electrostáticas..... 521-05-27
dissipador (de calor)..... 521-05-33
dopagem (de um semicondutor)..... 521-03-05
dreno (de um transistor de efeito de campo)..... 521-07-08
duração de vida no material (de portadores minoritários)..... 521-02-57

E

efeito fotocondutivo 521-01-22
efeito fotoeléctrico 521-01-20
efeito fotoelectromagnético 521-01-23
efeito fotovoltaico..... 521-01-21
efeito Hall 521-09-01
efeito magneto-resistivo 521-02-84
efeito piezo-resistivo..... 521-02-85
efeito tenso-resistivo..... 521-02-85
efeito túnel (numa junção PN)..... 521-02-83
electrão solitário 521-01-18
eléctrodo (de um dispositivo semicondutor)..... 521-05-01
electrões de condução 521-02-14
elemento de circuito parasita..... 521-05-36
emissor..... 521-07-04
(montagem de) emissor comum..... 521-07-15
(montagem de) emissor comum inverso..... 521-07-18
energia de activação das impurezas..... 521-02-05
energia de ionização de um aceitador.... 521-02-44
energia de ionização de um dador 521-02-43
epitaxia..... 521-03-12
estado condutor..... 521-08-07
estado cortado..... 521-08-08
estado cortado em sentido inverso (de um tiristor cortado em sentido inverso) 521-08-09
estado trancado..... 521-10-11
estatística de Fermi 521-01-15
estatística de Fermi-Dirac..... 521-01-15
estatística de Maxwell-Boltzmann 521-01-03

F

fonte (de um transistor de efeito de campo)..... 521-07-07
fotoacoplador..... 521-04-45
fotodíodo 521-04-32
fotodíodo de avalanche 521-04-44
fotoemissor..... 521-04-35
fotorresistor 521-04-43
fototiristor..... 521-04-72
fototransistor..... 521-04-51
frequência da relação de transferência unitária de corrente..... 521-07-22
frequência de corte..... 521-05-20
frequência de corte resistiva..... 521-06-04
frequência de transição 521-07-21
função de Fermi-Dirac..... 521-01-16
funcionamento em modo de depleção ... 521-07-10
funcionamento em modo de empobrecimento..... 521-07-10
funcionamento em modo de enriquecimento 521-07-11

G

gerador de Hall..... 521-04-26
grelha (de um transistor de efeito de campo)..... 521-07-09
grelha de conexão (de um invólucro) 521-05-32

I

imperfeição (de uma rede cristalina) 521-02-47
implantação iónica..... 521-03-14
impureza..... 521-02-04
invólucro..... 521-05-31
isolante..... 521-02-31

J

junção..... 521-02-72
junção abrupta..... 521-02-73
junção colectora 521-07-02
junção emissora 521-07-01
junção PN..... 521-02-78
junção por difusão 521-02-76
junção por estiramento..... 521-02-77
junção por liga 521-02-75
junção progressiva 521-02-74

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---
Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

L

LED *(abreviatura)* 521-04-39
lei de distribuição das velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld 521-01-19
lei de distribuição das velocidades de Maxwell-Boltzmann..... 521-01-05
limite PN 521-02-65

M

macrocélula 521-11-22
magnetómetro de efeito Hall 521-04-28
magnetorresistor..... 521-04-29
matriz lógica programável 521-11-02
matriz pré-difundida programável..... 521-11-03
memória associativa..... 521-11-13
memória de acesso directo 521-11-08
memória de acesso sequencial 521-11-12
memória de circuito integrado 521-11-05
memória de leitura..... 521-11-06
memória de leitura e escrita 521-11-07
memória dinâmica de leitura e escrita.... 521-11-10
memória endereçável pelo conteúdo..... 521-11-13
memória estática de leitura e escrita..... 521-11-09
memória volátil 521-11-11
microcircuito 521-10-02
microconjunto 521-10-04
microelectrónica 521-10-01
micromontagem..... 521-10-04
mobilidade (de um portador de carga).... 521-02-58
mobilidade de Hall 521-09-04
modulação da condutividade (de um semicondutor)..... 521-02-55
modulador de efeito Hall..... 521-04-25
módulo de díodo laser 521-04-38
(número quântico de) momento angular total 521-01-11
(montagem de) base comum..... 521-07-13
(montagem de) base comum inversa 521-07-16
(montagem de) colector comum 521-07-14
(montagem de) colector comum inverso..... 521-07-17
(montagem de) emissor comum 521-07-15
(montagem de) emissor comum inverso..... 521-07-18
multiplicador de Hall 521-04-27

N

nível aceitador 521-02-41
nível dador..... 521-02-40
nível de energia..... 521-01-12
nível de Fermi..... 521-01-17
nível de impureza 521-02-36
nível de superfície 521-02-42
nível local 521-02-35
nivelamento por zona 521-03-04
(número quântico de) momento angular total 521-01-11
(número quântico de) spin..... 521-01-10
número quântico (de um electrão num átomo dado)..... 521-01-07
número quântico orbital..... 521-01-09
número quântico principal 521-01-08
número quântico secundário 521-01-09

O

optoacoplador..... 521-04-45

P

parâmetros de circuito..... 521-05-34
passivação de superfície..... 521-03-13
película (de um circuito integrado em películas) 521-10-07
película espessa (de um circuito integrado em películas) 521-10-09
película fina (de um circuito integrado em películas) 521-10-08
penetração (entre duas junções PN)..... 521-05-12
perfuração (de uma junção PN polarizada inversamente) 521-05-06
perfuração por avalanche (de uma junção PN semicondutora) 521-05-07
perfuração por efeito térmico (de uma junção PN)..... 521-05-11
perfuração por efeito túnel (de uma junção PN)..... 521-05-09
perfuração por efeito Zener (de uma junção PN)..... 521-05-09
ponto de pico (de um díodo túnel)..... 521-06-01
ponto de pico projectado (de um díodo túnel) 521-06-03
ponto de retorno 521-08-12
ponto de vale (de um díodo túnel)..... 521-06-02
porta 521-08-01
porta (de um transistor de efeito de campo)..... 521-07-09
portador..... 521-02-51
portador de carga 521-02-51
portador em excesso..... 521-02-54
portador maioritário 521-02-52
portador minoritário 521-02-53
princípio de exclusão de Pauli-Fermi 521-01-14
pulverização sob vácuo..... 521-03-17
purificação por zona 521-03-03

R

RAM *(abreviatura)* 521-11-08
receptor semicondutor fotoeléctrico 521-04-42
região de carga espacial 521-02-79
região de carga espacial (de uma junção PN)..... 521-02-80
região de resistência diferencial negativa..... 521-05-05
região de transição..... 521-02-66
região neutra 521-02-68
relação de Boltzmann..... 521-01-04
relação de magneto-resistência 521-09-19

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

relação de transferência directa da corrente para pequenos sinais, com saída em curtocircuito 521-07-19
resistência aparente directa 521-06-05
resistência aparente no estado condutor 521-08-13
resistência dinâmica directa 521-06-05
resistência dinâmica no estado condutor 521-08-13
resistência térmica (de um dispositivo semicondutor) 521-05-13
ROM *(abreviatura)* 521-11-06

S

semicondutor 521-02-01
semicondutor compensado 521-02-11
semicondutor composto 521-02-03
semicondutor de tipo N 521-02-09
semicondutor de tipo P 521-02-10
semicondutor degenerado 521-02-13
semicondutor elementar 521-02-02
semicondutor extrínseco 521-02-08
semicondutor intrínseco 521-02-07
semicondutor iónico 521-02-06
semicondutor não degenerado 521-02-12
sensibilidade à corrente de comando (de uma sonda de Hall) 521-09-13
sensibilidade de magneto-resistência 521-09-20
sensibilidade magnética (de uma sonda de Hall) 521-09-12
sensor de imagem por transferência de carga 521-11-17
sentido directo (de uma junção PN) 521-05-03
sentido inverso (de uma junção PN) 521-05-04
sentido inverso de funcionamento 521-07-12
separação energética 521-02-24
serigrafia 521-03-16
sistema não quantificado (de partículas) 521-01-01
sistema quantificado (de partículas) 521-01-02
sonda de Hall 521-04-28
(número quântico de) spin 521-01-10
substrato 521-05-28
superfície efectiva de indução da malha de saída 521-09-08
superfície efectiva de indução do anel da corrente de comando 521-09-09
superfície efectiva de indução do anel de saída 521-09-08

T

técnica de difusão 521-03-08
técnica de liga 521-03-07
técnica de microliga 521-03-10
técnica mesa 521-03-11
técnica planar 521-03-09
temperatura equivalente interna (de um dispositivo semicondutor) 521-05-14
temperatura virtual (de um dispositivo semicondutor) 521-05-14
temperatura virtual (equivalente) de junção 521-05-15
tempo de armazenamento (dos portadores) 521-05-23
tempo de atraso 521-05-21
tempo de descida 521-05-24
tempo de recuperação directo 521-05-25
tempo de recuperação inverso 521-05-26
tempo de subida 521-05-22
tempo de vida no material (de portadores minoritários) 521-02-57
tensão de avalanche 521-05-08
tensão de comando induzida (de um dispositivo de efeito Hall) 521-09-16
tensão de corte (de um transistor de efeito de campo de depleção) 521-07-23
tensão de disparo de porta 521-08-15
tensão de Hall 521-09-05
tensão de limiar (de um díodo ou de um tiristor) 521-05-19
tensão de limiar (de um transistor de efeito de campo por enriquecimento) 521-07-24
tensão de não-disparo de porta 521-08-16
tensão de Zener 521-05-10
tensão flutuante 521-05-17
tensão principal 521-08-04
tensão residual para um campo magnético nulo (de um dispositivo de efeito Hall) 521-09-15
tensão residual para uma corrente de comando nula (de um dispositivo de efeito Hall) 521-09-14
terminais de comando (de um gerador de Hall) 521-09-07
terminais Hall 521-09-06
terminais principais 521-08-03
terminal (de um dispositivo semicondutor) 521-05-02
termistor 521-04-22
termoelemento semicondutor 521-04-23
tiristor 521-04-61
tiristor assimétrico 521-04-71
tiristor bloqueável 521-04-68
tiristor de porta N 521-04-70
tiristor de porta P 521-04-69
tiristor díodo bidireccional 521-04-66
tiristor díodo bloqueado em sentido inverso 521-04-62
tiristor díodo conduzindo em sentido inverso 521-04-64
tiristor tríodo bidireccional 521-04-67
tiristor tríodo bloqueado em sentido inverso 521-04-63
tiristor tríodo conduzindo em sentido inverso 521-04-65
transcondutância (de um transistor de efeito de campo) 521-07-25

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

transistor 521-04-46
transistor bidireccional 521-04-49
transistor bipolar 521-04-47
transistor de efeito de campo 521-04-52
transistor de efeito de campo (metal-óxido-semicondutor) 521-04-55
transistor de efeito de campo de canal N 521-04-56
transistor de efeito de campo de canal P 521-04-57
transistor de efeito de campo de depleção 521-04-58
transistor de efeito de campo de junção de porta 521-04-53
transistor de efeito de campo de porta isolada 521-04-54
transistor de efeito de campo metal-semicondutor 521-04-60
transistor de efeito de campo por empobrecimento 521-04-58
transistor de efeito de campo por enriquecimento 521-04-59
transistor de junção 521-04-47
transistor tétrodo 521-04-50
transistor unipolar 521-04-48
triac *(abreviatura)* 521-04-67

V

valor estático da relação de transferência directa da corrente 521-07-20
velocidade crítica de crescimento da tensão no estado condutor 521-08-19
velocidade crítica de crescimento da tensão no estado cortado 521-08-18
velocidade de recombinação em superfície 521-02-56
visualizador optoelectrónico 521-04-36

Z

zona de transição da concentração das impurezas 521-02-67

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

INDEX

A

abrupt övergång ... 521-02-73
acceptor ... 521-02-39
acceptornivå ... 521-02-41
aktiveringsenergi för störatom ... 521-02-05
anodkarakteristik ... 521-08-06
anrikningsdrift ... 521-07-11
applikationsspecifik krets ... 521-11-18
ASIC ... 521-11-18
associativt minne ... 521-11-13
asymmetrisk tyristor ... 521-04-71

B

backdiod ... 521-04-06
backriktning ... 521-05-04
bas ... 521-07-03
begränsningsdiod för högfrekvens ... 521-04-15
bikvanttal ... 521-01-09
bipolär skikttransistor ... 521-04-47
blandardiod ... 521-04-08
blocktillstånd ... 521-08-08
Bohrs atommodell ... 521-01-06
Boltzmanns ekvation ... 521-01-04
branthet ... 521-07-25

C

CCD ... 521-11-16
chip ... 521-05-30
corbinoskiva ... 521-04-30

D

dalpunkt ... 521-06-02
degenererad halvledare ... 521-02-13
delvis besatt band ... 521-02-27
detektordiod ... 521-04-11
diac ... 521-04-66
differentiell framresistans ... 521-06-05
differentiell ledresistans ... 521-08-13
diffunderad övergång ... 521-02-76
diffusion ... 521-02-59
diffusionskonstant ... 521-02-61
diffusionsteknik ... 521-03-08
diffusionsväglängd ... 521-02-60
diod med snabb återhämtning ... 521-04-12
diodtyristor med spärrförmåga ... 521-04-62
diodtyristor utan spärrförmåga ... 521-04-64
direktminne ... 521-11-08
diskret halvledarkomponent ... 521-04-02
donator ... 521-02-38
donatornivå ... 521-02-40
dopning ... 521-03-05
driftrörlighet ... 521-02-58
dubbelriktad diodtyristor ... 521-04-66
dubbelriktad transistor ... 521-04-49
dubbelriktad triodtyristor ... 521-04-67
dynamiskt minne ... 521-11-10

E

effektiv area ... 521-09-08
efterledningstid ... 521-05-23
egenfält ... 521-09-10
egen(halv)ledare ... 521-02-07
egenkonduktivitet ... 521-02-48
egenledning ... 521-02-20
ekvivalent strömkrets ... 521-05-35
elektrod ... 521-05-01
elektronkonduktivitet ... 521-02-49
elektronledning ... 521-02-19
elektrostatiskt känslig komponent ... 521-05-27
emitter ... 521-07-04
emitter (hos fälteffekttransistor) ... 521-07-07
emitterövergång ... 521-07-01
energiband ... 521-02-25
energiband (i halvledare) ... 521-02-26
energigap ... 521-02-24
energinivå ... 521-01-12
energinivådiagram ... 521-01-13
enhetsgränsfrekvens ... 521-07-22
ensam elektron ... 521-01-18
epitaxi ... 521-03-12
ettelementshalvledare ... 521-02-02
excitationsband ... 521-02-28
extrapolerad enhetsgränsfrekvens ... 521-07-21

F

falltid ... 521-05-24
Fermi-Dirac-funktion ... 521-01-16
fermifördelning ... 521-01-19
ferminivå ... 521-01-17
fermistatistik ... 521-01-15
film ... 521-10-07
flyktigt minne ... 521-11-11
fotodiod ... 521-04-32
fotoelektrisk detektor ... 521-04-42
fotoelektrisk effekt ... 521-01-20
fotoelektromagnetisk effekt ... 521-01-23
fotoelektromotorisk cell ... 521-04-34
fotoelektromotorisk effekt ... 521-01-21
fotoemitter ... 521-04-35
fotokonduktiv cell ... 521-04-33
fotokonduktiv effekt ... 521-01-22
fotomotstånd ... 521-04-43
fototransistor ... 521-04-51
fototyristor ... 521-04-72
framriktning ... 521-05-03
frekvensmultipliceringsdiod ... 521-04-09
frispänning ... 521-05-17
funktionscell ... 521-11-21

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

fyllt band 521-02-32
(störämnes)fälla 521-02-63
fälteffekttransistor 521-04-52
fälteffekttransistor av anrikningstyp 521-04-59
fälteffekttransistor av utarmningstyp 521-04-58
fälteffekttransistor med isolerat styre 521-04-54
fälteffekttransistor med metallstyre 521-04-60
fälteffekttransistor med oxidisolerat styre 521-04-55
fälteffekttransistor med PN-styre 521-04-53
förbjudet band 521-02-30
fördröjningstid 521-05-21

G

gemensam bas 521-07-13
gemensam emitter 521-07-15
gemensam kollektor 521-07-14
genombrott 521-05-06
gradvis övergång 521-02-74
grindmatris 521-11-20
gränsfrekvens 521-05-20

H

halleffekt 521-09-01
hallgenerator 521-04-26
hallkomponent 521-04-24
hallkonstant 521-09-02
hallmobilitet 521-09-04
hallmodulator 521-04-25
hallmultiplikator 521-04-27
hallsond 521-04-28
hallspänning 521-09-05
hall(spännings)uttag 521-09-06
hallvinkel 521-09-03
halvledardiod 521-04-03
halvledare 521-02-01
halvledarkomponent 521-04-01
halvledarminne 521-11-05
halvledartermoelement 521-04-23
huvudkarakteristik 521-08-05
huvudkvanttal 521-01-08
huvudspänning 521-08-04
huvudström 521-08-02
huvud(ströms)uttag 521-08-03
hål 521-02-17
hålkonduktivitet 521-02-50
hålledning 521-02-18
hållström 521-08-10

I

icke-degenerad halvledare 521-02-12
icke-tändande styrspänning 521-08-16
icke-tändande styrström 521-08-17
ideal kristall 521-02-45
I-ledare 521-02-07
I-ledning 521-02-20
inducerad styrspänning 521-09-16
infrarödstrålande diod 521-04-40
inre elektriskt fält 521-02-81
integrerad filmkrets 521-10-06
integrerad halvledarkrets 521-10-05
integrerad krets 521-10-03
inverterad arbetsriktning 521-07-12
inverterad gemensam bas 521-07-16
inverterad gemensam emitter 521-07-18
inverterad gemensam kollektor 521-07-17
isolator 521-02-31

J

jonhalvledare 521-02-06
jonimplantering 521-03-14
joniseringsenergi för acceptor 521-02-44
joniseringsenergi för donator 521-02-43
jonledning 521-02-21

K

kanal 521-07-06
kapacitansdiod 521-04-07
kapsel 521-05-31
kollektor 521-07-05
kollektor (hos fälteffekttransistor) 521-07-08
kollektorövergång 521-07-02
kompenserad halvledare 521-02-11
komponentblock 521-10-04
konduktivitetsmodulering 521-02-55
kretsparameter 521-05-34
kristalldragning 521-03-01
kristallodling med zonsmältning 521-03-02
kritisk blockspänningsderivata 521-08-18
kritisk ledströmsderivata 521-08-19
kvantiserat system 521-01-02
kvanttal 521-01-07
kvanttal för totalt rörelsemängdsmoment 521-01-11
kylare 521-05-33

L

laddningsbärare 521-02-51
laddningsbärarlagring 521-02-62
laddningskopplad krets 521-11-16
laddningsöverförande bildsensor 521-11-17
laddningsöverförande krets 521-11-14
laserdiod 521-04-37
laserdiodmodul 521-04-38
lavindiod 521-04-20
lavinfotodiod 521-04-44
lavingenombrott 521-05-07
lavinspänning 521-05-08
ledare 521-02-16
ledningsband 521-02-22
ledningselektron 521-02-14
ledningsström 521-02-15
ledtillstånd 521-08-07
legerad övergång 521-02-75

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

legeringsteknik ... 521-03-07
likriktardiod ... 521-04-19
likriktarstapel ... 521-04-21
ljuskänslig halvledarkomponent ... 521-04-41
lokal nivå ... 521-02-35
lysdiod ... 521-04-39
låsningsläge ... 521-10-11
låsström ... 521-08-11
läs- och skrivminne ... 521-11-07
läsminne ... 521-11-06

M

magnetisk känslighet ... 521-09-12
magnetoresistiv effekt ... 521-02-84
magnetoresistiv koefficient ... 521-09-18
magnetoresistiv kvot ... 521-09-19
magnetoresistiv känslighet ... 521-09-20
magnetoresistiv R/B-kurva ... 521-09-17
magnetoresistor ... 521-04-29
majoritets(laddnings)bärare ... 521-02-52
makrocell ... 521-11-22
Maxwell-Boltzmann-fördelning ... 521-01-03
Maxwell-Boltzmanns hastighetsfördelning ... 521-01-05
mesateknik ... 521-03-11
mikroelektronik ... 521-10-01
mikrokrets ... 521-10-02
mikrolegeringsteknik ... 521-03-10
minnescell ... 521-11-04
minoritets(laddnings)bärare ... 521-02-53
moduleringsdiod ... 521-04-10
MOS-transistor ... 521-04-55
multikrets ... 521-10-10

N

neutralt område ... 521-02-68
N-kanal (fälteffekt)transistor ... 521-04-56
N-ledare ... 521-02-09

O

odlad övergång ... 521-02-77
okvantiserat system ... 521-01-01
område med negativ differentiell resistans ... 521-05-05
optoelektronisk komponent ... 521-04-31
optoelektronisk teckentablå ... 521-04-36
optokopplare ... 521-04-45

P

paketöverförande krets ... 521-11-15
parasitiskt kretselement ... 521-05-36
partikeldeponering ... 521-03-17
Pauli-Fermis princip ... 521-01-14
penetration ... 521-05-12
piezoresistiv effekt ... 521-02-85
P-kanal (fälteffekt)transistor ... 521-04-57
P-ledare ... 521-02-10
planarteknik ... 521-03-09
PN-gräns ... 521-02-65
PN-övergång ... 521-02-78
pol ... 521-05-02
potentialbarriär ... 521-02-69
potentialbarriär (i PN-övergång) ... 521-02-70
programmerbar grindmatris ... 521-11-03
programmerbar logikkrets ... 521-11-01
programmerbar logikmatris ... 521-11-02
projicerad toppunkt ... 521-06-03

R

RAM-minne ... 521-11-08
(spännings)referensdiod ... 521-04-16
rekombinationscenter ... 521-02-64
resistiv gränsfrekvens ... 521-06-04
restspänning för nollmagnetfält ... 521-09-15
restspänning för nollstyrström ... 521-09-14
rymdladdningsområde ... 521-02-79
rymdladdningsområde (i PN-övergång) ... 521-02-80

S

sammansatt halvledare ... 521-02-03
Schottky-barriär ... 521-02-71
screentryckning ... 521-03-16
seriellt minne ... 521-11-12
signaldiod ... 521-04-04
skiva ... 521-05-29
släckbar tyristor ... 521-04-68
småsignalströmförstärkningsfaktor ... 521-07-19
spinnkvanttal ... 521-01-10
spänningsreferensdiod ... 521-04-16
spänningsreglerdiod ... 521-04-17
spärrtillstånd ... 521-08-09
statiskt minne ... 521-11-09
stigtid ... 521-05-22
strypspänning ... 521-07-23
(småsignal)strömförstärkningsfaktor ... 521-07-19
strömreglerdiod ... 521-04-18
styre ... 521-08-01
styre (hos fälteffekttransistor) ... 521-07-09
styrström ... 521-09-11
styrströmskänslighet ... 521-09-13
styrströmsslingans effektiva area ... 521-09-09
styr(ströms)uttag ... 521-09-07
stökiometrisk sammansättning ... 521-02-46
stör(halv)ledare ... 521-02-08
störning (i kristallgitter) ... 521-02-47
störämne ... 521-02-04
störämnesband ... 521-02-37
störämnesfälla ... 521-02-63
störämneskompensering ... 521-03-06
störämnesnivå ... 521-02-36
substrat ... 521-05-28
switchdiod ... 521-04-13
switchdiod för högfrekvens ... 521-04-14

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

T

termisk kapacitans 521-05-16
termisk resistans 521-05-13
termiskt genombrott 521-05-11
termistor 521-04-22
tetrodtransistor 521-04-50
tilledarram 521-05-32
tillåtet band 521-02-29
tjockfilm 521-10-09
tomt band 521-02-33
toppunkt 521-06-01
total strömförstärkningsfaktor 521-07-20
transistor 521-04-46
triac 521-04-67
triodtyristor med spärrförmåga 521-04-63
triodtyristor utan spärrförmåga 521-04-65
tröskelspänning (för diod eller transistor) 521-05-19
tröskelspänning (för fälteffekttransistor av anrikningstyp) 521-07-24
tunneldiod 521-04-05
tunneleffekt (i PN-övergång) 521-02-83
tunnfilm 521-10-08
tyristor 521-04-61
tyristor med N-styre 521-04-70
tyristor med P-styre 521-04-69
tänd(styr)spänning 521-08-15
tänd(styr)ström 521-08-14

U

unipolärtransistor 521-04-48
utarmningsdrift 521-07-10
utarmningsområde 521-02-82
utgångsämne för ASIC 521-11-19

V

valensband 521-02-23
vippunkt 521-08-12
virtuell skikttemperatur 521-05-15
virtuell temperatur 521-05-14
volymlivslängd 521-02-57

Y

ytband 521-02-34
ytnivå 521-02-42
ytpassivering 521-03-13
ytrekombineringshastighet 521-02-56

Z

zenergenombrott 521-05-09
zenerspänning 521-05-10
zonrening 521-03-03
zonutjämning 521-03-04

Å

ångfasdeponering 521-03-15
återhämtad laddning 521-05-18
återhämtningstid i backriktning 521-05-26
återhämtningstid i framriktning 521-05-25

Ö

övergång 521-02-72
övergångsområde 521-02-66
övergångszon för störämneskoncentration 521-02-67
överskotts(laddnings)bärare 521-02-54

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC**/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

Non affrancare
No stamp required

A Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Switzerland

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: *(e.g. 60601-1-1)*

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard *(tick all that apply).* I am the/a:

purchasing agent ❑
librarian ❑
researcher ❑
design engineer ❑
safety engineer ❑
testing engineer ❑
marketing specialist ❑
other.....

Q3 I work for/in/as a: *(tick all that apply)*

manufacturing ❑
consultant ❑
government ❑
test/certification facility ❑
public utility ❑
education ❑
military ❑
other.....

Q4 This standard will be used for: *(tick all that apply)*

general reference ❑
product research ❑
product design/development ❑
specifications ❑
tenders ❑
quality assessment ❑
certification ❑
technical documentation ❑
thesis ❑
manufacturing ❑
other.....

Q5 This standard meets my needs: *(tick one)*

not at all ❑
nearly ❑
fairly well ❑
exactly ❑

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: *(tick all that apply)*

standard is out of date ❑
standard is incomplete ❑
standard is too academic ❑
standard is too superficial ❑
title is misleading ❑
I made the wrong choice ❑
other .....

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:
(1) unacceptable,
(2) below average,
(3) average,
(4) above average,
(5) exceptional,
(6) not applicable

timeliness.....
quality of writing.....
technical contents.....
logic of arrangement of contents .....
tables, charts, graphs, figures.....
other .....

Q8 I read/use the: *(tick one)*

French text only ❑
English text only ❑
both English and French texts ❑

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

--`,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`---

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Not for Resale

Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Suisse

ou

Télécopie: **CEI**/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

Non affrancare
No stamp required

A Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
1211 GENÈVE 20
Suisse

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact: (*ex. 60601-1-1)*

.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

agent d'un service d'achat ❑
bibliothécaire ❑
chercheur ❑
ingénieur concepteur ❑
ingénieur sécurité ❑
ingénieur d'essais ❑
spécialiste en marketing ❑
autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

dans l'industrie ❑
comme consultant ❑
pour un gouvernement ❑
pour un organisme d'essais/ certification ❑
dans un service public ❑
dans l'enseignement ❑
comme militaire ❑
autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence ❑
une recherche de produit ❑
une étude/développement de produit ❑
des spécifications ❑
des soumissions ❑
une évaluation de la qualité ❑
une certification ❑
une documentation technique ❑
une thèse ❑
la fabrication ❑
autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

pas du tout ❑
à peu près ❑
assez bien ❑
parfaitement ❑

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d'être révisée ❑
la norme est incomplète ❑
la norme est trop théorique ❑
la norme est trop superficielle ❑
le titre est équivoque ❑
je n'ai pas fait le bon choix ❑
autre(s) .....

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

publication en temps opportun .....
qualité de la rédaction.....
contenu technique .....
disposition logique du contenu .....
tableaux, diagrammes, graphiques, figures.....
autre(s) .....

Q8 Je lis/utilise: *(une seule réponse)*

uniquement le texte français ❑
uniquement le texte anglais ❑
les textes anglais et français ❑

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Not for Resale

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale

ISBN 2-8318-5754-6



ICS 01.040.31; 31.080

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Not for Resale